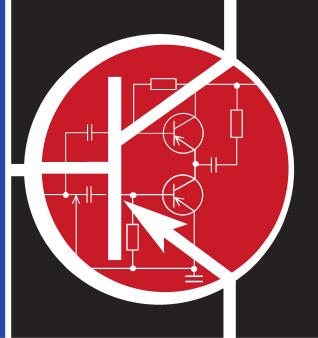
Н.В.БОБРОВ



# РАСЧЕТ РАДИО-ПРИЕМНИКОВ





### МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Основана в 1947 году

Выпуск 1027

Н. В. БОБРОВ

РАСЧЕТ РАДИО-ПРИЕМНИКОВ ББК 32.849 **5** 72 VIIK 621,396 62 001 24

#### РЕПАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Белкип Б. Г., Бондаренко В. М., Борисов В. Г., Ванеев В. И., Геницита Е. Н., Гороховский А. В., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. П., Хотунцев Ю. Л., Чистяков Н. И.

# Бобров Н. В.

Б 72 Расчет радиоприемников. — М.: Радио 1981 - 240 c. пл. — (Массовая связь. раднобиблиотска. Вып. 1027).

1 р. 30 к.

В книге приводятся методики расчета функциональных схем отдельных каскадов тразгансторных и ламновых радиоприемников. Для подготовленных радиолюбителей.

Б 30404-065 219-81 2402020000 046(01)-81

**ББК 32,849** 6Ф2.124

#### НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОБРОВ

## Расчет радиоприемников

Редактор В. А. Вяземский Редактор издательства Т. В. Жукова Технический редактор Н. П. Хотилева Корректор О. В. Корьева

#### H6 № 954

Сдано в набор 23 05.80 Подписано в печать 10.02 81 Фермат 84×108½ Бумага писчая № 1 Гарн, шрифта литературная Печать высокая Усл. печ л. 12,6 Уч-изд. л. 16.86 Тираж 80 000 экз, 11зд. № 19425 Заказ 1339 Пена 1 р. 20 к.

Издательство «Радио и связь», 161000, Москва, Главпочтамт, а/я 693 Ордена Октябрьской Ревелюции, ордена Трудового Красного\_Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Сеюзполиграфирома при Гесударствен-нем комитете СССР по делам падательств, полиграфир и книжной дорговли, 197136, Ленинграр, 11-136, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате Союзполиграфирома при Государственном комителе СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Чехов Месковской области

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные радиолюбители конструируют различную радиотехническую аппаратуру: станции радносвязи, навигационные радиоприемные устройства для «охоты на лис», системы радиоуправления движущимися моделями и т. п. Элементами таких систем являются как радиоприемник в целом, так и отдельные его составные части или каскады. Их характернстики могут быть весьма различными, и при проектировании следует найти наиболее оптимальные инженерные решения. Поэтому целесообразно создание пособий по расчету радиоприемников и их элементов, отвечающих заданным требованиям и обеспечивающих получение на основе синтеза возможно лучших характеристик (но не инже требуемых).

Предполагается, что читатель уже имсет определенные знания в области радиоприемных устройств, изучив, например, изданные в Массовой радиобиблиотеке учебники [5] или другие книги [3, 10,

25, 30, 401,

Основное внимание в книге сосредоточено на расчете структурной схемы радиоприемника (гл. 2), где на основе сравнения различных возможных вариантов выбирается наиболее приемлемый, позволяющий получить необходимые характеристики приемника. Сравнительная оценка ведется по достаточно большому числу различных вариантов (до 5—10 и более). При принятой методике расчета структурной схемы получаются все необходимые исходные данные для последующего расчета отдельных каскадов и систем регулировок приемника и исключается несбходимость изменения самой структурной схемы.

Большое внимание уделено выбору электронных приборов и селективных систем, позволяющих получить наилучшую чувствительность и селективность приемника при оптимальных технических и эксплуа-

тационных характеристиках.

Рекомендуемые методики расчета достаточно подробно нллюстрируются примерами расчета, что способствует более глубокому усвоению излагаемого магериала, правильному пониманию решения задач, требующих компромиссных подходов, и получению четких представлений о возможных предельно достижимых характеристиках

приемника и его каскадов.

В зависимости от различных вариантов исходных данных в гл. 3—12 описаны методики расчета отдельных каскадов и систем регулировок, которые позволяют получить оптимальные характеристики. Так, в 5—7 приводятся методики, нозволяющие построить каскад с селективной нагрузкой, гарантирующей наилучную селективность при заданном усилении каскада или наоборог, а также выбрать наилучшие способы построения селективных систем с переменной настройкой.

В гл. 13 приведен расчет структурной схемы приемника I класса, его отдельных каскадов, всех элементов схемы и основных характеристик.

В последние годы широкое применение при построении радиоаппаратуры находят интегральные гибридные микросхемы. Рекомендованные в гл. 14 методики расчета применимы для всех типов интегральных гибридных микросхем,

Автор выражает искреннюю благодарность В. П. Соколову и В. А. Вяземскому за цеппые замечания, высказанные при ревензи-

ровании и научном редактировании рукописи.

Автор будет признателен читателям за критические замечания, которые следует направлять по адресу: 101000, Москва, Главночтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», редакция Массовой радиобиблиотеки,

Автор

#### Глава первая

#### ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА РАДИОПРИЕМНИКА

#### 1-1. Задачи расчета и принципы их решения

Технический (или ииженерный) расчет радиоприемника выполняется для того, чтобы на основе требуемых (заданных) характеристик на приемник получить: 1) обоспованный и наиболее оптимальный вариант структурной схемы с выбором электронных приборов, схем и основных характеристик каждого каскада; 2) характеристики и параметры всех элементов (катушек индуктивности, резисторов, конденсаторов) каждого каскада приемника, включая выбор оптимального режима работы электронного прибора; 3) принципиальную схему приемника и спецификацию \* к ней. В соответствии со сказанным расчет приемника состоит из трех этапов: расчета структурной схемы, расчета отдельных каскадов, составления принципиальной схемы и спецификации к ней.

При расчете структурной схемы на основе сравнения нескольких вариантов радиоприемников, обеспечивающих требуемые характеристики, выбирается оптимальный, т. е. наиболее выгодный, который позволяет применять более простые (а значит, и более дешевые) электронные приборы и селективные системы при наименьшем числе катокадов. Для портативных и переносных приемников сравнительную оценку ведут также по требуемой мощности питания, поскольку такие приемники, как правило, питаются от электрохимических источников питания (батарей сухих элементов или аккумуляторов), стоимость,

габариты и масса которых пропорциональны их мощности.

Расчет отдельных каскадов начинают с выбора наиболее экономичного режима работы электронного прибора и определения его параметров в рабочем диапазоне частот, обеспечивающего требуемые характеристики каскада. Затем определяют сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов схемы, при которых достигается выбранный режим работы электронного прибора и требуемая стабилизация коллекторного тока. При этом в каждом отдельном случае по сортаментам, приводимым в справочниках, выбирают необходимый тип резистора или конденсатора. После этого рассчитываются параметры нагрузки каскада и проверяется соответствие реальных и требуемых характеристик каскада. На основе расчета составляется принципиальная схема каскада и спецификация к ней.

Составляя принципиальную схему приемника, используют схемы отдельных каскадов. При необходимости между выходом предыдущего

Спецификацией к принципиальной схеме называется таблица, составпенная по требованиям ГОСТ в содержащая сведения о всех приемника.

и входом последующего каскадов включаются нужные ссединительные элементы. Особое внимание при этом обращается на то, чтобы образующиеся межкаскадные цепи не нарушали работоспособность обоих каскадов [5].

### 1-2. Характеристики оконечного прибора и его выбор

Околечный прибор является нагрузкой выходного каскада радиоприемника. Поэтому для расчета приемника необходимо знать входнее сопротивление оконечного прибора и его зависимость от частоты в пределах возможных изменений модулирующих частот принимаемых сигналов, т.е. в полосе пропускания низкочастотного тракта приемника. Амплитудно-частотная характеристика громкоговорителей имеет некоторую неравномерность (по уровню звукового давления в зависимости от частоты). Поэтому для равномерного воспроизведения сигналов с различными модулирующими частотами в низкочастотном тракте приемника соответствующим образом корректируют амплитудно-частотную характеристику [5]. Характеристики оконечных приборов приводятся в [11, 22, 28].

Каждый громкоговоритель может воспроизводить с допустимым уровнем искажений звуковой сигнал, мощность которого не превышает его номинального значения. Эта мощность в вольт-амперах указывается первой цифрой в маркировке громкоговорителя. Так, к громкоговорителю типа 0,5ГД10 можно подводить сигнал с мощностью не более 0,5 В А. Таким образом, по необходимой мощности сигнала и днапазону модулирующих частот сигнала выбирается нужный гром-

коговоритель.

Кинескопы для нормальной работы требуют подведения на сигнальный (управляющий) электрод напряжения сигнала около 40—80 В и обладают практически чисто емкостным входным сопротивлением. Эти параметры также приводятся в литературе. Полоса частот телевизионного сигнала изображения в соответствии со стандартом в нашей стране составляет 6 МГц. Кинескоп выбирается, как правило, в соответствии с необходимыми размерами экрана (по его днагонали). Эти размеры стандартизированы.

# 1-3. Характеристики принимаемых сигналов, помех приему и выбор приемной антенны

Для расчета приемника необходимо знать следующие параметры принимаемых сигналов: минимальную  $f_{\rm c}$   $_{\rm min}$  и максимальную  $f_{\rm c}$   $_{\rm max}$  несущие частоты, вид модуляции, для амплитудно-модулированного сигнала (АМС) — максимальный коэффициент модуляции  $m_{\rm max}$ , а для частотно-модулированного сигнала (ЧМС) — индекс  $\psi_{\rm max}$  модуляции, нижнюю  $F_{\rm H}$  и верхнюю  $F_{\rm B}$  частоты модуляции, а также минимальную  $E_{\rm min}$  и максимальную  $E_{\rm max}$  напряженности поля принимаемых сигналов в мосте расположения приемной ангенны. Все эти параметры задаются в технических условиях на расчет приемника или могут быть выбраны радиолюбителем в соответствии с характеристиками радиостанций, сигналы которых желательно принимать. Для радионещательных приемников эти параметры определяются ГОСТ 5651—76.

Так, несущие частоты отечественных радновещательных станций распределяются в диапазонах, которые приведены в табл. 1-1.

Таблица 1-1

		Частот	а, МГц	Коэффи-		
Диапазон по шкал	те приемника	мини- мальная	макси- мальная	циент ди- апазона k <sub>д</sub> *	№ под- диапазона	
Длинноволновый	(ДВ)	0,15	0,405	2,73	I	
Средневолновый (СВ)  75 м  49 м  41 м  31 м	0,525	1,605	3,06	2		
	75 м	3,95	4	1,02	3	
	49 м	5,95	6,2	1,04	4	
	41 M	7, 1	7,3	1,03	5	
	31 м	9,5	9,775	1,03	6	
Коротковолно- вые (КВ)	25 м	11,7	11,975	1,03	7	
	19 м	15,1	15,45	1,03	8	
	16 м	17,7	17,9	1,02	9	
•	13 м	21,45	21,75	1,02	10	
	11 м	25,6	26,1	1,02	11	
Ультракоротковолновы.і (УКВ)		65,8	73	1,11	12	

<sup>\*</sup>  $k_{\pi}$  определяется отношением  $t_{\rm e,max}$  и  $t_{\rm e,min}$  внутри диапазона.

Для радновещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах километровых — декаметровых воли нижняя частота модуляции составляет 40  $\Gamma$ ц, а верхняя — 4,5 к $\Gamma$ ц.

В станциях метрового и дециметрового диапазонов волн с частотной модуляцией нижняя частота модуляции 40 Гц, а верхняя — 15 кГц при максимальном индексе модуляции 5. В первом случае ширина спектра сигиала, как известно, равна  $2F_B = 9$  кГц, во втором 250 кГц [5].

Несущие частоты телевизионных каналов, принятые в нашей стране, приведены в табл. 1-2. Параметры телевизионных сигналов отсчественных станций определяются ГОСТ 7845—72. Согласно ему несущая частота сигнала звукового сопровождения для каждого канала на 6,5 МГц выше несущей сигнала изображения. Минимальная частота спектра сигиала меньше несущей сигнала изображения на 1,25 МГц, а максимальная — больше несущей сигнала звукового сопровождения на 0,25 МГц. Ширина спектра любого телевизионного

канала составляет 8 МГц. Из табл. 1-2 следует, что первые 12 каналов находятся в метровом, а последующие 19 — в дециметровом диапазонах воли. В настоящее время все отечественные телевизоры имеют селектор телевизионных каналов, обеспечивающий фиксированную настройку на любом из первых 12 каналов. Каналы дециметрового диапазона предназначаются для использования по мере увеличения числа программ в крупных близко расположенных городах с целью исключения взаимных помех.

Таблица 1-2

№ кавала	Несущая частота изобра- жения, МГц	Граничные частоты спектра сигнала, МГц	№ Канала	Несущая час- тота изобра- жения, МГц	Граничные частоты спектра сигнала, МГц
1	49,75	48,5—56,5	8	191,25	190—198
2	59,25	5866	9	199,25	198—206
3	77,25	76—84	10	207,25	206214
4	85,25	84—92	11	215,25	214—222
5	93,25	92—100	12	223,25	222—230
6	175,25	174—182	21	471,25	470—478
7	183,25	182—190	39	615,25	614—622

Для радиолюбительских связей международными организациями выделены сравнительно узкие полосы частот (табл. 1-3). В каждой из них определен также характер передаваемого сигнала. Перекрытие по частоге любого из эгих поддиапазонов не представляет технических

трудностей, так как для них  $k_{\rm m} < 1.05$ .

При проектировании радиоприемников тин и параметры применяемых антени обычно задаются. Этими параметрами являются: действующая высота  $h_{\rm A}$ , собственная емкость  $C_{\rm A}$ , собственная пидуктивность  $L_{\rm A}$ , сопротивление потерь  $R_{\rm B}$  и сопротивление излучения  $R_{\rm \Sigma}$ . При работе радиоприемника в диапазоне частот указанные параметры должны быть заданы для каждой рабочей частоты. Чаще всего для этого служат экспериментально полученные данные, представленые в виде графиков или таблиц [16].

В радиолюбительской практике при выборе приемной антенны можно руководствоваться следующими рекомендациями. Для стационарного приемного устройства при необходимости вести прием сигналов со всех направлений следует применять ненаправленную проволочную или штыревую вертикальную антенну. Хорошие результаты могут быть получены и со слабонаправленными проволочными антеннами типа: наклонный провод, Г-образная, Т-образная. Формулы для расчета их нараметров приводятся в литературе [5]. Поскольку уровень внешних помех в километровых — декаметровых диапазонах воли достаточно высок, то обычно не следует брать большую длину

провода антенны, пропорционально которой увеличивается ее действующая высота и, следовательно, уровень внешних помех на входе радиоприемника. Как правило, бывает достаточно иметь действующую высоту антенны около 1,5—5 м. В портативных и переносных радиоприемных устройствах, предназначенных для приема сигналов в километровом — метровом диапазонах волн, в настоящее время используют ферритные и штыревые антенны, характеристики которых можно вычислить по методикам, описанным в [5, 13, 16, 35].

Таблина 1-3

Международное наименование	№ под- диала-		ие час- п. МГц	Вид сигнала и модуляции
	зона	min	max	
80-метровый	1	3,5	3,65	Телефон, телеграф АМ
40-метровый	2	7	7, 1	Телефон, телеграф АМ
	3	14	14,1	Телеграф АМ
20-метровый	4	14,1	14,3	Телефон АМ (двухполос- ный)
	5	14,3	14,35	Телефон АМ (однополосный)
	6	21	21,15	Телеграф АМ
14-метровый	7	21,15	21,35	Телефон АМ (двухполос- ныї)
	8	21,35	21,45	Телефон АМ (однополос- ный)
	9	28,0	28,2	Телеграф АМ
10-метровый	10	28,2	28,5	Телефон АМ (двухполос- ный)
	11	28,5	29,7	Телефон АМ (однополос- ный)
2-метровый	12	l 44	146	Телефон, телеграф АМ
70-сантиметровый	13	420	<b>43</b> 5	Телефон, телеграф АМ

Для приема телевизионных программ применяют направленные антенны. Характеристики таких антенн, позволяющих принимать сигналы 6—8 соседних каналов (из первых 12 по табл. 1-2), приводятся в [5, 22, 31].

В пределах ширины спектра радиовещательных и телевизионных сигналов основные внешние помехи приему (атмосферные, промышлению, космические) имеют практически равномерный спектр, весьма схожий со спектром собственных шумов приемника [5]. Их средний

уровень может быть определен для приема каждого канала радиовещания или телевидения в соответствии с графиками и формулами, приводимыми в [5, 31]. Вычислив среднее действующее значение напряжения помех  $U_{\rm п.в.x}$  на входе приемника, можно определить предельно осуществимую чувствительность проектируемого устройства

$$E_0 = \gamma_{U_{BX}} U_{\Pi_{CBX}}. \tag{1-1}$$

Значения коэффициента  $\gamma_{U_{\rm BX}}$ , определяющего необходимое превышение сигнала над помехами на входе приемника, приведены в табл. 1-4.

Таблица 1-4

Вид радиолинии	<b>Υ</b> <i>U</i> <b>BX</b>
Радиотелеграфия с приемом на: слух ондулятор буквопечатающий аппарат	0,7—2 2—5 3—10
Радиотелефония одноканальная с модуляцией: амплитудной частотной	3—10 2—5
Радиовещание с модуляцией: амплитудной частотной	7—30 2—3
Телевидение	7—30

# 1-4. Основные электрические характеристики приемника

Полные формулировки электрических и эксплуатационных характеристик приемников с достаточно подробными объяснениями приводятся в [3—5, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 30, 40]. Запишем их так, как это обычно делается в техническом задании на проектирование радиоприемника. Применительно к радиоприемникам

данные характеристики определяются ГОСТ 5651-76.

1. Диапазон рабочих частот, если он непрерывен, задается минимальной  $f_{\rm cmin}$  и максимальной  $f_{\rm cmax}$  частотами. Он в большой степени определяет выбор типа приемной антенны, электронных приборов и конструкцию радиотракта приемника. Если отдельные полосы из днаназона частот не являются рабочими, то это оговаривается и полный днапазоны делится на подднапазоны или частотные днапазоны. Так поступают применительно к радиовещательным приемникам. Граничные частоты их подднапазонов должны соответствовать табл. 1-1. Согласно табл. 1-1 для перекрытия всего днапазона радиовещательный приемник должен иметь 12 подднапазонов рабочих частот. Это

требует применения переключателя диапазонов на 12 фиксированных положений. Поскольку полосы частот поддиапазонов 3—11 относительно узкие, можно объединить пары соседних участков рабочих частот в один поддиапазон и тем самым уменьшить количество рабочих поддиапазонов, а следовательно, упростить конструкцию переключателя и приемника в целом. Последнее, естественно, сназит габариты, массу и стоимость приемника. Так, например, при объединении поддиапазонов 25 и 31 м можно взять один с граничными частотами 9,5—11,975 МГц. При выборе диапазона рабочих частот приемника необходимо учитывать также ряд конструктивных требований: плотность настройки, точность настройки по шкале, сложность изготовления механизмов шкалы и верньерного устройства.

Очевидно, что для входной цепи и каждого каскада радиочастотного тракта (включая преобразователь частоты) диапазоны рабочих частот должны быть такими же, какими они заданы для всего прием-

ника.

2. Полоса пропускания приемника определяется наиболее широким спектром принимаемых сигналов. Она должна быть шире спектра для учета нестабильности несущей сигнала и частоты гетеродина в супергетеродинном приемнике. Количественно превышение полосы пропускания над шириной спектра определяется коэффициентом расширения полосы [3, 5]. Чрезмерное расширение полосы пропускания увеличивает действие помех и снижает чувствительность приемника. Поэтому ее минимально необходимое значение должно определяться при расчете структурной схемы приемника. При расчете определяется также связь между полосами пропускания приемника и отдельных каскадов приемника (см. § 2-6). С целью унификации производства приемниках применяются типовые фильтры сосредоточенной селекции (ФСС). Их полосы пропускания выбраны так, чтобы обеспечивалась необходимая полоса пропускания всего приемника.

3. Чувствительность приемника задается минимальным значением э. д. с. сигнала  $E_0$ , создающейся в присмной антенне, при которой обеспечивается нормальный присм сигнала для требуемого значення коэффициента  $\gamma_{U_{\rm BX}}$  (см. табл. 1-4). При расчете приемника элементы высокочастотного тракта выбираются так, чтобы требуемая чувствительность обеспечивалась при выбранной антение. Поэтому чувствительность приемников различного типа рассчитывается исходя из технической возможности ее реализации, что определяется расчетом структурной схемы приемника (см. § 2-5). Так, согласно ГОСТ 5651—76, в поддиапазоне 1 чувствительность приемников высшего класса составляет 50 мкВ, а приемников класса IV — 200 мкВ. Чем выше чувствительность, тем сложнее и дороже будет радиотракт приемника.

тельность, тем сложнее и дороже оудет радиотракт приемника.

4 Селективность радиовещательных приемников по сост

4. Селективность радиовещательных приемников по соседним каналам задается ослаблением при расстройке  $\pm 9$  кГц. В поддиапазонах I и 2 для приемников высшего класса она составляет 55 дБ, а для класса IV — 26 дБ. В связных приемниках требуется лучшая селективность и ослабление по соседнему каналу должно быть до 80— 100 дБ. Двухсигнальная селективность связных приемников при расстройке 9 кГц обычло должна быть не менее 60 дБ.

Ослабление по зеркальному каналу также зависит от класса приемника и его диапазона рабочих частот. Так, для радиовещательных приемииков высшего класса в поддиапазоне 1 оно должно быть не менее 60 дБ, а в поддиапазонах 3—11—26 дБ (аналогично для прием-

ников IV класса — 34 и 10 дБ),

Подавление сигналов с промежуточной частотой в радиовещательных приемниках высшего класса должно превышать 40 дБ, а в приемниках класса IV-26 дБ. В связных приемниках этот параметр обычно бывает на 20-40 дБ выше.

При расчете структурной схемы приемника соответствующим выбором селективных систем трактов радиосигнала и промежуточной частоты обеспечиваются все указанные карактеристики селективности

приемника (см. § 2-6).

5. Коэффициент гармоник радиовещательных приемников выстшего класса при коэффициенте модуляции сигнала  $0.8\,$  в диапазоне модулирующих частот  $200-400\,$  Гц не должен превышать  $0.08\,$ , а при модулирующих частотах выше  $400\,$  Гц —  $0.05\,$ . Для приемников класса IV он должен быть соответственно меньше  $0.12\,$  и  $0.08\,$ . Примерно такие же значения коэффициента гармоник допускаются в связных приемниках.

Наибольшие нелинейные искажения создаются в выходном каскаде приемника, поскольку он работает в режиме усиления больших сигналов. Примерно одинаковый уровень нелинейных искажений дает детектор и предоконечный каскад. Нелинейными искажениями в других каскадах при правильном выборе режимов их работы обычно пренебрегают [3, 5]. Поэтому допустимые коэффициенты гармоник указанных каскадов на основании данных опыта определяются следующими равенствами:

$$k_{\rm f.\,BMX} \approx 0.7 k_{\rm f}; \quad k_{\rm f.\,H.\,K} \approx 0.3 k_{\rm f} \quad \text{M} \quad k_{\rm f.\,H} \approx 0.1 k_{\rm f}. \tag{1-2}$$

Здесь  $k_r$  — коэффициент гармоник всего приемника.

Кривая верности (по звуковому давлению) радиовещательных приемников для сигналов с частотами выше 250 Гц должна иметь неравиомерность менее 14 дБ, а на частотах ниже 250 Гц — менее 18 дБ. Такие параметры для приемников высшего класса необходимо обеспечивать в интервале модулирующих частот от 40 до 5600 Гц, а для приемников класса IV 200-3150 Гц. Для подднапазона 12 границы интервала модулирующих частот от 40 до 16 000 Гц. В связных приемниках всех классов границы интервала модулирующих частот приняты от 300 до 3400 Гц, что значительно проще выполнять. Для каждой частоты модуляции коэффициент амплитудно-частотных искажений приемника (а следовательно, и уровень соответствующей ординаты кривой верности) будет равен произведению коэффициентов амплитудно-частотных искажений отдельных каскадов приемника (включая громкоговоритель). При расчете структурной схемы приемника коэффициенты амплитудно-частотных искажений высокочастотного  $M_{\rm H, BQ}$  ( $M_{\rm B, BQ}$ ) и низкочастотного  $M_{\rm H, HQ}$  ( $M_{\rm B, HQ}$ ) трактов численио принимают равными. Следовательно,

$$M_{\text{H. BQ}} = M_{\text{H. HQ}} = \sqrt{M_{\text{H}}} \quad \text{if} \quad M_{\text{B. BQ}} = M_{\text{B. HQ}} = \sqrt{M_{\text{B}}}, \quad (1-3)$$

где  $M_{\rm H}$  и  $M_{\rm B}$  — допустимые значения коэффициентов амплитудночастотных искажений для всего приемника. Допустимый уровень амплитудно-частотных искажений в каждом каскаде выбирается при

расчете структурной схемы приемника (см. § 2-2).

6. Система APV, определяющая динамический диапазон, в радновещательных приемниках высшего класса должна обеспечивать измечение выходного иапряжения не более чем на 10 дБ при повышении уровня входного сигнала иа 60 дБ. Для приемников класса IV эти параметры соответствуют 10 и 26 дБ. Примерно такие же значения они имеют для связных приемников,

- 7. Выходная мощность радиовещательных приемников определяется при выбранном типе громкоговорителя средним (номинальным) авуковым давлением. Так, для приемников высшего класса оно должно превышать  $10\cdot10^5$  Па  $(4\cdot10^5$  Па при автономном источнике питания). У приемников класса IV эта характеристика соответствует 3,5  $(2)\times 10^5$  Па, а в перепосном варианте  $2\cdot10^5$  Па. Так, например, портативные динамические громкоговорителя типов 0,25 ГД-1 и 0,15 ГД-1 обеспечивают среднее звуковое давление 1,5· $10^5$  Па, что достаточно для переносных приеминков класса IV. Но первый тип громкоговорителя для этого требует номинальную мощность сигнала 0,25 Вт, и второй 0,15 Вт [11]. В связных приеминках определяется выходная мощность (в ваттах).
- 8. Потребление энергии от автономных источников питания для радиовещательных приемников высшего класса не должно превышать 4 Вт., а для класса IV 0,3 Вт.

Эксплуатационные характеристики приемника связаны с его конструктивным оформлением. Поэтому рассмотрим их более конкретно при расчете структурных схем и в примерах расчетов.

# 1-5. Выбор и построение структурных схем приемников

В диапазонах гектометровых и более коротких волн транзисторные и ламповые приемники с необходимой в настоящее время селективностью и удовлетворительной чувствительностью могут выполняться только по супергетеродинной схеме [3, 5]. Сказанное подтверждается тем, что все современные радновещательные приемники отмеченных ранее диапазонов волн, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью, являются супергетеродинными. Поэтому в основном будем рассматривать особенности построения и расчета структурных схем супергетеродинных приемников. Определить оптимальное число каскадов в различных трактах приемника можно только на осповании расчета структурной схемы. Ее следует выбирать, исходя из параметров радиовещательных приемников различных классов [5].

Так, для приемников II—IV классов, как правило, не требуется усилитель радиосигнала и бывает достаточно два каскада в тракте промежуточной частоты. Радиоприемники высшего и 1 классов для обеспечения чувствительности и необходимой селективности требуют применения хотя бы одного каскада усилителя радиосигнала при двух-трех каскадах в тракте промежуточной частоты. Сказанное легко проверить, сравнив структурные схемы радиовещательных приемников одинаковых классов, выпускаемых различными заводами [12, 13, 20, 24]. Такая же закономерность имеет место для связных [12] и для телевивионных [22] приемников.

Глава втирая

#### РАСЧЕТ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРИЕМНИКОВ АМС И ЧМС

# 2-1. Разбивка общего диапазона рабочих частот на поддиапазоны

Целью расчета является определение числя рабочих поддиапазонов, их граничных частот и выбор пересграиваемого элемента колебательных контуров тракта радиосигнала, Исходиыми данными для

решения этих задач являются: диапазоп рабочих частот приемника; расстройка соседнего канала  $\Delta f_{\rm c}$  (минимальный интервал между несущими частотами соседних по частоте сигналов); максимально допустимое число радиостанций  $N_{\rm c}$ , сигналы которых должны приниматься в одном поддиапазоне.

В днапазонах метровых и более длинных волн, в которых используются радиовещательные и радиолюбительские прнемники, в качестве резонансных систем радиотракта применяются электрическиз колебательные контуры с сосредоточенными параметрами. При перестройке такого контура конденсатором переменной емкости его максимально осуществимый коэффициент днапазона

$$k_{\text{m max}} = f_{0 \text{ max}} / f_{0 \text{ min}} = \sqrt{C_{9 \text{ max}} / C_{9 \text{ min}}}$$
 (2-1)

не превышает 2,5—3. Здесь  $f_0$  и  $C_2$ — резолансная частота и эквивалентная емкость контура соответственно. Максимальный коэффициент диапазона не превышает 1,5—2,5 при перестройке колебательного контура катушкой с переменной индуктивностью; 1,4—2,2— варикапом; 1,1—1,2— реактивным транзистором [4, 5]. Если при заданных граничных частотах рабочего диапазона  $f_{\rm c\ max}$ ,  $f_{\rm c\ min}$  и выбранном элементе перестройки контура выполняется неравенство

$$f_{c \max} \leq k_{\pi \max} f_{c \min}, \tag{2-2}$$

то весь диапазоп рабочих частот может быть перекрыт одним контуром. Однако при  $k_{\rm I}>1,5\div2,5$  в декаметровом и метровом диапазонах воли может оказаться очень большая плотность настройки, т. е. число возможных радностанций на одно деление шкалы. Настройка на частоты соседних станций должна отличаться по шкаль настройки не менее чем на одно деление шкалы [5, 12]. При общей длине шкалы  $l_{\rm ul}=120\div150\,$  мм и расстоянии между рисками соседних делений шкалы  $\Delta l_{\rm ul}=1\div1,5\,$  мм число делений шкалы будет:

$$n_{\rm ini} = l_{\rm ini}/\Delta l_{\rm ini} = (120 \div 150)/(1 \div 1.5) = 80 \div 150.$$
 (2-3)

Число станций  $N_c$ , которое может разместиться в одном рабочем поддиапазоне, согласно сказанному ранее не может превышать числа делений шкалы, т. е.  $N_c \leqslant n_{\rm m}$ . Следовательно, для каждого поддиапазона должно выполняться равенство

$$k_{\rm A} = \frac{f_{\rm c \, max}}{f_{\rm c \, min}} = \frac{f_{\rm c \, min} + n_{\rm m} \, \Delta f_{\rm c}}{f_{\rm c \, min}} = 1 + \frac{n_{\rm m} \, \Delta f_{\rm c}}{f_{\rm c \, min}} = 1 + \frac{N_{\rm c} \, \Delta f_{\rm c}}{f_{\rm c \, min}}. \quad (2-4)$$

Чем выше минимальная рабочая частота, тем меньший коэффициент диапазона требуется в каждом поддиапазоне. Для радиовещания в декаметровом и более длинноволновых диапазонах прииято  $\Delta f_{\rm c}=10~$  кГц. Поэтому при  $f_{\rm c}$  min = 9,5 МГц и  $n_{\rm m}=100~$  согласно (2-4) получим  $k_{\rm g}=1+100\cdot 10^4/(9.5\cdot 10^6/)=1.1$ , что значительно меньше максимально осуществимых значений при любом из указанных способов перестройки контура. Для рассматриваемого примера  $f_{\rm c}$  max =  $k_{\rm g}f_{\rm c}$  min = 1,1·9,5 = 10,5 МГц. Согласно табл. 1-1 при таком  $k_{\rm g}$  может быть перекрыт лишь поддиапазон 31 м.

Во многих радновещательных приемниках объединяются в один поддиапазоны 25 и 31 м. Для этого согласно табл. 1-1 требуется  $k_{\pi} = 12 \cdot 10^9 / (9,5 \cdot 10^9) = 1,27$ , что внолне осуществимо. Но согласно равенству (2-4) число возможных соседиих каналов в поддиапазоне

будет  $N_0=(k_{\pi}-1)\,f_{\rm c\,min}/\Delta f_{\rm c}=(1.27-1)\,9.5\cdot10^6/10^4=256$ . Для перестройки приемника на соседнюю станцию потребуется сместить указатель настройки на 1/256 длины шкалы, что будет гораздо меньше деления шкалы. Именно поэтому оказывается столь затруднительной настройка приемников в рассмотренном поддианазоне.

Чтобы облегчить настройку приемника в декаметровом диапазоне, применяют подднапазоны с растяпутой настройкой, охватывающие только рабочие участки диапазона согласно табл. 1-1 [5]. Необходимый коэффициент диапазона контура при этом не превышает 1,05.

Если допускать одинаковую плотность настройки на каждом поддианазоне, то согласно (2-4) с увеличением частоты необходимо брать меньший коэффициент диапазона. Такой способ разбивки общего диапазона рабочих частот на поддиапазоны называют способом с постоянным интервалом частот. Выполияют его в следующей последовательности. Задаются допустимым числом сигналов в каждом поддиапазоне  $N_{\rm c}$ . Его берут равным числу делений шкалы  $n_{\rm m}$ . Определяют интервал частот для каждого поддиапазона

$$\Delta f'_{\text{nex}} = N_c \, \Delta f_c. \tag{2-5}$$

По его значению находят необходимое число поддиапазонов

$$n_{\text{not}} \gg (f_{\text{c max}} - f_{\text{c min}})/\Delta f_{\text{nog}}'$$
 (2-6)

принимая ближайшее большее целое число. После этого определяют действительный интервал частот поддиапазонов

$$\Delta f_{\text{non}} = (f_{\text{c max}} - f_{\text{c min}})/n_{\text{non}}$$
 (2-7)

и находят граничные частоты, добавляя к минимальной расочей частоте  $\Delta f_{\rm nog}$ ,  $2\Delta f_{\rm nog}$ ,  $3\Delta f_{\rm nog}$  и так до  $f_{\rm c max}$ . Счет поддианазонов ведут от минимальной рабочей частоты (первым будет тот, у которого  $f_{\rm min} = f_{\rm c min}$ ).

За счет погрешности в параметрах контурной катушки и конденсатора контура, а также нестабильности этих параметров в процессе эксплуатации граничные частоты поддиапазонов могут несколько отличаться от расчетных. Если максимальная частота предыдущего поддиапазона за счет отмеченных факторов уменьшится, а минимальная последующего поддиапазона — увеличится, то между граничными частотами этих поддиапазонов образуется разрыв. Может стать невозможным прием станций, несущие частоты которых окажутся в пределах разрыва между граничными частотами поддиапазонов. Чтобы этого не получалось, обеспечивают запас перекрытия по частоте между соседиими поддиапазонами. Их минимальные граничные частоты уменьшают, а максимальные — увеличивают па 2—3 %. Таким образом, получают окончательные расчетные значения граничных частот поддиапазонов.

В декаметровых приемниках магистральных линий связи рабочий дианазон частот обычно достаточно широк и непрерывен. Рассмотрим разбивку его на поддианазоны на примере.

Пример 2-1. Разбить днапазон рабочих частот связного приемника при:  $f_{\rm c \ min} = 2 \ {\rm M} \Gamma {\rm u}, \ f_{\rm c \ max} = 30 \ {\rm M} \Gamma {\rm u}, \ \Delta f_{\rm c} = 25 \ {\rm \kappa} \Gamma {\rm u}, \ N_{\rm c} = n_{\rm m} = 100.$ 

По формуле (2-5)  $\Delta f_{\text{под}}' = 100 \cdot 25 \cdot 10^3 = 25 \cdot 10^5$  Гц. Согласно неравенству (2-6)  $n_{\text{под}} \geqslant (30-2)/2, 5 = 11, 2$ , Принимаем 12 под

диалазонов 6 и из уравнения (2-7) находим  $\Delta f_{\text{под}} = (30 \div 2) \cdot 10^6/12 = 2.333 \cdot 10^6 \, \Gamma_{\text{II}}$ .

Определяем граничные частоты поддиапазонов по указанной ранее методике. Они составляют: 2; 4,333; 6,666; 9,0; 11,333; 13,666; 16,0; 18,333; 20,666; 23,0; 25,333; 27,666; 30 МГц. Для обеспечения перекрытия минимальные частоты поддиапазонов берем меньше, а максимальные — больше на 2% граничных частот. Полученные минимальные и максимальные частоты поддиапазонов приведены в табл. 2-1. По их значениям вычисляют коэффициенты диапазонов (табл. 2-1). Они вполне могут быть обеспечены при иастройке контуров раднотракта конденсаторами переменной емкости, катушками с переменной индуктивностью или с помощью варикапов.

Таблица 2-1

	Поддиапазон											
Параметр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
Минимальная частота, МГц	1,94	4,25	6,55	8,83	11,3	13,4	15,7	18,0	20,3	22,6	24,9	27,2
Максимальная частота, МГц	4,42	6,8	9,18	11,6	13,9	16,3	18,7	21,1	23,4	25,8	28,2	30,6
Коэффициент диапазона	2,24	1,6	1,4	1,32	1,23	1,22	1,19	1,17	1,16	1.15	1,14	1,14

Пример 2-2. Определить минимальные и максимальные частоты поддиапазонов радиовещательного приемника I класса, обеспечивая запас перекрытия по частоте  $2\ \%$ .

Согласно ГОСТ 5551—76 радиовещательные приемники I класса должны иметь рабочими все участки частот согласно табл. 1-1. Поэтому минимальные и максимальные частоты поддиапазонов должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2-2. Поскольку для первых двух поддиапазонов  $k_{\pi}$  достаточно велик, настройку контуров можно осуществить с помощью конденсаторов переменной емкости. Именно этим объясняется данный метод настройки контуров радиотракта радиовещательных приемников.

Определение крайних частот поддиапазонов приемников любительской связи выполняется так же, как в примере 2-2, но с использо-

ванием данных табл. 1-3.

Таблица 2-2

					]	Годди	апазо	Н	_			
Параметр	i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мицимальная частота, МГц	0.147	0,515	3,88	5,85	6,85	9,3	11,4	14,6	17,3	21	25,1	64
Максимальная частота, МГц	0,417	1,64	4,08	6,32	7,45	9,95	12,2	15,7	18,6	22,2	26,6	74,5
Коэффициент диапазона	2,83	3,18	1,05	i.08	1.09	1,07	1,07	1,07	1,07	1,05	1.06	1,11

### 2-2. Предварительный расчет выходного каскада

Целью предварительного расчета являются выбор схемы каскада, типа транзистора и его режима работы, определение необходимого входного сигнала, расчет входного сопротивления, являющегося нагрузкой предыдущего каскада. Эти задачи решаются на основе следующих исходных данных: номинальной выходной мощности  $P_{\rm H, Bык}$  и сопротивления нагрузки  $R_{\rm H}$ ; нижней  $F_{\rm H}$  и верхней  $F_{\rm B}$  частот усиливаемого сигнала; допустимого коэффициента гармоник  $k_{\rm F}$ ; коэффициента амплитудно-частотных искажений на нижней  $M_{\rm H}$  и на верхней  $M_{\rm B}$  частотах усиливаемого сигнала. Первые две пары исходных данных задаются в характеристиках приемника. Допустимый коэффициент гармоник выходного каскада определяется первым равенством из (1-2). Уровень амплитудно-частотных искажений в выходном каскада принимают примерно равным их уровню в остальных каскадах низкочастотного тракта (включая детектор). Поэтому согласно равенствам (1-3) можно принять для выходного каскада

$$M_{\text{H. BMX}} = \sqrt{M_{\text{H. Hq}}} = \sqrt[4]{M_{\text{H. Hq}}} = \sqrt[4]{M_{\text{H. BMX}}} = \sqrt{M_{\text{B. Hq}}} = \sqrt[4]{M_{\text{B. Hq}}} = \sqrt[4]{M_{\text{B. Hq}}}.$$
 (2-8)

Для остальных каскадов низкочастотного тракта

$$M_{\text{H-K}} = \sqrt[n]{M_{\text{H-BMX}}} = \sqrt[4n]{M_{\text{H}}} \quad \text{M} \quad M_{\text{B-K}} = \sqrt[n]{M_{\text{B-BMX}}} = \sqrt[4n]{M_{\text{B}}}. \quad (2-9)$$

Здесь п — число каскадов в низкочастотном тракте (вместо вы-

жодного каскада сюда входит детектор).

В выходном каскаде приемника транзистор может включаться по схеме с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Наибольший коэффициент передачи обеспечивает схема с ОЭ, но она дает большие пелинейные искажения по сравнению со схемой с ОБ, обеспечивающей меньшее усиление. В схеме с ОК коэффициент передачи по напряжению меньше единицы. Входное сопротивление усилителя по схеме с ОБ наименьшее (десятки ом), что увеличивает нагрузку предыдущего каскада. У усилителя с ОЭ оно составляет сотни ом, а у усилителя с ОК — единицы и десятки килоом. Выходное сопротивление — наименьшее у усилителя по схеме с ОК, благодаря чему требуется меньший коэффициент трансформации выходного трансформатора (или меньшее сопротивление нагрузки в бестрансформаторном усилителе). В усилителях с ОЭ оно больше и самое большое в схеме с ОБ.

При введении отрицательной обратной связи (ООС) в усилителе с ОЭ можно значительно снизить нелинейные искажения и сделать их меньшими по сравнению с другими схемами при большем коэффициенте усиления каскада. Поэтому в подавляющем большинстве приемников в выходных каскадах транзисторы включают по схеме с ОЭ и лишь иногда применяют включение по схеме с ОБ. Схема с ОК иногда используется в бестрансформаторных каскадах. В выходных

каскадах ламповых приемников используется схема с ОК.

Тип транзистора и схема каскада выбираются с учетом следующих соображений. В однотактном выходном каскаде можно использовать только режим класса Л, который обладает малым к. п.д. (меньше 40 %), требует от источника питания большого тока при отсутствии усиливаемого сигнала, имеет большой постоянный подмагничнаяющий ток в первичной обмотке выходного трансформатора (что приводит к увеличению его размеров и стоимости). Максимальная выходнат

мощность однотактного трансформаторного каскада в первом приближении определяется уравнением

$$P_{\max} = 0.5 \xi_n E_{\kappa} \xi_I I_{\text{K max}} = 0.5 U_{m \text{K}} I_{m \text{K}}, \qquad (2-10)$$

где  $E_{\mathbf{k}}$  — напряжение источника питания коллекторной цепи;  $I_{\mathrm{Kmax}}$  — максимальный коллекторный ток при выбранном  $E_{\mathbf{k}}$ ;  $\xi_u$  и  $\xi_I$  — коэффициент использования коллекторного напряжения и коллекторного тока (их значения приведены в табл. 2-3) [1, 4, 10, 12, 16].

Таблина 2-3

Схема	каскада н ј	режим работы	ξu	<b>\$</b> /	£ <sup>0</sup> 1	ξ <sub>0</sub> μ
Однотактиая	класса А	Трансформагорная	0,85	0,4	0,5	1
		Трансформаторная	0,85	0,85	0,35	l
Двухтактная АВ	класса	Бестрансформатор- ная	0,4	0,85	0,45	0,5

Рассенваемая мощность коллектора транзистора в режиме класса А

$$P_{\kappa} = U_0 I_0 = \xi_{0u} E_{\kappa} \xi_{0l} I_{K \text{ max}}, \qquad (2-11)$$

не должна превышать  $P_{\mathrm{K\ max}}$ , т. е. максимально допустимой для транзистора при любых значениях усиливаемого сигнала

$$P_{\rm K} \leq P_{\rm K max}. \tag{2-12}$$

Для проверки выполнения этого неравенства на поле выходных характеристик транзистора строится зависимость  $P_{\kappa} = U_0 I_0 = P_{\kappa \max}$  (кривая I на рис. 2-1). Неравенство (2-12) будет выполняться, если нагрузочная лиция (прямая BB) не пересекается с кривой I.

Однотактные каскады применяются при выходной мощности не более 0,05 Вт. При больших мощностях, как правило, используются двухтактные каскады, обладающие лучшим к. п. д. и меньшими раз-

мерами выходного трансформатора.

В однотактном каскаде рабочая точка А выбирается в средней части нагрузочной характеристики. Наклон этой характеристики оптимален в том случае, когда выходные характеристики отсекают на ней почти равные по своей длине огрезки. При этом нелинейные искажения получаются наименьшими.

Часть энергии сигнала тратится в выходном трансформаторе. Обозначив его к. п. д. через  $\eta_{\tau p}$ , получим формулу для выбора тран-

энстора одногаженого каскада

$$P_{\max} \eta_{rp} \geqslant P_{\text{H. Bid}}. \tag{2-13}$$

Значения  $\eta_{\rm TP}$  обычно составляют 0,65—0,75 при выходной мощности менее 1 Вт и 0,75—0,85 при выходной мощности от 1 до 10 Вт.

Согласно формулам (2-13) и (2-10) для достижения наибольшей выходной мощности каскада следует брать возможно большее напряжение  $E_{\mathbf{k}}$ . Напряжение на коллекторе транзистора в однотактном каскаде, работающем в режиме класса A, при максимальном входном сигнале почти вдвое превышает  $E_{\mathbf{k}}$ . В процессе эксплуатации напряжение автономных источников синжается. Поэтому перавенство (2-12) проверяется при номинальном напряжении источника

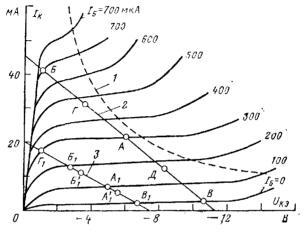


Рис. 2-1.

питания  $E_{\rm K}=E_0$ . При максимально допустимом коллекторном напряжении транзистора  $E_{\rm K}$   $_{\rm max}$  номинальное напряжение источника питания должно выбираться с учетом неравенства

$$E_0 \leq (0.3 \div 0.4) E_{\text{K max}}.$$
 (2-14)

Леобходимый входной сигнал транзистора определяется по входным характеристикам, показанным на рис. 2-2, а. Для этого следует перенести на характеристику с выбранным  $E_{\rm K}$  рабочую точку A и точки B и B, лежащие на нагрузочной характеристике. Амплитуду первой гармоники тока базы и напряжения  $U_{\rm B9}$  в первом приближении можно вычислить по формулам:

$$I_{mB} \approx 0.5 \left[ (I_{BB} - I_{BA}) + (I_{BA} - I_{BB}) \right] = 0.5 \left( I_{BB} - I_{BB} \right)$$
 (2-15)

$$U_{m \text{ B3}} \approx 0.5 [(U_{\text{BB}} + U_{\text{BA}}) + (U_{\text{BA}} - U_{\text{BB}})] = 0.5 (U_{\text{BB}} - U_{\text{BB}}).$$

И

Здесь токи  $I_{\,\mathrm{B}A}$ ,  $I_{\,\mathrm{B}B}$  и  $I_{\,\mathrm{B}B}$  соответствуют токам базы тех выходных характеристик, на которых лежат точки A, B и B нагрузочной карактеристики на рис. 2-1.

Входное сопротивление транзистора в выбранной рабочей точке

$$h_{119}^* = U_{m \, \text{B}} - I_{m \, \text{B}}.$$
 (2-16)

Малые нелинейные искажения в каскаде по схеме с ОЭ получаются при выборе внутреннего сопротивления источника сигнала (т. е. сопротивления нагрузочного резистора предыдущего каскада) из соотношения [1, 4, 16]

 $R_{\rm c} \approx (2 \div 8) h_{113}. \tag{2.17}$ 

С увеличением коэффициента (2—8) нелинейные искажения понижаются, а передача сигнала из коллекторной цени предыдущего каскада к участку база—эмиттер выходного каскада уменьшается.

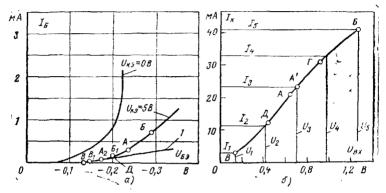


Рис. 2-2.

Выходным напряжением предыдущего каскада и входным напряжением данного каскада является падение напряжения сигнала на внутреннем сопротивлении источника сигнала, а входным напряжением транзистора, приложенным непосредственно к переходу база — эмиттер, будет напряжение сигнала на входном сопротивлении транзистора. Входное сопротивление каскада зависит ие только от режима работы транзистора каскада, но и от сопротивления источника сигнала  $R_{\rm c}$ . В первом приближении его можно вычислить по формуле

$$U_{m_{BX}} = U_{B3} \frac{R_{c} + r_{6}' + h_{119}}{h_{119}}.$$
 (2-18)

При наличии в справочнике проходной характеристики (зависимости коллекторного тока от входного сигнала, рис. 2-2,  $\delta$ ) по ней находят непосредственно амплитуду входного сигнала каскада, подставляя во вторую формулу (2-15) вместо напряжений  $U_{\rm BB}$  и  $U_{\rm BB}$  соответствующие точкам  $\cal B$  и  $\cal B$  напряжения  $\cal U_{\rm BXB}$  и  $\cal U_{\rm BXB}$ .

Для усилителя по схеме с ОБ коэффициент в уравнении (2-17)

следуег брать от 2 до 5 с учетом сделанных ранее замечаний.

Коэффициент гармоник каскада вычисляется по проходной характеристике каскада, если она приведена в справочнике [32]. Но для приближенных расчетов можно воспользоваться следующей методикой. Отмечают на нагрузочной характеристике (см. рис. 2-1) точки  $\Gamma$  и  $\mathcal{L}$ , которые должны быть серединой отрезков EA и AB и определяют соответствующие им токи базы  $I_{BI}$  и  $I_{BA}$ . Если эти точки ока-

зываются между выходными карактеристиками (рис. 2-1), то определение токов выполняют методом интерполирования. Затем по формулам:

$$I_{mB1} = 0.33 (I_{BB} + I_{B\Gamma} - I_{B\Pi} - I_{BB});$$

$$I_{mB2} = 0.25 (I_{BB} + I_{BB}) - 0.5I_{BA};$$

$$I_{mB3} = 0.167 (I_{BB} - I_{BB}) - 0.33 (I_{B\Gamma} - I_{B\Pi});$$

$$I_{mB4} = 0.083 (I_{BB} + I_{BB}) - 0.33 (I_{B\Gamma} + I_{B\Pi}) + 0.5I_{BA};$$

$$k_{\Gamma} = \frac{\sqrt{I_{mB2}^2 + I_{mB3}^2 + I_{mB4}^2}}{I_{mB1}}$$
(2-19)

вычисляют высшие гармоники тока базы и коэффициент гармоник [1,4] Если полученное значение  $k_{\rm f}$  удовлетворяет допустимому, транзистор при выбранном режиме приемлем для выходного каскада. Если коэффициент гармоник окажется больше допустимого, следует применить в усилителе обратную отрицательную связь или взять более мощный транзистор. При более мощном транзисторе необходимый рабочий участок нагрузочной характеристики между точками  $\mathcal B$  и  $\mathcal B$  на рис. 2-1 будет дальше от границ поля выходных характеристик, а следовательно, и в области, где характеристики идут более равномерно. Но при этом потребуется большая мощность питапия каскада, а стоимость транзистора и выходного трансформатора будут, как правило, выше. Введение ООС уменьшает усиление и может потребовать применения добавочных каскадов в низкочастотном тракте приемника. Но этот путь оказывается экономически более оправданным и потому применяется значительно чаще.

Коэффициент амплитудно-частотных искажений транзистора на верхней частоте сигнала определяется формулой

$$M_{\text{B-T}} = \sqrt{1 + \left[\frac{F_{\text{B}}}{f_{\alpha} (1 - \alpha)}\right]^2}$$
 (2-20)

и не должен превышать 40-60~% коэффициента амплитудно-частотных искажений, допустимого для всего каскада. Этот запас учитывает искажения, вносимые выходным трансформатором и другими элементами схемы.

В случае применения ООС коэффициент передачи определяется уравнением

$$K_{\text{o.c}} = \frac{K_{\text{T}}}{1 + \varepsilon K_{\text{T}}}.$$
 (2-21)

Здесь

$$K_{\rm T} = U_{mK}/U_{mBB}$$
 (2-22)

 коэффициент усиления каскада при отсутствии обратной связи и без учета выходного трансформатора (рис. 2-3), а в — коэффициент обратной связи.

Наиболее часто в низкочастотном тракте применяется обратная связь по напряжению, когда часть сигнала, создающегося в коллекторной цепи  $U_{\rm K}$ , через цепь обратной связи подводится на вход каскада. Подводимое на вход каскада напряжение обратной связи  $U_{\rm o,c}$  должно быть в противофазе со входным сигналом усилителя, В этом случае

$$\mathbf{8} = U_{0,c}/U_{K},\tag{2-23}$$

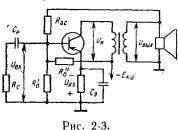
Точный расчет цепей обратной связи для необходимого уменьшения нелинейных искажений сложен. Однако данные опыта позеоляют воспользоваться следующим условием. За счет ООС коэффициент гармоник каскада уменьшается, а верхияя граничная частота резисторного каскада увеличивается примерно во столько раз, во сколько уменьшеется коэффициент усиления каскада. Предположим, что требуется уменьшить коэффициент гармоник в а раз. Тогда из уравнений (2-21) и (2-23) получим требуемый коэффициент обратной связи

$$\varepsilon = (a-1)/K_{\tau}. \tag{2-24}$$

Поскольку ООС уменьшает усиление каскада в а раз, то при расчете структурной схемы низкочастотного тракта следует увеличивать входной сигнал, определенный при отсутствии обратной связи, в а раз.

Сказанное справедливо, когда а не

превышает 4-5.



В низкочастотном тракте цепь обратной связи делают активной. Для этого высокопотенциальный (не соединенный с шасси приемника) конец вторичной обмотки выходного трансформатора ссединяют через резистор обратной связи  $R_{\mathrm{o.c}}$ (рис. 2-3) с базой транзистора. Подбором конца вторичной обмотки, соединяемого с шасси, задают пужное фазовое соотношение напряжения обратной связи. Отноше-

ние  $U_{\text{вых}}/U_{\kappa}=n$  равно коэффициенту трансформации выходного трансформатора. Согласно рис. 2-3 и формуле (2-16) результирующая активная входная проводимость каскада будет:

$$G_{\rm Bx} \approx 1/h_{\rm H_2} + 1/R_6' + 1/R_6''$$
 (2-25)

Поэтому для обеспечения необходимого в усилителе с трансформаторным выходом коэффициента обратной связи сопротивление обратной связи должно быть

$$R_{\text{o.c}} = \frac{n - \varepsilon}{\varepsilon G_{\text{EX}}}.$$
 (2-26)

Чтобы резистор  $R_{
m o,c}$  не шунтнровал резистор базовой цепи  $R_{
m b}'$ и не влиял на режим работы транзистора, должно выполняться неравенство

$$R_{\text{o.c}} \geqslant 10/G_{\text{BX}}.\tag{2-27}$$

С уменьшением n уменьшается и  $R_{
m o,c}$ , что приводит к большому отбору выходной мощности цепью обратной связи. При

$$n \leqslant \varepsilon$$
 (2-28)

для образования цепи обратной связи погребуется  $R_{o.c} \leqslant 0$ , т. е. короткое замыкание между высокопотенциальным концом вторичной обмотки выходного трансформатора и базой транзистора, что недопустимо. Физически неравенство (2-28) означает, что для получения требуемого коэффициента обратной связи напряжение сигиала на вторичной обмотке выходного трансформатора должно быть меньше напряжения обратной связи, определяемого формулой (2-23). Поэтому в этих случаях цепь обратной связи с выхода вторичной обмотки замыкают на вход предвыходного каскада. Под коэ фициентом усиления в этом случае понимают

$$K = \frac{U_{K \text{ вых}}}{U_{\text{sx. пред}}} = K_{\text{пред}} K_{\text{т. вых}}, \tag{2-29}$$

где  $K_{\rm пред}$  — коэффициент усиления по напряжению предыдущего каскада, а  $K_{\rm \tau, c_{\rm MX}}$  определяется формулой (2-22). При выполнении неравенства (2-28) и нежелательности охвата обратной связью предыдущего каскада резистор обратной связи через разделительный конденсатор  $C_{\rm p}$  можно подключить непосредственно к коллектору транянстора. При включении без конденсатора существенно изменится напряжение  $U_{\rm E9}$ , а следовательно, и выбранная рабочая точка транзистора. В этом случае в уравнении (2-26) следует положить n=1, а емкость конденсатора определить по перавенству

$$C_{\rm p} \geqslant (100 - 500)/(R_{\rm o.c}F_{\rm H}).$$
 (2-30)

Как правило, емкость этого конденсатора должиа равняться десяткам микрофарад, что увеличивает размеры и стоимость каскада.

Расчет параметров элементов схемы каскада, обеспечивающих

выбранный режим транзистора, описывается в § 3-2.

Пример 2-3. Выполнить предварительный расчет однотактного выходного каскада связного приеминка по следующим исходным данным: номинальная выходная мощность 25 МВт, сопротивление нагрузки 600 Ом (стандартные условия работы головных телефонов); частота сигиала пижняя 300 Гц, верхняя 3400 Гц; допустимый коэффициент гармоник 12 %: коэффициенты амплитудно-частотных искажений  $M_{\rm H}=M_{\rm B}=4$  дВ; номинальное напряжение источника питания 6 В.

Наиболее подходящим для рассматриваемого каскада является траизистор типа МП41А по схеме с ОЭ. Нз табл. П-1-1 выписываем его характеристики, пеобходимые для расчета:  $E_{\kappa\,\text{max}}=30\text{ B};\ I_{K\,\text{max}}=$  = 0,05 A;  $f_{\text{гр}}=$  1,4 МГц;  $h_{21.5}=$  0,98;  $r_{\text{Б}}=$  100 Ом. При заданном напряжении источника питания неравенство (2-14) 6  $\leqslant$  (0,3 — 0,4) 30 = 9 — 12 выполняется. С учетом данных табл. 2-3 по формуле (2-10) находим  $P_{\text{max}}=$  0,5-0,85-6-0,4-0,05 = 0,05 Вт. Положим  $\eta_{\text{тр}}=$  0,65. Неравенство (2-13) 0,025  $\leqslant$  0,65-0,05 = 0,035 выполняется и транзи-

стор обеспечит необходимую выходную мощность каскада.

На рис. 2-1 приведены выходные характеристики транзистора типа МП41А. Здесь кривая I определяет максимальную рассеиваемую мощность коллектора. Проводим нагрузочную характеристику 2 и выбираем рабочую точку A при полном напряжении источника питания 6 В. Ей соответствует  $R_{\rm K}=247$  Ом,  $U_{\rm K}=6$  В,  $I_{\rm BA}=0.3$  мА и  $I_{\rm KA}=21$  мА. При полном использовании коллекторного тока точкам E и E на нагрузочной характеристике будут соответствовать: E E 1 В, E 1 В, E 2 1 мА. Подставляя в первую формулу (2-15) соответствующие значения коллекторного тока, находим E 2 (0,041—0,003) = 0,019 А. По второму уравнению вычисляем E 3 мА В. С учетом (2-13) и (2-10) выходиая мощность каскада будет E 4,8 В. С учетом (2-13) и (2-10) выходиая мощность каскада будет E 1 ва 0,5 0,65 4,8 0,019 = 0,028 Вт, что лишь на 10 % больше требуемой, Следовательно, положение предельных точек E на E на

выходных характеристиках будет с достаточной точностые соответствовать необходимому режиму работы транзистора и пересчета можно

не производить.

Для вычисления коэффициента гармоник обозначим на нагрузочной характеристике точки Г и Д. Интерполируя по полю характеристик, находим соответствующие им гоки базы  $I_{\rm B,T} = 475$  мкА и  $I_{\rm B,T} =$ = 165 мкА. По формулам (2-19) вычисляем гармоники базового тока и коэффициент гармоник:  $I_{m \ E1} = 0.33 \ (700 + 475 - 165 - 0) = 337 \ \text{мкA};$   $I_{m \ E2} = 0.25 \ (700 + 0) - 0.5 \times 300 = 25 \ \text{мкA};$   $I_{m \ E3} = 0.167 \ (700 - 10.5) \times 300 = 25 \ \text{мкA};$   $I_{m \ E3} = 0.167 \ (700 - 10.5) \times 300 = 25 \ \text{мкA};$ -0) -0.33(475-165) = 15 MKA;  $I_{m.64} = 0.083(700+0) - 0.33(475+0.083)$ + 165) + 0,5·300 = -3 мкА;  $k_{\rm r} = \frac{\sqrt{25^2 + 15^2 + 3^2}}{337} = 0,087$ . Коэффициент гармоник меньше допустимого и применение ООС не требуется.

На рис. 2-2, а приведена входная характеристика траизистора типа МП41А для напряжения на коллекторе — 5 В. Поскольку ток базы мало зависит от изменения папряжения в пределах 3-10 B, можно считать эту характеристику соответствующей рабочему напряжению на коллекторе — 6 В [3, 4, 5]. Наносим на характеристику (рис. 2-2, а) точки Б и В, пользуясь соответствующими им токами базы. При этом получим  $U_{\rm B,B}=0.29~{\rm B}$  и  $U_{\rm B,B}=0.13~{\rm B}.$  По второй формуле (2-15) вычисляем амплитуду входного напряжения транзистора  $U_{m \text{ вх}} = U_{m \text{ БЭ}} = 0.5 \; (0.29 - 0.13) = 0.08 \; \text{B.}$  Согласно (2-16) входное сопротивление транзистора будет  $h_{119} = 0.08/0.000337 =$ = 230 Ом. Положим численный коэффициент в формуле (2-17) равным 6 и вычислим сопротивление нагрузки предвыходного каскада  $R_c = 6.230 = 1380 \, \text{Ом.}$  Согласно (2-18) амплитуда входного папряжения каскада будет  $U_{m\,\mathrm{RX}}=0.08~(1380+100+230)~/230=0.61~\mathrm{B}$ . По уравнению (2-20) вычисляем коэффициент амплитудно-частот-

ных искажений транзистора 
$$M_{\rm B...7} = \sqrt{1 + \left[\frac{3400}{14 \cdot 10^5 (1 - 0.985)}\right]^2} = 1,015$$
, что значительно меньше допустимого для каскада.

Поскольку на рис. 2-1 нагрузочная характеристика 2 не пересекается с параболой 1, то дополнительных проверок по неравенству (2-12) не требуется. Следовательно, выбранный транзистор обеспечит все необходимые характеристики и предварительный расчет каскада можно считать законченным.

В двухтактном каскаде с целью повышения к. п. д. обычно применяется режим работы АВ. Рабочая точка транзистора при этом выбирается при коллекторном токе [1, 31]:

$$I_{K0} \approx (0.04 \div 0.07) I_{Kmax},$$
 (2-31)

 $\tau$ . е. в районе точки A (рис. 2-4). Поскольку в каскаде работают два транзистора, то каждый из них должеи обеспечивать половину требуемой выходной мощности каскада. Эта мощность вычисляется по формуле (2-10) с использованием соответствующих данному режиму коэффициентов из табл, 2-3. Рассенваемая мощность коллекторов транзисторов

$$P_{\rm w} = P_{\rm 0} - P_{\rm max}, \tag{2-32}$$

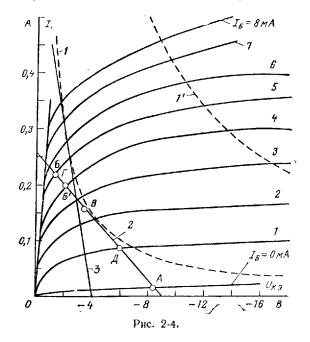
где

$$P_0 = 2E_{\rm g} [I_{\rm KE} + I_{\rm KA} (\pi - 1)]/\pi \tag{2-33}$$

мощность, потребляемая коллекторной целью транзисторов от источника питания.

После выбора транзисторов проверяется выполнение неравенства (2-12). Напряжение питания каскада выбирается по иеравенству (2-14).

Для сравнительно мощных транзисторов в справочинках приводятся входные динамические характеристики (рис. 2-5). Перенося точки A и B с семейства выходных характеристик на входную с соответствующим (или достаточно близким  $\pm$  3 B) напряжением коллектор—эмиттер, можно в первом приближении определить амплитуду



необходимого входного сигнала транзистора, а по выходным характеристикам — амплитуду базового тока по формулам:

$$U_{m_{\rm BX}} \approx U_{\rm BBB} - U_{\rm BBA}; \quad I_{m_{\rm BX}} \approx I_{\rm BB} - I_{\rm BA}.$$
 (2-34)

Если вместо входных динамических характеристик имеются статические входные характеристики (рис. 2-6), для нахождения параметров входного сигнала транзисторов точки А и Б с семейства выходных характеристик по ранее описанной методике переносят на статическую входную характеристику, соответствующую выбранному иапряжению питания. По положению этих точек из формул (2-34) определяют параметры входного сигнала транзисторов.

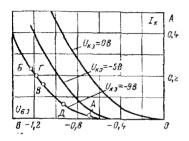
Входное сопротивление траизисторов каскада вычисляют по формуле (2-16) с использованием выражений (2-34). Сопротивление источника сигнала для каждого гранзистора двухгактного каскада выби-

рается по формуле (2-17), а амплитуда входного сигнала каскада вычисляется по уравнению (2-18).

В первом приближении коэффициент гармоник двухтактного каскада определяется уравнением

$$k_{\rm r} \approx \frac{2C - 1}{2\left(1 + C\right)}.\tag{2-35}$$

Здесь C = AB/AB, а AB и AB — соответственно длины отрезков нагрузочной характеристики между точками A-B и A-B. Положе-



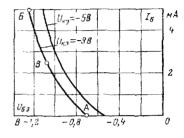


Рис. 2-5.

Рис. 2-6.

ние точки B определяется пересечением пагрузочной характеристики с выходной характеристикой, для которой ток базы равен половине тока базы, соответствующего выходной характеристике, проходящей через точку B. Если коэффициент гармоник окажется больше допу-

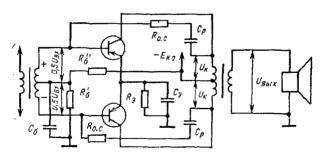


Рис. 2-7.

стимого, то для его спижения, так же как в однотактном каскаде, следует или применять ООС, или брать транзистор большей мощности. В первом случае для расчетов используются ранее описанные методики. Согласно рис, 2-7 для двухтактного каскада следует считать:

$$K_{\tau} = U_{\mathrm{K}}/U_{\mathrm{BOT}} \tag{2.36}$$

R

$$n = U_{\text{Barr}} / 2U_{\text{K}}, \tag{2-37}$$

При создании обратной связи с выхода каскада на вход в двухтактном каскаде должны быть две идентичные цепи, подключаемые через разделительные конденсаторы между коллектором и базой каждого транзистора. Для расчетов используются формулы (2-24) — (2-28) и (2-30). Но если обратная связь охватывает и предвыходной каскад, то резистор  $R_{o,c}$  обычно подключают ко вторичной обмотке выходного трансформатора и используют для расчета формулу (2-29).

Пример 2-4. Выполнить предварительный расчет выходного каскада перепосного транзисторного приемника I класса по следующим исходным данным: номинальное (среднее) звуковое давление 4·10<sup>6</sup> Па; частота сигнала низшая 150 Гц, высшая — 12 кГц; допустимый для приемника коэффициент гармоник 8 %; допустимые коэффициенты амплитудно-частотных искажений приемника на пижней и верхней частотах модуляции сигнала 14 дБ; номинальное напряжение источника пита-

ния 12 В.

Для персносных приемников I класса максимальная мощность, потребляемая от автономного источника питания, определена ГОСТ 5651—76 равной 2 Вт. Поэтому для таких приемников можно применять громкоговорители с потребляемой мощностью сигнала не болес I В А, так как к. п. д. двухтактного выходного каскада не превышает 0,6—0,7. Сеедений об одноваттных громкоговорителях, обеспечивающих в полосе частот 150—12 000 Гц среднее звуковое давление 4·10<sup>5</sup> Па, в литературе не приводится [11, 13]. Наиболее подходящим является громкоговоритель типа 1ГД-18. Его характеристики следующие: потребляемая мощность I В А, полоса воспроизводимых частот 100—10 000 Гц, среднее звуковое давление 2,8·10<sup>5</sup> Па, сопротивление обмотки 6,5 Ом. Для воспроизведения в заданной полосе частот следует взять второй громкоговоритель, например, типа 1ГД-2 (ВЭФ), воспроизводящий полосу частот 2—15 кГц, создающий среднее звуковое давление 4·10<sup>5</sup> Па и имеющий сопротивление обмотки 6,3 Ом.

Поскольку требуемый к. п. д. каскада более 0,5, выходной каскад следует выполнять по двухтактной схеме в режиме класса АВ. Положни к. п. д. выходного трансформатора равным 0,75. Приняв в (2-13) знак равенства, вычислим необходимую мощность сигнала в коллекторной цепи каждого транзистора  $P_{\rm max}=0,5\cdot1/0,75=0,67$  Вт. Будем считать напряжение  $U_{\rm K9}=9$  В. Тогда с учетом данных табл. 2-3 максимальный коллекторный ток транзистора вычисляем по уравнению (2-10)  $I_{\rm K\,max}=0,67/(0,5\cdot0,85\cdot0,85\cdot9)=0,21$  А. Из транзисторов с p-n-p проводимостями наиболее подходящим является транзисторо ГТ403Б, имеющий максимальный ток до 0,8 А при дополнительном теплоизлучателе (радиаторе) при  $P_{\rm K\,max}=4$  Вт и 0,4 А без теплоизлучателя при  $P_{\rm K\,max}=0,6$  Вт [32] \* (работа при комнатной температуре с нагревом не выше  $80^{\circ}{\rm C}$ ).

Согласно равенству ( $\frac{2}{8}$ ) для выходного каскада допустимо иметь  $M_{\rm B.\,BhX} = \sqrt[4]{5,14} = 1,5$ . По уравнению (2-20) вычисляем  $M_{\rm B.\,T} = \sqrt{1+\left[\frac{12\,000}{10^6\,(1-(1,985))}\right]} = 1,2^{-1}$ , что меньше допустимого для каскада и приемлемо. Поэтому данный транзистор обеспечит допустимые амплитудно-частотные искажения и приемлем для последующего расчета.

Выходные характеристики транзистора ГТ403Б для схемы с ОЭ при• При п-р-п проводимостях можно использовать транзистор ГТ404Г

ведены на рис. 2-4. Здесь кривая I соответствует  $P_{\kappa \, \text{max}} = 0.6 \; \text{Вт} \; \text{и}$ I'-4 Вт. Для линии A-B, показанной на рис. 2-4, сопротивление нагрузки равно 34,6 Ом и отвечает условиям получения малых нелинейных искажений.

При  $I_{K,S} = 0.22$  А и  $I_{K,A} = 0.015$  А, что соответствует выбору рабочей точки по уравнению (2-31), получим  $U_{\rm K3.5}=1.4~{\rm B}$  и  $U_{\rm K3.4}=$ = 8.4 В. Заменяя в формулах (2-34) базовые токи на соотретствующие коллекторные, получаем амплитуды коллекторных тока и напряжеиня  $I_{m,K} = 0.22 - 0.015 = 0.205$  A и  $U_{m,K} = 8.4 - 1.4 = 7$  В. Согласно формуле (2-10) максимальная мощность сигнала в коллекторной цепи каждого транзистора при выбранном режиме будет  $P_{\mathrm{max}} = 0.5 \cdot 7 \times$  $\times 0,205 = 0,71$  Вт. что лишь на 7 % больше требуемой. Принимаем этот режим за исходный для дальнейшего расчета. Находим по формуле (2-33)  $P_0 = 2.9[0.22 + 0.015(3.14 - 1)]/3.14 = 1.44$  Вт и по уравиению (2-32)  $P'_{\kappa} = 1.44 - 0.71 = 0.73$  Вт. Следовательно, для одного транзистора на коллекторе рассенвается вдвое меньшая мощность  $(0.5 \cdot 0.73 = 0.37 \;\; \mathrm{Br})$  и неравенство (2-12) 0.37 < 0.6 выполняется при отсутствии дополнительного теплоизлучателя.

На рис. 2-5 изображены входные динамические характеристики транзистора ГТ403Б для схемы с ОЭ. Переносим на характеристику с  $E_{\kappa} = -9$  В точки A и E и определяем значения соответствующих им напряжений:  $U_{\rm BBS} = 1.24$  В,  $U_{\rm BBA} = 0.7$  В. Согласно первой формуле (2-34) получаем амплитуду входного сигнала транзистора  $U_{m,5,3} = 1,24 - 0,7 = 0,54$  В. Из характеристик на рис. 2-4 находим  $I_{6.6} = 5$  мА и  $I_{6.4} = 0$ . По второй формуле (2-34)  $I_{m.6.9} = 5 - 0 =$ — 5 мА. Входное сопротивление каждого транзистора вычисляем из (2-16)  $h_{119}=0.54/0.005=108$  Ом. Полагая численный коэффициент равным 6, по формуле (2-17) находим сопротивление источника сигнала для каждого транзистора каскада  $R_c = 6 \cdot 108 = 648$  Ом. По формуле (2-18) вычисляем амплитуду входного напряжения каскада  $U_{m, \text{вх}} =$ = 0.54 (648 + 100 + 108)/108 = 4.3 В. Из равенства (2-22) вычисляем коэффициент усиления напряжения транзисторами выходного каскада  $K_r = 7/0.54 = 13$ .

Точка B на нагрузочной прямой соответствует току базы  $I_{BB} =$ = 2,5 мА. Для выбранной нагрузочной линии отношение отрезков AB/AB = C = 0.65. По (2-35) вычисляем коэффициент гармоник  $k_r =$ =  $(2 \cdot 0.65 - 1)/[2(1 + 0.65)] = 0.092$ . Аналогичные расчеты для нагрузочного сопротивления 21 Ом дают  $k_{\rm r}=0.11$ , а при  $R_{\rm H}>35$  Ом максимальная мощность сигнала в коллекторной цепи получается меньше требуемой. Эти данные подтверждают правильность выбранного

наклона нагрузочной характеристики.

Согласно первому равенству (1-2) для выходного каскада коэффициент гармоник может быть не более  $k_{\rm r, \, Bbix} = 0.7 \cdot 0.08 = 0.05 \hat{6}$ . Следовательно, для его обеспечения необходимо применить ООС, уменьшающую усиление каскада в  $a=k_{\rm r}/k_{\rm r,\,Bbix}=0.092/0.056=$  1.65 раза. Во столько же для компенсации действия обратной связи необходимо увеличить входной сигнал каскада, охваченного ООС. Поэтому входное напряжение каскада при наличии обратной связи должно быть  $U_{m \text{ вх. о. c}} = aU_{m \text{ вх}} = 1,65.4,3 = 7,1 \text{ B.}$ 

По формуле (2-24) вычисляем требующийся коэффициент обратной связи e = (1.65 - 1)/13 = 0.05. Таким образом, все необходимые

карактеристики выходного каскада найдены,

## 2-3. Расчет структурной схемы низкочастотного тракта

Целью расчета структурной схемы НЧ тракта является выбор типа транзисторов; схемы их включения и режима работы в каждом каскаде; минимально возможного числа каскадов, что повышает надежность работы, уменьшает размеры, стоимость и мощность питания приемника. Исходными данными для расчета служат: сопротивление источника  $R_{\rm c}$  и входное напряжение  $U_{\rm BX, ok}$  оконечного каскада; нижняя и верхняя частоты усиливаемого сигнала; коэффициенты амплитулю-частотных искажений низкочастотного тракта; напряжение источника питания, минимальная амплитуда входного сигнала  $U_{\rm BX, min}$ . Частоты  $F_{\rm H}$  и  $F_{\rm B}$  и напряжение питания задаются характернстиками приемника;  $R_{\rm c}$  и  $U_{\rm BX, ok}$  определяются при предварительном расчете выходного каскада; коэффициенты амплитудно-частотных искажений и  $U_{\rm BX, min}$  находятся в процессе расчета.

Минимальная амплитуда входного сигнала определяется из следующих соображений. Если радиовещательный приемпик предназначается для использования с проигрывателем грампластинок, то согласно ГОСТ 5651—76 выходное напряжение звукоснимателя принято равным 0,25 В. Из-за малого входного сопротивления первого транзисторного каскада низкочастотного тракта приемника на вход каскада обычно поступает лишь 0,05—0,01 часть выходного напряжения звукоснимателя. При работе с проигрывателем следует считать входное напряжение первого каскада низкочастотного тракта равным 12,5—25 мВ.

Минимальное входное напряжение детекторов в транзисторных приемниках обычно составляет 0,5—1 B, а их коэффициенты передачи составляют 0,03—0,05. Следовательно, минимальное выходное напряжение детекторов АМС при m=0,3 составляет 5—15 мВ. Таким образом, минимальную амплитуду сигнала на входе первого транзистора низкочастотного тракта следует считать не более  $U_{\rm Bx\ min}=5$  мВ, а при максимально возможном коэффициенте модуляции 0,9, соответствующем номинальной выходной мощиости, его можно принять равным  $(5\cdot0,9)/0,3=15$  мВ.

Коэффициент усиления каскадов низкочастотного тракта без выходного каскада согласно сказанному должен быть

$$K'_{\text{HH}} = U_{m \text{ BX, OK}} / U_{m \text{ BX min}},$$
 (2-38)

В рассматриваемых каскадах транзисторы обычно включаются по схеме с ОЭ при резистивной нагрузке. Коэффициент усиления по напряжению таких каскадов в первом приближении определяется формулой

$$K_{0R} \approx \frac{Y_{21}}{1,2G_{BX-CB}ab}$$
, (2-39)

где  $Y_{21}$  — проводимость прямой передачи транзистора;  $G_{\rm RX,cn}$  — активная входная проводимость следующего каскада, определяемая уравнением (2-25); a — коэффициент увеличения входного сигнала для компенсации действия отрицательной обратной связи, он обычно не превышает 2—3; b — коэффициент, учитывающий передачу сигнала из колекторной цепи предыдущего к участку база — эмиттер последующего каскада, согласно формуле (2-18) он обычно не превышает 6—8.

Если использовать в рассматриваемых каскадах одинаковые транзисторы, то согласно (2-38) и (2-39) число каскадов должно быть

$$n'_{\mu\nu} = \lg K'_{\mu\nu} / \lg K_{\mu\nu}. \tag{2-40}$$

Оно берется равным ближайшему большему целому числу. Расчет следует проводить для нескольких (если есть выбор) типов транзисторов при различных режимах работы, выбирая тот, при котором можно получить наименьшее число каскадов и хорошие экономические показатели.

Входная мощность выходного каскада вычисляется по уравнению

$$P_{\text{BY OK}} \approx 0.5I_{m,\text{BY}}^2 (h_{112} + r_6).$$
 (2-41)

При однотактном выходном каскаде входные токи и иапряжения определяются формулами (2-15), а при двухтактном — (2-34). В предвыходном каскаде следует применять транзистор, обеспечивающий необходимую мощность для работы выходного каскада. Максимальный коллекторный ток транзистора предвыходного каскада должен на 20—25 % превышать амплитуду входного тока выходного каскада, определяемую (2-15) или (2-34), так как часть коллекторного тока транзистора протекает по его нагрузочному резистору, т. е. по внутреннему сопротивлению источника сигнала (2-17) для выходного каскада.

Пример 2-5. Рассчитать структурную схему инэкочастотиого тракта переносного транзисторного приемника I класса. Параметры выходного каскада будем считать соответствующими примеру 2-4, а  $U_{m\,\mathrm{Bx}\,\mathrm{min}}=5$  мВ при m=0,3,

Входной ток выходного каскада равен 5 мА, поэтому для предоконечного каскада следует брать транзистор с  $I_{\rm K\,max}>8\div10$  мА, например МП41А, имеющий  $I_{\rm K\,max}=50$  мА (см. табл. П-1-1);  $E_{\rm K\,max}=20$  В;  $f_{\rm rp}=1.4$  МГи,  $P_{\rm K\,max}=0.15$  Вт,  $r_{\rm 6}=150$  Ом,  $Y_{\rm 21}=0.5$  См,  $h_{\rm 216}=0.97$ .

Требуемое усиление в каскадах определяем по формуле (2-38), подставляя в нее максимальные напряжения, соответствующие m=0.9,  $K'_{\rm Hu}=7.1/0.015=472$ .

Предвыходной каскад строим с трансформаторным выходом, чтобы с его вторичной обмотки получить необходимые входные напряжения для обонх плеч двухтактного выходного каскада. Выберем напряжение питания коллектора 5 В, что удовлетворяет перавенству (2-14) 5 < (0.3-0.4) 20=6-8. Рабочую точку  $A_1$  транзистора выбираем в режиме класса А ( $I_{\rm K}=7$  мА и  $I_{\rm B}=0.1$  мА, рис. 2-1). Максимальная входная мощность выходного каскада на оба плеча согласно формуле (2-41) будет  $P_{\rm BX, OK}=0.5\cdot0.005^2$  (100 + 108) = 0.0026 Вт. Полагая к. п. д. трансформатора равным 0.65, получаем требуемую максимальную мощность сигнала в коллекторной цепи  $P_{\rm K, max}=0.0026/0.65=0.004$  Вт.

Строим на рис. 2-1 нагрузочную прямую 3 и определяем положение точек  $B_1$  и  $B_1$ , при которых обеспечивается необходимая максимальная мощность сигнала. Этим точкам соответствуют  $I_{K|B1}=12.5$  мА,  $I_{B|B1}=0.09$  мА,  $U_{K\ni B1}=2.7$  В,  $I_{K|B1}=3.5$  мА,  $I_{B|B1}=0.09$  мА н $U_{K\ni B1}=6.5$  В. Подставляя в (2-15) вместо базовых токов и напряжений коллекторные, соответственно получаем  $I_{mK}=0.5$  (12.5 — 3.5) = 4.5 мА и  $U_{mK}=0.5$  (6.5 — 2.7) = 1.9 В. Из равенства (2-10) вычисляем

мощность сигнала в коллекторной цени  $P_{\rm K\,max} = 0.5 \cdot 1.9 \cdot 0.0045 =$ = 0,0042 Вт. что отличается от требуемой лишь на 5 % и допустимо

в технических расчетах.

По уравнению (2-15) находим  $I_{m,6} = 0.5$  (190 — 20) = 85 мкА. Переносим точки  $B_1$  и  $B_1$  на входную характеристику (рис. 2-2, a). Для них получаем U  $_{\rm B9\,B1}=$  0,215 В и U  $_{\rm B9\,B1}=$  0,145 В. По формуле (2-15) находим амплитуду входного сигнала транзистора предвыходного каскада  $U_{m \text{ BO nnew}} = 0.5 (0.215 - 0.145) = 0.035 \text{ B. Входное}$ сопротивление предвыходного каскада вычисляем по (2-16)  $h_{119} =$ = 0.035/0.0085 = 410 Ом (входная проводимость 0.0024 См). Сопротивление нагрузочного резистора предыдущего каскада вычисляем из (2-17), взяв численный коэффициент равным 6:  $R_{\rm c} = 6\cdot410 = 2460$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 2,4 кОм. Амплитуду входного сигнала предвыходного каскада находим по уравнению (2-18)  $U_{m \text{ FX nDeg}} = 0.035 (2400 + 150 + 410)/410 = 0.25 \text{ B}.$ 

В низкочастотном тракте следует но возможности использовать однотипные транзисторы. Согласно (2-39) усиление резисторного каскада на транзисторе МП41A при a=2.5 и b=7 будет  $K_{0\kappa}=$  $=0.5/(1.2\cdot0.0024\cdot2.5\cdot7)=10$ . Положим, что до предвыходного каскада имеется еще один каскад. Тогда его коэффициент усиления должен быть K = 0.25/0.015 = 17. Следовательно, в низкочастотном тракте приемника кроме предвыходного и выходного каскадов, должно быть сще два резисторных каскада на транзисторах МП41А. При четырех каскадах пизкочастотного тракта допустимый коэффициент амплитудночастотных искажений каждого каскада вычисляем из уравнения (2-9)  $M_{\mathrm{B-K}}=\frac{10}{1}5=\frac{1.11}{5}$ . По равенству (2-20) находим  $M_{\mathrm{B-T}}=$   $=\sqrt{1+\left|\frac{12\,000}{14\cdot10^5\,(1-0.97)}\right|^2}=1.04$ , что позволяет применять вы-

бранный транзистор.

Если выбрать рабочую точку транзисторов этих каскадов при  $E_{\rm K}=5~{
m B}$  и  $I_{\rm K}=2.5~{
m mA}$ , то согласно рис. 2-2, a этим условиям соответствует точка  $A_2$  ( $U_{\rm E,9}=0.174$  В). Проведенная к этой точке касательная 1 имеет наклон, соответствующий входному сопротивлению травзистора  $h_{11} = \Delta U_{\text{B}3}/\Delta I_{\text{B}3} = (0.3 - 0.125)/[(0.25 - 0) 0.001] =$ = 700 Ом. Для него согласно равенству (2-17) получим:  $R_{\rm c} = 6 \cdot 700 =$ = 4200 См. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 3,9 кОм.

Таким образом, все элементы структурной схемы визкочастотного тракта определены. Он должен состоять из трех однотактных кас-кадров на транзисторах МП41А (третий из них с трансфермитерным выходом) и двухтактного выходного каскада на транзисторах ГТ403Б.

# Расчет полосы пропускания приемника

Полоса пропускания супергетеродинного приемника спределяется шириной спектра принимаемого сигнала  $F_{\rm cu}$  и нестабильностью частоты несущей сигнала  $f_{\rm c}$ , а также частоты гетеродина  $f_{\rm r}$ 

$$\Pi = F_{cn} + 2\sqrt{b_c^2 f_c^2 + b_r^2 f_r^2}, \qquad (2-42)$$

где  $b_{
m c}$  и  $b_{
m r}$  — коэффициенты относительной нестабильности частоты сигнала и гетеродина соответственно. Значения (долговремсниые) для различных схем и режимов работы гстеродинов приведены в табл, 2-4.

		Қоэффи	циент <i>b<sub>г</sub></i>		
	Гетеродин	Декаметровые и более длинные волны			
		транзисторный	ламповый		
	без кварцевой стабили- зации	10-8-10-4	10-3-10-4		
Однокаскадный	с кварцевой стабилиза- цией	10-5-10-6	10-5-10-6		
Многокаскадный и кварцевой с		10-6-3 - 10-7	10-6-4 · 10-7		

Продолжение табл. 2-4

		Қоэффи	циент <i>b<sub>г</sub></i>
	Гетеродин	Метровые и бо во.	одее короткие лиы
		транзисторный	ламповый
Однокаскадный	без кварцевой стабили- зации	10-2-10-3	2 · 10 <sup>-3</sup> —10 <sup>-4</sup>
	с кварцевой стабилиза- цией	10-4-10-5	3.10-5-3.10-6
Многокаскадный и кварцевой с		10-5-4-10-7	10-6-5-10-3

Ширина спектра основных сигналов, применяющихся в радиовещании и радиолюбительской связи, вычисляется по формулам табл. 2-5  $[\tau_{\min}$  и  $\tau_{\max}$  — минимальная и максимальная длительность телеграфной посылки (знака);  $F_{\text{тон}}$  — частота тональной модуляции телеграфного сигнала;  $\psi_{\max}$  — максимальное значение индекса частотной модуляции].

При решении вопроса о выборе структурной схемы приемника удобно пользоваться коэффициентом расширения полосы пропускания приемника для учета нестабильности частоты сигнала и гетеродина

$$k_{\rm p} = \frac{\Pi}{F_{\rm crit}} = 1 + \frac{2}{F_{\rm crit}} \sqrt{b_{\rm c}^2 f_{\rm c}^2 + b_{\rm r}^2 f_{\rm r}^2}.$$
 (2-52)

Если он меньше 1.1-1.3, то за счет повышения стабильности частот сигнала и гетеродина нельзя достигнуть существенного сужения полосы пропускания, а значит, и ослабления действия помех и ловышения чувствительности приемника. При значениях  $k_p^{\bullet} > 1.3 \div 1.5$  путем повышения стабильности частот сигнала и гетеродина можно обеспечить сужение полосы пропускания и соответственно повысить чувствитель-

					•
<b>2</b> 50	Вид модуляции	Xapai	ктер сигнала	Ширина спектра	№ формулы
Бобров Н.		<b>Телеграфиый</b>	без тональной модуляции	(3- <del>1-</del> 5)/τ <sub>min</sub>	(2-43)
В.	Амплитудная двухполос- ная	телеграфиян	с тональной модуляцией	(3÷5)/τ <sub>min</sub> +F <sub>τοн</sub>	(2-44)
		Телефонный		2F <sub>B</sub>	<u>C</u> (2-45)
	Амплитудная однополос-	Телеграфный		$(1,5-2,5)(1/\tau_{\min}-1/\tau_{\max})$	(2-46)
	ная	Телефонный		$F_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}$ — $F_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$	(2-47)
		Togogradus	с разрывом фазы	$\frac{2}{\tau_{\min}}(1+\psi_{\max}+\sqrt{\psi_{\max}})$	(2-48)
	Частотная	Телеграфный	без разрыва фазы	$\frac{2}{\tau_{\min}}(3+\psi_{\max})$	(2-49)
	INCIOLITAN	Телефонный	ψ <sub>max</sub> <[	2F <sub>B</sub>	(2-50)
ಟ		Темефонный	$\psi_{max} > 1$	$2F_{\rm B}(1+\psi_{\rm max}+\sqrt{\psi_{\rm max}})$	(2-51)

п ость и селективность приеминка. Когда при наилучшей достижимой стабильности частот сигнала и гетеродина коэффициент расширения пелосы пропускания оказывается больше 1,5—2, то может оказаться нелесосбразным применение системы автоматической подстрейки частоты гетеродина (АПЧГ). При прочих равных условиях  $k_{\rm p}$  увенечивается с ростом частоты инпала. Поэтому для сигналов с узким спектрем (радиовещательных и связтых при амелитудией медуляция) в конпе декаметрового и более коротконолисвых длапаяснах воли целесобразно приметение системы АПЧГ; на более длинисволновых диапазонах применение АПЧГ не эффективью.

Для приемника прямого усиления в формулах (2-42) и (2-52) следует полагать  $b_r = 0$ . Если оператор имеет возможность вепрерывно подстраивать приемник на принимаемый сигнал, полосу пропускания приемника можно брать равной впірине спектра сигнала. Так иногда поступают в приемниках для профессиональной и любительской

связи.

Для приема радиовещательных программ с частотной модуляцией полоса пропускания в днапазоне метровых воли (65,8—73 МГц) ГОСТ 5651—76 определена в интервале 120—180 кГц в зависимости от класса приемника. Для остальных днапазонов значение полосы пропускания не стандартизировано и определяется расчетом.

Пример 2-6. Выбрать полосу пропускания радиовещательного переносного транзисторного приемпика I класса. Относительную песта-

бильность частоты сигнала будем считать равной 10 °.

Радисвещательный приемник I класса должен имсть рабочие частоты, соответствующие всем подднаназонам табл. 1-1. В первых 11 подднапазонах радиовещательные станции имеют амплитудную модуляцию с верхней частотой модуляции 4,5 кГц, а в 12-м подднапазоне частотную с максимальной девиацией частоты 75 кГц, верхней частотой модуляции 15 кГц (максимальный индекс модуляции  $\psi_{max} = 75/15 = 5$ ).

В приемниках I класса преобразователь частоты выполняется с отдельным одноконтурным гетеродином, в схеме которого предусматраваются специальные меры для стабилизации питающего напряжения в коллекторного тока. В этом случае согласно табл. 2-4 можно принять  $b_{\rm r}=2\cdot 10^{-4}$ . Для первых 11 поддиапазонов промежуточная частота приемников определена ГОСТ 5651—76 равной 465 кГи, а для 12-го поддиапазонз — 6,5, 8,4 или 10,7 МГи при верхней настройке гетеродина. Поэтому  $f_{\rm r}=f_{\rm c}+f_{\rm np}$ .

Для поддиапазона 1 на максимальной частоте согласно формулам

(2-45) и (2-42) получим

 $\Pi_1 = 2 \cdot 4500 + 2\sqrt{10^{-12} \cdot 15^2 \cdot 10^8 + 4 \cdot 10^{-8} \cdot 615^2 \cdot 10^6} = 9250$  Гц. Результаты аналогичных расчетов приведены в табл. 2-6. Согласно уравнению (2-51) ширина спектра частотно-модулированного сигнала в 12-м подднапазоне  $F_{\rm cn} = 2 \cdot 15~000~(1 + 5 + \sqrt{5}) = 247~000~$  Гц.

Из табл. 2-4 для рассматриваемого поддиапазова принимаем  $b_{\rm r}=3\cdot 10^{-4}$ . Берем значение промежуточной частогы 8,4 МГц. Необходимая полоса пропускания определяется (2-42)  $\Pi_{12}=247\ 000-2\ 1\ 10^{-12}\cdot 73^2\cdot 10^{12}+9\cdot 10^{-8}\cdot 814^3\cdot 10^{10}=286\ 000\ \Gamma$ ц.

Для поддиавазона 1 коэффициент расширения полосы пропускання вычисляем по равенству (2-52)  $k_{\rm p}=9250,9000=1,03$ . Результаты подсолых расчетов для других поддианазонов приведены в табл. 2-6.

Согласно ГОСТ 5651—76 приемники I класса в поддианазонах 1 и 2 должны имегь ослабление соседних каналов не менее 40 дБ при расстройке ± 9 кГц (для других поддиапазонов эта характеристика не оговорена).

Обеспечить это требование можно только с помощью соответствующих

фильтров в тракте промежуточной частоты.

Для достижения необходимого усиления в гракте промежуточной частоты обычно применяют не менее двух-трех каскадов. Если имегь в этих каскадах селективные системы из двух связанных контуров, то для расстройки  $\pm 9$  к $\Gamma$ ц две такие пары контуров при критической связи могут обеспечить ослабление 15-20 д $\mathrm{B}$ , а три пары -18-25 д $\mathrm{B}$ .

Таблица 2-6

№ поддиана- зона	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Полоса про- пускания, кГц	9,25	9,8	10,9	11,7	12,1	13,1	14,1	15,4	16,4	17,9	19,6	286
Коэффициент расширения полосы	1,03	1,09	1,2	1,3	1,35	1,45	1,56	1.71	1,82	1.99	2,18	1,16

В табл. 2-7 приведены характеристики фильтров сосредоточенной селекции (ФСС), которые предназначены для использования в присмниках с промежуточной частотой 465 кГц. Самые широкополосные из них (ПФП-5-3; ПФП-0; 22; ЭМФП-5-465-13) позволяют получить полосу пропускания 12—14 кГц, что достаточно лишь для первых семи подднапазонов. При расстройке ±9 кГц ФСС имеют ослабление лишь 26 дБ. Для увеличения требуемого ослабления можно включить в тракт промежуточной частоты два фильтра. Полоса пропускания двух таких фильтров составляет 85—90 % полосы одного фильтра. Наиболее целесообразно использовать пьезоксрамические фильтры типа ПФПП-0,22, при этом полоса пропускания составит 11,5—12 кГц. Это значение и примем для приемника в подднапазонах 1—11. Возможную расстройку приемника относительно частоты сигнала в подднапазонах 6—11 можно будет компенсировать соответствующей подстройкой приемника радиослушателем.

Для поддиапазона 12 примем наибольшее рекомендуемое ГОСТ значение полосы пропускания (180 кГц), но это, естественно, вызовет некоторое увеличение искажений сигнала.

Пример 2-7. Выбрать полосу пропускания приемника для любительской радиосвязи с параметрами, соответствующими связному приемнику 1 класса, который должен работать в подднанкзонах 1—11 согласно табл. 1-3. Частоты модуляции сигнала при телефонной передаче: цизшая 300 Гц. высшая 3400 Гц.

При выполнении любительских радносвязей длительность сеанса связи сравнительно кратковременна. Поэтому можно считать, что оператор при необходимости имеет возможность вести подстройку приемника по принимаемому сигналу. Следовательно, нолосу пропускания приемника можно брать равной ширине спектра принимаемого сигнала. Раднолюбители ведут связь при трех следующих видах сигнала: телеграфным с работой ключом при амплитудной модуляции без тональной модуляции (обозначение режима работы по международному коду СW); телефонным двухполосным с амплитудной модуляцией; телефонным однополосным с амплитудной модуляцией; телефонным однополосным с амплитудной модуляцией (SSW).

			Пьезомеханич	еские фильтры	Пъе	зокерамиче
Парамет	гры		ПФ1П-4-3	ПФ1П-5-3	пфіп-м	пфіп-2
Число звенье	В		3	3	4	4
Средняя част	ота,	, кГц	465	5±2		
Полоса про (при ослаба границе), к	ıены		7—10 (2)	9—14	7—9,5 (2)	8,5—12,5
стройке 🛨	пабление при растройке ±10 кГц редней частоты, дБ		34	26	46	40
Коэффициент	-	10	2—2,6	1,3—2,1	1,7-2,4	1,3-2
прямоуголь ности крив селективнос	йой Сти	100	2,3-3,1	_	2-2,7	1,6-2,3
при ослаб. нии	ле-	1000	_	_	>4	
Коэффициент иия на сред тоте			0,25	0,25	0	,25
Номиналь-			(	0,5		·
ная прово- димость	вы	ходная		1,0		
Емкости на-	на	входе	-	_		
стройки, пФ	•	а вы- ходе				

При телеграфном режиме минимальная длительность передачи точек обычно составляет 75 мс. Согласно формуле (2-43) ширина спектра такого сигиала будет  $F_{\rm cn}=(3\pm5)/0,075=40\pm67$  Гц. В случае телефонного двухполосного сигнала по выражению (2-45) вычисляем  $F_{\rm cn}=2\cdot3400=6800$  Гц, а для однополосного сигнала по уравнению (2-44)  $F_{\rm cn}=3400-300=3100$  Гц.

Селективность по соседнему каналу в рассматриваемом классе приемников при расстройке  $\pm$  10 кГц обычно берется не ниже 50-60 дБ. Поэтому в тракте промежуточі ой частоты любительские связные приемники обязательно имеют ФСС (иногда и более одного). Согласно табл. 2-7 для приема двухполосного телефонного сигнала можно воспользоваться

Таблица 2-7

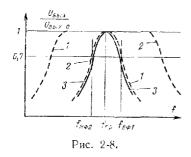
ские фильт	ры			Электром	еханически	е фильтры
ФП1П-0,22	ФП1П-0,23	ФП1П-0,26	ФПП-0,27	Э <b>М</b> ФП- 465-6	ЭМФП-5- 465-9	ЭМФП-5- 465-13
4	4	4	4	5	5	5
	465 <u>+</u>	2			465 <u>±</u> 2	·
10,5—14,5 (2)	8—11,5 (2)	7—10 <b>,</b> 5 (2)	8—11,5 (2)	5,6—6,4 (1,41)	8,4—9,6 (1,41)	12,2—13,8 (1,41)
26 (±9)	40 (±9)	26 (±9)	35 (上9)	56	42	26
1,5—1,6	1,3—2	1,9—2,4	1,5—2,1	2,8-3,1	1,7—2	1,3—1,5
1,9-2,3	1,6—2,3	1,8	1,82,5	3-3,4	2—2,3	_
>3,8	>4	>4	>3,9	3,3-3,7	>4	
				0,37	0,45	0,4
						,
	0,835	5			1,0	
	0,417	•			0,1	
	_				300	
			ĺ	1500	2200	3300

одним из типовых фильтров, например ЭМФП-5-465-6 вли ПФ1П-М. Первый обладает наиболее приемлемыми характеристиками, но он значительно (в десятки раз) дороже второго. Поэтому целесообразно включать последовательно два фильтра ПФ1П-М, что обеспечит нужные карактеристики приемника. Подбором фильтров можно получить необходимую для данного режима полосу пропускания приемника — 6800 Гц.

Для приема однополосного телефонного сигнала типовых фильтров нет. В этом случае необходимую полосу пропускания можно получить следующим способом. Выбирают два  $\Phi CC$ , чтобы верхняя граничная частота полосы пропускания  $f_{\rm B, \Phi I}$  первого фильтра была на 3—3,3 кГи выше нижней граничной частоты полосы пропускания  $f_{\rm H, \Phi I}$  второго

фильтра, в включают эти фильтры в первый в второй каскады тракта промежуточной частоты. Получается пара расстроенных каскадов [5], Кривая селективности первого каскада соответствует штриховой кривой 1 на рис. 2-8, а второго — кривой 2. Результирующая кривая селективности двух каскадов определяется произведением ординат кривых 1 и 2 для одинаковых частот. Она будет соответствовать сплошной кривой 3. Промежуточную частоту приемника в данном случае следует брать, естественно, равной средней частоте кривой 3. При использовании пьезокерамических или электромеханических фильтров селабление двух таких каскадов при расстройке ±9 кГц будет на 15—20 дВ больше, чем у одного фильтра, что вполне достаточно. Справедливость сказанного подтверждается практикой [«Радно», 1972, № 9, с. 20].

Может показаться, что при более значительной расстройке двух фильтров получится селективная система с сще более узкой полосой пропускания, псобходимой для приема телеграфных сигналов, — около 100 Ги. Однако при столь узкой полосе пропускания потребовался бы очень сложный вериьерный механизм для настройки приемника. Кроме того, даже относительно небольная нестыбильность частоты сигнала



или гегеродина выводила бы спектр полезного сигнала из пределов полосы пропускания гракта промежуточной частоты [5, 19]. А при этом происходило бы полное прекращение приема сигнала и нельзя было бы «угадать», в какую сторону следует вращать ручку настройки приемика для возобновления приема. Это значительно затрудняло бы работу оператора. Поэтому для приема телеграфных сигналов полосу пропускания приемика делают не менее 0,5—1 кГц [4, 13, 38]. Такую полосу пропускания можно полу-

чить при указанной расстройке двух фильтров, особенно если с помощью шлифовки резонаторов одного фильтра повысить их собственные частоты до нужного предела [6]. Такую же полосу пропускания можно получить с четырех-изтиконтурным фильтром. Его применение нелесообразно, если запухание контуров удовлетворяет неравенству [3—5]

$$\delta_{9} \leqslant \Pi/(2.83f_{\rm up}). \tag{2-53}$$

При затухании контуров 0,01 полосу пропускания I кГи обеспечит промежуточная частота менсе  $f_{\rm np}=1000/(2.83\cdot0.01)=35\,000\,$  Гц. Размеры контурных катушек для такой резонансной частоты оказались бы очень большими, а применение фильтра сильно увеличило бы размеры и стоимость приемника. Одиако в профессиональных сиязных приемниках подобные фильтры находят применение.

## 2-5. Выбор типа транзисторов, селективных систем и схем каскадов тракта радиосигнала

Чувствительность радиоприеминков различного назначения определяется соответствующими ГОСТ или пормалями. Рассмотрим решение поставленной задачи на примере радиовещательного перепосного приеминка 1 класса, для которого ГОСТ 6551—76 определяет значения

чувствительности, приведенные в табл. 2-8. При выборе транзистора следует учитывать, что в схеме с ОЭ достагочно большой коэффициент устойчивого усиления получается, если максимальная рабочая частота приемника менее 0,15  $f_{\rm FD}$  [5].

Таблица 2-8

Подді	<b>гапазо</b> н	τ	1 увствитель	ность		шенне л/шум.		одимое Існие на
,			мкВ	мВ/м		Б		те, дБ
	Наиме-		тенн <b>ы</b> та внешней	с внут-				
N∘	нова- ние	пере- носные прием- ники	стационар- ные при- емники	ренней маснитной антенны	допу- стимое	взятое в рас- чете	зер- каль- ной	проме- жуточ- ной
$\frac{1}{2}$ $3-11$ $12$	ДВ СВ КВ УКВ	150 100 150 10	150 100 100 100 5	1 0,7 —	20 20 20 20 26	26 26 26 26 26	40 34 16 26	30 30 30 50

1. Для поддиапазона 12 (УКВ) согласно табл. 11-1-1 может быть использован транзистор ГТЗ13Б. Транзистор ГТЗ13А обладает большими междуэлектродными проводимостями, и его применение менее целесообразно [37]. Транзистор П411 также имеет худние параметры при существению меньшей предельной частоте.

Относительная полоса частот поддиапазона 12  $2(f_{\max}-f_{\min})/(f_{\max}+f_{\min})=2$  (73 — 68,5)/(73 + 68,5) = 0,064 сравнительно мала, и можно считать параметры транзистора постоянными во всем поддианазоне, соответствующими средней частоте  $f_{\rm cp}=0.5$  ( $f_{\max}+f_{\min})=0.5$  (73 + 68,5) = 70,75 МГц. Их значения по табл. П-1-1 при  $E_{\rm K}=-5$  В и  $I_{\rm K}=1$  мА следующие:  $h_{\rm 21.6}=0.993$ ;  $f_{\rm rp}=600$  МГц;  $r_{\rm 6}=50$  Ом;  $C_{\rm 12}=1$  пФ;  $C_{\rm 22}=4$  пФ;  $I_{\rm K,0}=3$  мкА;  $g_{\rm 11}=6$  мСм;  $g_{\rm 22}=550$  мкСм;  $I_{\rm 21}=55$  мСм;  $I_{\rm 11}=24$  пФ.

Для рассматриваемого поддиалазона выходное активное сопротивление антенны определено ГОСТ 5651-76 равным  $r_{\rm A}=300$  Ом. Следовательно,  $g_{\rm A}=3,33$  мСм и выходная проводимость антенны меньше входной проводимости транзистора в схеме с ОЭ. Поэтому для получения максимального коэффициента передачи входной цепи в режиме согласования следует брать полное включение антенны и неполное включение входа транзистора к контуру входной цепи (рис. 2-9) [5]

$$p_1 = 1$$
 и  $p_2 \sqrt{\frac{g+G_1}{G_2}} = \sqrt{\frac{g+g_A}{g_{11}}}$ . (2-54)

Собственная резонансная активная проводимость параллельного колебательного контура определяется уравненнем

$$g = \delta \omega_0 C_0 = \delta / (\omega_0 L). \tag{2-55}$$

Положим эквивалентную емкость входного контура  $C_0 = 20$  пФ, а его собственное затухание  $\delta = 0.02$ . При этом  $g = 0.02 \cdot 6.28 \times 10^{-2}$ 

 $\times$  7075·10<sup>4</sup>·2·10<sup>-11</sup> = 178·10<sup>-6</sup> См; она в 19 раз меньше выходной проводимости антенны и в 34 раза меньше входной проводимости транзистора, что пренебрежимо мало. В этом случае расчет входной цепи обычно ведут на режим согласования, при котором коэффициент шума входной

цепи и первого каскада по схеме с ОЭ записывается равенством

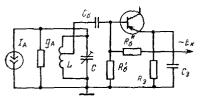


Рис. 2-9.

$$U_{\rm c} \approx 1 + (r_6 + 4R_{\rm m}) g_{11} + \frac{G_{\rm m} (1 + r_6 g_{11})^2 + r_6 b_{11}^2}{g_{11}} \cdot$$

$$(2-56)$$

Здесь

$$R_{\rm m} = 20I_{\rm K}/|Y_{21}|$$
 H  
 $G_{\rm m} = 20I_{\rm K}(1/h_{21} - 1)$  (2-57)

— шумовые параметры трапзистора [5, 37]. Для выбранного режима  $G_{\rm in}=20\cdot 10^{-3}\,(1/0,993-1)=14\cdot 10^{-5}\,{\rm CM}$  и  $R_{\rm in}=20\cdot 10^{-3}/55\cdot 10^{-3}=0,365\,{\rm CM}$ . По уравнению (2·56) получаем  $U_{\rm ir}=1+(50+4\cdot 0,365)\times 6\cdot 10^{-3}++[14\cdot 10^{-5}(1+50\cdot 6\cdot 10^{-3})^2+50\cdot 6,28^2\cdot 7075^2\cdot 10^8\cdot 24^2\times 10^{-24}]/6\cdot 10^{-3}==1,4.$  Положим, что последующие каскады приемника (кроме первого) увеличивают коэффициент шума в 1,5 раза, при этом для всего приемника можно считать  $U=1,5U_{\rm c}=1,5\cdot 1,4=2,1$ .

Требуемое отношение сигнал/шум (по напряжению) на входе приемника определяется формулой

$$\gamma_{U_{BX}} = \gamma_{U_{Bbix}}/\psi_{M}, \qquad (2-58)$$

где  $\gamma_{U_{\rm BMX}}$  — необходим ое отношение сигнал/шум на выходе детектора;  $\psi_{\rm M}$  — максимальный индекс модуляции сигнала. Для рассматриваемого поддиапазона из табл. 2-8 берем для расчета  $\gamma_{U_{\rm RMX}} = 20$  и из примера 2-6  $\psi_{\rm M} = 5$ . Следовательно, на основании (2-58) отношение сигнал/шум на входе приемника должно быть  $\gamma_{U_{\rm RX}} = 20/5 = 4$ , что соответствует отношению по мощности  $\gamma_{\rm RX} = \gamma_{U_{\rm RX}}^2 = 16$ .

Коэффициент шума приемника, обеспечивающий заданную чувствительность приемника  $E_{{\rm A}\,0}$  при компатной температуре (290 K), определяется неравенством [5]

$$M_{\text{Aon}} \leqslant K_{\text{P}\Phi} \left( \frac{E_{A0}^2}{1.6 \cdot 10^{-20} r_A H_{\text{REBCTB}} \gamma_{\text{BX}}} - 1 + t_A \right).$$
 (2-59)

Действующая полоса пропускания приемника  $\Pi_{\text{действ}}$  при числе каскадов высокочастотного тракта более двух-трех связана с его полосой при ослаблении 1,41 выражением [3, 5]

$$\Pi_{\text{действ}} \approx 1.1\Pi.$$
 (2-60)

В поддиапазоне 12 она будет  $\Pi_{\text{действ}}=1,1\cdot180000=2\cdot10^5$  Гft. В переносных приемниках антенны находятся близко от входиого контура и можно считать коэффициент передачи фидера по мощности  $K_{\text{P}, \Phi}=1$ . Будем полагать, что внешних шумовых помех антенна не воспринимает, т. е. ее относительная шумовая температура  $t_{\text{A}}=1$ . Это хорошо согласуется с экспериментальными данными [4]. Подставляя принятые исходные данные в (2-59), получаем  $M_{\text{дей}} \leq$ 

$$\leq 1 \left( \frac{10^{-10}}{1,6 \cdot 10^{-20} \cdot 300 \cdot 2 \cdot 10^5 \cdot 16} - 1 + 1 \right) = 6,5$$
. Следовательно, вы-

бранный транзистор обеспечит необходимую чувствительность приемника в поддиапазоне 12 с запасом. Если  $III_{\rm доп} < III_{\rm c}$ , требуемая чувствительность приемника при выполнении входной цепи на режим согласования не обеспечивается. В этом случае можно построить входную цепь, рассчитывая на минимально возможный коэффициент шума  $III_{\rm мин}$  [3, 5]. Так, например, поступают при антеннах с малой действующей высотой (см. § 5-5). Если и при этом не обеспечивается выполнение неравенства  $III_{\rm доп} \geqslant III_{\rm мин}$ , следует взять транзистор с меньшими шумами, т. е. более высокочастотный.

В режиме согласования максимальный коэффициент передачи входной цепи при  $g_{\rm A} < g_{11}$  определяется формулой

$$K_{\rm B \ ii, max} = 0.5 \sqrt{\frac{g_{\rm A} + g}{g_{\rm B}}}$$
 (2-61)

В нашем случае  $K_{0 \text{ в. ц max}} = 0.5 \sqrt{\frac{(3330 + 178) \cdot 10^{-6}}{6 \cdot 10^{-3}}} = 0.38$ . Эквивалентное затухание входного контура при этом запишется выражением

$$\delta_{\mathbf{q}} = 2\delta (1 + g_{\mathbf{A}}/g).$$
 (2-62)

Следовательно,  $\delta_9=2\cdot 0.02~(1+333\cdot 10^{-6}/178\cdot 10^{-6})=0,785$ . При таком эквивалентном затухании селективные свойства колебательного контура будут очень низкими. Согласно табл. 1-2 несущая частота сигнала звукового сопровождения второго телевизионного канала  $f_{32}=59.25+6.5=65.75~\mathrm{MFu}$ , а расстройка его относительно средней частоты поддиапазона  $\Delta f=70.75-65.75=5~\mathrm{MFu}$ . Апалогично расстройка несущей сигнала изображения третьего телевизионного канала  $\Delta f_{19}=77.25-70.75=6.5~\mathrm{MFu}$ .

Ослабление сигнала колебательным контуром определяется уравнением

$$d = V \overline{1 + \xi^2}, \tag{2-63}$$

в котором

$$\xi = \frac{1}{\delta_B} \left| \frac{f_0 - \Delta f}{f_0} - \frac{f_0}{f_0 - \Delta f} \right| \tag{2-64}$$

— обобщенная расстройка, а  $\Delta f = f_0 - f_c$  — абсолютная расстройка частоты сигнала относительно резонансной частоты контура. При  $\Delta f < 0.25\,f_0$  с погрешностью менее 10 % вместо формулы (2-64) можно пользоваться приближенным равенством

$$\xi \approx 2\Delta f/(\delta_9 f_0).$$
 (2.65)

Пользуясь формулой (2-65) для сигнала второго телевизионного канала, получаем  $\xi_{\rm T}=2.5\cdot 10^6/[0.785\cdot 7075\cdot 10^4]=0.181$ . Ослабление вного сигнала входной целью по уравнению (2-63) будет составлять  $d_{\rm T}=\sqrt{1+0.181^2}=1.02$ . Аналогично для зеркального канала по формуле (2-65) получим  $\xi_{\rm S}=2\cdot 2\cdot 84\cdot 10^5/(0.785\cdot 7075\cdot 10^4)=0.6$  и из равенства (2-63) находим  $d_{\rm S}=\sqrt{1+0.6^2}=1.17$ . Для оценки ослабления сигналов с промежуточной частотой расчет обобщенной расстройки следует вести по формуле (2-64), так как относительная расстройка

$$(70.75-8.4)/70.75=0.88>0.25$$
. Она будет  $\xi_{\rm HP}=\frac{1}{0.785}\left|\frac{8.4}{70.75}\right|^{-1}$   $-\frac{70.75}{8.4}\left|=10.6$  и согласно уравнению (2-63)  $d_{\rm HP}=\sqrt{1+10.6^2}=10.6$ . Таким образом, входная цепь с такими парамеграми не будет ослаблять сигналы соседних телевизионных каналов, чго неизбежно приведет к значительному мещающему действию и созданию большого уровия перекрестных искажений в каскаде усилителя радиосигнала и комбинационных искажений в преобразователе частоты.

Устойчивый коэффициент усиления каскада с ОЭ определяется

формулой

$$K_{0 \text{ yct}} = \sqrt{\frac{2(1-k_y) \cdot Y_{21}}{\omega C_{12}}}.$$
 (2-66)

Здесь  $k_{\rm y}=0.8\div0.9$  — коэффициент устойчивости. Чем больше  $k_{\rm y}$ , тем устойчивее работа, но меньше усиление каскада. При  $k_{\rm y}=0.9$  получим:

$$K_{0 \text{ yet}} = \sqrt{\frac{2 (1 - 0.9) 55 \cdot 10^{-3}}{6.28 \cdot 7075 \cdot 10^{1} \cdot 10^{-12}}} = 5.$$

В преобразователе частоты обычно используется такой же транзистор, как в усилителе радиосигнала. Входные параметры транзистора преобразователя частоты определяются приблаженными равенствами:

$$g_{1104} \approx 0.75g_{11} \text{ H } C_{1104} \approx 0.8C_{11}.$$
 (2-67)

Таким образом,  $g_{1114} = 0.75 \cdot 6 \cdot 10^{-8} = 4.5 \cdot 10^{-3}$  См.

Для режима согласования коэффициент усиления каскада усилителя радиосигнала определяется равенством [5]

$$K_{0 \text{ c max}} = \frac{0.5 |Y_{21}|}{V(\rho_1^2 G_1 + g)G_2},$$
 (2-68)

где  $G_1$  — активная составляющая проводимости коллекторной цепи транзистора рассматриваемого каскада;  $G_2$  — активная составляющая входной проводимости следующего каскада. Подставляя численные значения в формулу, получаем:

$$K_0 \text{ c max} = \frac{0.5 \cdot 55 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{(550 + 178) \cdot 10^{-6} \cdot 45 \cdot 10^{-4}}} = 15.$$

Это больше  $K_{\rm вуст}$ , и расчет необходимо вести на получение устойчивого коэффициента усиления. Для этого в коллекторную цень транзистора необходимо включить контур с коэффициентом включения

$$p_1 = K_{0 \text{ ycr}} / K_{0 \text{ c max}}. \tag{2-69}$$

В рассматриваемом случае получим  $p_1=5/15=0,33$ . При этом эквивалентное затухание контура будет [5]:

$$\delta_{\theta} = 2\delta \left(1 + p_1^2 G_1/g\right) \approx 2\delta \left(1 + p_1^2 g_{22}/g\right),$$
 (2-70)

т. е.  $\delta_{\mathfrak{s}}=2\cdot0.02$  (1 +  $0.33^2\cdot55\cdot10^{-5}/(178\cdot10^{-6})=0.0545$ . Для него из выражения (2-65)  $\xi_{\mathfrak{t}}=2\cdot5\cdot10^{4}/(0.0545\cdot7075\cdot10^{4})=2.6$  и  $\xi_{\mathfrak{s}}=2\times16.8\cdot10^{6}/(0.0545\cdot7075\cdot10^{4})=8.7$ . На промежуточной частоте по уравнению (2-64) находим  $\xi_{\mathfrak{up}}=\frac{1}{0.0545}\left|\frac{8.4}{70.75}-\frac{70.75}{8.4}\right|=152$ . На осно-

вании формулы (2-63) получим  $d_{\rm T}=V\overline{1+2.6^2}=2.8;\ d_3=8.75$  и  $d_{\rm HD}=152.$ 

Общее усиление и ослабление помех в тракте радиосигнала определяется формулами:

$$K_{9p,c} = K_{0B,n}K_{by,p,c} \times d_{p,c} = d_{n,n} = d_{y,p,c}.$$
 (2-71)

При полученных значениях  $K_{0p,c} = 0.38 \cdot 5 = 1.9, d_T = 1.02 \cdot 2.8 = 0.000$ 

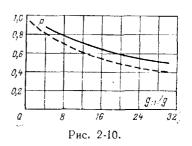
 $= 2.86, d_3 = 10.2$  и  $d_{np} = 1600$ .

Сравнение полученных данных с требованиями к селективности приемника, приведенными в табл. 2-8, показывает, что селективность по зеркальному каналу в рассмотренном варианте 1 тракта радиосигнала не удовлетворяется.

Аналогичный расчет каскада усилителя радиосигнала по схеме с ОБ дает результаты, соответствующие варианту 2, приведенному в табл. 2-9. Его селективность и усиление инже, чем в варианте 1.

Улучшения селективных свойств входной цепи можно достигнуть, если допустить иекоторое увеличение коэффициента шума каскада и снижение коэффициента передачи входной цепи. В этом случае можно уменьшить коэффициент включения меньшей внешней для контура входной цепи проводимости. А это соответственно снизит эквивалентное затухание контура и улучшит его селективность. Улучшение селективности

будет тем эффективнее, чем больше отношение внешней для контура проводимости к его собственной проводимости [5]. В нашем случае меньшей внешней для контура проводимостью является выходная проводимость антенны. Отношение  $g_A/g=0.00333/0.000178=18.7$ . Допустим ухудшение коэффициента шума на 20 %, т.е. примем  $III=1.2\ III.e=1.2\ III.e=1.7$ . Тогда по штриховой кривой на рис. 2-10 находим допустимое уменьшение коэффициента включения  $p_1=0.5$ .



Эквивалентное затухание контура входной цепи в этом случае уменьшается примерно в  $p_1^2$  раз. Оно будет  $\delta_9=0.5^2\cdot 0.785=0.19$ . При схеvе каскада с ОЭ характеристики тракта радиосигнала соответствуют варианту 3 (табл. 2-9). Коэффициент персдачи входной цени уменьшается примерно на 20 % и будет составлять  $K_{0R,R}'=0.8\cdot 0.38=0.3$ . Как следует из табл. 2-9, вариант 3 тракта радиосигнала обеспечивает исобходимую чувствительность и все требования по селективности. Следовательно, его можно принять к реализации.

Если допустить аналогичное увеличение коэффициента шума и синжение коэффициента передачи входной цепи, то в случае построения усилителя радносигнала по схеме с ОБ получим характеристики раднотракта, приведенные в табл. 2-9 для варианта 4. Они также удовлетворнот всем гребованиям, но усиление сигнала получается в 2,5 раза

меньше, чем в нарианте 3.

Увеличить селективность и коэффициент передачи входной цепи можно построением усилителя радносигиала по каскодной схеме, в которой первый транзистор включается по схеме с ОК, обеспечивающей наименьшую входную проводимость.

			Вход	і кви	teпь		Уси	литель	радис	осигна	ла		Радио	тракт			
Вари- ант	Схема каскада УРС	К₀ <sub>в.п</sub>	ŏ,	d <sub>T</sub>	d <sub>3</sub>	апр	K <sub>ov.p.c</sub>	Ů,	d <sub>T</sub>	d <sub>3</sub>	ďпр	К <sub>ор.с</sub>	d <sub>T</sub>	ď3	d <sub>np</sub>	Ш	<i>U</i> <sub>вх∙пъ</sub> мкВ
1	ОЭ (ТТ313Б)	0,38	0,785	1,02	1,2	10,6	5	0,055	2,8	8,7	152	1,9	2,9	10	1600	1,4	19
2	OB (ГТ313Б)	0,19	0,79	1,02	1,2	10,5	6,2	0,061	2,3	7,8	136	0,7	2,4	9,2	1430	1,4	7,4
3	ОЭ (ГТ313Б)	0,3	0,196	1,23	2,6	42	5	0,055	2,8	8,7	152	1,5	3,4	23	6380	1,7	15
4	ОБ (ГТ313Б)	0,1	0,198	1,23	2,6	42	6,2	0,061	2,3	7,8	136	0,6	2,9	20	5700	1,7	6,2
5	ОК + ОЭ (ГТ313Б)	0,9	0,23	1,18	2,3	36	4,3	0,055	2,8	8,7	152	3,9	3,3	20	5470	1,4	40

			Вход	цная ц	цепь		Уси	литель	радио	сигна	ла		Радио	тракт			
Вари- ант	Схема каскада УРС	Ков.ц	ð <sub>9</sub>	d <sub>T</sub>	<i>d</i> <sub>3</sub>	$d_{\pi p}$	Коу.р.с	ė,	d <sub>T</sub>	d <sub>3</sub>	$d_{\pi p}$	K <sub>op-c</sub>	d <sub>T</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>np</sub>	Ш	υ <sub>вх-пъ</sub> мкВ
6	ОК + ОБ (ГТ313Б)	0,5	0,74	1,02	1,2	11,3	3	0,061	2,5	7,9	137	1,5	2,6	9,4	1550	1,4	15,1
7	ОИ (КП350Б)	2,1	0,042	3,5	11	196	3	0,051	3	9,4	173	6,2	I 1	103	34000	2,3	62
8	ОС (КП302A)	2,1	0,043	3,5	11	195	0,4	0,76	1	1,2	11	0,8	3,5	13	2120	5	8,4
9	ОС(КП302A) + ОЭ (ГТ313Б)	2,1	0,043	3,4	11	188	1,6	0,055	2,8	8,7	152	3,4	9,6	98	28600	5	34
10	ОС(КП302A) + ОБ (ГТ313Б)	2	0,044	3,4	11	188	0.3	0,081	2,5	7,9	137	0,6	8,5	85	258 <b>00</b>	5	6,1

Пример 2-8. Определить параметры тракта радиосигнала для подіднапазона 12, если в качестве усилителя радиосигнала используется каскодный усилитель с транзисторами ГТЗ13Б.

Схема, соответствующая условням примера 2-8, изображена на рис. 2-11. Выходное сопротивление транзистора и нагрузочное сопротивовние каскада с ОК определяются формулами:

$$R_{\rm BMX} \approx 1/(Y_{\rm eff}); R_{\rm eff} \approx (10-20)/(Y_{\rm eff}) = 1/G_{\rm eff}.$$
 (2-72)

В нашем случае  $R_{\rm эк}=15.0,055=270~{\rm OM}$  и  $G_{\rm эк}=3,68~{\rm мCm}$ . Коэффициент усиления каскада с ОК

$$K_{\text{o K}} = \frac{(Y_{21+1}, +g_{11+1})}{(Y_{21+1}, +g_{11+1}) + G_{9K,1} + g_{BX,2}},$$
 (2-73)

а его входные активная проводимость и емкость определяются формулами:

$$g_{11K} = g_{11(1)} (1 - K_{OK}) \text{ if } C_{BX, K} = C_{11(1)} (1 - K_{OK}).$$
 (2.74)

В этих формулах индексом 1 обозначены параметры первого, а индексом 2 второго транзистора каскадной схемы. Подставляя цифровые

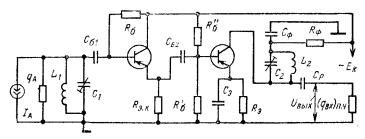


Рис. 2-11.

данные в выражение (2-73), получаем  $K_{\rm OK}=0.055\pm0.006/(0.055\pm0.006)$ 0,055  $\pm0.006\pm0.00368\pm0.006$ 0 = 0.86. Пользуясь первой формулой (2-74), находим  $g_{\rm tix}=0.006$  (1 — 0.86) = 0.00084 См, что в 7 раз меньше входной проводимости траизистора и в 4 раза меньше выходной проводимости антенны.

При  $g_{\rm A}>g_{\rm 11k}$  коэффициент нередачи входной цени в режиме согласования определяется уравнением

$$K_{\text{ob. ii, max}} = 0.5 \sqrt{\frac{g_{\text{A}}}{g + g_{\text{mis}}}}$$
 (2-75)

Подставляя цифровые данные, получаем  $K_{\rm BH\,II,\; max} = 0.5 \sqrt{\frac{0,00333}{0,000178 \div 0,00084}} = 0.9$ . Эквивалентное затухание контура входной цени в этом случае вычисляется по равенству

$$\delta_{9,c} = 2\delta (1 + g_{11R}/g).$$
 (2-76)

Оно равно  $\delta_{\text{э.с}}=2\cdot0.02~(1+0.00084/0.000178)-0.23$ . По уравнению (2-65) получим  $\xi_{\text{т}}=2\cdot5/(0.23\cdot70.75)=0.62$  и  $\xi_{\text{3}}=2.1$ , а по

(2-64)  $\xi_{\rm np} = \frac{1}{0.23} \left| \frac{8.4}{70.75} - \frac{70.75}{8.4} \right| = 36$ . Этим относитель•

ным расстрой кам из выражения (2-63) соответствуют  $d_T = \sqrt{1 + 0.6 \hat{x}^{22}}$  $= 1,18; d_3 = 2,32$  и  $d_{\rm np} = 36$ . По формуле (2-70) вычисляем эквивалентное затухание выходного контура усилителя  $\delta = 2.0,02 (1 + 0.33^2 \times 10^{-3})$  $\times$  0,00055/0,000178) = 0,0545 и согласно ранее сделанным вычислениям этот контур обеспечит ослабление  $d_1=2.8;\,d_3=8.75$  и  $d_{\rm пp}=152.$ 

Общий коэффициент усиления радиотракта в данном варианте в соответствии с формулой (2-71) получится  $K_{0,p,z} = 0.9 \cdot 0.86 \cdot 5 = 3.9$ , что в 2 раза больше, чем в усилителе радиосигнала по схеме с ОЭ. Характеристики селективности рассчитанного радиотракта соответствуют варианту 5 табл. 2-9. Опи полностью удовлетворяют требованиям к приеминку.

Если в каскедном усилителе второй транзистор включить по схеме с ОБ, то из-за очень большой входрой проводимости транзистора в этой схеме, равной  $Y_{21} + Y_{11}$ , коэффициент усиления первого транзистора в соответствии с формулой (2-73) будет малым, а на основании уравнения (2-74) входная проведиместь каскада будет большой. В связи с этим характеристики входной цени будут существенно ниже (см. вариант 6,

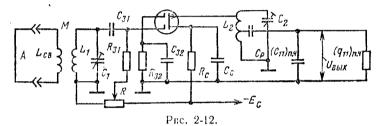


табл. 2-9). Из этого следует, что селективность по зеркальному каналу для даниого варианта радиотракта не удовлетворительна.

Очень малой входной проводимостью обладают полевые транзисторы. Применим в каскаде усилителя радносигнала транзистор типа КПЗ50Б по схеме с общим истоком (ОИ) (рис. 2-12).

Пример 2-9. Рассчитать параметры радиотракта поддиапазона 12

на транзисторе КПЗ50Б по схеме с ОИ.

Из табл. П-1-1 находим параметры траизистора для средней частоты поддиапазона:  $Y_{21}:=6$  мСм;  $g_{11}=10$  мкСм;  $g_{22}=50$  мкСм;  $C_{11}=3$  пФ;  $C_{22}=3$  пФ;  $C_{12}=0.05$  пФ. В режиме согласования при  $g_A>g_{11}$  коэффициент шума каскада с полевым транзистором определяется формулой [23]

$$III_c = 1 + (g + g_3)/(g + g_{11}) + 4R_{ui}(g + g_{11}).$$
 (2-77)

Злесь

$$R_{111} = g_{21} / Y_{21},^2 (2.78)$$

шумовое сопротивление полевого транзистора и

$$g_3 = 0.12 (\omega C_{11})^2 / g_{21}$$
 (2-79)

- проводимость цени затвора.

Для полевых транзисторов можно считать  $g_{21}\approx (0.9-0.95)\mid Y_{21}\mid$  . В нашем случае  $g_{21}=0.95\cdot0.006=0.0057$  См, По формуле (2-78) на-

жодим  $R_{\rm in}=0.0057/0.00036=160$  Ом и по уравнению (2-79) вычися ляем  $g_3=[0.12~(6.28\cdot7075\cdot10^4\cdot3\cdot10^{-12})^2]/0.0057=0.000037$  См. Используя выражение (2-77), получаем  $M_c=1+(178+37)\cdot10^{-6}/[(178+10)\cdot10^{-6}]+4\cdot160~(178+10)\cdot10^{-6}=2.3$ , что обеспечит требуемую чувствительность приемника.

Вычисляем по формуле (2-75) для режима согласования коэффи-

цвент передачи  $K_{0B, \, \text{ц max}} = 0.5$   $\sqrt{\frac{0.00333}{(178+10)^{-6}}} = 2.1$  и по уравнению (2-76) эквивалентное затухание контура входной цепи  $\delta_9 = 2 \cdot 0.02 \, [1+10^{-6}/(178\cdot10^{-6})] = 0.0423$ . Находим обобщенные расстройки по формуле (2-65) для ближнего телевизионного канала  $\xi_7 = 2 \cdot 5/(0.0423 \cdot 70.75) = 3.37$  и  $\xi_3 = 11.2$ , а по уравнению (2-64)  $\xi_{\rm пp} = \frac{1}{0.0423} \left| \frac{8.4}{70.75} - \frac{70.75}{8.4} \right| = 196$ . Пм согласно уравнению (2-63) соответствуют  $d_7 = 3.5$ :  $d_3 = 11.3$  и  $d_{\rm пp} = 196$ , что значительно выше предыдущих варнантов.

Вычисляем по выражению (2-66) устойчивый коэффициент усиления каскада  $K_{0\text{уст}} = \sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.006}{6.28\cdot7075\cdot10^4\cdot5\cdot10^{-14}}} = 7.3$ . На основании формулы (2-68) с учетом сказанного ранее коэффициент усиления каскада  $0.5\cdot0.006$  в режиме согласования  $K_{0\text{ max}} = \frac{0.5\cdot0.006}{V\,(178+50)\,10^{-6}\cdot45\cdot10^{-4}} = 2.95$ . Значит, расчет следует вести на режим согласования. При нем эквивалент-

ное затухание выходного контура каскада вычислим по формуле (2-76)  $\delta_3 = 2.0,02 (1 + 0,00005,0,000178) = 0,051$ . Ему соответствуют ослабования  $d_1 = 3$ ,  $d_2 = 0.4$  и  $d_3 = 1.73$ 

ления  $d_r = 3$ ,  $d_3 = 9.4$  и  $d_{np} = 173$ .

Общее усиление радиотракта вычисляем по уравнению (2-71)  $K_{0\,\mathrm{p.\,c}}=2,1\cdot2,95=6,2.$  В табл. 2-9 вариант 7 характеризует рассмотренную схему радиотракта. Она является наилучшей по всем параметрам. Но транзистор КПЗ50Б самый дорогой из всех, рассмотренных ранее. Более дешевым является полевой транзистор КПЗ02А. Однако из-за большой емкости обратной передачи  $C_{12}=2,4$  пФ в схеме с ОИ его устойчивый коэффициент усиления на частоте 70,75 МГц меньше единицы. Если построить на этом транзисторе усилитель радиосигнала по схеме с общим стоком (ОС), то коэффициент усиления каскада по напряжению будет всего 0.4. Но общие характеристики радиотракта, представленные в табл. 2-9 вариантом 8, удовлетворяют требованиям к приемнику, хотя коэффициент шума схемы оказывается на пределе, а усиление по напряжению меньше единицы.

Если применить транзистор КПЗ02А по схеме с ОС первым в каскодном усилителе, то при использовании вторым транзистора ГТЗ13Б по схеме с ОЭ (см. вариант 9 табл. 2-9) можно получить характеристики радиотракта, лишь в малой степени уступающие усилителю с транзистором КПЗ50Б. Вариант 10 табл. 2-9 соответствует каскодному усилителю с транзисторами КПЗ02А по схеме с ОС и ГТЗ13Б по схеме с ОБ.

Обозначим э. д. с. полезного сигнала в приемной антенне через  $E_{\mathbf{A_0}}$ . Тогда напряжение полезного сигнала на входе преобразователя частоты определится равенством

$$U_{\rm BX, \Pi^{\rm f}} = E \, A_0 K_{\rm op. \, c}.$$
 (2-80)

Подставляя в эту формулу значение чувствительности из табл. 2-8, получаем при использовании в усилителе радвосигнала транзистора ГТ313Б по схеме с ОЭ  $U_{\rm BX, RQ}=10^{-5}\cdot 1.9=1.9\cdot 10^{-5}$  В. Результаты

аналогичных расчетов для других вариантов тракта радиосигнала приведены в табл. 2-9.

Для переносного приемника I класса наиболее дешевым и требующим меньшей мощности питания будет усилитель радиосигнала на транзисторе ГТЗ13Б по схеме с ОЭ с использованием по варианту 3 (см. табл. 2-9, рис. 2-9).

2. Для первых 11 поддиапазонов (ДВ, СВ и КВ) радиовещательных приемников всех классов промежуточная частота определена ГОСТ 5651—76 равной 465 кГц. Поэтому для всех этих поддиапазонов радиотракт строится по одинаковой схеме с использованием одних и тех же транзисторов. На основании этого выбор схемы и транзисторов радиотракта выполняют для самого высокочастотного, т. е. 11-го поддиапазона 25,6—26,1 МГц. На остальных поддиапазонах характеристики радиотракта по чувствительности и селективности, естественно, будут лучше. Относительная ширина поддиапазона 11 2 (26,1—25,6)/(26,1—25,6) = 0,02 вссьма мала. Поэтому изменениями параметров транзистора в пределах поддиапазона можно пренебречь и считать их по стоянными и соответствующими средней частоте поддиапазопа  $f_{\rm cp}$  = 0,5 (26,1 + 25,6) = 25,85 МГц.

В переносных радиовещательных приеминках для декаметровых волн (КВ), т. е. для поддиапазонов 3—11, применяются вертикальные штыревые телескопические антенны длипой 1 м. Характеристики такой антенны приведены в табл. 2-10 в зависимости от рабочей частоты.

Таблица 2-1

Частота, МГц	4	6,1	7,2	9,7	11,8	15,3	17,8	21,6	25,9
Активное сопротивление, Ом	0,04	0,08	0,11	0,2	0,31	0,51	0,74	1	1,5
Емкость, пФ	6,8	6, 1	6	6	6	6,1	6, 1	6,2	6,3

При использовании внешней проволочной антенны ее усредненны параметры принято считать ностоянными [4]:

$$h_{\rm A} \approx 2$$
 м;  $r_{\rm A} = 50$  Ом;  $C_{\rm A} = 75$  пФ;  $L_{\rm A} = 2$  мкГн. (2-81)

При приеме амплитудно-модулированного сигнала и воздействии шумовой или другой широкополосной помехи связь между отношениями сигнал/шум на выходе и входе детектора определяется уравнением [4]

$$\gamma_{U_{\rm BMX}} \approx \frac{\gamma_{U_{\rm BMX}}}{m\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2\Pi_{F_{\rm Действ}}}{\Pi_{\rm Действ}}}.$$
 (2-82)

.....Здесь m — средний коэффициент модуляции сигнала, который принимают равным 0,3;

$$\Pi_{F\text{meActb}} \approx 1.1 \Pi_F$$
 (2-83)

— действующая полоса пропускания, а  $\Pi_F$  — полоса пропускания инзкочастотного тракта приемника.

Пример 2-10. Определить допустимый коэффициент шума для поддиапазона 11 переносного приемника I класса. Ширину полосы пропус-

кания высокочастотного тракта будем считать соответствующей примеру 2-6 и равной 12 кГц.

Граничные частоты пизкочастотного тракта приемника определяем ГОСТ 5651—76:  $F_{\rm H}=100~\Gamma_{\rm H}$  и  $F_{\rm B}=12.5~{\rm к}\Gamma_{\rm H}$ , следовательно,  $\Pi_{\rm F}=$  $= 12\,500 - 100 = 12\,400\,\Gamma$ ц. Действующую полосу пропускания низкочастотного тракта вычисляем по формулс (2-83)  $\Pi_{F, \text{действ}} = 1,1\cdot 12$  400 = 13 640 Гц. Из (2-60) находим действующую полосу пропускания высокочастотного гракта приемника  $\Pi_{\text{действ}} = 1,1 \cdot 12\,000 = 13\,200\,\Gamma$ ц. Из табл. 2-8  $\gamma_{U_{\rm BMX}}=$  20. Из (2-82)  $U_{\gamma_{\rm BX}}=\frac{20}{0.3\cdot 1.41}\sqrt{\frac{2\cdot 13640}{13200}}=$ =67 и  $\gamma_{\rm BX}\!=\!67^2$ . Будем считать с учетом сказанного ранее наибольшее возможное сопротивление антенны равным 50 Ом, чтобы определить самые жесткие требования к обеспечению чувствительности приемника. Полагая  $K_{\hat{\mathbf{p}}_{\mathbf{d}}}=1$  и  $t_{\mathbf{A}}=1$  и подставляя полученные значения в формулу (2.59), вычисляем допустимое значение коэффициента шума для поддиапазонов 3—11 приемника:  $III_{\rm доп} \lesssim 1 \left( \frac{15^2 \cdot 10^{-10}}{16^{-21} \cdot 50 \cdot 13\,200 \cdot 67^2} - 1 + 1 \right) = 530$ . С любым типом транзистора, обеспечивающим усиление сигнала в рассматриваемых поддиапазонах, можно получить значительно меньший коэффициент шума. Расчеты, аналогичные проделанным в начале параграфа, дают коэффи-

селектинность приемника. При заданной промежуточной частоте максимально допустимое эквивалентное затухание контуров радиотракта, если в нем применяется  $n_c$  одиночных колебательных контуров, при верхней настройке гетеродина определяется неравенством

инент шума не более 20—30 (см. пример 2-11). Поэтому транзисторы и схемы радиотракта выберем так, чтобы гарантировать необходимую

$$\delta_{\text{a.c}} \leq \frac{4f_{\text{np}}}{\sqrt{\sqrt[n_{\text{c}}]{d_{\text{a}}^2 - 1}}} \cdot \tag{2-84}$$

Когда в раднотракте имеется только входная цепь ( $n_{\rm c}=1$ ), из когда в радпотракте имеется только  $\frac{4\cdot 465\,000}{261\cdot 10^5\, V\, 5^2-1}=0.0145.$  При

собственном затухании контура 0,01 в транзисторном приемнике такое эквивалентное затухание можно получить лишь при слабой связи контура со входом транзистора. А это неизбежно снизит коэффициент передачи сигнала в радиотракте. Поэтому целесообразно в радиотракте применить два контура: один во входной цепи, а второй в усилителе радиосигнала. В этом случае из неравенства (2-84) вычисляем  $\delta_{\text{9. c}} \le \frac{4 \cdot 465\ 000}{261 \cdot 10^3\ V\ V 5^3 - 1} = 0.036$ , что реализуемо при большом усн-

лении.

При двух колебательных контурах в тракте радиосигиала для настройки приемника погребуется блок конденсаторов переменной емкости и трех секций (третья секция для настройки гетеродинього контура). Но поскольку относительная ширина полосы частот подднагазонов 3-11 сравнительно мала и коэффициенты диапазона для них согласно табл, 1-1 равны всего 1,02—1,04, то один контур радиотракта можно сделать неперестранваемым (с постоянной настройкой). Сделаем

таким контур усилителя радиосигнала и настроим его на среднюю частоту поддиапазона 11, а эквивалентное затухание примем равным 0.02.

Полоса пропускания одиночного колебательного контура определяется равенством

$$\Pi_{\kappa} = \delta_{\vartheta} f_0. \tag{2-85}$$

При выбранном затухании она будет  $\Pi_{\nu} = 0.02 \cdot 2585 \cdot 10^4 =$ = 517 000 Гц, что больше ширины поддианазона 11. Поэтому ослабле-

ние сигналов на граничных частотах получится менее 0,7, что

вполне допустимо.

Согласно рис. 2-13 наименьшее ослабление зеркального канала получим при приеме сигнала с минимальной частотой поддиапазона. Для сигнала с этой частотой расстройка зеркального канала относительно резонансной частоты контура будет  $\Delta f_3 = 2f_{np} - 0, 5(f_{cmax} -$ 

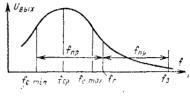


Рис. 2-13.

 $-f_{c,min}$ ) = 2.465 000 — 0,5 (261—256) 10<sup>5</sup> = 680 000 Гц. Расстройке согласно (2-65) соответствует обобщенная расстройка  $\xi_3 = 2 \times$  $\times$  680 000/(0,02·25 850 000) = 2,62. По уравненню (2-63) находим минимальное ослабление зеркального канала контуром  $=\sqrt{1+2,62^2}=2,8$ . Для сигнала с максимальной частотой (рис. 2-13) имеем  $\Delta f_3 = 2f_{\rm np} + 0.5 (f_{\rm c max} - f_{\rm c min}) = 2.465 000 + 0.5 (261 - 0.5)$ -256)  $10^5 = 1$  180 000 Гц. Этому соответствуют  $\xi_3 = 4.5$  и  $d_3 = 4.6$ .

Примем эквивалентное затухание перестраиваемого контура входной цепи  $\delta_{_{2,\,\mathrm{R},\,\mathrm{H}}}=0,025$  . При максимальной частоте сигнала обобщениях расстройка для зеркального канала будет  $\xi_{_{3\,\mathrm{min}}}=2\cdot2\cdot465\,$  000/(0,025 imesimes 2 610 000) = 2,85, а ослабление  $d_{3\,\mathrm{max}} = \sqrt{1+2,85^2} = 3$ . Проведя аналогичные расчеты для минимальной частоты сигнала, получим  $d_{3 \, \mathrm{min}} = 3,07$ . Таким образом, согласно формуле (2-71) ослабление зеркального канала радиотрактом будет на минимальной частоте  $d_{3 \min} =$ = 3,07·2,8 == 8,6 и на максимальной  $d_{3,\text{max}} = 3\cdot4,6 = 13,8$ .

По формуле (2-64) вычислим относительную расстройку для промежуточной частоты контура входной цепи на минимальной частоте под- $\pm 0.465$ 25,6диапазона  $\xi_{\rm np} = \frac{1}{0,025} \left| \frac{1}{25,6} - \frac{1}{0,465} \right|$ = 2200,чему соответствует  $d_{\text{frp. B. II}} = 2200$ . Ослабление контура усилителя радиосигнала получится  $d_{\mathrm{nb},\,\mathrm{yp,\,c}}^{\mathrm{nb,\,nc}}=2230$ . Общее ослабление тракта радносигнала по промежуточной частоте будет  $d_{\mathrm{np}}=2200\cdot2230=49\cdot10^5$ . Аналогичные расчеты для подднапазона 3, частоты которого наиболее близки к промежуточной частоте, дают  $d_{\rm пр. \ B. \ H}=335; d_{\rm np. \ y.p.c}=420$  и  $d_{\rm np}=335\cdot 420=$ = 141 000. Полученные характеристики селективности значительно лучше требуемых, поэтому рассчитанный вариант схемы раднотракта приемлем для реализации.

Хорошие усилительные и селективные свойства каскада транзисторы обеспечивают, когда их предельная частота превышает максимальную рабочую частоту усилителя в 5—7 раз [3-5]. Поэтому для усилителя радиосигнала поддиапазона 11 целесообразно брать транзисторы  $c f_{rp} > 100 - 150 M \Gamma u$ 

Пример 2-11. Проверить возможность использования транзистора

П403 в усилителе радиссигнала поддиапазона 11.

Из табл. П-1-1 находим параметры транзистора на средней частоте поддиапазона:  $r_6=50\,$  Ом;  $h_{216}=0,98;\ |Y_{21}|=0,023\,$  См;  $g_{11}=0,013\,$  См;  $g_{22}=0,19\,$  мСм;  $G_{22}=0$  пФ;  $G_{22}=0,013\,$  См;  $G_{23}=0,013\,$  См;  $G_{24}=0,013\,$  См;  $G_{25}=0,013\,$  См;  $G_{$ 

$$K_{\text{oyc}\tau} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)0.023}{6.28 \cdot 2585 \cdot 10^4 \cdot 75 \cdot 10^{-13}}} = 1.9.$$

В преобразователе частоты обычно используют те же транзисторы, что и в усилителе радиосигнала. Согласно (2-67) в режиме преобразования  $g_{11\mathrm{Hp}}=0.75\cdot0.0113=0.0085$  См. При заданном эквивалентном затухании контура наибольшее усиление каскада определяется выражением

$$K_{\text{emax}} = \frac{0.5 \ Y_{21}}{V_{g_{99}g_{11}}} \left( 1 - \frac{\delta}{\delta_{9}} \right),$$
 (2-86)

где  $Y_{21}$  и  $g_{22}$  — параметры транзистора рассматриваемого каскада, а  $g_{11}$  — активная входная проводимость следующего каскада. Для нашего

случая, приняв собственное затухание контура равным 0,01, получим 
$$K_{6\text{max}} = \frac{0.5 \cdot 0.023}{V \cdot 0.00019 \cdot 0.0085} \left(1 - \frac{0.01}{0.02}\right) = 4.5$$
. Следовательно, расчет

каскада необходимо производить на устойчивый коэффициент усиления. При заданном эквивалентном затухании контура наибольший коэффициент передачи одноконтурной входной цепи определяется уравнением [5]

$$K_{\text{6B. II, max}} = \frac{0.5}{Z_{\text{A}}^{\prime} \sqrt{g_{\text{A}}^{\prime} g_{\text{BX}}}} \left(1 - \frac{\delta}{\delta_{\text{a}}}\right), \qquad (2-87)$$

в котором  $Z_{\mathbf{A}}'$  и  $g_{\mathbf{A}}'$  — параметры антенной цепи с учетом элемента связи антенны со входным контуром, а  $g_{\rm BX}$  — входная проводимость первого каскада.

В декаметровом диапазоне воли наиболее целесообразно применять входную цепь с индуктивной связью с антенной, когда собственная частота аитенной цепи ниже минимальной частоты поддиапазона. Она обычно выбирается из условия

$$f'_{\rm A} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L'_{\rm A}C_{\rm A}}} \le (0.5 \div 0.7) f_{\rm c min}.$$
 (2-88)

В этом случае выходная проводимость антенной цепи [5]

$$g'_{\rm A} = r'_{\rm A}/{Z'_{\rm A}^2} \approx \delta_{\rm CB}/Z'_{\rm A}.$$
 (2-89)

Сопротивление антенной цепи в рассматриваемой схеме входной цепи

 $Z'_{\Lambda} \approx \omega L_{\rm cn}$ . (2-90)

Используя условие (2-88), можно записать  $\omega_A' \approx 0.7 \, \omega_{\min} \approx$  $pprox rac{1}{VL_{
m cu}C'_{
m A}}$  . Отсюда  $L_{
m cB} = rac{1}{0.72\omega_{
m cm}^2 C'_{
m A}}$  .

Подставляя полученное выражение в (2-90), получаем  $Z_A' \approx \omega \frac{1}{0.7^2 \omega_{\min}^2 C_A'}$ . Так как средняя частога поддиапазона мало отличается

от минимальной частоты (всего на 1 %), то с небольшой погрешностью можно записать:

 $Z_A \approx 2/(\omega_{\rm cp}^2 C_A').$  (2-91)

С учетом уравнений (2-89) и (2-91) формулу (2-87) можно переписать так

$$K_{0 \text{ B. II max}} = 0.5 \sqrt{\frac{\omega_{cp} C_A'}{2\delta_{cg} g_{11}}} \left(1 - \frac{\delta}{\delta_{\theta}}\right). \tag{2-92}$$

Катушку связи обычно наматывают тонкой проволокой, поэтому ее собственное затухание получается равным 0,025 — 0,035. Принимая  $\delta_{\rm cB}=0.03$ , из формулы (2-92) получаем

$$K_{0 \text{ в. ц max}} = 0.5$$
  $\sqrt{\frac{6.28 \cdot 2585 \cdot 10^4 \cdot 63 \cdot 10^{-13}}{2 \cdot 0.03 \cdot 0.0113}} \left(1 - \frac{0.01}{0.025}\right) = 0.37.$  По уравнению (2-71) вычисляем общий коэффициент передачи

радиотракта по напряжению  $K_{0 \text{ p. c}} = 0.37 \cdot 1.9 = 0.71$ .

Коэффициент устойчивого усиления каскада при включении транзистора по схеме с ОБ определяется выражением

$$K_{0 \text{ yct OB}} = \frac{2(1-k_y)|Y_{21}|}{\omega_0 C_{22}},$$
 (2-93)

а входная проводимость каскада приближенным равенством

$$g_{\rm BX OB} \approx |Y_{21}| + g_{11}.$$
 (2-94)

Для схемы с ОБ найдем по формуле (2-93)  $K_{\rm 0yc\tau}=2~(1-0.9) \times 0.023/(6.28\cdot2585\cdot10^4\cdot10^{-11})=2.8$  и по выражению (2-94) активную входную проводимость каскада  $g_{\rm BX}\approx (23+11.3)\times 10^{-3}=0.0343$  См. Выходная проводимость транзистора практически будет такой же, как в схеме с ОЭ [3, 23]. Поэтому  $K_{\rm 0max}$  согласио (2-86) будет таким же, т.е. равным 4,5, и расчет каскада следует вести на устойчивый коэффициент усиления. Подставляя в формулу (2-92)  $g_{\rm BX}$  вместо  $g_{\rm 11}$ , получаем максимально возможное значение коэффициента передачи входной цепи:

$$K_{0 \text{ B. } \text{Il max}} = 0.5 \text{ } \sqrt{\frac{6.28 \cdot 2585 \cdot 10^4 \cdot 63 \cdot 10^{-13}}{2 \cdot 0.03 \cdot 0.0343}} \text{ } \left(1 - \frac{0.01}{0.025}\right) = 0.21.$$

По уравнению (2-71) вычисляем  $K_{\rm Op.\, c}=0.21\cdot 2.8=0.6$ . При одинаковой селективности усилитель с ОБ обеспечивает на 12 % меньший коэффициент передачи сигнала в радиотракте.

Для условий, обеспечивающих наибольший коэффициент передачи входной цепи при заданном эквивалентном затухании контура, коэффициент шума определяется уравнением

$$\mathcal{H}_{\text{disc}} = 1 + \frac{2\delta}{\delta_{\mathfrak{d}} - \delta} + r_{6}g_{11} \left( \frac{2\delta}{\delta_{\mathfrak{d}} - \delta} + 1 \right)^{2} + \\
+ \frac{G_{ut}}{g_{11}} \left[ 1 + r_{6}g_{11} \left( \frac{2\delta}{\delta_{\mathfrak{d}} - \delta} + 1 \right) \right]^{2} + \frac{r_{6}b_{11}^{2}}{g_{11}} \left( 1 + G_{ut}r_{6} \right) + \\
+ R_{ut}g_{11} \left( 2 + \frac{2\delta}{\delta_{\mathfrak{d}} - \delta} \right). \tag{2-95}$$

Вычислим по формулам (2-57)  $G_{10}=0.02$  (1/0,98 — 1) =  $4\cdot 10^{-4}$  См и  $R_{11}=20\cdot 0.98\cdot 10^{-3}/0.023=0.85$  Ом. Из равенства (2-95) находим

$$\mathcal{U} = 1 + \frac{2 \cdot 0.01}{0.025 - 0.01} + 50 \cdot 0.0113 \left( \frac{2 \cdot 0.01}{0.025 - 0.01} + 1 \right)^2 + \\ + \frac{0.0004}{0.0113} \left[ 1 + 50 \cdot 0.0113 \left( \frac{2 \cdot 0.01}{0.025 - 0.01} + 1 \right) \right]^2 + \\ + \frac{50 \cdot 6.28^2 \cdot 2585^2 \cdot 10^8 \cdot 81^2 \cdot 10^{-24}}{0.0113} \left( 1 + 4 \cdot 10^{-4} \cdot 50 \right) + \\ + 0.85 \cdot 0.0113 \left( 2 + \frac{2 \cdot 0.01}{0.025 - 0.01} \right) = 6.4, \text{ что в 84 раза меньше допу-}$$

CTHMOFO.

Пспользуя данные табл. 2-8, по формуле (2-80) вычисляем напряжение сигнала на входе преобразователя частоты, соответствующее чувствительности приемника; при применении в радиогракте траизистора 11403 по схеме с ОЭ получим  $U_{\rm BX-HY} = 10^{-4}0.71 = 71 \cdot 10^{-6} \rm B$ .

Результаты расчетов, аналогичных приведенным в примере 2-11, для транзисторов П416, ГТ310Б, ГТ308В, ГТ313Б, КП302А и КН350Б даны в табл. 2-11.

Входная проводимость полевых транзисторов весьма мала, Поэтому даже при полном включении их входа к контуру для обеспечения эквивалентного затухания колебательного контура входной цени, равного 0,025, в режиме достижения максимального коэффициента передачи необходимо включать парадлельно входу транзистора добавочный резистор. Эквивалентная сму проводимость ди может быть найдена из уравнения

 $g_{11} = 0.5g(\delta_3/\delta - 1) - g_{11}$ (2-96)

Активная проводимость на входе транзистора должна быть

$$g'_{11} = g_{11} + g_{11} = 0.5g (\delta_9/\delta - 1),$$
 (2-97)

где g — собственная проводимость контура входной цепи.

Пример 2-12. Найти сопротивление шунтирующего резистора, который следует включить на входе транзисторов КП302А и КП350Б для обеспечения эквиналентного затухания входного контура равным 0,025.

Положим эквивалентную смкость контура входной цепи равной 35 пФ, что вполне реализуемо в поддиапазоне 11. Тогда согласно (2-55)  $g=0.01\cdot 6.28\cdot 25$  850 000 35 ·  $10^{-12}=568\cdot 10^{-7}$  См. Для транзистора КП302А  $g_{11}=37\cdot10^{-7}$  См. Подставляя это значение в формулу (2-96), находим  $g_{11}=0.5\cdot568\cdot10^{-7}\cdot(0.025/0.01-1)-37\cdot10^{-7}=389\cdot10^{-7}$  См; ціунтирующий резистор должен иметь сопротивление  $R_{\rm m}=1/(389 \times 10^{-3})$  $\times$  10 $^{-1}$ ) = 25 700 Ом. Аналогично для транзистора КПЗ50Б получим  $R_{\rm m} = 23~900~{\rm Om}$ . Эти резисторы используются в схеме для подачи необходимого смещения на затвор.

В нормальном режиме работы сопротивление резистора, включающегося параллельно входу полевого транзистора, можно брать гораздо большим и равным 0,7-0,9 МОм. В этом случае проводимость входа каскада с полевым транзистором КПЗО2А определяется уравнением (2-97), т. е.  $g'_{11} = (37 + 12) \cdot 10^{-7} = 5 \cdot 10^{-6}$  См. Из уравнения (2-95) получим эквивалентное затухание контура в режиме максимального кожффициента передачи

 $\delta_3 = \delta (2g'_{11}/g + 1).$ (2-98)

Пример 2-13. Определить селективные свойства входной цепи в поддианазоне 11 при использовании в усилителе радносигнала полс-

Таблица 2-11

Усили	тель радиосиг	нала	Ì							Мин	имальн	oe oc.	лаблені	ie	
Транзи- стор	Схема	Вери- ант	Koyen	Komax	K <sub>ovpc</sub>	К <sub>в.цтах</sub>	K <sub>op.c</sub>	шБЭ		жальн канал			промез ной час		U <sub>вх.пц,</sub> мкВ
		<u> </u>							ВЦ	УРС	PT	вц	УРС	PT	
П403	ОЭ	1	1,9	4,5	1,9	0,37	3,71	6,4	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	71
	ОБ	2	2,8	4,5	2,8	0,21	0,6	6,4	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	co
П416	09	3	2	5,4	2	0,43	0,86	5,7	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	86
	ОБ	4	3,3	5,4	3,3	0,22	0,72	5,7	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	72
ТТ310Б	09	5	2,6	5,6	2,6	0,44	1,15	6	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	115
	ао	6	2,3	5,6	2,3	0,23	0,52	6	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	52
		-\ <u></u> -		<del> </del>	<u></u>				<u> </u>	!				<u> </u>	<u> </u>
ГТ308В	ОЭ	7	6,2	8,6	6,2	0,77	4,77	3,9	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	477
	ОБ	8	9,5	8,6	8,6	0,21	1,8	9,5	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	180

Усили	гель радносиги	ала								Мин	имальн	эе осл	аблени	2	
Транзи- стор	Схема	Вари- ант	K <sub>0 yct</sub>	K <sub>omax</sub>	Koypc	K <sub>B.II</sub> max	Кор.с	Ш БЭ	зе	ркалы канал		поп	тромеж часто	уточной те	U <sub>Ра.пц</sub> мкВ
						ļ			вц	уРС	PT	вц	УРС	PT	
<b>L</b> 1313P	09	9	10	41	10	0,77	7,7	4,3	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	770
	ОБ	10	25	41	25	0,13	3,3	4,3	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	330
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	
<b>К</b> П302 <b>A</b>	ОИ $\delta_{\mathfrak{s}} = 0.025$	11	1,24	3	1,24	6	7,4	4,2	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	740
	ОИ δ <sub>э</sub> =0,012	12	1,24	3	1,24	4,4	5,4	27,7	6,1	2,8	17	700	420	294 000	540
КП350Б	ОИ δ <sub>э</sub> =0,025	13	12,1	16	12,1	6	72	2,6	3,07	2,8	8,6	335	420	141 000	9550
	ОИ δ <sub>э</sub> =0,011	14	12,1	16	12,1	3	36	33,6	6,8	2,8	19	740	420	311 000	4780
	,			{											

вых транзисторов КП302А и КП350Б, когда шунтирующий резистор

на входе транзистора отсутствует.

Подставляя числовые значения в уравнение (2-98), получаем  $\delta_9=0.01$  (2-0,000005/0,0000568 + 1) = 0,012. Это значение и  $g_{11}=5\cdot10^{-6}$  См (вместо  $g_{11}$ ) должны быть подставлены в формулу (2-92) при расчете коэффициента передачи входной цепи. Аналогичный расчет для транзистора КП350Б дает  $\delta_9=0.011$ . При эквивалентном затухании контура входной цепи  $\delta_9=0.012$  минимальное ослабление зеркального канала  $d_{3, B, II}=6.1$  и по промежуточной частоте  $d_{\text{пр. B, II}}=700$ , а при  $\delta_9=0.011$  соответственно 6.8 и 740. За счет этого селективность радиотракта повышается в 2 раза по сравнению с селективностью при  $\delta_9=0.025$  (см. варианты 12 и 14 табл. 2-11). Усиление каскада с полевыми транзисторами для табл. 2-11 рассчитывалось для случая, когда в преобразователе частоты используется транзистор типа ГТ308В.

Проанализируем данные табл. 2-11. Для всех рассмотренных транзисторов коэффициент шума значительно меньше допустимого, что гарантирует требуемую чувствительность приемника. Транзисторы П403 и П416 не обеспечивают усиления сигнала по напряжению в радиотракте, причем дают больший коэффициент передачи радиотракта при построении усилителя по схеме с ОЭ благодаря большему коэффициенту передачи входной цепи из-за меньшей входиой проводимости транзистора. Транзисторы ГТ310Б, ГТ308В и ГТ313Б обеспечивают в радиотракте усиление по напряжению. Оно получается большим для схемы с ОЭ. Применение полевого транзистора КП302А дает большее усиление, чем с транзисторами ГТ310Б, ГТ308В, и примерно такое же, как с транзистором ГТ313Б. С полевым транзистором КП350Б достигается почти на порядок большее усиление по сравнению с лучшими диффузными транзисторами. Кроме того, полевые транзисторы позволяют получить в 2 раза лучшую селективность радиотракта. Следовательно, для усилителя радиосигнала и преобразователя частоты в поддиапазонах 3—11 целесообразно применять гранзисторы ГТ308В, ГТ313Б, КП302А или КПЗ50Б. Окончательно тип транзистора выбирают при расчете тракта промежуточной частоты из условия обеспечения требуемого усиления высокочастотного тракта приемника при наименьшем числе каскадов и наиболее дешевых транзисторах.

3. Для поддиапазонов 1 и 2 (ДВ и СВ) используется магнитиая (ферритовая) антенна, а структурная схема тракта радиосигнала выполняется такой же и с теми же транзисторами, которые применены в поддиапазонах 3—11. Согласно табл. 2-8 в поддиапазоне 1 ослабление зеркального канала должно быть более 100 и по промежуточной частоте более 50, а в поддиапазоне 2 — соответственно более 69 и 50.

Расстройка зеркального канала в поддиапазонах 1 и 2 сравнима с максимальной резонансной частотой контуров. Поэтому для расчета допустимого эквивалентного затухания контуров следует пользоваться точной формулой обобщенной расстройки (2-64). В этом случае при известном числе  $n_{\rm c}$  одиночных контуров в радиотракте и заданной промежуточной частоте максимально допустимое эквивалентное затухание контуров должно удовлстворять неравенству

$$\delta_{\text{a. c}} \leq \frac{\left(\frac{4 f_{\text{np}}}{f_{\text{c max}}} + 2\right)^2 - 4}{2\left(\frac{4 \text{ np}}{f_{\text{c max}}} + 2\right)^{\frac{n_c}{2}} \sqrt{\frac{n_c}{d_a - 1}}}.$$
 (2-99)

Если полагать в радиотракте один контур (во входной цепи), то его эквивалентное затухание в поддиапазоне 2 должно быть  $\delta_{3,+2} \le \frac{(4\cdot465\ 000/1\ 605\ 000+2)^2-4}{2\ (4\cdot465\ 000/1\ 605\ 000+2)\ V69^2-1} = 0,016.$  Для поддиапазона 1 получим  $\delta_{3,+1} \le 0,0296$ .

Полоса пропускания входного контура в начале подднапазона 1 согласно формуле (2-85)  $\Pi_1=0.0296\cdot 147\,000=4350$   $\Gamma_{\rm L}$  и нодднапазона 2  $H_2=0.016\cdot 515\,000=8000$   $\Gamma_{\rm L}$ . В § 2-4 полоса пропускания приемника принята равной 11,5—12 к $\Gamma_{\rm L}$ . В подднапазоне 1 полоса пропускания контура входной цени оказалась значительно уже необходимой полосы пропускания приемника, поэтому вариант радиотракта с одним контуром не приемлем.

Пример 2-14. Полагая в тракте радиосигнала два колебательных контура, определить их эквивалентное затухание для поддиапазонов 1 и 2. Это условие соответствует расчету структурной схемы радиотракта в поддианазонах 3—11 и должно быть согласно сказанному ранее принято.

Из неравенства (2-99) находим

$$\delta_{\text{a. c.}2} \leqslant \frac{(4\cdot 465\ 000/1\ 605\ 000+2)^2-4}{2\ (4\cdot 465\ 000/1\ 605\ 000+2)\ V\ 69-1} = \text{0.15 if }\delta_{\text{a. c.}1} \leqslant 0.295.$$

Положим минимальное значение полосы пропускания радиотракта равным 13 кГц в начале поддиапазона 1, что шире требуемой полосы пропускания приемника. При этом можно считать, что радиотракт не будет оказывать существенного влияния на результирующую полосу пропускания приемника, так как на остальных частотах его полоса пропускания будет шире. Для осуществления сказанного эквивалентное затухание контуров должно удовлетворять равенству

$$\delta_{\text{a. c}} = \Pi_{\text{p. c}} \psi_1(n_c) / f_{\text{e min.}}$$
 (2-100)

Из табл. 2-12 находим  $\psi_1$  (2) = 1,56. Подставляя в формулу (2-100) численные значения, получаем для поддианазона 2  $\delta_{\rm 9,~c}$  2 = 13 000  $\times$  × 1,56/525 000 = 0,039 и для иподданазона 1  $\delta_{\rm 9,~c1}$  = 13 000  $\times$  х 1,56/150 000 = 0,135. Эти значения эквивалентного затухания удом летворяют необходимому подавлению зеркального канала и должны быть приняты для дальнейшего расчета радиотракта поддианазонов 1 и 2.

Индуктивность контурной катушки каждого поддиапазона определяется уравнением

$$L = 1/(\omega_v^2 C_{\theta}). \tag{2-10i}$$

Используя это уравнение для магнитной антенны и индуктивной связи со входом транзистора, можно записать формулу для коэффициента передачи входной цепи в следующем виде:

$$K_{0 \text{ B, Q}} = \frac{1}{\delta_{9}} \sqrt{\frac{\delta_{9} - \delta}{\sigma_{11}}} \omega C_{9}. \tag{2-102}$$

Если заменить эквивалентную емкость контура через индуктивность и частоту согласно формуле (2-101), уравнение (2-102) перепишется так

$$K_{0 \text{ B. } \text{II}} = \frac{1}{\delta_{9}} \sqrt{\frac{\delta_{9} - \delta}{g_{11}\omega L}}.$$
 (2-103)

Таблица 2-12

Тип селективной	Характе-		- 1	Інсло сі	icrem n		
Системы	ристика	1	2 1	3	4	5	6
Резонансные кон-	$K_{n10}$	10	4,8	3,75	3,4	3,2	3,1
туры	$K_{1100}$	100	16	9	7	6,1	5,6
}	K 11000	1000	49	20	13	10	8,6
	$\psi_1(n)$	1,0	1,56	1,96	2,3	2,58	2,8
	$\theta_1(n)$	2,22	1,61	1,31	1,21	1,18	1, 1
Расстроенные пары	K <sub>1:10</sub>		3,2		2,2		1,9
контуров при критической рас-	$K_{v100}$	Ì	10		4.0		3,0
стройке	$K_{\rm n1000}$		32		7,0		4,4
	$\psi_2(n)$		0,71		0,88		0,9
	$\theta_2(n)$		6,76		6,80		7,3
Цва связанных	К пао	3,2	2,2	1,95	1,85	1,78	1,7
контура при кри-	K <sub>n100</sub>	10	4,0	3,0	2,7	2,5	2,4
тической связи	$K_{1:1000}$	32	7,0	4, 1	3,6	3,2	3,0
	$\psi_3(n)$	0.71	0,88	0,98	1,09	1.16	1,2
	$\ell_3(n)$	2,06	1,98	1,89	1,73	1,69	1,6
Смешаниая схема	Kuto		2,15		1,67		1,5
при предельной	Κ <sub>п100</sub>		4,64		2,5		2,2
связи в связан- ных контурах	$K_{\rm n1000}$		10,0		3,67		2,8
max kontypax	$\psi_4(n)$		0,5		0,58		0,6
	$\theta^{4}(u)$		3,1		3,2		3,3
į						1	<u>                                     </u>
Цва связапных	$K_{\pi 10}$	2,32	1,67	1.54	1,48	1,45	1,4
конгура при пре-	K 1100	7,1	2,9	2,2	2,0	1,85	1,7
дельной связн	K 11001	22	5,5	3,2	2,6	2,4	2,1
	$\psi_s(n)$	0,32	0,46	0,55	0,61	0,67	0,7
J	$\theta_{\kappa}(n)$	2,02	1,78	1,70	1,69	1,67	1,5

Тип селективной		Характери-		ч	исло си	стем п		
системы		Стика	1	2	3	4	5	6
С фильтрами со-	4	K 1190	2,2	1,3				
средоточенной селекции при	1	$K_{\pi 1000}$	3,7	1,7				
числе кон-		$\psi_5(n)$	2,82	2,6				
туров	5	K n100	1,8	1,2				
		$K_{1:1000}$	2,7	1,5				
		$\psi_6(n)$	2,82	2,6				
1	6	K v 100	1,52	1,15				
		K ::1000	2,2	1,3				
		$\psi_7(n)$	2,82	2,6				

На основании этого можно записать уравнение, связывающее коэф-фициент передачи входной цепи в конце и начале поддиапазона:

$$\frac{K_{0 \text{ B.H. K}}}{K_{0 \text{ B.H. K}}} = \sqrt{\frac{g_{11 \text{ k}} f_{\text{c max}}}{g_{11 \text{ g}} f_{\text{c min}}}} = \sqrt{k_{\text{g}} \frac{g_{11 \text{ K}}}{g_{11 \text{ g}}}} . \tag{2-104}$$

Пример 2-15. Вычислить коэффициент передачи входной цепи для крайних частот поддиапазонов 1 и 2, полагая, что в усилителе радиосигнала используется транзистор ГТ310Б.

Так как контуры радиотракта настраиваются в различных поддиапазонах одинаковыми конденсаторами переменной емкости, а в поддиапазонах 1 и 2 коэффициенты диапазона почти равны (2,83 и 3,18), то минимальная эквивалентная емкость контуров в этих поддиапазонах будет близкой по значению и составит 50—60 пФ. Положим ее равной 55 пФ. В первом приближении будем считать эквивалентное затухание контуров постоянным в пределах каждого поддиапазона. Тогда при заданном транзисторе ( $g_{11}=0.0005$  См) для конца поддиапазона 1 согласно формуле (2-102)  $K_{a,B,Rik}=\frac{1}{0.135}\sqrt{\frac{0.135-0.01}{0.0005}}$  6,28 408 000 55 10 12 = 1,38. Для начала поддиапазона 1 по уравнению (2-104) получим  $K_{0,B,Rik}=1.38\sqrt{\frac{408,000}{150,000}} \frac{0.0005}{0.0005}=2,27$ , а для конца поддиапазона  $2K_{0B,Rik}=4.35$  и для начала поддиапазона 2 ( $g_{11}=0.00056$  См)  $K_{0B,Rik}=8$ . Пример 2-16. Определить усиление радиотракта на крайних час-

тотах поддиапазонов 1 и 2, если в усилителе радиосигнала применен траизистор ГТ 310 Б.

Для схемы с ОЭ по формуле (2-66) вычисляем коэффициент устойчивого усиления в конце поддиапазона 1

$$K_{\text{u ycr 1}} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)}{6.28 \cdot 408\ 000} \cdot \frac{0.026}{4 \cdot 10^{-12}}} = 22.5,$$

Максимальный коэффициент усиления каскада находим по уравнению (2-86), полагая, что преобразователь частоты выполнен на транзисторе

ГТЗ10Б, 
$$K_{0 \text{ max 1}} = \frac{0.5 \cdot 0.026}{\sqrt{7 \cdot 10^{-6} \cdot 0.75 \cdot 5 \cdot 10^{-4}}} \left(1 - \frac{0.01}{0.135}\right) = 230$$
. Он значительно больше устойчивого усиления, на которое и следует

рассчитывать каскад.

В транзисторном резонансном каскаде связь между коэффициентами усиления и полосами пропускания в начале и конце поддиапазона в первом приближении определяется уравненнями:

$$K_{\text{OK}}/K_{\text{OH}} \approx k_{\pi} (1+a)/(1+k_{\pi}ab);$$
 (2-105)

$$\Pi_{\kappa}/\Pi_{H} \approx k_{\pi} (1 + abk_{\pi})/(1 + a).$$
 (2-106)

Здесь

$$a = \frac{\Pi_{\rm T} p \psi_1 (n_{\rm c})}{\delta f_{\rm min}} - 1; (2-107)$$

$$b = g_{11K}/g_{11H} \approx g_{22K}/g_{22H}; \qquad (2-108)$$

 $k_\pi$  — коэффициент диапазона, определяющийся формулой (2-1);  $\Pi_{\rm rn}$  минимально допустимое значение полосы пропускания.

Полоса пропускания в начале поддиапазона минимальна, поэтому следует считать  $H_{\rm H} = H_{\rm Tp}$ . Коэффициент устойчивого усиления уменьшается с ростом частоты, и можно полагать  $K_{\rm 0K} = K_{\rm 0ycr}$ . Для выбранного транзистора в поддиапазоне і входная и выходная проводимости постоянны и согласно формуле (2-108) коэффициент b=1. Поскольку в радиотракте имеются два одиночных контура, то из табл. 2-12 значение функции  $\psi_1$  (2) = 1,56. Тогда по формуле (2-107) вычисляем a= $= 13\ 000 \cdot 1,56/(0,01 \cdot 150\ 000) = 13,5$ . Подставляя полученные значе-

ния в уравнение (2-105), находим  $K_{0\mathrm{H}} = \frac{22,5 \ (1+13,5 \cdot 1 \cdot 2,72)}{2,72 \ (1+13,5)} = 21,4$ .

По равенству (2-71) вычисляем усиление радиотракта для конца  $K_{0p, \ cl\,\kappa}$  =  $=1,38\cdot 22,5=31$  и для начала поддиапазона 1  $K_{\rm 0p,\ clh}=2,27\cdot 21,4=$ = 48.5.

В табл. 2-13 приведены результаты аналогичных расчетов для второго поддиапазона, а также при других типах транзисторов, выполненные для поддиапазонов 1 и 2.

Поскольку вход полевых гранзисторов подключается полностью к контуру входной цепи, то ее коэффициент передачи по напряжению при магнитной антенне равен эквивалентной добротности контура [5]

$$K_{0 \text{ B}, u} = Q_0 = 1/\delta_0.$$
 (2-109)

Для обеспечения необходимого эквивалентного затухания к контуру в этом случае должен подключаться соответствующий шунтирующий резистор.

Обозначим напряженность поля полезного сигнала в месте расположения приемной антенны через E и действующую высоту ее через  $h_n$ . Напряжение сигнала на входе преобразователя частоты при этом запитется уравнением

$$U_{\text{BX, Hq}} = E h_{\text{A}} K_{0 \text{ p.c}}. \tag{2-110}$$

Для поддиапазонов 1 и 2 действующая высота магнитной антенцы прямо пропорциональна частоте принимаемого сигнала.

Пример 2-17. Вычислить напряжение сигиала на входе преобразователя частоты в поддиапазонах 1 и 2, если в усилителе радиосигнала применен транзистор ГТ310Б.

В начале поддианазонов 1 и 2 действующая высота магнитной антенны составляет примерно 0,003 м, а в конце 0,01 м [5]. Подставляя эти значения и данные табл. 2-8 в формулу (2-110), получаем в начале  $U_{\rm вx, пq. g} = 0,001\cdot 0,003\cdot 48,5 = 146\cdot 10^{-6}$  В и конце поддианазона 1  $U_{\rm nx, nx, x} = 0,001\cdot 0,01\cdot 31 = 31\cdot 10^{-6}$  В. Проводя аналогичный расчет для поддианазона 2, получаем напряжение на входе преобразователя частоты соответственно 182 и 343 мкВ. Аналогичные данные для других вариантов радиотракта приведены в табл. 2-13.

Таблица 2-13

		Ma	гнитная	антенна	IIp	оволочная	итенна
	No.		ение в гракте	Минималь-		пение в потракте	Минималь-
Транзи- стор	подли- апазо- на	в на- чале поддн- апа- зона	В кон- це под- диапа- зона	ный вход- ной сигнал преобразо- вателя частоты, мкВ	в на- чале подди- апа- зона	в конце поддиапа- зона	ный вход- ной сигнал преобразо- вателя частоты, мкВ
ГТ310Б	1	48,5	31	146	2,1	2,25	315-7
	2	87	49	182	1,08	1,13	156
ГТ308В	I	131	80	393	4,95	5,2	743
	2	205	113	430	2,55	2,6	382
ГТ313Б	1	233	148	700	7,9	8,3	1185
	2	563	213	1118	5,3	4,2	790
<b>К</b> ПЗ02А	1	69	73	207	18,8	19,8	2820
	2	122	125	256	9,8	10	1470
<b>К</b> П350Б	1	670	710	2000	182	192	27 200
	2	1170	1200	2460	94	96	14 100

Связь внешней проволочной антенны со входным контуром выбирается достаточно слабой, обеспечивающей допустимую расстройку входного контура антенной. Для подднапазонов 1 и 2 она чаще всего выбирается внешне емкостной [24, 31, 33]. Коэффициент передачи входной цепи при использовании в усилителе радиосигнала транзистров с большой входной проводимостью (больше 1 мсМ) обычно ис п. вышает 0,1—0,2, а при полевых транзисторах и электронных лампах составляет 2—5 [5]. При наиболее распространенной трансформаториссвязи контура со входом транзистора коэффициент передачи входишени при внешней проволочной антенне в поддиапазоне изменяется очень мало. Этому способствует то, что за счет внешнеемкостной связь с антенной коэффициент передачи увеличивается с ростом частоты, а за счет трансформаторной связи входного коитура с транзистором — уменьшается [5]. Поэтому в первом приближении для поддиапазонов

1 и 2 можно считать козфрициент передачи входной цепи постоянным

и равным приведенным ранее значениям.

Пример 2-18. Вычислить напряжение сигнала на входе пресбразователя частоты для поддиапазонов 1 и 2 при внешней проволочной антение, если в усилителе радносигнала примеияется транзистор ГТ3106.

Согласно формуле (2-80)  $U_{\text{вх. вч}} = E_A K_{0_{\text{в. ц}}} K_{0_{\text{в. р. с.}}}$ . Полагая  $K_{\text{в. ц.}} = 0,1$ , с учетом данных табл. 2-8 для начала подднаназона 1 получаем  $U_{\text{вх. вч 1 к}} = 0,00015 \cdot 0,1 \cdot 21 = 315 \cdot 10^{-6}$  В, а для конца подднаназона  $U_{\text{вх. вч 1 к}} = 0,00015 \cdot 0,1 \cdot 22,5 = 338 \cdot 10^{-6}$  В. Для остальных рассмотренных вариантов радкотракта даные аналогичных расчетов приведены в табл. 2-13, при этом для полевых транзисторов коэффициент передачи входной цени привят равным 2.

Анализ данных табл. 2-13 показывает, что при магнитной антение минимальное напряжение сигнала на входе преобразователя частоты получается в поддиапазоне 1. Это япляется следствием значительно большего эквивалентного затухания колебательных контуров, необходимого для обеспечения требуемой полосы пропускания, и меньшего коэффициента передачи входной цепп. При проволочной антенне, наоборот, наименьший сигнал на входе преобразователя частоты получается в поддиапазоне 2, что является следствием уменьшения устойчивого усиления транзисторов с повышением частоты, поскольку коэффициент передачи входной цепп в обоих поддиапазонах практически одинаков.

Сравнение данных табл. 2-11 и 2-13 позволяет определить наименьшее входное напряжение преобразователя частоты для каждого из рассмотренных типов транзисторов. Эти напряжения должны быть исходными для выбора типа транзисторов, схемы и числа каскадов в тракте

промежуточной частоты.

Для поддиапазонов 1-11 в усилителе радносигнала нанболее целерообразно применять транзистор ГТ308В по схеме с ОЭ, как обеспечавающий достаточно большое усиление и обладающий меньшей стоимостью по сравнению с транзисторами, дающими лучшие характеристики радиотракта.

## 2-6. Выбор промежуточной частоты и селективных систем приемника

В тех случаях, когда промежугочная частота не задана, ее значелие для связных и близких к ним по характеристикам транзисторных и ламповых приемников дециметровых и более длинных воли наиболее челесообразно выбирать по описанной далее методике. При этом следует помнить о том, что при более низкой промежуточной частоте требуемое усиление в тракте промежуточной частоты можно получить при меньшем числе каскадов, а при более высокой проще обеспечивать ослабжие зеркального капала в радиотракте. Кроме того, промежуточную частоту следует брать равной одному из следующих значений: 0,11; %465; 0,9; 1,6; 6,5; 8,4; 10,7; 30; 35; 60; 100 МГц [4, 5, 12, 27]. Пот Вначале выбирают тип и количество селективных систем в тракте вромежуточной частоты из условия обеспечения селективности по соседнему каналу.

Когда селективность по соседнему каналу задана коэффициентом прямоугольности при стандартном ослаблении (10,100, 1000) то задача решается с использованием табл. 2-12. По ней выбирают простейший

тип селективной системы (одиночный контур, два связанных контура, расстроенные одиночные контуры, ФСС) при минимально возможном числе элементов (что требует наименьшего числа каскадов), обеспечивающий необходимый коэффициент прямоугольности кривой избирательности приемника.

Пример 2-19. Выбрать тип и количество избирательных систем,

**га**рантирующих коэффициент прямоугольности  $K_{n100} \le 3$ .

Анализ данных табл. 2-12 показывает, что одиночные колебательные контуры (резонансный усилитель) не позволяют получить требуемый коэффициент прямоугольности. Он может быть достигнут применением следующих вариантов: а) трех пар связанных контуров при критической связи; б) трех расстроенных пар контуров (при критической расстройке); в) четырех смешанных селективных систем (два одиночных и две пары связанных контуров); г) одного четырехзвенного ФСС. Первая селективная система является нагрузкой преобразователя частоты. Следовательно, для реализации варианта «а» необходимая селективность до стигается при двух каскадах в усилителе промежуточной частоты, для варианта «б» — пяти, для варианта «в» — трех каскадах и для варианта «г» — без каскадов усилителя промежуточной частоты. Усилитель с расстроенными парами контуров проще в изготовлении, чем усилитель со связанными контурами, но сложнее в настройке. Поэтому, если для обеспечения усиления достаточно двух каскадов, предпочтительнее остановиться на схеме усилителя с двумя связанными контурами. Усилитель со смещанными селективными системами по сложности изготовления, иастройке, габаритам и стоимости равноценеи усилителю с парами связанных контуров. При использовании ФСС для достижения необходимого усиления применяют резистивные каскады, наиболее простые по схеме, изготовлению, налаживанию и по экономическим и габаритным характеристикам. Одним из критериев выбора селективной системы может быть общее число колебательных контуров. Так, четырехзвечный ФСС в этом отношении лучше трех пар связанных контуров. Окончательно селективную систему выбирают при определении числа каскадов в усилителе промежуточной частоты.

Если селективность по соседнему каналу определена требуемым ослаблением  $d_{\rm c}$  при заданной расстройке  $\Delta f_{\rm c}$ , то селективные системы выбирают двумя следующими способами. Когда необходимое ослабление соседнего канала близко к табличным значениям для коэффициентов прямоугольности (10, 100, 1000), то по известной полосе пропускания  $\Pi$  вычисляют требуемый коэффициент прямоугольности по уравнению

$$K_{\mathfrak{n}d_c} = 2\Delta f_c / \Pi. \tag{2-111}$$

Затем выбирают тип и количество селективных систем по приведенной ранее методике. С определенным запасом селективности задача может быть также решена, если пользоваться данными табл. 2-12 для табличного значения ослабления больше требуемого.

Пример 2-20. Выбрать тип и количество селективных систем для тракта промежуточной частоты, если его полоса пропускания 11,8 кГц при уровие отсчета 1,41, ослабление по соседнему каналу 46 дБ при рас-

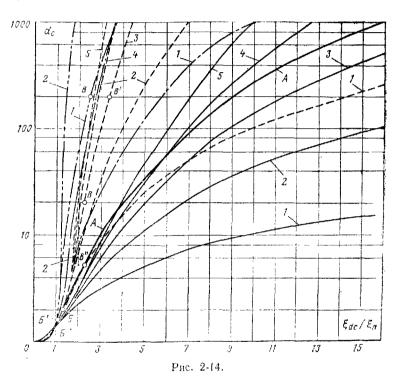
стройке 10 кГц.

Абсолютное значение требуемого ослабления  $d_{\rm c}=200$ . По формуле (2-111) находим  $K_{\rm n200}=2\cdot 10/11,8=1,7$ . Анализ данных табл. 2-12 показывает, что получить такой коэффициент прямоугольности при большем ослаблении (1000) можно только при использовании двух четырехзвенных  $\Phi CC$ .

Ту же задачу более точно можно решить с помощью обобщенных кривых селективности для различного числа каскадов. Для этого, рассчитав по формуле (2-111) требуемое значение  $K_{\rm nd\,c}$ , подбирают такую обобщениую кривую селективности, для которой выполняется неравенство

$$\xi_{d_c}/\xi_{\pi} \leqslant K_{\pi d_c} \tag{2-112}$$

Здесь  $\xi_{f_{\mathbf{C}}}$  и  $\xi_{\pi}$  — значения обобщенных расстроек, соответствующих заданному ослаблению соседнего канала и уровню отсчета полосы пропускания.



Пример 2-21. Пользуясь обобщенными кривыми селективности, выбрать тип и количество селективных систем для тракта промежуточной частоты по условиям примера 2-20.

На рпс. 2-14 приведены обобщенные кривые селективности различных усилителей. Сплошные кривые соответствуют резонансному усилителю, штриховые — усилителю с двумя связанными коптурами при критической связи, штрихпунктирные с одной точкой — усилителю со смешанной селективной системой при предельной связи пар связанных контуров, штрихпунктирные с двумя точками — усилителю с четырехконтурным ФСС. Номера кривых обозначают число каскадов усилителя.

По оси абсцисс приведены значения  $\xi_{d_{\rm C}}/\xi_{\rm B}$ , благодаря чему все кривые имеют общую точку, соответствующую абсциссе 1 и ординате 1,41, т. е. уровню отсчета полосы пропускания. Из рисунка следует, что при  $d_{\rm c}=200$  только двухкаскадный усилитель с четырехзвенными  $\Phi CC$  имеет  $\xi_{200}/\xi_{\rm B}<1,53$ , а это подтверждает справедливость принятого в примере 2-20 решения.

Пример 2-22. Выбрать тип и количество селективных систем для тракта промежуточной частоты перепосного приемника III класса

в поддиапазонах 1-11.

Верхняя граничная частота модуляции сигнала для данного приемника равна 3,5 кГц. Полагая нестабильность частот сигнала и гетеродина такими же, как в примере 2-6, согласно формуле (2-42) можно считать, что полоса пропускания рассматриваемого приемника должна быть уже по сравнению с полосой пропускания приемника 1 класса, определеной в примере 2-6. Примем ее равной 9 кГц. При расстройке  $\pm$ 9 кГц ослабление приемника 111 класса должно превышать 20. На формулы (2-[11] находим  $K_{n20}=2\cdot9/9=2$ . На табл. 2-12 при большем табличном ослаблении 100 такой коэффициент прямоугольности могут обеспечить: четыре пары связанных контуров при предельной связи; два четырех звенных ФСС; один пятизвенный ФСС.

Воспользуемся для решения задачи кривыми на рис. 2-14. Из него находим, что требуемую селективность обеспечивают: пять пар связанных контуров при критической связи; две пары смещанной селективной системы (четыре каскада); один четырехзвенный ФСС. В данном случае более точный мегод с использованием обобщенных кривых селективности позволяет принять более правильное и целесообразное инженерное решение об использовании наиболее простой селективной системы — одного ФСС из четырех звенься.

После выбора типа и количества селективных систем определяют минимально осуществимое эквивалентное затухание их колебательных контуров. Для этого пользуются формулой

$$\delta_{a, \text{ mp min}} = (1.4 \div 1.8) \delta.$$
 (2-113)

Собственное затухание контуров  $\delta$  обычно бывает от 0,008 до 0,015 в зависимости от качества применяемых катушек.

Промежуточная частота, при которой обеспечивается необходимая полоса пропускания, определяется неравенством

$$f_{\text{np. n}} \leqslant \frac{\Pi}{\delta_{\text{p. no min}}} \psi(n_{\text{np}}).$$
 (2-114)

Значение функции  $\psi$  ( $n_{\rm inp}$ ) находится из табл. 2-12 соответственно выбраноому типу селективной системы и количеству их  $n_{\rm np}$ . Знак неравечства в (2-114) берется потому, что при меньших частотах необходимую полосу пропускания можно получить, увеличивая эквивалентное затухание колебательных контуров. Но меньше  $\delta_{\rm э, np \, min}$  его, естественно, получить не удается.

Минимально необходимая полоса пропускання раднотракта определяется равенством

$$\Pi_{\text{p.c min}} = (1, 1 \div 1, 4)\Pi,$$
 (2-115)

где  $\Pi$  — необходимая полоса пропускания приемника. В многодиапазонных приемниках с коэффициентом диапазона самого длинноволнового поддиапазона более 1,2-1,3 берут меньшее значение численного

коэффициента, а при меньших коэффициентах диапазона и при постоян-

ной настройке — большее.

Задаются наиболее простой селективной системой радиотракта при минимальном числе колебательных контуров в ней (например, одноконтурной входной ценью). Если селективная система состоит из одиночных колебательных контуров, то по формуле (2-100) вычисляют минимально допустимое при выбранных условиях эквивалентное затухание контуров. Если селективная система радиотракта состоит из пар связанных контуров при критической связи, расчет ведут по той же формуле, подставляя в нее соответствующее схеме значение функции  $\psi_3$  ( $n_c$ ) из табл. 2-12. При использовании в радиотракте пар расстроенных колебательных контуров при критической расстройке берут значение функции  $\psi_2$  ( $n_c$ ).

Если выполняется неравенство

$$\delta_{\mathsf{a. c}} \geqslant (1.4 \div 1.8) \, \delta,$$
 (2-116)

где  $\delta$  — минимальное конструктивно осуществимое собственное затужание контуров, то полученное в расчете эквивалентное затужание осуществимо и его принимают для последующих расчетов. Когда неравенство (2-116) не выполняется, то эквивалентное затухание контуров принимают соответствующим равенству в (2-116). В этом случае полоса пропускания радиотракта будет шире необходимой полосы пропускания приемника.

При одиночных контурах в радиотракте промежуточиую частоту, обеспечивающую требуемое ослабление зеркального канала  $d_3$ , вычис-

ляют по формуле

$$f_{\text{mp. a}} \geqslant 0.5Bf_{\text{c max}},\tag{2-117}$$

где

$$B = 0.5 (A + \sqrt{A^2 + 4}) - 1; \ A = \delta_{\text{a.c}} \sqrt{\frac{n_{\text{c}}}{2} \sqrt{d_3} - 1}. \quad (2-118)$$

Знак перавенства в уравнении (2-117) стоит потому, что с ростом промежуточной частоты ослабление зеркального канала увеличивается.

Если выполняется неравенство

$$f_{\text{np. n}} \geqslant f_{\text{np. 3}}, \tag{2-119}$$

то промежуточная частота прнемника может иметь любое значение в интервале частот от  $f_{\rm np.\, n}$  до  $f_{\rm np.\, p}$  так как оно обеспечит и требуемую полосу пропускания и ослабление зеркального канала. Когда неравенство (2-119) не выполняется, то нет значений частоты, которые можно взять в качестве промежуточной, чтобы получить и нужцую полосу пропускания приемника и требуемое ослабление зеркального канала. Выполнение неравенства (2-119) за счет существенного повышения  $f_{\rm np.\, n}$  практически затруднительно. Действительно, согласно данным табл. 2-12 при увеличении  $n_{\rm np}$  существенного возрастания функции  $\psi$  (n) не происходит, а возрастание  $n_{\rm np}$  значительно увеличивает габариты, усложняет, удорожает и снижает надежность приемника. Сильно уменьшать эквивалентное затухание контуров тракта промежуточной частоты против значений, определяющихся равенством (2-113), практически также не представляется возможным, так как для этого придется уменьшать коэффициенты включения транзисторов к контуру, что псизбежно приведет к синжению усиления каскадов и

к увеличению их числа. Отмеченные меры позволяют повысить  $f_{\rm пр.\,n}$  лишь на 5-10~%.

Более целесообразно добиваться выполнения перавенства (2-119) за счет снижения  $f_{\rm пр. 3}$ . Как следует из уравнения (2-118) и неравенства (2-117), этому способствует увеличение числа контуров  $n_{\rm c}$ . Но последнее приводит к увеличению числа каскадов в усилителе радиосигнала, что значительно усложняет и удорожяет приемник. Поэтому более выгодно снижать  $f_{\rm пр. 3}$  за счет использования в радиотракте вместо одиночных колебательных контуров колебательных систем с лучшей селективностью (например, пар связанных контуров).

Для пар связанных контуров при критической связи в радиотракте промежуточную частоту, обеспечивающую требуемое ослябление зер-

кального канала, следует определять из неравенства

$$f_{\text{np. 3}} \ge 0.354\delta_{\text{s. c}} f_{\text{c max}} \sum_{i=1}^{2n_{\text{c}}} \sqrt{d_{\text{3}}}.$$
 (2-120)

Эквивалентное затухание контуров вычисляется по формуле (2-100)  ${\bf c}$  подстановкой в нее функции  $\psi_3$  (n), соответствующей селективной

системе из двух связанных контуров.

При необходимости использовать три колебательных контура в радиотракте целесообразно применять комбинацию из одиночного и двух связанных колебательных контуров. Когда параметр связи взят несколько большим 1, то кривая селективности связанных контуров имеет провал на средней частоте, который скомпенсируется торбом кривой селективности одиночного контура. Если взять

$$\eta = V\bar{3}$$
 и  $\delta_{9. \text{ од}} = 2\delta_{9. \text{ св}},$  (2-121)

то для определения промежуточной частоты следует пользоваться неравенством

$$f_{\text{np.a}} \ge \left[0.5 \, \sqrt{0.5\delta_{\text{s.ca}}^2 \xi_{d_3}^2 + 1} + \delta_{\text{s.ca}} \xi_{d_3} - 0.5\right] f_{\text{c.max}}.$$
 (2-122)

Минимально допустимое затухание связанных контуров вычисляют по формуле (2-100). Обобщенную расстройку определяют по кривой A (рис. 2-14) и требуемому ослаблению зеркального канала, которому соответствует значение ординаты рисунка —  $d_{\rm c}$ . При этом следует считать  $\xi_{\rm n}=1$ .

Если ии одна из рассмотренных мер не обеспечивает выполнения перавенства (2-119), то следует применить двойное преобразование частоты. Первую промежуточную частоту выбирают только из условия ослабления зеркального капала, т. е. выполнения неравенств (2-117), (2-120) или (2-122), в зависимости от селективных систем в радиотракте. Вторую промежуточную частоту определяют из неравенства (2-114), обеспечивая нужную полосу пропускания приемника. Тип и количество селективных систем тракта первой промежуточной частоты принимают такими, чтобы при замене частоты сигнала первой промежуточной частотой выполнялось соответствующее перавенство (2-117), (2-120) или (2-122) и неравенство (2-119). Иначе говоря, тракт первой промежуточной частоты должен обеспечивать требуемое подавление второго зеркального канала, образующегося при работе второго преобразователя частоты.

Пример 2-23. Выбрать промежуточную частоту связного приемника, диапазон рабочих частот которого соответствует примеру 2-1. Ослабление зеркального канала 60 дБ, полоса пропускания 6,8 кГц, ослабление соседнего канала 60 дБ при расстройке ±10 кГц,

Ослабление соседнего канала  $d_{\rm c} \approx 1000$  соответствует табличному. Поэтому попробуем решить з дачу с использованием коэффициента прямоугольности. Его значение вычисляем по формуле (2-111)  $K_{\rm п1000} = 2 \cdot 10/6.8 = 2.94$ . По табл. 2-12 выбираем приемлемые варианты: а) четыре пары связанных контуров при предельной связи; б) смешанная схема из трех пар связанных и трех одиночных колебательных контуров при предельной связи и парах; в) один ФСС с пятью звеньями.

Анализ табл. 2-7 показывает, что ни один из ФСС, характеристики которых приведены в ней, не обладает нужным коэффициентом прямоугольности. Для обеспечения коэффициента прямоугольности возможно использование вариантов: г) два фильтра типа ЭМФП-5-465-6; д) два фильтра типа ПФ1П-4-3. Но последние три варианта осуществимы лишь в случае, когда промежуточная ча-

стота составляет 465 кГц.

Положим собственное затухание колебательных контуров тракта промежуточной частоты равным 0,01. Принимая численное значение коэффициента 1,6, из формулы (2-113) получаем их минимально осуществимое эквивалентное затухание  $\delta_{3.\,\mathrm{np\,min}}=1,6\cdot0,01=0,016$ . Поскольку для варианта «а»  $\psi_3$  (4) = 0,61, то из неравенства (2-114) находим  $f_{\mathrm{np.\,n}} \leqslant \frac{6800}{0,016}$  0,61 = 260 000 Гц. Но эта частота находится в поддиапазоне 1, поэтому с учетом рекомендуемых значений следует взять промежуточную частоту 110 кГц. Результат расчета для варианта «б» приведен в табл. 2-14. Согласно формуле (2-53), определяющей необходимое затухание колебательных контуров ФСС, для варианта «в» получаем  $f_{\mathrm{np.}} > 6800/(2,83\cdot0,016) = 156\,000\,\Gamma$ ц.

Таблица 2-14

Вариант	a	ď	В	r	Д	e
$f_{\rm np}$ , к $\Gamma$ ц	260	268	156	465	465	465

Коэффициент диапазона поддиапазона 1 согласно табл. 2-1 равен 2,24, поэтому при расчетах по формуле (2-115) можно принять численный коэффициент, близкий к минимальному значению. Примем его равным 1,15, тогда минимальная полоса пропускания радногракта согласно формуле (2-115) получится  $\Pi_{\rm p.c\,min\,1}=1,15\cdot6800=7900$  Гц. Для поддиапазона 12  $k_{\rm d}=1,12$ , поэтому численное значение коэффициента берем равным 1,4. При этом  $\Pi_{\rm p.c\,min\,12}=1,4\cdot6800=9600$  Гц.

Рассмотрим следующие варианты селективных систем в радиотракте: 1) один колебательный контур; 2) два одиночных колебательных контура; 3) три одиночных колебательных контура; 4) два связанных колебательных контура при критической связи; 5) две пары связанных контуров при критической связи; 6) смешанная схема из одиночного и двух связанных контуров при параметре связи 1/3.

Для первого варианта из табл.  $2 \cdot 12 \psi_1$  (1) = 1 и согласно формуле (2-100) минимально допустимое эквивалентное затухание контура поддиалазона 1  $\delta_{9.c\,min\,1} = 7900 \cdot 1/1~940~000 = 0,0041$ . Положим собственное затухание контура равным 0,015. При этом перавенство (2-116) не выполняется. Поэтому для дальнейших расчетов будем считать согласно равенству (2-116)  $\delta_{9.c\,1} = 1,5 \cdot 0,015 = 0,023$ , Аналогично для

поддиапазона 12 из формулы (2-100) имеем  $\delta_{
m s.\,c.\,min12} = 9600 \cdot 1/(272 imes 100)$  $\times$  105) = 0.00035, что также не обеспечивает выполнения неравенства (2-116). Следовательно, и для поддиапазона 12 принимаем  $\delta_{s, c12} = 0.023$ . При этом наименьшая полоса пропускания радиотракта будет в начале поддиапазона 1 согласно уравнению (2-85)  $\Pi_{min} = 0.023 \cdot 1940000 =$ = 45 000 Гц, что в 6,6 раза больше полосы пропускания приемника. Вычисляем по формуле (2-118) вспомогательные коэффициенты A==  $0.023 \ \sqrt{1000^2 - 1} = 23 \ \text{H} \ B = 0.5 (23 + \sqrt{23^2 + 4}) - 1 = 22.1.$ неравенства (2-117) имеем  $f_{\rm np.\,3} \geqslant 0.5\cdot 22.1\cdot 303\cdot 10^5 = 33\cdot 10^6$  Гц. Эта частота выше максимальной рабочей частоты приемника и не удовлетворяет неравенству (2-119) для всех рассмотренных ранее вариантов тракта промежуточной частоты (см. табл. 2-14), поэтому первый вариант системы радиотракта не присмлем. Результаты аналогичных расчетов для второго и третьего вариантов приведены в табл. 2-15.

Для поддиапазона 1 и четвертого варианта согласно формуле (2-100)  $\delta_{\text{3.c min I}} = 7900 \cdot 0.71/(1.940.000) = 0.0029$  и для поддиапазона 12 — 0,00025. Поэтому, как и для одиночных контуров, принимаем для всех поддиапазонов по формуле (2-113)  $\delta_{a, c, min} = 0.023$ . Тогда из перавенства (2-120)  $f_{\text{пр. 3}} \ge 0.354 \cdot 0.023 \cdot 303 \cdot 105 \sqrt{1000} = 79 \cdot 105 \Gamma \mu$ . Результаты подобного расчета для пятого варианта приведены

в табл. 2-15.

При шестом варианте для полдиапазона 1 из формулы (2-100) имеем  $\delta_{s,cmin} = 7900 \cdot 0.5/1 \ 940 \ 000 = 0.002$  и для поддиапазона 12 -— 0,00018. Принимаем для всех поддиапазонов с учетом равенства (2-113)  $\delta_{s,c}=0.023$ . По кривой A (см. рис. 2-14) находим  $\xi_{s,a}=15.9$ . Из неравенства (2-122) получаем  $f_{\rm np.\,3} \! > \! [0.5\,V\,\overline{0.5\,\cdot\,0.023^2\,\cdot\,15.9^2\,+\,1}\,-\!\!\!\!+$  $+ 0.023 \cdot 15.9 - 0.5 \cdot 1.303 \cdot 10^5 = 1.160 \cdot 000 \cdot \Gamma_{\rm Hz}$ 

Таблина 2-15

Ва- ри- ант	Число перестран- ваемых контуров радно- тракта	Минимально допустимое эквиналентное затухание для		f <sub>np.3</sub> ,	Неравенство (2=119) для варианта тракта проме- жуточной частоты		Заключе- ние о ва-
		поддна 1		Mru	выпол- пастся	не выполняется	рианте радио- тракта
1	2	0,023	0,023	33	Hет	а, б, в, г, д, е	Не пригоден
2	3	0,023	0,023	6,5	Нет	а, б, в, г, д, е	То же
3	4	0,023	<b>0</b> ,023	1,9	Нет	а, б, в, г, д, е	» »
4	3	0,023	0,023	7,9	Нет	а, б, в, г, д, е	» »
5	5	0,023	0,023	1,4	Пет	а, б, в, г, д, е	» »
6	4	0,023	0,023	1,16	Нет	а, б, в, г, д, е	» »

Из табл. 2-15 следует, что даже самые сложные из рассмотренных вариантов с четырьмя-пятью перестраиваемыми контурами в радиотракте ни при одном из описанных в табл. 2-14 вариантов тракта промежуточной частоты не позволяют обеспечить выполнение неравенства (2-119). Применение более сложных вариантов селективных систем в радиотракте (три пары связанных контуров или две пары связанных и два одиночных контура) сильно усложнит конструкцию приемника и неприемлемо с экономической и конструктивных точек зрения. Поэтому реглизуемое решение поставленной задачи может быть получено лишь при использовании двойного преобразования частоты.

Если из приведенных в начале параграфа рекомендуемых значений первую промежуточную частоту взять равной 1,6 МГц, то ее применению будут удовлетворять лишь пятый и шестой варианты радиотракта. Более подходящим может быть шестой вариант, в котором радиотракт имеет на один перестраиваемый колебательный контур меньше. Пля тракта второй промежуточной частоты целесообразно взять вариант «д». Его ФСС обладает достаточно хорошими селективными сеойствамя и значительно дешевле ФСС варианта «е». Фильтры варианта «г» обладают плехой селективностью при больших расстройках [5, 16]. Таким образом, вторая промежуточная частота будет равна 465 кГц.

Выберем селективные системы для тракта первой промежуточной частоты, полагая ее постоянной для всех поддиапазонов. Положим собственное затухание колебательных контуров этого тракта равным 0.01. Взяв в неравенстве (2-116) знак равенства, получим минимально осуществимое затухание контуров  $\delta_{3, \text{прл}} = 1,5 \cdot 0,01 = 0,015$ . Если в качестве селективной системы взять два связанных контура при критической связи, то согласно формуле (2-100) при замене  $f_{
m c \, min}$  на  $f_{
m np \, 1}$  их полоса пропускания будет  $\Pi_{\text{прt}} = 0.015 \cdot 16 \cdot 10^5 / 0.71 = 34\,000$  Гц. Это в 5 раз шире необходимой полосы пропускания приемпика; контуры радиотракта не будут влиять на формирование полосы пропускания приемника. Подставляя  $f_{\rm пр1}$  вместо  $f_{\rm cmax}$  в неравенство (2-120), получаем  $f_{\rm np.\,32} \geqslant 0.354 \cdot 0.015 \cdot 16 \cdot 10^5 \, \sqrt{1000} = 27 \cdot 10^5 \, \Gamma$ ц,что больше принятого значения первой промежуточной частоты. Следовательно, такая селективиая система не обеспечит нужного ослабления по зеркальному каналу. При трех колебательных контурах лучшие результаты дает комбинированная схема. Пользуясь неравенствами (2-122), находим  $f_{\text{пр. 32}} \ge [0.5 \sqrt{0.5 \cdot 0.015^2 \cdot 15.9^2 + 1} + 0.015 \cdot 15.9 - 0.5] \times$  $\times$  16·10<sup>5</sup> = 4·10<sup>5</sup> Гц, что ниже принятого значения первой промежуточной частоты и обеспечит ослабление второго зеркального канала больше требуемых 60 дБ. Таким образом поставленная задача решена,

## 2-7. Выбор и расчет детектора АМС

Исходными данными для расчета детектора АМС являются нижняя  $F_{\rm R}$  и верхняя  $F_{\rm R}$  частоты модулирующего сигнала; максимальный коэффициент модуляции  $m_{\rm max}$  сигнала. Из расчета структурной схемы приемника используются: амплитуда входного напряжения низкочастотного тракта при нормальном (m=0.3)  $U_{m\,{\rm BX, HY}}$  и максимальном коэффициентах модуляции  $U_{m\,{\rm BX, HOM}}$ ; входное сопротивление первого каскада низкочастотного тракта  $R_{{\rm BX, III}}$ ; минимально допустимое входное сопротивление детектора  $R_{{\rm BX, III}}$ ;

В результате расчета следует выбрать схему и тип нелинейного элемента детектора, определить амплитуду входного напряжения детектора, которое является выходным напряжением тракта промежуточной частоты  $U_{m,\mathrm{max},\mathrm{no}}$ .

Благодаря малым нелинейным искаженням, простоте схемы и отсугствию потребления мощности от источника питания в современных приеминках используются, как правило, диодные (полупроводниковые) детекторы. Поэтому остановимся на расчете именно такого детектора. Выбор схемы и расчет гранзисторных детекторов описываются в [3, 4, 5, 13, 16].

Для уменьшения шунтирования выходного контура тракта промежуточной частоты, что повышает селективность и усиление его последнего каскада, желательно иметь большое входное сопротивление детектора. С этой точки зрения более выгодна схема последовательного дереного детектора, которая имеет наибольшее распространение в современных радиопрнемниках. Входное сопротивление диодного детектора в основном определяется сопротивлением его нагрузочного резистора R и пропорционально ему. При  $R > (20 \div 30) R_i$  эта пропорциональность становится прямой. Однако малое входное сопротивление транзистерного первого каскада низкочастотного тракта не позволяет брать нагрузочный резистор детектора с большим сопротивлением [5]. Кривая I

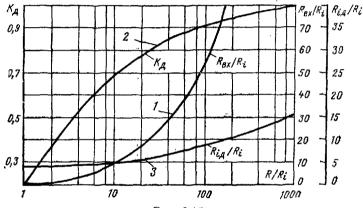


Рис. 2-15.

на рис. 2-15 позволяет определить входное сопротивление последовательного днодного детектора при любом сопротивлении нагрузки фициент передачи диодного детектора также определяется отног  $R/R_i$  и может находиться но кривой 2 (рис. 2-15).

Для отсутствия в диодном детекторе нелипейных искажени счет неодинаковости его нагрузки постоянному и переменному то сопротивление нагрузки детектора должно быть много меньше ного сопротивления следующего каскада. Но при малом сопротивления нагрузки входное сопротивление и коэффициент передачи детектора становятся малыми. Поэтому в транзисторных приемниках с целью некоторого повышения нагрузочного сопротивления детектора между выходом детектора и входом первого каскада низкочаетотного тракта включают добавочный резистор  $R_{100}$ . С этой же целью нагрузку детекторымолняют из двух последовательно включенных резисторов  $R_1$  и  $R_2$  как показано на рис. 2-16.

Диод для детектора выбирают так, чтобы его максимальная рабочая частота (см. табл. П-1-6) была в несколько раз больше последы промежуточной частоты приемника, кругизна прямого прохожденова возможно большей (при этом внутреннее сопротивление  $R_i = 1/S$  окажется меньше), обратное напряжение — более утроенной амплитуды максимального входного сигнала, а междуэлектродная емкость - возможно меньшая,

Согласно схеме на рис. 2-16 нагрузка диода

$$R = R_1 + R_2. (2-123)$$

По заданному минимальному входному сопротивлению детектора и внутреннему сопротивлению диода по кривой 1 на рис. 2-15 находят

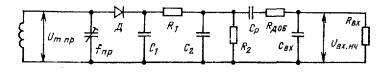


Рис. 2-16.

наибольшую возможную нагрузку и подбирают сопротивления резисторов  $R_1$  и  $R_2$  с учетом уравнений

$$R_1 \approx (0.2 \div 0.3) R$$
 is  $R_2 \approx (0.7 \div 0.8) R$ . (2.124)

Сопротивление добавочного резистора определяется неравенством

$$R_{\text{Ao6}} \ge \frac{\left[m_{\text{max}} \left(R_1 + R_2\right) - R_1\right] R_2}{\left(R_1 + R_2\right) \left(1 - m_{\text{max}}\right)} - R_{\text{BX. Hq}}.$$
 (2-125)

Коэффициент передачи детектора для схемы на рис. 2-16 вычисляют по формуле

$$K'_{\pi} = K_{\pi} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{R_{\text{BX. Hq}}}{R_{\pi 06} + R_{\text{BX. Hq}}}.$$
 (2-126)

Здесь  $K_{\rm A}$  — коэффициент передачи дегектора с нагрузкой  $R_1+R_2$ , определяющийся кривой 2 на рис. 2-15.

Поскольку увеличение сопротивления добавочного резистора снижает коэффициент передачи детектора, при его определении по неражиству (2-125) следует брать наименьшее возможное значение по станмэнцыртной шкале сопротивлений резисторов.

Амплитуда несущей входного сигнала детектора, т. е. выходного

ье жапряжения промежуточной частоты, определяется равенством окам

$$U_{mnp} = U_{mnx, nq} / (K_A' m). \tag{2-127}$$

HHE Здесь m=0.3 — среднее значение коэффициента модуляции сиг-

Пример 2-24. Определить основные характеристики последовательного диодного детектора, чтобы его входное сопротивление было равно 4 кОм, если амплитуда входного сигнала первого каскада низкочастотного тракта равна 0.005 В при m=0.3; входное сопротивление первого каскада низкочастотного тракта составляет 700 Ом, максимальный коэффициент модуляции 0,8, промежуточная частота 465 кГц.

Ñ. Из табл. П-1-6 выбираем диод Д1Е, как удовлетворяющий сформурян лированным ранее условиям. Его внутреннее сопротивление 100 Ом,  $C_{\rm BE}$  немкость  $C_{\rm BE}=1$  пФ. Согласно кривой 1 на рис. 2-15 требующемуся отношению  $R_{\rm BX}/R_i=4000/100=40$  соответствует отношение  $R/R_i=74$ . Следовательно,  $R=R_1+R_2=7400$  Ом. С учетом данных табл. П-3-1 и формул (2-124) принимаем  $R_1=1800$  Ом и  $R_2=5600$  Ом. Сопротивление добавочного резистора вычисляем по неравенству (2-125)

$$R_{\text{A06}} \geqslant \frac{[0.8 (1.8 + 5.6) 1000 - 1800] 5600}{(1.8 + 5.6) 1000 (1 - 0.8)} - 700 = 14\,900 \text{ Om.}$$

Согласно табл. П-3-1 принимаем сопротивление резистора равным 15 кОм.

Коэффициент передачи собственно детектора находим по кривой 2 на рис. 2-15. Он равен 0,88, а по формуле (2-126) вычисляем  $K_{\mathbf{A}}'=$ 

 $=0.88 \frac{5600}{1800+5600} \frac{700}{15\,000+700} = 0.03$ . Амплитуду минимального выходного напряжения тракта промежуточной частоты вычисляем по уравнению (2-127)  $U_{m\,np} = 0.005/(0.03\cdot0.3) = 0.56$  В. Линейный режим детектора с полупроводниковым диодом достигается при амплитуде входного сигнала более 0.5-0.7 В. Поэтому возьмем амплитуду входного напряжения детектора равной 0.6 В. При этом входной сигнал первого каскада низкочастотного тракта окажется в 1.1 раза больше требуемого, но он может быть уменьшен до нужного значения ручным регулятором громкости.

## 2-8. Выбор типа транзисторов и числа каскадов тракта промежуточной частоты

Исходными данными для расчета служат: минимальное выходное напряжение тракта промежуточной частоты  $U_{m\,np}$ ; минимальное входное напряжение преобразователя частоты  $U_{m\,nq}$  вх (первого, если применяется многократное преобразование частоты сигнала); типы и количество селективных систем, выбранных для тракта промежуточной частоты.

Первые два исходных данных определяют коэффициент усиления тракта промежуточной частоты

$$K_{\text{unp}} = a \frac{U_{m\pi p}}{U_{m\pi q - nx}},$$
 (2-128)

где а — коэффициент запаса усиления, необходимый для учета снижения усилительных свойств транзисторов в процессе эксплуатации и возможных потерь усиления за счет включения регуляторов усиления и полосы пропускания. Этот коэффициент достаточно брать равным 2—4.

Для каскадов усилителя напряжения промежуточной частоты следует выбирать наиболее дешевые и экономичные транзисторы, предельная частота ( $f_{\rm rp}$ ) которых в 5—10 раз выше промежуточной частоты. Из равноценных с указанных точек зрения предпочтительнее будут те, у которых выше коэффициент устойчивого усиления, что позволит иметь меньшее число каскадов и повысит надежность работы приемника.

При одинаковых селективных системах тракта и однократном преобразовании частоты поставленияя задача решается следующим образом. В радновещательных, связных и других близких к ним по характеристикам относительно узконолосных приемниках наибольшее усиление каскада тракта промежуточной частоты, как правило, равно

устойчивому коэффициенту усидения. Промежуточная частота обычно бывает значительно меньше максимальной рабочей частоты приемника. Поэтому в преобразователе частоты применяют более высокочастотные транзисторы, чем в наскадах усилителя напряжения промежуточной частоты. Крутизна преобразования транзистора  $Y_{21\, \rm np}$  составляет ке менее 0.25-0.4 его проводимости прямой передачи  $Y_{21}$  [5]. Если для обеспечения селективности требуется  $n_{\rm np}$  систем, то число каскадов в усилителе напряжения промежуточной частоты будет  $N_{\rm np}=n_{\rm np}-1$  (одна селективная система служит нагрузкой преобразователя частоты). Пусть коэффициент устойчивого усиления транзистора на промежуточной частоте  $K_{\rm pycr}$ . Тогда общее усиление тракта промежуточной частоты (от входа преобразователя частоты до входа детектора) определится уравнением

$$K_{\text{onp}} = (0.25 \div 0.4) \frac{Y_{21\text{nq}}}{Y_{21\text{np}}} q^p K_{\text{Oyer}}^{N_{\text{np}}+1},$$
 (2-129)

где  $Y_{21\,\mathrm{BS}}$  и  $Y_{21\,\mathrm{BS}}$  — проводимости прямой передачи транзисторов преобразователя частоты и каскадов усилителя напряжения промежуточной частоты; q — коэффициент селабления сигнала  $\Phi$ CC на средней частоте; p — число используемых в транзистора преобразователя частоты  $\Phi$ CC. Проводимость  $Y_{21\,\mathrm{BS}}$  берется для транзистора преобразователя частоты на максимальной рабочей частоте приемника.

Приравнивая правые части уравнений (2-128) и (2-129), получаем формулу дли расчета числа каскадов в усилителе напряжения промежуточной частоты, которсе необходимо для обеспечения требуемого усиления:

$$N_{\rm np} \ge \frac{\lg (2.5 \div 4) \frac{Y_{210p} K_{011p}}{q^p Y_{211nq}}}{\lg K_{0ycr}} - 1.$$
 (2-130)

Если получится

$$N_{\rm np} \leqslant n_{\rm np} - 1, \tag{2-131}$$

то при выбранном типе транзистора для обеспечения требуемого усиления в тракте промежуточной частоты числа каскадов  $N_{\rm np}$  будет достаточно. В тех случаях, когда окажется, что  $N_{\rm np} \ll n_{\rm np} = 2$  или даже  $N_{\rm np} \ll n_{\rm np} = 3$ , число необходимых систем будет на 1 или 2 больше требуемого числа каскадов из условия нужного усиления. При отмеченых условиях может оказаться целесообразным применение варианта с более сложными селективными системами при меньшем их количестве (например, варианта «б» вместо варианта «а» или варианта «в» вместо «а» из примера 2-23). Это уменьниг число каскадов в приемнике. При невыполнении неравенства (2-131) следует взять транзистор с более высоким коэффициентом устойчивого усиления, добиваясь выполнения перавенства с превышением правой части над левой в пределах единицы (естественно, что число  $N_{\rm up}$  может быть только целым), или добавить недостающее число каскадов, выполненных по резистивной схеме.

Пример 2-25. Выбрать типы транзисторов и число каскадов в тракте промежуточной частоты переносного приемника I класса для поддвапазонов 1—11, считая, что его радиотракт выполнен по вариантам 7 (см. табл. 2-11) и 2 (см. табл. 2-13), низкочастотный тракт по варианту примеров 2-4 и 2-5, детектор — по варианту примера 2-24, а селективные системы тракта промежуточной частоты соответствуют примеру 2-21.

Вари-	<b>T</b> p a	поистор	П402	Г1403	
1	Число каскадов	расчетное	2,96—3,13	3,1-3,45	
		конструктивное	3	4	,
2	Число каскадов	расчетное	2,7—2,9	2,8—2,97	
		конструктивное	3	3	
3	Число каекадов	расчетное	2,5-2,7	2,62,8	
		конструктивное	3	3	

В примере 2-20 промежуточная частота равна 465 кГ ц, а в качестве селективных систем тракта промежуточной частоты выбраны два четырехзвенных ФСС. В примере 2-6 показано, что для обеспечения требуемых полосы пропускания и селективности можно использовать два ФСС типа ПФІП-0,22. Преобразователь частоты в вариантах 7 (см. табл. 2-11) и 2 (см. табл. 2-13) выполнен на транзисторе ГТ308В (на максимальной рабочей частоте  $Y_{21}=0,031$  См). По данным примера 2-24 амплитуда входного сигнала детектора должна быть не менее 0,6 В. Для принятых вариантов раднотракта минимальный входной сигнал преобразователя частоты составляет 382 мкВ.

Приняв коэффициент запаса усиления равным 3, по формуле (2-128) вычисляем минимально необходимый коэффициент усиления тракта промежуточной частоты  $K_{0 \text{пр}} = 3 \cdot 0.6/(0.000382) = 4710$ . Начнем расчеты с определения характеристик при использовании транзистора П402. Его параметры для частоты 465 кГи:  $Y_{21} = 0.03$ ;  $C_{12} = 6$  пФ;  $g_{11} = 0.7$  мСм;  $g_{22} = 7$  мкСм. По формуле (2-66) вычисляем коэффициент устойчивого усиления  $K_{\text{оусt}} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)0.03}{6.28 \cdot 465\ 0.00 \cdot 6 \cdot 10^{-12}}} = 18.5$ . По неравенству (2-130) определяем число необходимых каскадов в усилителе напряжения промежуточной частоты

$$N_{\rm np} \ge \frac{\lg (2.5 \div 4) \, 0.03 \cdot 4710/0.33^2 \cdot 0.031}{\lg 18.5} - 1 = 2.96 - 3.13.$$

Таким образом, можно иметь три каскада: один с ФСС и два резистивных. Но чтобы можно было применить последовательный детектор, в последнем каскаде усилителя напряжения промежуточной частоты необходимо взять нагрузку из двух связанных контуров. Их полоса пропускания должна быть в 1.3—1,5 раза шире полосы пропускания приемника, чтобы эти контуры не влияли на формирование полосы про-

	11416	ГТ31: Б	ГТ308В	Система
	3.05—3,18	2,8—2,96	2,01-2,09	Два ПФ1П—0,22
	4	3	2	
-	2,75—2,92	2,5—2,7	1,8—1,9	Один ПФ1П-2 и два свя- запных контура
	3	3	2	
	2,5—2,7	2,3—2,4	1,6—1,7	Один ПФИП—0.22 и два связ занных контура
	3	3	2	

пускания приемника. Результаты аналогичных расчетов для других, более высокочастотных транзисторов приведены в табл. 2-16.

Но можно использовать пару связанных контуров последнего каскада для улучшения селективности по соседнему каналу и попытаться исключить из тракта промежуточной частоты один ФСС. Так, ФСС типа ПФ1П-2 обеспечивает ослабление при расстройке  $\pm 10$  кГц 40 дВ и полосу пропускания до 12,5 кГц, если подобрать самый широкополосный фильтр. Возьмем одну пару связанных контуров при критической связи с полосой пропускания 12 кГц. Для этого согласно табл. 2-12  $\psi_2$  (1) = 0,71 и по формуле (2-100) эквивалентное затухание контуров должно быть  $\delta_{9, \text{ пр}} = 12 \cdot 10^3 \cdot 0,71/465 000 = 0,0185$ . Для относительной расстройки  $\xi_d = (2 \cdot 10)/12 = 1,7$   $\xi_{\Pi}$  по штриховой кривой I на рис. 2-14 получим ослабление  $d_{\xi_d} = 3$  или 9,5 дВ, что позволяет получить общее ослабление при расстройке  $\pm 10$  кГц. — 49,5 дБ, т. е. больше требуемых от приемника 46 дВ. В этом варианте число необходимых каскадов при транзисторе П402 согласно неравенству (2-130) должно быть  $N_{\Pi p} \ge 1g$  (2.5  $\pm$  4) 0 03  $\cdot$  4710/(0.25  $\cdot$  0.031)

 $\geqslant \frac{\lg (2,5 \div 4) \ 0.03 \cdot 4710/(0.25 \cdot 0.031)}{\lg 18,5} - 1 = 2,7 - 2,9,$  т. е. следует

также применять три каскада.

Результаты аналогичных расчетов для других типов транзисторов приведены в табл. 2-16 (вариант 2). Анализ данных табл. 2-16 показывает, что вариант 2 селективных систем тракта промежуточной частоты позволяет при транзисторах П403 и П416 иметь также три каскада, как в варианте 1 для транзисторов П402, ГТ310Б.

Если в радиотракте применнть траизистор ГТ313Б (вариант 9 табл. 2-11 и вариант 3 табл. 2-13), минимальный входной сигнал преобразователя частоты будет 700 мкВ. Согласно равенству (2-128) получим  $K_{0\text{ пр}} = 3 \cdot 0.6/0.0007 = 2570$ . Этому случаю соответствует вариант 3 табл. 2-16. По числу необходимых каскадов он полностью адекватен

варианту 2, но требует применения в радиотракте более дорогого типа

транзистора, почему его применение не целесообразно.

Построив каскады усилителя напряжения промежуточной частоты по схеме с ОБ на транзисторе П402, согласно формуле (2-93) получим по схеме с ОБ на транзисторе 11402, согласно формуле (2-30) полу алм  $K_{0ycr} = \frac{2 (1-0.9) 0.03}{6.28 \cdot 465 000 \cdot 14 \cdot 10^{-12}} = 150$ . Для схемы с ОБ  $g_{11 \text{ ОВ}} \approx Y_{21} + g_{11} = 0.03 + 0.0007 = 0.0307$  См. По равенству (2-68) при  $\delta = 0.01$  получаем  $K_{0 \text{ max}} = \frac{0.5 \cdot 0.03}{V 7 \cdot 10^{-6} \cdot 0.0307} \left(1 - \frac{0.01}{0.021}\right) = 17$ .

Это меньше, чем  $K_{0 \text{ уст}}$  при схеме с ОЭ. Поэтому схему с ОБ при-

менять нецелесообразно, а следует остановиться на варианте 2 с тремя каскадами усилителя папряжения промежуточной частоты на транзисторе П402 (как болсе дещевых по сравнению с другими) или на варианте 2 с двумя каскадами на транзисторах ГТЗОВВ. Окончательное решение следует принять после выбора типа транзисторов и числа каскадов для тракта промежуточной частоты при приеме ЧМС (см. пример 2-31),

#### Проверка осуществимости регулировок 2-9.

Основными характеристиками системы АРУ являются допустимое изменение выходного напряжения

$$B = U_{\text{BMX max}}/U_{\text{BMX min}} \tag{2-132}$$

при заданном диапазоне амплитуд входного сигнала

$$D = E_{A \text{ max}} / E_{A0}. \tag{2-133}$$

В большинстве современных приемников применяется задержанная APУ. Для нее напряжение задержки выбирается так, чтобы до значения  $U_{\rm BMX\,min}$ , соответствующего чувствительности приемника  $E_{\Lambda 0}$ , система АРУ не действовала. В этом случае максимальное регулирующее напряжение будет:

$$U_{\text{p max}} = K_{\text{B}} U_{\text{BMX min}} B, \qquad (2-134)$$

где  $K_{\pi}$  — коэффициент передачи выпрямителя АРУ. Для хорошей работы системы АРУ транзисториых приемников достаточно иметь напряжение задержки 0,5-1 В, а для ламповых приемников — 5—10 В. При таких значениях максимального регулирующего напряжения глубина регулирования усиления одного каскада

$$\Gamma_{\kappa} = K_{0 \text{ max}} / K_{0 \text{ min}} \tag{2-135}$$

обычно бывает не менее 5-10.

Согласно уравнениям (2-132) и (2-133) глубина регулирования всего приемника определяется формулой

$$\Gamma = \Gamma_{\kappa_1} \Gamma_{\kappa_2} \dots \Gamma_{\kappa_n} = K_{\max} / K_{\min} = (U_{\max \min} / E_{A0}) : (U_{\max \max} / E_{A \max}) = \mathcal{I} / B. \quad (2-136)$$

Если полагать глубины регулирования усиления каскадов одинаковыми  $\Gamma_{\text{KI}} = \Gamma_{\text{K2}} = ... = \Gamma_{\text{K}n} = \Gamma_{\text{K}}$ , то для получения необходимых характеристик АРУ число регулируемых каскадов запишется неравен-

$$N_{\mathbf{p}} \geqslant \frac{\lg \frac{\mathcal{H}}{B}}{\lg \Gamma_{\mathbf{k}}}.$$
 (2-137)

Обозначим через  $N_{\rm вч}$  число каскадов высокочастотного тракта. Тогда условием осуществимости необходимых характеристик системы APУ явится выполнение неравенства

$$N_{\rm Bq} \geqslant N_{\rm p}$$
. (2-138)

Когда  $N_{\rm HV}$  на несколько единиц превышает  $N_{\rm p}$ , то для уменьшения нелинейных искажений сигнала из управления системой APV следует исключать каскады высокочастотного тракта в следующем порядке: преобразователь частоты, последний каскад усилителя напряжения промежуточной частоты, первый каскад усилителя радиосигнала, предпоследний каскад усилителя напряжения промежуточной частоты [5].

Если при задержанной АРУ неравенство (2-138) не выполняется, то следует применить задержанную и усиленную АРУ, для которой глубина регулирования усиления каскада может быть принята равной 8—12. В случае невыполнения неравенства (2-138) для задержанной и усиленной АРУ следует добавить регулировку усиления за счет изменения межкаскадной связи с помощью управляемого системой АРУ диода. Она обеспечивает глубину регулирования до 20—30 дБ на один переход с управляемым диодом [5].

Пример 2-26. Определить осуществимость работы системы задержанной АРУ для переносного приемника 1 класса, структурная схема

которого определена в примере 2-25.

Для переносного приемника I класса (ГОСТ 5651—76) характеристики системы APУ определены следующими значениями:  $B=10~{\rm д B}$  и  $\mathcal{A}=36~{\rm д B}$ . Будем считать глубину регулирования каскада равной 7. Необходимое число регулируемых каскадов вычисляем по неравенству

(2-137) 
$$N_{\rm p} \ge \frac{\lg \frac{63}{3,16}}{\lg 7} = 1,54$$
. Следовательно, достаточно регулировать

усиление только в двух каскадах из пяти имеющихся в высокочастотном тракте приемника (один каскад усилителя радносигнала, преобразователь частоты и три каскада усилителя напряжения промежуточной частоты). Поэтому можно ограничиться регулировкой усиления только первых двух каскадов усилителя напряжения промежуточной частоты.

Глубвна регулирования ручного регулятора громкости (РРГ) для перепосного приемника (ГОСТ 5651—76) должиа равняться 50 дБ (318). Такая регулировка вполне осуществима с помощью одного потенциометрического регулятора, включенного в переходную цепочку между детектором и первым каскадом усилителя наприжения модулирующей частоты. Таким образом, все требуемые регулировки для приемника осуществимы.

#### 2-10. Особенности расчета структурной схемы приемника с двойным преобразованием частоты

Выбор и расчет детектора, структурных схем радио- и низкочастотного трактов, а также осуществимости регулировок выполняется по методикам, приведенным ранее. Но при расчете полосы пропускания необходимо учитывать нестабильность частоты обонх гетеродинов.

Если работа тетеродинов независима и частоты колебаний каждого из них не определяют друг друга, то для расчета следует пользоваться формулой

 $\Pi = F_{c.t.} + 2 \sqrt{b_c^2 f_c^2 + b_{c.t}^2 f_{c.t.}^2 + b_{c.t.^2}^2}.$  (2-139)

При одинаковой относительной нестабильности частоты обоих гетеродинов  $(b_{\rm f1}=b_{\rm f2})$  третье слагаемое под радикалом обычно получается существенно меньше второго, так как частота первого гетеродина, как правило, бывает выше частоты второго гетеродина. В этом случае за счет нестабильности второго гетеродина полоса пропуска-

ния приемника расширяется сравнительно мало.

В некоторых типах приемников и, в частности, в связных для обоих гетеродинов используется один общий задающий генератор. При этом частота второго гетеродина, как правило, определяется частотой первой гармоники задающего генератора, а частота первого гетеродина более высокой гармоникой, что позволяет иметь лучшую относительную стабильность частоты первого гетеродина, поскольку задающий генератор работает в более низкочастотном диапазоне. Кроме того, выбирая в одном преобразователе верхиюю, а во втором — нижнюю настройку гетеродина, можно добиться некоторой компенсации отклонения частоты полезной комбинационной составляющей второго преобразователя частоты от промежуточной частоты приемника. Но в приемнике с переменной настройкой первая промежуточная частота тоже будет изменяться в пределах каждого поддиапазона, что, естественно, усложивет тракт первой промежуточной частоты и весь приемник, Построение подобных гетеродинов описано в [3, 4, 40].

Выбор промежуточных частот и селективных схем трактов промежуточной частоты производится в соответствии с матерналами § 2-6. Типы транзисторов для обонх трактов берутся с учетом рекомендаций § 2-8, при этом для второго преобразователя частоты берут те же тран-

зисторы, что и в тракте первой промежуточной частоты.

Число каскадов усилителя первой промежуточной частоты обычно принимают равным  $N_{\rm np1}=n_{\rm np1}-1$ , поскольку одна селективная система служит нагрузкой первого преобразователя частоты. Затем, рассчитав коэффициент устойчивого усиления транзисторов тракта первой промежуточной частоты, по формуле (2-129) находят коэффициент усиления этого тракта. Амплитуда входного сигнала второго преобразователя частоты определяется уравнением

$$U_{m_{11}q_2} = U_{m_{11}q_1} K_{0np_1}. (2-140)$$

Подставляя это значение вместо  $U_{m,\, \rm BX \, HY}$  в формулу (2-128), определяют число кискадов в тракте второй промежуточной частоты по приведенной в § 2-8 методике.

В тех случаях, когда при двойном преобразовании частоты в трактах радносигнала и первой промежуточной частоты требуется применять большее число (больше 3) сложных селективных систем, может оказаться более целесообразиым применить тройнее преобразование частоты. Это, как правило, бывает необходимо для приемников дециметровых и более коротких воли при узкополосных сигналах. Первую и третью промежуточные частоты определяют по методике § 2-6, а вторую подбирают так, чтобы в трактах радиосигнала и первой промежуточной частоты можно было использовать минимальное количество и наиболее простых систем, папример одиночных колебятельных контуров.

Пример 2-27. Выбрать гины транзисторов и часло каскадов в трактах первой и второй промежуточных частот связного приемника, диапазон рабочих частот которого определяется табл. 2-1. Считать, что чувствительность приемпика 3 мкВ, типы транзисторов радиотракта соответствуют варианту 7 табл. 2-11, а его селемивные системы выполнены по варианту 6 и варианту «д» примера 2-23; амплитуда входного напряжения детектора равна 0,6 В, типы систем и значения промежуточных частот соответствуют примеру 2-23 ( $f_{\text{пр1}} = 1.6$  МГц и  $f_{\text{пр2}} =$  $= 465 \text{ к}\Gamma$ μ).

В радиотракте должны быть использованы две селективные системы: пара связанных контуров и один одиночный. Одна из них, наиболее селективная, должна служить входной цепью, а вторая — нагрузкой усилителя радиосигнала. Қоэффициент передачи двухконтурной входной цепи при прочих равных условиях составляет примерно половину от коэффициента передачи одноконтурной входной цепи [5]. Согласно табл. 2-11 коэффициент передачи одноконтурной входной цепи в варианте 7 равен 0,77, поэтому будем полагать для двухконтурной входпой цепи его равным 0.38.

Коэффициент устойчивого усиления транзистора ГТ308В вычисляем по фюрмуле (2-66) на максимальной частоте сигнала (см.

табл. 2-1)
$$K_{0\text{уст}} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)0.03}{6.28 \cdot 303 \cdot 10^5 \cdot 10^{-12}}} = 5,6$$
. Он и определ яст максимальное усиление каскада. Коэффициент передачи напряжения радио-

тракта находим по уравнению (2-71)  $K_{0,00} = 0.38 \cdot 5.6 = 2.1$ . Амилитуду входного сигнала первого преобразователя частоты вычисляем по формуле (2-80)  $U_{m,ret,\, BXI}=3\cdot 10^{-6}\cdot 2,1=63\cdot 10^{-7}\,$  В.

Для тракта первой промежуточной частоты следует выбрать транзисторы с предельной частотой более 10-15 МГц. Наиболее подходящими являются транзисторы П402, П403 и П416. Оценим их свойства. Основные характеристики транзистора П402 выписываем из табл. П-1-1 для частоты 1,6 МГц:  $f_{\Gamma p}=50$  МГц;  $G_{12}=6$  пФ;  $g_{11}=830$  мкСм;  $g_{22}=16$  мкСм;  $Y_{21}=0.03$  См;  $g_{11}$  пч = 0,75 · 0,83 = 0,62 мСм. Коэффициент устойчивого усиления вычисляем по формуле (2-66)

$$K_{\text{oyer}} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)0.03}{6.28 \cdot 16 \cdot 10^{5} \cdot 6 \cdot 10^{-12}}} = 10.$$

Селективными системами тракта первой промежуточной частоты должны быть пара связанных и один одиночный колебательные контуры. Их собственное затухание равно 0,015, эквивалентное затухание контуров пары 0.023 и одиночного контура  $2 \cdot 0.023 = 0.046$ . Связанные контуры используем в качестве нагрузки первого преобразователя частоты, а одиночный — нагрузки каскада усилителя напряжения первой промежуточной частоты. При использовании во вгором преобразователе частоты того же транзистора П402 по формуле (2-86) максимальный коэффициент усиления резонансного каскада будет  $K_{0,\max,n} =$ 

$$=\frac{0.5\cdot0.03}{V\,0.000016\cdot0.000062}\,(1-\frac{0.015}{0.046})=108;$$
 каскад рассчитываем на устойчивое усиление.

Коэффициент усиления тракта первой промежуточной частоты вычисляем по формуле (2-129), нзяв численный коэффициент равным 0.3. Но поскольку нагрузкой первого преобразователя частоты служат два связанных контура, то в формулу добавим множитель 0,5, так как усиление каскада с двумя связанными контурами при критической связи

в 2 раза меньше усиления каскада резолансного усилителя при прочих равных условиях,  $K_{0:p1}=0.5\cdot0.3\cdot0.035\cdot10^2/0.03=17.5$ . В формулу подставлена проводимость прямой передачи транзистора первого преобразователя частоты ГТЗ08В (0,035 См). Следовательно, амплитуда сигнала на входе второго преобразователя частоты по формуле (2-140) будет  $U_{m \, \Pi 9.\, B \times 2}=63\cdot10^{-7}\cdot17.5=11\cdot10^{-6}$  В. Результаты аналогичных расчетов для транзисторов П403 и П416 приведены в табл. 2-17.

Таблица 2-17

Варн- ант	Тран- энстор	Усиление каскада				Входное	
		устойчи- вое	макси- мальное	принятое в расчете	Усиление тракта первой проме- жугочной частоты	напряжение второго нре- образователя частоты, мкВ	
1 2 3	П:02 П:03 П416	10 9,1 9,4	108 134 100	10 9,1 9,4	17,5 14,1 15	110 89 91	

Необходимое усиление тракта второй промежуточной частоты вычисляем по формуле (2-128), взяв коэффициент запаса равным 3. Для первого варианта тракта первой промежуточной частоты получим  $K_{0 \text{ пр.2}} = 3 \cdot 0.6/(11 \cdot 10^{-5}) = 16 300$ .

При использовании в тракте второй промежуточной частоты граиэисторов П402 устойчивый коэффициент усиления каскада согласно

формуле (2-66) 
$$K_{\rm 0yct} = \sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.03}{6.28\cdot465\,000\cdot6\cdot10^{-12}}} = 18,5$$
. Селективными системами тракта второй промежуточной частоты приняты два ФСС типа ПФПП-М. Параметры фильгра выписываем из табл. 2-7:  $q=0.25$ ;  $C_{\rm BX}=835$  мкСм;  $G_{\rm Bbix}=417$  мкСм. Коэффициент усиления каскада усилителя второй промежу гочной частоты с этим фильтром опре-

$$K_0 = p \cdot p_2 q Y_{21} / G_{\text{BX}},$$
 (2-141)

где  $Y_{21}$  — проводимость прямой передачи транзистора каскада;  $G_{\rm BX}$  — входная проводимость ФСС;  $\rho_1$  и  $\rho_2$  — коэффициенты включения ФСС в коллекториую цень транзистора каскада и ко входу следующего каскада; q — коэффициент ослабления сигнала ФСС на средней частоте. Положим  $\rho_1=\rho_2=1$  (это определяется подбором элементов схемы питания транзисторов с учетом их собственных входной и выходной про-

водимостей), тогда  $K_0 = \frac{0.03}{0.000835} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.25 = 9$ , что меньше устойчи-

вого коэффициента усиления. Принимаем это значение за расчетное. Коэффициент преобразования второго преобразователя частоты вычися ляем по формуле (2-141), заменив в ней  $Y_{21}$  на  $Y_{21\, \rm np}$  траизистора второго преобразователя частоты. Для этого обычно пользуются приближенным равенством

$$Y_{2100} \approx (0.3 \div 0.4) Y_{21}.$$
 (2-142)

Взяв численное значение коэффициента равным 0,3, для транзистора П402 получим  $Y_{21\text{пр}}=0,3\cdot0,03=0,009$  См. Следовательно,  $K_{01\text{пр}}=\frac{0,009}{0,000835}\,1\cdot1\cdot0,25=2,7$ , Остальные каскады целесообразно выпол-

деляется формулой

нить резистивными. Их усиление должно быть  $K_{\rm 0pe3}=K_{\rm 0np2}/(K_{\rm 0}K_{\rm 0np})=\pm 16\,300/(9\cdot2,7)=670$ . Коэффициент усиления такого каскада не должен превышать устойчивый (18,5). Следовательно, необходимо иметь три таких каскада. Результаты аналогичных расчетов для траизисторов П403 и П416 приведены в табл. 2-18. Из нее следует, что применениев в обоих трактах промежуточной частоты транзисторов П402 более целесообразно как наиболее дешевых.

Таблица 2-18

Варнант тракта про- межуточной частоты		ор ыя коэф- усиления		юе усиле- второй эчной ча-	Коэффициент усиления			астивных
первой	второй	Транзистор	. Устойчивый : фицнент уси	Необходимое усил иие тракта второй промежуточной ча стоты	каскада с ФСС	преобра- зователя частоты	резистив- ных ка- скадов	Число-резистивных каскадов
1	1	П402	18,5	16 300	9	2,7	670	3
2	1	П402	18,5	20 000	9	2,7	820	á
	2	П403	16,8	20 000	9,3	2,8	720	3
3	1	П402	18,5	19 000	9	2,7	780	3
	3	П416	17,4	19 000	9,3	2,8	730	3

### 2-11. Особенности расчета структурной схемы приемников ЧМС

Общий подход к выбору и расчету структурной схемы приемника ЧМС сохранился таким же, как и для приемника АМС. В частности, расчет структурных схем высокочастотного и низкочастотного трактов сохраняется таким же. Отличия заключаются в определении ширипы спектра сигнала и полосы пропускания высокочастотного тракта и в выборе схемы детектора и ограничителя амплитуды.

1) Ширина спектра ЧМС в зависимости от характера сигнала вычисляется по соответствующей формуле (2-48)—(2-51) из табл. 2-5. Подставляя ее значения в уравнение (2-42), находят требуемую ширину полосы пропускания высокочастотного тракта приемника. ЧМС радиовещательных станций, как правило, имеет верхиюю модулирующую частоту до 10-15 кГц, а максимальный индекс модуляции до 5-10. При этих параметрах ширина спектра сигнала в соответствии с формулой (2-51) будет  $F_{\rm cn}=2$  ( $12\div15$ ) 1000 ( $1+5+\sqrt{5}$ ) = (195-250)  $10^3$  Гц.

2) Полоса пропускания приемника в метровом диапазоне воли определяется в основном шириной спектра сигнала, так как величина радикала в формуле (2-42) обычно оказывается меньше ширины спектра сигнала. При приеме ЧМС нестабильность частоты сигнала и гетеродина

вызывает изменение частоты несущей напряжения промежуточной частоты и приводит к соответствующему влиянию на выходной сигнал детектора, т. е. к появлению нелинейных искажений сигнала. Поэтому в приемниках ЧМС следует обеспечивать хорошую стабильность частоты тетеродина, даже если коэффициент расширения полосы пропускания приемника, определяющийся формулой (2-52), имеет сравнительно малое значение (меньше 1,1—1,2). Для этого стабилизируют напряжение и коллекторный ток транзистора гетеродина, а также выполняют гетеродин по схемам, обеспечивающим лучшую стабильность работы гетеродина, например емкостную или индуктивную трехточку [3, 5, 30, 40].

3) Детекторы современных приемников ЧМС чаще всего выполняют по дифференциальной и дробной схемам. Дифференциальный детектор ЧМС обладает меньшими нелинейными искажениями, но перед ним обязательно применение ограничителя амплитуды. Дробный детектор может работать без ограничителя амплитуды. В канале звукового сопровождения современных транзисторов чаще всего применяется дробный детектор. В высококачественных радиовещательных

приемниках используют дифференциальный детектор.

Если селективная система детектора ЧМС состоит из двух связанных контуров, как это имеет место в дифференциальном и дробном дегекторах, то параметр связи между контурами следует брать от 1,5 до 2,5. При большем параметре связи несколько увеличивается коэффициент передачи детектора, но и существенно возрастают нелинейные искажения. В детекторе с расстроенными контурами относительную расстройку также берут в интервале от 1,5 до 2,5. При больших звачениях немного возрастает коэффициент передачи детектора и сильно увеличиваются нелинейные искажения.

Коэффициент передачи детектора ЧМС, равный отношению амплитуды его выходного напряжения  $U_{m,\Omega}$  к амплитуде сигнала  $U_{m1}$  на первичном контуре селективной системы детектора, в первом приближения

нии может быть вычислен по формуле [4, 5]

$$K_{\text{qg}} \approx apK_{\text{g}} \frac{R_{\text{BX, PQ}}}{R_{\text{BX, PQ}} + R_{\oplus}},$$
 (2-143)

гле p — коэффициент включения диодов детектора к колебательному контуру;  $K_{\pi}$  — коэффициент передачи диодных детекторов, определяющийся графиком 2 на рис. 2-15. Коэффициент a для дифференциального детектора равен 0,23, для детектора с расстроенными контурами — 0,46 и для дроблого детектора — 0,046.

а) Для дифференциального детектора сопротивление нагрузочных

резисторов вычисляют по формуле

$$R_1 = R_2 \le (0.8 \div 1.2) (R_{\phi} + R_{\text{BX-HY}}),$$
 (2-144)

где  $R_{\rm BX,Hq}$  — входное сопротивление первого каскада низкочастотного тракта;  $R_{\rm \Phi}$  — сопротивление фильтра корректирующей цепочки, включаемой на выходе детектора. Обычно берут  $R_{\rm \Phi} \approx R_{\rm BX,Hq}$ . Коэффициент включения диодов к контуру определяется уравнением

$$p = \sqrt{0.5gR_{\text{BX-X}}(\delta_9/\delta - 1)},$$
 (2-145)

где g — активная собственная проводимость вторичного контура;  $\delta$  и  $\delta_3$  — его собственное и эквивалентное затухание;  $R_{\rm Bx,\, x}$  — входное сопротивление диодных дегекторов схемы, определяющееся графиком I на рис. 2-15. Отметим, что наибольший реализуемый коэффициент

включения согласно схемам дифференциального и дробного детекторов составляет 0,5. Может показаться, что, принимая p = 0.5, согласно равенству (2-143) можно увеличить коэффициент передачи детектора. Однако увеличение р сверх значения, определяющегося уравнением (2-145), приведет к существенному возрастанию δ<sub>3</sub> контуров и снизит коэффициент а в формуле (2-143). А это приведет к снижению коэффициента передачи детектора.

Для обеспечения необходимой полосы пропускания селективной системы детектора эквивалентное затухание ее колебательных контуров должно быть

 $\delta_a \geqslant 1.5\Pi/(\eta f_{\rm np})$ , (2-146)

где П — полоса пропускания высокочастотного тракта приемника;

п — параметр связи между контурами системы.

Пример 2-28. Вычислить коэффициент передачи дифференциального частотного детектора, если полоса пропускания высокочастотного тракта приемника 250 кГц, промежуточная частота 8,4 МГц, собственное затухание контуров 0,01, эквивалентиая емкость контуров 45 пФ, входное сопротивление первого каскада низкочастотного тракта 700 Ом.

Выберем параметр связи между контурами равным 2 и по формуле  $(2\cdot146)$  вычислим необходимое  $\delta_3\geqslant 1.5\cdot250~000/(2\cdot84\cdot10^5)=0.0224$ . Принимаем с некоторым запасом  $\delta_3=0.035$ . Положим  $R_{\Phi}=R_{\rm BX,HM}$ н из табл. П-3-1 выберем резистор сопротивлением 750 Ом. Сопротивление нагрузочных резисторов детектора согласно выражению (2-144) должно быть  $R_1=R_2=1,1$  (750 + 700) = 1600 Ом. По табл. П-3-1 берем резисторы сопротивлением 1,6 кОм.

Выбираем по табл. П-1-6 диоды Д2Е. Их внутреннее сопротивление равно 100 Ом. По графикам на рис. 2-15 определяем входное сопротивление диодных детекторов схемы  $R_{\rm вх. д}=1200$  Ом и коэффициент передачи  $K_{\rm A}=0.75$ . Вычисляем собственную активную проводимость контуров по формуле (2-55)  $g=0.01\cdot6.28\cdot84\cdot10^5\cdot45\cdot10^{-12}=$ = 24 · 10-6 См, а по уравнению (2-145) необходимый коэффициент включения к контуру  $\rho = \sqrt{0.5 \cdot 24 \cdot 10^{-6} \cdot 1200(0.035/0.01-1)} = 0.019$ , что меньше максимально реализуемой величины 0,5 и присмлемо. Пользуясь формулой (2-143), определяем коэффициент передачи детектора  $K_{\mathbf{q},\mathbf{J}} = 0.23 \cdot 0.19 \cdot 0.75 \cdot 700/(750 + 700) = 0.016.$ 

б) Для дробного детектора сопротивление нагрузочных резисторов определяется неравенством (2-144). Эквивалентное затухание контуров должно удовлетворять как неравенству (2-146), так и неравенству

 $\delta_a > (4 \div 5) \delta$ . (2-147)

Чтобы оно лучше выполнялось, иногда берут предельно осуществимый коэффициент включения  $\rho = 0.5$ .

Остальные нараметры этого детектора выбираются по ранее прибеденным формулам.

Пример 2-29. Определить коэффициент передачи дробного детек-

тора по исходным дапным примера 2-28. По формуле (2-147) находим  $\delta_3=5\cdot 0,01=0,05$ . Это значение больше, чем требуемое уравнением (2-146) из условия необходимой полосы пропускания, поэтому принимаем его для дальнейших расчетов с некоторым запасом  $\delta_3 = 0.06$ . Сопротивление нагрузочных резисторов и диодов сохраняем таким же, как в примере 2-27. Тогда необходимый коэффициент включения определится формулой (2-145) p = $=V_{0,5\cdot 24\cdot 10^{-6}\cdot 1200}$  (0,06/0,01-1) = 0,268. Коэффициент передачи

вычисляем из уравнения (2-143)  $K_{\mathfrak{A},\mathfrak{g}}=0.046\cdot0.268\cdot0.75\cdot700\cdot(750$  |-

+ 700) = 0,0045.

4. Ограничители амплитуды характеризуются пороговым  $U_{\text{пор}}$  и выходным  $U_{m\,\text{вых}}$  напряжениями (табл. 2-19). Выходное напряжение ограничителя амплитуды является входным для детектора ЧМС. Если коэффициент амплитудной модуляции сигнала помехой обозначить  $m_{\text{п}}$ , то амплитуда входного сигнала ограничителя амплитуды выбирается по перавенству

 $U_{m0\text{BX}} \geqslant \frac{U_{\text{nop}}}{1 - m_{\pi}}.$  (2-148)

Это напряжение равно выходному напряжению усилителя сигнала промежуточной частоты.

Таблица 2-19

Ограничитель	Напряжение, В			
амплитуды	пороговое	выходное		
Гранзисторный Диодный Пентодный	$0.03 - 0.05 \\ 1 - 2$	$\begin{array}{c} (0.25-0.4) \ E_{\rm B} \\ 0.5-1 \\ 2-5 \end{array}$		

Как для транзистора, так и для пентода при использовании их в схеме ограничителя амплитуды принимается понижениее напряжение питания коллектора (2—3 В) или анода (20—30 В).

Пример 2-30. Определить амилитуду входного сигнала ограничителя амплитуды на транзисторе П403 или ГТ308В и амплитуду выходного напряжения дифференциального детектора ЧМС. Исэффициент амилитудной модуляции сигнала равен 0,5, а параметры детектора соот-

ветствуют примеру 2-28.

Для заданных транзисторов при типовых режимах в ограничителе амплитуды напряжение  $U_{\rm B}$  не превышает 0,1—0,2 В. Поэтому согласно табл. 2-19 можно считать пороговое напряжение равным 0,15 В. Амплитуда входного сигнала согласно неравенству (2-148)  $U_{m0\,{\rm BX}} \geqslant 0,15/(1-0,5)=0,3$  В. Положим напряжение на коллекторе транзистора равным 2 В. Тогда согласно табл. 2-19 амплитуду выходного напряжения ограничителя амплитуды можно считать  $U_{m0\,{\rm BbX}}=(0,25\div0,4)2=0,5\div0,8$  В. Для последующих расчетов возъмем меньшее значение 0,5 В. Оно и будет входиым для детектора ЧМС. Поскольку коэффициент передачи детектора, рассчитанного в примере 2-28, равен 0,015, то амплитуда выходного сигнала детектора  $U_{m\,\Omega}=U_{m\,{\rm BX}}K_{\rm A}=0,5\cdot0,015=0,0075$  В,

# 2-12. Особенности расчета структурной схемы комбинированных приемников АМС и ЧМС

Для расчета детекторов за общее исходное значение берут амплитуду входного сигнала первого каскада низкочастотного тракта,

Вначале рассчитываются структурные схемы радно- и пизкочастотных трактов по методикам § 2-1 — 2-5 и 2-7, После этого раздельно выбираются значения промежуточной частоты, твлы и количество селективных систем тракта промежуточной частоты для АМС и ЧМС. С целью исключения коммутации в тракте промежуточной частоты при переходе с одного сигнала на другой их число для ЧМС должно быть на единицу больше, чем для АМС, так как в комбинированных присмниках ПЧ для АМС при приеме ЧМС работает в режиме усиления напряжения промежуточной частоты. Число каскадов с селективными системами на обе промежуточные частоты будет одинаково, а остальные каскады могут быть резистивными.

Затем выбирается тип транзистора и количество необходимых каскадов из условия обеспечения необходимого усиления ЧМС, так как для него требуется более высокая промежуточная частота и устойчивый коэффициент усиления этих каскадов будет меньше, чем для АМС. Затем проверяется обеспечение нужного усиления с выбранным числом

каскадов при приеме АМС. Если проверка дает положительный результат, то число каскадов тракта промежуточной частоты считается окончательно выбраным. В противном случае добавляют соответствующее число резистивных каскадов.

Пример 2-31. Выбрать типы транзисторов и число каскадов в комбинированном тракте промежуточной частоты переносного приемника I класса для приема АМС и ЧМС. При приеме ЧМС радиотракт приемника соответствует варианту 3 (см. габл. 2-9), а для приема АМС — варианту 7 (см. табл. 2-11). Детектор АМС характеризуется данными примера 2-24, ограничитель амплитуды и детектор ЧМС — данными примеров 2-30 и 2-28.

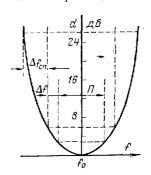


Рис. 2-17.

Тракт промежуточной частоты для приема АМС считаем соответствую-

шим варианту 2 (см. табл. 2-16).

Полоса пропускания высокочастотного тракта ЧМС выбрана в примере 2-6 равной 180 кГц, а промежуточная частота 8,4 МГц. Селективность тракта приема ЧМС определена ГОСТ усредненной крутизной спада боковых ветвей характеристики селективности 0,2 дБ/кГц в пределах ослаблений от 6 до 26 дБ. Спад кривой селективности между этими уровнями должен происходить в интервале частот  $\Delta f_{ extsf{c}_{11}} = 100$  к $\Gamma$ ц (рис. 2-17). Но в интервале ослаблений от 3 до 6 дБ крутизна спада кривой не задана. Если проанализировать кривые на рис. 2-14, то можно считать крутизну спада в этом интервале в 2—3 раза меньшей, чем в интервале ослаблений 6-26 дБ. Положим эту крутизну равной 0,08 дБ/кГц и получим интервал частот  $\Delta f = 3/0,08 = 37,5$  кГц. Согласно рис. 2-17 и формуле (2-111) ослаблению 26 дБ (20) будет соответствовать коэффициент прямоугольности  $K_{n20} = [\Pi + 2](\Delta f_{cn} +$  $+\Delta J)I/II = [180 + 2 (100 + 37,5)]/180 = 2,5$ . Анализ кривых на рис. 2-14 показывает, что  $K_{\rm n}$  можно получить при одном четырехконтурном ФСС или при трех парах связанных контуров. Эти системы целесообразно включать в первые каскады тракта ЧМС. В остальных каскадах тракта с селективными системами можно использовать одиночные контуры, как более простые в изготовлении и настройке. Основными селективными системами в тракте промежуточной частоты при приеме ЧМС выбираем три пары связанных контуров,

Согласио табл. 2-9 при варианте 3 для приема ЧМС входной сигнал преобразователя частоты равен 15 мкВ, а входной сигнал ограничнеля амплитуды на траизисторе ГТ308В из примера 2-30 должей быть больше 0,3 В. Минимальный коэффициент усиления тракта промежуточной частоты вычисляем по формуле (2-128), приняв коэффициент запаса усиления равным 3,  $K_{0\text{ пр}}=(3\text{-}0,3)/(15\text{-}10\text{-}6)=60000$ . Определим число каскадов при использовании траизисторов П403. Их параметры при  $I_{\mathrm{K}}=1$  мА и  $U_{\mathrm{K}9}=5$  В для частоты 8,4 МГц:  $Y_{21}=0,031$  См;  $C_{12}=7,5$  пФ;  $C_{22}=10$  пФ;  $g_{11}=0,0028$  См;  $C_{11}=117$  пФ;  $g_{22}=40$  мкСм. Вычислим по формуле (2-66)

$$K_{\rm 0ycr} = \sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.031}{6.28\cdot84\cdot10^{5}\cdot75\cdot10^{-13}}} = 3,96.$$
 Находим по формуле

$$\delta_9 = \frac{\Pi \psi_3 (n)}{f_{\rm np}}.$$
 (2-149)

113 табл. 2-12  $\psi_3$  (3) = 0,98. Следовательно,  $\delta_{0.\,\mathrm{чмc}} = \frac{0,18\cdot0,98}{8,4} \leqslant 0,021$ . Собственное затухание контуров положим равным 0,01. По формуле (2-86)  $K_{0\,\mathrm{max}} = \frac{0,5\cdot0,031}{V\,0,0028\cdot0,00004} \left(1-\frac{0,01}{0,021}\right) = 76$  и расчет ведем на устойчивый коэффициент усыления.

ведем на устойчивый коэффициент усиления.
При приеме ЧМС ПЧ тракта АМС работает как усилитель сигнала промежуточной частоты и формула (2-129) должна быть записана так:

$$K'_{0\pi p} = (0.25 \div 0.4) \frac{Y_{21\pi q}}{Y_{21\pi p}} \frac{Y_{21\pi q \cdot 3MC}}{Y_{21\pi p}} q^p K^{N_{np}+2}_{0ycr},$$
 (2-150)

где  $Y_{21~\mathrm{BH},\,\mathrm{amc}}$  — проводимость прямой передачи транзистора преобразователя частоты тракта АМС (ГТ308В). Число каскадов тракта промежуточной частоты определяется формулой

$$N_{\rm np} \ge \frac{\lg (2.5 \div 4) \frac{Y_{\rm 21np}}{q^{\rho} Y_{\rm 21nq}} \frac{Y_{\rm 21np}}{Y_{\rm 21nq.amc}} K'_{\rm 0np}}{\lg K_{\rm 0yer}} - 2.$$
 (2-151)

При выбранном транзисторе получим:

$$N_{\rm np} \ge \frac{\lg (2,5 \div 4) \frac{0.031}{0.035} \frac{0.031}{0.035} 60000}{\lg 3.96} - 2 = 6.5 \div 6.8.$$

Результаты аналогичных расчетов для других типов транзисторов приведены в табл. 2-20.

Для усилителя с ОБ устойчивый коэффициент усиления каскада определяется формулой (2-93). При транзисторе П403  $K_{\rm 0ycr.06} = \frac{2 \left(1-0.9\right) 0.031}{6.28 \cdot 84 \cdot 10^5 \cdot 10^{-11}} = 11.8$ . По уравнению (2-94) получаем  $g_{\rm BX.06} = 10.031 + 0.0028 = 0.0338$  См и из равенства (2-86) находим

$$K_{0 \text{ max}} = \frac{0.5 \cdot 0.031}{0.0338 \cdot 0.00004} \left( 1 - \frac{0.01}{0.021} \right) = 6.95.$$

В формулу (2-151) следует подставлять максимально достижимый коэффициент усиления. При этом получим  $N_{\rm up} \geqslant 4.1 \div 4.3$ . Результаты расчетов для других типов транзисторов приведены в табл. 2-20.

	Транзистор	11403	П416	ГТ310Б	ГТ308В	
C 09	Число каскадов	расчетное	6,5-6,8	6,36,6	5,1—5,4	2,9-3,1
		конструк- тивнос	7	7	6	3
СОБ	Число каскадов	расчетное	4,1-4,3	3,84,1	3,73,9	5,86,1
		конструк- тивное	5	4	4	6
Каскод- ная	Число каскадов	расчетное	2,8-3	2,62,8	3,13,3	1,6—1,7
		конструк- тивное	3	3	4	2

Использование каскадной схемы дает коэффициент устойчивого усиления каскада, равный коэффициенту усиления каскада с ОБ, и максимально осуществимый коэффициент усиления, равный такому же коэффициенту усиления каскада с ОЭ [3, 5]. Подставляя в формулу (2-151) меньшее из этих значений, получаем  $N_{\rm np} \geqslant 2,8 \div 3$ . Проанализируем данные табл. 2-20. Для рассмотренных типов

Проанализируем данные табл. 2-20. Для рассмотренных типов транзисторов (кроме ГТ308В) схема с ОБ обеспечивает необходимсе усиление при меньшем числе каскадов по сравнению со схемой с ОЭ, а для транзистора ГТ308В — наоборот. При использовании транзисторов П403, П416, ГТ310Б и ГТ308В необходимое усиление в тракте промежуточной частоты получается при наименьшем числе транзисторов соответственно 5, 4, 4 и 3. Каскодная схема требует большего числа транзисторов, чем лучшие варианты со схемами с ОБ или ОЭ.

Нз варианта 2 (см. табл. 2-16) следует, что для приема АМС при транзисторе ГТ308В в тракте промежуточной частоты требуются лишь два каскада, а при других рассмотренных типах транзисторов — три. Следовательно, транзистор ГТ308В обеспечивает необходимое усиление тракта промежуточной частоты при минимальном числе каскадов, поэтому целесообразно применять в комбинированном тракте промежуточной частоты для приема ЧМС и АМС транзисторы ГТ308В. Резонансное сопротивление колебательного контура определяется уравнением

 $R_{\rm op} = 1/(\delta_{\rm p}\omega_{\rm np}C_{\rm p}). \tag{2-152}$ 

Для получения оптимальных параметров контура его эквивалентная емкость должна выбираться из равенства

$$C_9 \approx 0.0003/f_{\rm up}$$
 (2-153)

Для тракта ЧМС получим  $C_{3,\text{чмс}} = 0,0003/8\,400\,000 = 36\cdot 10^{-12}\,$  Ф, что конструктивно осуществимо. По формуле (2-152) находим  $R_{\text{ра.чм}} = 1/(0,021\cdot 6,28\cdot 84\cdot 10^5\cdot 36\cdot 10^{-12}) = 24\,400\,$  Ом.

Сопротивление параллельного контура при расстройке определяется уравнением

 $R_{\xi} = R_{09}/(1 + \xi^2)^{0.5}. \tag{2-154}$ 

Обобщенную расстройку для промежуточной частоты АМС вычисляем по формуле (2-64)

$$\zeta_{\text{amc}} = \frac{1}{0,021} \left| \begin{array}{c} 8\,400\,000 - (8\,400\,000 - 465\,000) \\ \hline 8\,400\,000 \\ \hline - \, \frac{8\,400\,000}{8\,400\,000 - (8\,400\,000 - 465\,000)} \end{array} \right| = 860.$$

По равенству (2-154) получаем

$$R_7 = 24\,400/(1+860)^{0.5} = 28.4$$
 Om.

Эквивалентная емкость контуров промежуточной частоты АМС по формуле (2-153) будет  $C_{3.\,\mathrm{am}}=0.0003/465\,000=65\cdot10^{-11}$  Ф, что осуществимо. В тракте промежуточной частоты АМС всего одна пара связанных контуров при критической связи с полосой пропускания 12 кГц (см. пример 2-25). Из табл. 2-12 находим  $\psi_3$  (1) = 0,71 и по формуле (2-149) вычислим  $\delta_{3.\,\mathrm{am}}=12\,000\cdot0,71/465\,000=0,0184$ . Это конструктивно реализуемо. Из (2-152)  $R_{0.0}=1/(0,0184\cdot6,28\times 465\,000\cdot65\cdot10^{-11})=28\,500$  Ом. Из (2-64) вычисляем обобщенную расстройку для промежуточной частоты тракта ЧМС

$$\xi_{\text{ЧMC}} = \frac{1}{0.0184} \left| \frac{465\ 000 - (8\ 400\ 000 - 465\ 000)}{465\ 000} - \frac{465\ 000}{465\ 000 - (8\ 400\ 000 - 465\ 000)} \right| = 980.$$

По формуле (2-154) получаем  $R_{\rm T}=28\,500/(1+980^2)^{6.5}=29\,$  Ом. Сопротивление контура тракта AMC на промежуточной частоте тракта ЧМС составляет всего  $29/24\,400=0,0012$  резонаисного сопротивления контуров тракта ЧМС, а сопротивление контура тракта ЧМС на промежуточной частоте тракта АМС  $28,4/28\,500=0,001$  резонансного сопротивления контуров тракта АМС. При последовательном включении этих контуров в коллекторную цепь транзистора влияние контура тракта АМС на усиление каскада в тракте ЧМС и наоборот практически будет ничтожно малым. Следовательно, возможно построение комбинированного тракта промежуточной частоты без дополнительной коммутации контуров при переходе с приема АМС на ЧМС и обратно.

 $\Gamma$ лава третья

#### РАСЧЕТ ВЫХОДНОГО КАСКАДА

#### 3-1. Исходные данные и задачи расчета

Из общих характеристик приемника исходными данными для расчета выходного каскада являются низшая  $F_{\rm H}$  и высшая  $F_{\rm B}$  частоты модуляции принимаемых сигналов и напряжение источника питания  $E_{\rm 0}$ . В расчете структурной схемы низкочастотного тракта (см. § 2-3) определяются следующие исходные данные: номинальная выходная мощ-

ность  $P_{\mathrm{Bidx.H}}$ , сопротивление нагрузки  $R_{\mathrm{H}}$ , максимально допустимые коэффициенты гармоник  $k_{\mathrm{F}}$  и коэффициенты амилитудно-частотных искажений  $M_{\mathrm{H}}$  и  $M_{\mathrm{B}}$ . Кроме того, в расчете структурной схемы выбирается схема каскада, тип транзисторов, исходный режим их работы и определяются параметры входного сигнала ( $P_{\mathrm{EX}}, U_{m\,\mathrm{BX}}, I_{m\,\mathrm{EX}}$ ) и входное сопротивление каскада  $R_{\mathrm{RX}}$ .

В процессе расчета каскада необходимо выполнить конструктивный расчет выходного трансформатора; уточнить рабочий режим транзисторов и входные параметры каскада; рассчитать сопротивления резисторов и емкостей конденсаторов схемы и выбрать стандартные типы всех резисторов и конденсаторов; составить принципиальную схему каскада и спецификацию к ней.

### 3-2. Расчет однотактного трансформаторного каскада

1. Выбранный режим работы транзистора уточияется в том случае, когда коэффициент гармоник вычислялся без использования проходной характеристики. В этом случае, пользуясь входными и выходными характеристиками, необходимо построить проходную характери-

стику транзистора.

При налнчий семейства входных характеристик построение проходной достаточно подробно описано в [1, 4]. Однако в справочниках для маломощных транзисторов обычно приводят лишь две входные характеристики для напряжений  $U_{\rm K9}=0$  и типового значения этого напряжения (см. рис. 2-2, а). В этом случае с допустимым приближением проходную характеристику можно построить, пользуясь следующей методикой. Для одной из точек нагрузочной линии на семействе выходных характеристик определяют значение коллекторного и базового токов и коллекторного напряжения. Так, для точки  $\mathcal I$  нагрузочной линии 2 рис. 2-1  $I_{\rm K\mathcal I}=12$  мА,  $I_{\rm B\mathcal I}=165$  мкА и  $U_{\rm K9}=8,3$  В. По полученным параметрам переносят точку  $\mathcal I$  на входную характеристику, напряжение  $U_{\rm K9}$  для которой наиболее близко к рабочему напряжению, т. е. на характеристику с  $U_{\rm K9}=5$  В (см. рис. 2-2, а). Точка  $\mathcal I$  на рис. 2-2, а соответствует  $U_{\rm B9}=0,2$  В и  $I_{\rm B\mathcal I}=165$  мкА, Затем по формуле

 $U_{\rm nx} = U_{\rm BO} + I_{\rm B}R_{\rm c} \tag{3-1}$ 

вычисляют входное напряжение каскада с ОЭ, соответствующее коллекторному току рассматриваемой точки  $\mathcal{A}$ . В формуле  $R_c$  — сопротивление источника сигнала для каскада, в котором используется рассматриваемый транэистор. Нагрузочная линии 2 на рис. 2-1 соответствует примеру 2-3, в котором произведен расчет однотактного выходного каскада. В нем было принято  $R_c=1380$  Ом. Тогда по формуле (3-1) получаем  $U_{\mathrm{BX}\,\mathcal{A}}=0.2+0.000165\cdot1380=0.428$  В. Аналогичные расчеты для других точек нагрузочной линии дают значения  $U_{\mathrm{BX}\,\mathcal{B}}=1.26$  В ( $I_{\mathrm{K}\,\mathcal{B}}=41$  мА),  $U_{\mathrm{BX}\,\mathcal{F}}=0.92$  В ( $I_{\mathrm{K}\,\mathcal{F}}=31$  мА),  $U_{\mathrm{BX}\,\mathcal{A}}=0.64$  В ( $I_{\mathrm{K}\,\mathcal{A}}=21$  мА) и  $U_{\mathrm{BX}\,\mathcal{B}}=0.135$  В ( $I_{\mathrm{K}\,\mathcal{B}}=3$  мА). По полученным значениям строят проходную характеристику каскада в координатной системе (см. рис. 2-2,  $\delta$ ).

Амплитуда входного сигнала каскада определяется уравнением

$$U_{m_{\rm BX}} = 0.5 (U_{\rm BX B} - U_{\rm BX B}), \tag{3-2}$$

а соответствующее ей положение рабочей точки A' — входным напряжением

$$U_{\rm RY} A' = U_{\rm RY} R + U_{m \, RY}. \tag{3-3}$$

Для определения коэффициента гармоник методом пяти ординат по проходной характеристике определяют значения коллекторного тока  $I_1 - I_5$  для значений входного напряжения

$$\begin{array}{lll} U_{1}\!=\!U_{_{\rm BX}B}\!;\;U_{2}\!=\!U_{_{\rm BX}B}\!+\!0.5U_{_{m_{\,\rm BX}}}\!;\;\;U_{3}\!=\!U_{_{\rm BX}B}\!+\!U_{_{m_{\rm BX}}};\;\;&U_{4}\!=\!U_{_{\rm BX}B}\!+\!1.5U_{_{m_{\,\rm BX}}}\!,\;&U_{4}\!=\!U_{_{\rm BX}B}\!+\!2U_{_{m_{\,\rm BX}}}. \end{array} \eqno(3-4)$$

По полученным значениям токов вычисляют гармоники коллекторного тока, пользуясь формулами:

$$\begin{split} I_{m \, \text{K1}} = & \, 0.33 \, (I_5 + I_4 - I_2 - I_1); \quad I_{m \, \text{K2}} = 0.25 \, (I_5 + I_1) - 0.5I_3; \\ I_{m \, \text{K3}} = & \, 0.167 \, (I_5 - I_1) - 0.33 \, (I_4 - I_2); \\ I_{m \, \text{K4}} = & \, 0.083 \, (I_5 + I_1) - 0.33 \, (I_4 + I_2) + 0.5I_3. \end{split} \tag{3-5}$$

Пересчет режима работы каскада по выходной мощности не требуется, когда вычисленное по формуле (3-5) значение  $I_{m \, \mathrm{K} \, \mathrm{I}}$  отличается от значения, полученного в расчете структурной схемы приемника, не более чем на 5-10 %. Если отличие больше, то следует произвести пересчет, увеличивая входной сигнал транзистора при меньшем значении  $I_{m \times 1}$ , и наоборот.

Коэффициент гармоник вычисляют по последней формуле (2-19). Если он удовлетворяет допустимому значению, то режим работы транзистора не уточняют. Если же коэффициент гармоник окажется больше допустимого и отличается от значения, полученного в расчете эквивалентной схемы более чем на 5—10 %, то режим обратной связи пересчитывают в соответствии с методиками § 2-2.

Пример 3-1. Определить правильность предварительного расчета,

выполненного в примере 2-3.

Проходная характеристика транзистора, изображенная рис. 2-2, б, соответствует исходным данным примера 2-3. Вычисляем амплитуду входного сигнала по уравнению (3-2)  $U_{mix} = 0.5$  (1,26—  $0.135)=0.56~{\rm B}.$  Входное напряжение, соответствующее выбранной рабочей точке, определяем по равенству (3-3)  $U_{\rm BX}$  A'=0.135+0.56== 0,7 В. Пользуясь формулами (3-4), находим  $U_1=0,135$  В,  $U_2=0,485+0,5\cdot0,56=0,42$  В,  $U_3=0,135+0,56=0,7$  В,  $U_4=0,135+1,5\cdot0,56=0,97$  В,  $U_5=0,135+2\cdot0,56=1,26$  В. Этим напряжениям на характеристике (рис. 2-2, б) соответствуют токи:  $I_1 =$  $= 3 \text{ MA}, I_2 = 11.3 \text{ MA}, I_3 = 23.3 \text{ MA}, I_4 = 32.7 \text{ MA} \text{ M} I_5 = 41 \text{ MA}.$ По уравнениям (3-5) вычисляем гармоники коллекторного тока граизистора:  $I_{m,\mathrm{K},1}=(0.33(41+32.7-11.3-3)=19.8$  мА;  $I_{m,\mathrm{K},2}=$ =  $0.25(41 + 3) - 0.5 \cdot 23.3 = -0.65 \text{ mA}$ ;  $I_{m \text{ K} 3} = 0.167(41-3) -$ -0.33(32.7-11.3) = -0.79 MA;  $I_{mK.4} = 0.083(41+3) = 0.33(32.7+11.3)$ +11.3)  $+0.5\cdot23.3=0.65$  MA.

В примере 2-3 первая гармоника коллекторного тока была равна 19 мА, что отличается от более точного значения лишь на 4%. В примере 2-3 амплитуда входного сигнала каскада определена равной 0,61 В, что на 9 % больше точного значения. Поэтому выбор амплитуды

входного сигнала 0,56 В можно считать окончательным,

Вычисляем по последней формуле (2-19)

$$k_{\rm r} = \frac{\sqrt{0.65^2 + 0.79^2 + 0.65^2}}{19.8} = 0.061.$$

Это меньше допустимого и меньше, чем было получено в предварительном расчете каскада. Таким образом, пересчета исходного режима транзистора не требуется.

2. Расчет электрических характеристик выходного трансформатора начинают с определения допустимых активных сопротивлений его обмоток по формулам:

$$r_1 = \frac{R_{\kappa}}{2\eta_{\rm rp}} (1 - \eta_{\rm rp});$$
 (3-6)

$$r_2 = \frac{R_{\rm H}}{2\eta_{\rm TD}} (1 - \eta_{\rm TD}).$$
 (3-7)

Минимально допустимая индуктивность первичной обмотки трансформатора должна удовлетворять неравенству

$$L_{1} \ge \frac{R_{K} \eta_{TP} (R_{H} + r_{2})}{2 \pi F_{H} R_{H} V M_{H}^{2} - 1}$$
(3-8)

Допустимая индуктивность рассеяния определяется неравенством

$$L_s \leqslant \frac{(R_{22} + R_{\kappa}) \sqrt{M_{\text{B. Tp}}^2 - 1}}{2\pi F_n}.$$
 (3-9)

В приведенных формулах  $R_{\rm K}$  — сопротивление нагрузки транзистора, определяющееся наклоном нагрузочной линии на поле выходных характеристик (линия 2 на рис. 2-1);  $R_{\rm H}$  — нагрузочное сопротивление каскада (например, сопротивление громкоговорителя);

$$R_{22} = \Delta U_{\rm K} / \Delta I_{\rm K} \tag{3-10}$$

— выходное сопротивление транзистора каскада в исходной рабочей точке, определяемое наклоном выходной характеристики в рабочей точке;

$$M_{\rm B, Tp} = M_{\rm B, Bbb}/M_{\rm B, T}$$
 (3-11)

— коэффициент амплитудно-частотных искажений, допустимый для трансформатора на верхней частоте усиливаемого сигнала;  $M_{\rm B,\, BhX}$  — допустимый коэффициент амплитудно-частотных искажений каскада;  $M_{\rm B,\, T}$  — коэффициент амплитудно-частотных искажений, вносимый транзистором, определяющийся формулой (2-20).

Минимальный коэффициент рассеяния трансформатора

$$k_s = L_s/L_1$$
 (3-12)

при типовой конструкции составляет обычно 0,005—0,02. Если окажется, что он меньше, то следует взять его равным 0,01 и определить из уравнения (3-12) соответствующее ему минимально осуществимое значение  $L_s$ . Затем, взяв в (3-9) знак равенства, вычислить  $M_{\rm B, \, Tp}$ . После этого проверяют выполнение неравенства

$$M_{\rm B, BMX} \leq M_{\rm B, T} M_{\rm B, TD}.$$
 (3-13)

Если оно выполняется, то амплитудно-частотные искажения в каскаде будут менее допустимых. Если же неравенство (3-13) не выполняется, то по получившемуся  $M_{\rm B,BdX}$  следует уменьшить коэффициент амплитудио-частотных искажений  $M'_{\rm B,HY}$  для других каскадов низкочастотного тракта, пользуясь равенством

$$M'_{B_{BBMX}} = 0.5M_{B}/M_{B_{BBMX}}.$$
 (3-14)

Қозффициент трансформации выходного трансформатора определяется уравнением

 $n = \sqrt{\frac{R_{\rm ff}}{\eta_{\rm Tp}R_{\rm K}}}.$  (3-15)

Полные методики конструктивного расчета выходных трансформаторов достаточно подробно описаны в [1, 4, 12].

3. Расчет элементов схемы каскада при выбранных режиме работы транзистора и папряжении источника питания  $E_{\rm K0}$  наиболее удобно выполнять по следующей методике.

По формуле (3-6) вычисляют максимально допустимое сопротивление первичной обмотки выходного трансформатора и, пользуясь уравнением

$$U_1 = I_{K_0} r_1, \tag{3-16}$$

находят падение напряжения на первичной обмотке. Вычисляют напряжение на эмиттерном сопротивлении (см. рис. 2-3) по равенству

$$U_{R_a} = E_{K0} - U_1 - U_{K0}, \tag{3-17}$$

где  $U_{K0}$  — напряжение между коллектором и эмиттером транзистора в рабочей точке. Сопротивление эмиттерного резистора должно быть

$$R_{9} = \frac{U_{R_{9}}}{I_{K_{0}} + I_{B_{0}}}.$$
 (3-18)

Здесь  $I_{\rm K0}$  и  $I_{\rm B0}$  — коллекторный и базовый токи в рабочей точке. Емкость конденсатора, шунтирующего эмиттерный резистор, определяется перавенством

$$C_{\mathfrak{p}} \geqslant (10 \div 20)/(F_{\mathfrak{t}}R_{\mathfrak{p}}).$$
 (3-19)

При напряжении  $U_{{\sf E}{\sf B}{\sf O}{\sf D}}$  в рабочей точке напряжение на резисторе  $R_{\sf E}'$  должно удовлетворять уравнению

$$U_{R_{5}'} = U_{R_{9}} + U_{5 \ni 6}, \tag{3-20}$$

Ток через делитель напряжения из резисторов  $R_6'$  и  $R_6''$  выбирают из условия

$$I_n = (5 \div 10) I_{\text{Ba}}.$$
 (3-21)

Чем он больше, тем стабильнее режим работы каскада. Но с увеличением этого тока увеличивается мощность питания каскада и снижается его к. п. д. Сопротивление резисторов делителя напряжения определяется уравнениями:

$$R_6' = U_{R_6'}/I_{\mathfrak{n}};$$
 (3-22)

$$R_{6}'' = \frac{E_{80} - U_{R'6}}{I_{n} + I_{B9}}.$$
 (3 23)

Коэффициент нестабильности коллекторного тока вычисляется по формуле

$$\sigma = \frac{1 + R_{9}/R_{6}' + R_{9}/R_{6}''}{1 - \alpha_{0} + R_{9}/R_{6}' + R_{9}/R_{6}''}.$$
 (3.24)

Высокая стабильность работы каскада достигается при  $\sigma=2\div5$  и вполне удовлетворительная при  $\sigma=6\div12$ . При наличии сильной отрицательной обратной связи коэффициент нестабильности можно увеличивать на 40-60~%.

4. Расчет потребляемых каскадом тока и мощности от источников питания. Постояниая составляющая коллекторного тока транзистора в режиме класса А определяется уравнением

$$I_{K_0} = 0.167 (I_1 + I_5) + 0.33 (I_2 + I_4),$$
 (3-25)

а потребляемая мощность - равенством

$$P_0 = E_{K_0} (I_{K_0} + I_{v}). \tag{3-26}$$

Значения токов  $I_1 - I_5$  определяются по проходной характеристике транзистора, как описано рансе.

**Пример 3-2.** Вычислить электрические характеристики выходного трансформатора и элементов схемы для каскада, рассчитанного в примере 2-3, с учетом уточнений режима, проведенного в примере 3-1.

Максимально допустимые сопротивления обмоток согласно равенств

(3-6) и (3-7) будут 
$$r_1 = \frac{247}{2 \cdot 0.65}$$
 (1—0,65) = 66,5 Ом и  $r_2 = \frac{600}{2 \cdot 0.65}$  (1—

- 0,65) = 161 Ом. Минимальная индуктивность первичной обмотки определяется перавенством (3-8)  $L_1 \geqslant \frac{247 \cdot 0,65 \ (600+161)}{6,28 \cdot 300 \cdot 600 \ \sqrt{1,58^2-1}} =$ 

=  $0.087 \Gamma_{\rm H}$ .

Принимая равенство в формуле (3-13), получаем допустимое значение амплитудно-частотных искажений  $M_{\rm B,Tp}=1,58/1,015=1,56$ . По наклопу характеристики с  $I_{\rm B}=0,3$  мА (см. рис. 2-1), на которой выбрана рабочая точка транзистора, и формуле (3-10) находим  $R_{22}=(10-2)/(0,022-0,021)=8000$  Ом.

Допустимую индуктивность рассеяния трансформатора вычисляем по (3-9)

$$L_s \leqslant \frac{(8000 + 247)\sqrt{1,56^2 - 1}}{6,28 \cdot 3400} = 0,46 \text{ Гн.}$$

Допустимый коэффициент рассеяния согласно формуле (3-12)  $k_s = 0.46/0.087 = 5.3$  и значительно больше конструктивного. Поэтому трансформатор обеспечит амплитудно-частотные искажения на верхней частоте менее допустимых. Необходимое ограничение верхней граничной частоты может быть осуществлено за счет соответствующего выбора параметров цепочки регулятора тембра.

По равенству (3-25) находим  $I_{R0} = 0,167 (3+41) + 0,33 \times (11,3+32,7) = 22$  мА. Вычисляем падение напряжения на первичной обмотке трансформатора по равенству (3-16)  $U_1 = 0,22 \cdot 66,5 = 1,47$  В. Напряжение на эмиттерном резисторе находим из уравнения (3-17)  $U_{R_3} = 9 - 1,47 - 6 = 1,53$  В. Сопротивление эмиттерного резистора согласно формуле (3-18)  $R_3 = 1,53/(0,022+0,0003) = 68,5$  Ом. По табл. П-3-1 принимаем резистор 68 Ом. По неравенству (3-19) вы-

числяем емкость конденсатора  $C_* \geqslant \frac{10 \div 20}{200 \cdot 68} = 0{,}0008 \div 0{,}0016$  Ф.

По табл. П-3-2 принимаем емкость конденсатора 1000 мкФ. Согласно рис. 2-2, a для исходной рабочей точки транзистора A  $U_{\rm B9_0}=0.235$  В. Следовательно, напряжение на резисторе  $R_6'$  по уравнению (3-19) должно быть  $U_{R_6'}=1,53+0,235=1,765$  В. Положим в равенстве (3-21) численный коэффициент равным 7,5 и  $I_{\rm II}=7,5\cdot0,3=2,25$  мА. При этом по формулам (3-22) и (3-23) получим  $R_6'=1,765/0,00225=780$  Ом и  $R_6'=(9-1,765)/[(2,25+0,3)\cdot10^{-8}]=2840$  Ом. По

табл. П-3-1 принимаем  $R_6'=750$  Ом и  $R_6''=3$  кОм. Согласно уравнению (3-24)  $\sigma=(1+68/750+68/3000)/(1-9,985+68/750+68/3000)=8,7$ , что позволяет получить удовлетворительную стабилизацию коллекторного тока. Потребляемую от источника мощность вычисляем по формуле (3-26)  $P_0=9$  (0,022 + 0,00225) = 0,22 Вт. Коэффициент полезного действия каскада будет  $\eta_{\rm K}=0,028/0,22=0,13$ .

#### 8-3. Расчет двухтактного трансформаторного каскада

1. Режим работы транзисторов уточняется так же, как и для однотактного каскада с учетом особенностей работы двухтактного каскада. Кроме того, при использовании режима класса АВ входное сопротивление каскада (между базами транзисторов на рис. 2-7) в 4 раза больше входного сопротивления транзистора

$$R_{\text{BX. K}} = 4R_{\text{BX. T}} = 4U_{m \text{ B} \, \Im}/I_{m \, \text{B}}.$$
 (3-27)

Полное сопротивление нагрузки каскада, т. е. сопротивление между коллекторами транзисторов (см. рис. 2-7), также в 4 раза больше сопротивления, определяющегося нагрузочной линией для одного транзистора (линией 2 на рис. 2-4)

$$R_{\rm K}' = 4R_{\rm K} = 4U_{m\rm K}/I_{m\rm K}.$$
 (3-28)

Сопротивление нагрузки предыдущего каскада в 4 раза больше сопротивления источника сигнала для каждого транзистора, т. е.

$$\dot{R_{c. K}} = 4R_{c.} \tag{3-29}$$

где Rc определяется формулами (2-17) и (2-16).

2. Электрические характеристики выходного трансформатора вычисляются по формулам (3-6) — (3-15) с заменой в них  $R_{\rm K}$  на  $R_{\rm K}$ , определяющееся уравнением (3-28).

3. Расчет элементов схемы каскада применительно к рис. 2-7 выполняют по методике, описанной в п. 3 § 3-2. Но при этом следует учитывать, что по эмиттерному сопротивлению протекают эмиттерные и базовые токи обоих транзисторов. По этой же причине в формуле (3-21) следует удванвать численный коэффициент. Согласно рис. 2-7 постоянная составляющая тока каждого транзистора протекает по соответствующей половине первичной обмотки выходного трансформатора, Поэтому в формулу (3-16) следует подставлять половину сопротивления первичной обмотки трансформатора.

4. Постоянная составляющая коллекторного тока каждого транвистора для номинальной (т. е. максимальной) выходной мощности и соответствующая ей максимальная потребляемая от источника мощность вычисляется по уравнениям:

$$I'_{K0} = \frac{1}{\pi} \left[ I_{KB} + I_{KA} (\pi - 1) \right] + P_{0 max} = E_{K0} \left( 2I'_{K0} + I_{\pi} \right).$$
 (3-30)

В формулах (3-30) токи  $I_{K\mathcal{B}}$  и  $I_{K\mathcal{A}}$  определяются для точек  $\mathcal{B}$  и  $\mathcal{A}$ 

нагрузочной линии (см. рис. 2-4).

Согласно ГОСТ 5651—76 потребляемая приемником мощность оценивается для выходной мощности, равной 0,3 номинальной. Для этого определяется ток  $I_{KE}$ , соответствующий этой мощности. Поскольку при заданном нагрузочном сопротивлении мощность сигнала пропорциональна квадрату амплитуды тока, то можно считать  $I_{KE} \approx$ 

$$\approx \sqrt{0,3} I_{KB}$$
 и

$$I_{K_0} = \frac{1}{\pi} [I_{KE} + I_{KA} (\pi - 1)];$$
  

$$P_0 = 2E_{K_0} (2I_{K_0} + I_{\pi}).$$
 (3-31)

Пример 3-3. Уточнить режим работы транзисторов, а также рассчитать параметры выходного трансформатора и элементов схемы касмада по исходным данным примера 2-4.

Строим проходную динамическую характеристику гранзистора, пользуясь формулой (3-1). Для точки E (рис. 2-4) имеем  $I_{KE}=0.22$  А,  $I_{BE}=5$  мА. По рис. 2-5 для этой же точки определяем  $U_{BBE}=1.22$  В. В примере 2-4 сопротивление источника сигнала для одного транзистори

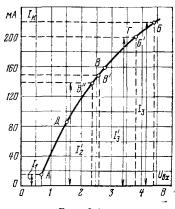


Рис. 3-1.

ра определено равным  $R_{\rm c}=648$  Ом. Подставляя полученные значения в формулу (3-1), получаем  $U_{\rm BX\,B}=1.22\pm0.005\cdot648=4.46$  В. Аналогичные расчеты для точек A,  $\mathcal{A}$ , B,  $\Gamma$  дают следующие результаты:  $U_{\rm BX\,A}=0.7$  В ( $I_{\rm K\,A}=15$  мА),  $U_{\rm BX\,B}=1.51$  В ( $I_{\rm K\,B}=85$  мА),  $U_{\rm BX\,B}=2.76$  В ( $I_{\rm K\,B}=157$  мА) и  $U_{\rm BX\,\Gamma}=3.77$  В ( $I_{\rm K\,\Gamma}=0.2$  А). На рис. 3-1 построена проходная характеристика при выбранном режиме работы.

Если полагать транзисторы каскада идентичными, то для транзистора второго плеча проходная характеристика будет такой же, но симметрично расположенной относительно отрицательных направлений осей (рис. 3-1), при этом точки A обеих ветвей должны быть совмещены с точкой A. Находят входное напряжение каскада и обозначают соответствующую ему на проходной характеристике точку B. В данном случае  $U_{m \text{ вх } B} = 0,5$  ( $U_{m \text{ вх } B} - U_{m \text{ вх } A}$ ) +  $U_{m \text{ вх } A} = 0,5$  (4,46-0,7) + 0,7=2,58 В.

Гармоники коллекторного тока транзисторов в рассматриваемом режиме работы рассчитываются по формулам [1]:

$$I_{m \text{ K}_1} = 0.667 (I_2 + I_3); \quad I_{m \text{ K}_2} = 0.04I_3; I_{m \text{K}_3} = 0.333I_3 - 0.667I_2; \quad I_{m \text{ K}_4} = 0.0134I_3 - 0.0536I_2.$$
 (3-32)

В данном случае  $I_1=15$  мА,  $I_2=143$  мА,  $I_3=220$  мА. Следо вательно,  $I_{m|K|1}=0.667~(143+220)=242$  мА. Первая гармоника мел лекторного тока оказалась на 18% больше значеняя, принятого в предварительном расчете каскада, что увеличит выходную мощность примерно на 30% против требуемой. Поэтому следует уменьшить амилитуду

входного сигнала примерно на 15 %.

Примем максимальное входное напряжение транзистора равным  $3,8 \; \mathrm{B} \;$  (точка  $\; \mathit{B'} \;$  на рис. 3-1), что соответствует амплитуде входного сигнала каскада 3,05 В. Тогда точка B' сместится в точку B'', при этом  $I_1=15$  мА,  $I_2=128$  мА и  $I_3=200$  мА. По формулам (3-32) вычисляем  $I_{m \ \mathrm{K}\, 1}=0,667$  (128 + 200) = 218 мА. Согласно рис. 2-4 при принятом интервале изменения коллекторного тока амплитуда изменения коллекторного напряжения по аналогии с формулой (2-34) будет  $U_{m,\mathrm{K}} =$  $=U_{K9A}-U_{K9B}=8,4-2,0=6,4$  В. Максимальная мощность сигнала в коллекторной цепи согласно формуле (2-10) будет  $P_{\kappa}=0.5 imes$  $\times$  6,4  $\cdot$ 0,218 = 0,695 Вт, что лишь на 4 % больше требуемой. Поэтому данный режим принимаем за окончательный. Согласно рис. 2-5 и формуле (2-34) амплитуда входного сигнала транзистора будет  $U_{m\,{
m B},9} =$ = 1,18 - 0,7 = 0,48 В. Коэффициент усиления напряжения сигнала транзистором вычисляем по формуле (2-36)  $K_r = 6.4/0.48 = 13.4$ . Высшие гармоники тока согласно равенств (3-32) будут:  $I_{m \text{ K2}} = 0.04 \times$  $\times$  200 = 8 мА;  $I_{m \text{ K}3}$  = 0,333 · 200 — 0,667 · 128 = — 18,7 мА; и  $I_{m \text{ K}4}$  = 0,0134 · 200 — 0,0536 · 128 = —4,2 мА. По последней формуле (2·19) вычисляем коэффициент гармоник  $k_r = \sqrt{8^2 + 18,7^2 + 4,2^2/2}$  18 = 0,095, чго больше допустимого. Поэтому необходимо ввести обратную связь и увеличить амплитуду входного сигнала в a = 0.095/0.056 = 1.69 раза. Следовательно, амплитуда входного сигнала должиа быть  $U_{m,\mathrm{BX},\mathrm{O},\mathrm{C}} =$  $= 1,69 \ U_{min} = 1,69 \cdot 3,05 = 5,15 \ B$ , что в 1,4 раза меньше, чем было получено в предварительном расчете, и позволяет соответственно уменьшить усиление предыдущих каскадов.

Вычисляем по уравнению (3-27) входное сопротивление оконечного каскада  $R_{\rm BX}=4\cdot 108=432$  Ом и по равенству (3-29) выходное сопротивление предоконечного каскада  $R_{\rm c}'=4\cdot 648=2592$  Ом. Полное нагрузочное сопротивление каскада находим по формуле (3-25)  $R_{\rm k}'=4\cdot 34,6=138,4$  Ом. Допустимое сопротивление обмоток выходного трансформатора вычисляем по (3-6)  $r_1=138,4\cdot (1-0,75)/(2\cdot 0,75)=23$  Ом и (3-7)  $r_2=6,5\cdot (1-0,75)/(2\cdot 0,75)=1,1$  Ом. Индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора согласно неравенству

(3-8)

$$L_1 \geqslant \frac{138,4 \cdot 0,75 \cdot (6,5+1,1)}{6,28 \cdot 150 \cdot 6,5 \cdot V} = 0,12 \, \Gamma$$
н.

Пользуясь формулой (3-10), вычисляем выходное сопротивление транзистора в рабочей точке A (рис. 2-4)  $R_{22}=(16-4)/(0.02-0.01)==1200$  Ом. По уравнению (3-11) находим коэффициент амплитудночастотных искажений трансформатора  $M_{\rm B,\,Tp}=1.5/1.29=1.16$ . Максимально допустимую индуктивность рассеяния трансформатора вычисляем по (3-9)

 $L_s \leqslant \frac{(1200+138,4)}{6,28\cdot 12\ 000}\ V \overline{1,16^2-1} = 0.01\ \Gamma_{\rm H}.$ 

Допустимый коэффициент рассеяния находим по формуле (3-12)  $k_s = 0.01/0.12 = 0.083$ , что больше конструктивно осуществимого.

Примем его равным 0,01 и по уравнению (3-12) получим  $L_s=0,01\times 0,12=0,0012$  Гн. Из равенства (3-9) допустимой индуктивности рассеяния соответствует  $M_{\rm B.\ Tp}=V$  (6,28 · 12 000 · 0,0012/1200 + 138,4)² + 1 = 1,0023, а коэффициент амплитудно-частотных искажений каскада вычисляем по формуле (3-11)  $M_{\rm B.\ BMX}=1,0023\cdot 1,29=1,29$ . Максимальную постоянную составляющую коллекторного тока каждого транзистора вычисляем по (3-30)  $I_{\rm KO}=1/3,14$  [200 + 15 (3,14 - 1)] = 74 мА. Подставляя в (3-30) соответственно токи базы  $I_{\rm BB}=4$  мА и  $I_{\rm BA}=0$ , получаем  $I_{\rm BO}=1/3,14$  [4 + 0 (3,14 - 1)] = 1,27 мА.

Падение напряжения на первичной обмотке трансформатора с учетом сказанного ранее вычисляем по (3-16)  $U_1=0.074\times0.5\cdot23=0.85$  В. Напряжение на эмиттерном резисторе вычисляем по (3-17)  $U_{R_9}=12-0.85-9=2.15$  В. Сопротивление эмиттерного резистора вычисляем по уравнению (3-18), удваивая значения коллекторного и базового токов  $R_9=2.15/[2~(0.074+0.00127)]=14.3$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 15 Ом. Емкость конденсатора, шунтирующего эмиттерный резистор, находим по (3-19)  $C_9 \ge 10 \div 20/(150\cdot15)=0.0044 \div 0.0088$  Ф. По табл. П-3-2 выбираем электролитический конденсатор емкостью 5000 мкФ.

В рабочей точке A напряжение  $U_{B\mathcal{I}}=0.7$  В. По равенству (3-20) находим напряжение на резисторе  $R_6/U_{R6}=2.15+0.7=2.85$  В. Ток потенциометра питания базы вычисляем по формуле (3-21)  $I_{\pi}=-7.5\cdot 1.27=9.6$  мА. По уравнению (3-22) находим сопротивление резистора  $R_6'=2.85/0.096=300$  Ом. Удваивая значение базового тока, по формуле (3-23) вычисляем сопротивление резистора  $R_6'=-(12-2.85)/[(9.6+2\cdot 1.2)\ 10^{-3}]=760$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резисторы сопротивлением 300 и 750 Ом. Коэффициент нестабильности коллекторного тока по формуле (3-24)

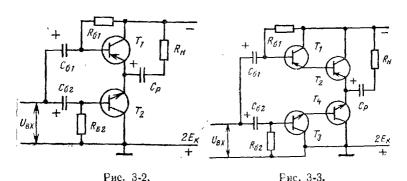
$$\sigma = \frac{1 + 15/300 + 15/750}{1 - 0.985 + 15/300 + 15/750} = 12,6,$$

что удовлетворительно при наличии сильной отрицательной обратной связи в каскаде.

По формуле (2-24) вычисляем коэффициент обратной связи  $\varepsilon=(1,69-1)/13,4=0,0515$ . По равенству (2-25) находим входную проводимость каскада  $G_{\rm BX}\approx 1/108+1/300+1/750=0,0139$  См. ( $R'_{\rm BX}=1/0,0139=77,5$  См). Согласно рис. 2-7 цень обратной связи подключена к первичной обмогке выходного трансформатора. Поэтому, полагая в уравнении (2-26) n=1, получаем  $R_{\rm O,c}=(1-0,0515)/(0,0515\times 0,0139)=1320$  См. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 1,3 кОм. При этом неравенство (2-27) выполняется  $1300 \ge 10/(0,0139)=775$ . Емкость разделительного конденсатора вычисляем по (3-19), заменяя в нем  $C_3$  на  $C_6$  и  $R_3$  на  $R_{\rm O,c}$ . В нашем случае  $C_6 \ge (10-20)/(150\cdot1300)=(52-104)\cdot 10^{-6}$  Ф. По табл. П-3-2 выбираем электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ. Максимальную потребляемую каскадом мощность вычисляем по второй формуле (3-30),  $P_{\rm Omax}=12$  (2-0,071+0,0096)=1,88 Вт. Коэффициент полезного действия каскада  $\eta_{\rm K}=1/1,88=0,53$ . По первому уравнению (3-31) находим ток  $I_{\rm KE} \approx \sqrt{0,3}\cdot 200=109$  мА, а по второму и третьему получаем  $I_{\rm KO}=1/3,14\cdot[109+15(3,14-1)]=45$  мА,  $P_0=12$  (2×  $\times$  0,045+0,0096)=1,19 Вг.

#### 3-4. Бестрансформаторные двухтактные каскады

Бестрансформаторные двухтактные каскады с транзисторами, имеющими различную проводимость переходов в каждом плече, облад, ют двумя существенными преимуществами. Они работают без выходного трансформатора, а их предокопечный каскад должен иметь один выход (рис. 3-2), а не два биполярных, как в каскаде с транзисторами с одинаковой проводимостью переходов. Но в таком каскаде напряжение источника питания должно быть вдвое больше. Для обеспечения малых пелинейных искажений оба транзистора должны иметь мало различающеся характеристики (не более чем на 5—7 %). Это в значительной степени затрудняет выбор пригодных транзисторов. Кроме того, транзисторы должны иметь достаточно большой максимальный коллек-



торный ток, так как наклон нагрузочной линии 2 на поле выходных характеристик (см. рис. 2-4) определяется непосредственно сопротивлением громкоговорителя, которое обычно не превышает 6—10 Ом. Если использовать транзистор ГТ403Б без охлаждающего радиатора, то при ваибольшем возможном  $E_{\rm K}$  с необходимым наклоном нагрузочную линию 3 можно провести при  $E_{\rm K}=4$  В. При этом максимальный коллекторный ток и амплитуда его переменной составляющей будут 0,45 A, а амплитуда переменного напряжения 3 В. Следовательно, согласно формуле (2-10) максимальная мощность сигнала в коллекторной цепи получается  $P_{\rm Kmax}=0.5\cdot3\cdot0.45=0.67$  Вт, что соответствует данным примера 2-4. Но для достижения этой мощности потребуется максимальный базовый ток 13 мА, что в 3 раза больше, чем в трансформаторном каскаде. Во столько же раз примерно потребуется большее входное напряжение, а значит, и усиление в предыдущих каскадах.

Методика расчета такого каскада практически соответствует приведенной в § 3-3, за исключением выбора элементов схемы питания. Наиболее эффективно работают такие выходные каскады при использовании в каждом плече по два транзистора (рис. 3-3). Здесь транзисторы  $T_1 - T_2$  и  $T_3 - T_4$  образуют как бы составиме (сдвоенные) транзисторы для каждого влеча. Методики расчета подобных каскадов подробно описаны в  $\{1,29\}$ .

### РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ТРАКТА

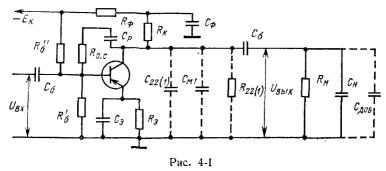
#### 4-1. Исходные данные и задачи расчета

Для расчета усилителей напряжения низкочастотного тракта исходными данными из общих характеристик приемника являются низшая  $F_{\rm H}$  и высшая  $F_{\rm B}$  частоты модуляции принимаемых сигналов и напряжение источника питания  $E_{\rm O}$ .

Из расчета структурной схемы низкочастотного тракта приемника принимаются во внимание такие исходные данные: номицальная выходная мощность  $P_{\mathrm{Botx,H}}$  или напряжение  $U_{\mathrm{Botx,H}}$ ; сопротивление нагрузки  $R_{\mathrm{H}}$  (равное сопротивлению источника сигнала носледующего каскада); максимально допустимые коэффициенты гармоник  $k_{\mathrm{I}}$  и амплитудночастотных искажений  $M_{\mathrm{II}}$  и  $M_{\mathrm{II}}$ ; коэффициент усиления каскада по напряжению  $K_{\mathrm{O}}$ . Кроме того, при расчете структурной схемы выбирается тип транзистора и ориентировочный режим его работы. При расчете каскада следует уточнить режим работы транзистора, опредслить параметры всех элементов схемы и выбрать стандартные типы всех резисторов и конденсаторов и составить полную принципиальную схему каскада и спецификацию к ней.

#### 4-2. Расчет резистивного каскада с общим эмиттером

Типовая схема резистивного каскада с ОЭ показана на рис. 4-1. Здесь резистор  $R_{\rm H}$  и кондепсатор  $C_{\rm H}$  являются эквивалентом входа следующего каскада или нагрузки каскада (потребителя выходного



сигнала), если последующего каскада нет. Когда нагрузкой является вход следующего каскада, то его параметры определяются равенствами:

$$1/R_{\rm H} = 1/R_{\rm 6}' + 1/R_{\rm 6}'' + 1/R_{\rm BX2} = g_{\rm H}; \quad C_{\rm H} = C_{\rm BX2} + C_{\rm M2}.$$
 (4-1)

Здесь индексом 2 обозначены параметры следующего каскада, а  $C_{\rm M2}$  — монтажная емкость, относящаяся ко входу следующего каскада. Из расчета структурной схемы низкочастотного тракта известно сопро-

тивление источника сигнала  $R_{
m c}$  следующего каскада. Этим сопротивле $m{\cdot}$ 

нием в схеме должен служить резистор  $R_{\rm K}=R_{\rm C}$ . Штриховыми линиями на рис. 4-1 ноказаны  $C_{\rm BMX,1}=C_{\rm 22}-$  выходная емкость,  $C_{\rm M1}$  — монтажная емкость схемы и  $R_{221}$  — выходное сопротивление, относящееся к коллекторной цепи траизистора какада. Обозначим:

$$C_{22} + C_{M1} = C_{31}$$
 is  $1/R_K + 1/R_{22}$  (1) =  $1/R_V = g_V$ . (4-2)

На средних частотах рабочего интервала частот усилителя шунтирующее действие емкостей  $C_{\mathbf{u}}$  и  $C_{\mathbf{x}}$  на резисторы  $R_{\mathbf{u}}$  и  $R_{\mathbf{x}}'$  обычно бывает малым, а сопротивление разделительного конденсатора С6 благодаря большой его емкости значительно меньше сопротивления резистора  $R_{\rm H}$ . Поэтому на средних частотах коэффициент усиления каскада определяется равенством

$$K_{0 \text{ cp}} \approx |Y_{21}|_1/G_{9K}, \tag{4-3}$$

в котором

$$G_{9K} = 1/R_K' + 1/R_H = 1/R_{22} + 1/R_K + 1/R_{BX2} + 1/R_6' + 1/R_6''$$
 (4-4)

 эквивалентная активная проводимость нагрузки каскада. Суммарная емкость

$$C_{\text{BMX 1}} + C_{\text{M1}} + C_{\text{HX 2}} + C_{\text{HX 2}} + C_{\text{HX 2}} = C_{\text{HX}} \tag{4-5}$$

является эквивалентной емкостью каскада.

Коэффициент амплитудно-частотных искажений каскада на верхней частоте определяется равенством

$$M_{\rm B. K} = M_{\rm B. T} \sqrt{1 + (2\pi F_{\rm B} C_{\rm 9K} R_{\rm 9K})^2},$$
 (4-6)

в котором  $M_{\rm B,T}$  вычисляется по уравнению (2-20).

Емкость разделительного конденсатора должна удовлетворять неравеиству

$$C_6 \geqslant \frac{1}{2\pi F_{\rm H}(R_{\rm K}' + R_{\rm H}) \sqrt{M_{\rm H}^2 - 1}}$$
 (4-7)

Если число каскадов низкочастотного тракта более трех, то в первых каскадах (кроме последних двух) питание коллекторной цепи необходимо производить через развязывающий фильтр  $R_{\Phi}C_{\Phi}$  (см. рис. 4-1). Сопротивление резистора фильтра следует брать по условию

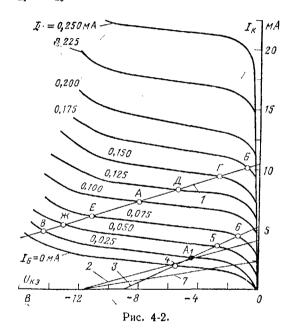
$$R_{\Phi} \approx (0.1 \div 0.2) R_{\text{K}}, \tag{4-8}$$

 $^{
m B}$ о чтобы падение напряжения на нем не превышало 1-1,5  $^{
m B}$ . Емкость конденсатора фильтра вычисляют по неравенству (3-19), заменяя в нем  $C_{\mathfrak{I}}$  на  $C_{\mathfrak{I}}$  и  $R_{\mathfrak{I}}$  на  $R_{\mathfrak{I}}$ .

Элементы схемы питания транзистора вычисляются по формуламп. 3 § 3-2. При этом в формулу (3-16) вместо  $r_1$  подставляют  $R_{\kappa}+R_{\Phi}=$  $=R_{\kappa}^{"}$ . Цепь  $R_{
m o.\,c}, C_{
m p}$  служит для создания отрицательной обратной связи, снижающей пелинейные искажения сигнала.

Пример 4-1. Рассчитать резистивный каскад по следующим исходным данным: транзистор МП41А; низшая частота 150 Гц; высшая частота 12 000 Гц; коэффициент гармоник 0,01; коэффициенты амплитудночастотных искажений  $M_{\rm B.\,K}=1,15$  и  $M_{\rm H.\,K}=1,11$ ; амплитуда выходного напряжения 0,29 В; напряжение источника питания 12 В; сопротивление нагрузочного резистора 2,4 кОм. Эти исходные данные сформулированы на основе примеров (4-3) и (2-5). Предполагается, что рассчитываемый каскад находится в низкочастотном тракте переносного приемника 1 класса и стоит перед каскадом, рассчитанным в примере 4-3.

Сопротивления резисторов базового делителя напряжения в каскаде, рассчитанном в примере 4-3,  $R_6'=2.4$  кОм и  $R_6''=11$  кОм. Входное сопротивление транзистора следующего каскада в рабочей точке 400 Ом, входная емкость 20 000 пФ. Монтажные емкости будем считать равными  $C_{\text{M1}}=C_{\text{M2}}=10$  пФ.



По равенствам (4-1) находим  $1/R_{\rm H}=1/2400+1/11~000+1/400=0,003$  См и  $R_{\rm H}=333$  Ом;  $C_{\rm H}=20~000+10=20~010$  пФ. Поскольку рассчитываемый каскад является третьим от выхода

Поскольку рассчитываемый каскад является третьим от выхода низкочастотного тракта приемника, то в коллекториую цепь включаем развязывающий фильтр. Сопротивление его резистора согласно равенству (4-8)  $R_{\Phi}=(0,1\div0,2)$  2400 = 240 — 480 Ом. Из табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивленнем 300 Ом. При этом резистивное сопротивление в коллекторной цепи будет  $R_{\kappa}^{'}=R_{\kappa}+R_{\Phi}=2400+300=$  = 2700 Ом. На выходных характеристиках транзистора (рис. 4-2) проводим нагрузочную линию 2 для постоянного тока из точки на оси абецисе с  $U_{K,9}=12$  В под углом, соответствующим сопротивлению 2700 Ом. Амплитуда выходного напряжения каскада сравнительно мала (0,29 В). Поэтому выбираем рабочую точку  $A_{\rm f}$ , для которой  $I_{K,0}=$  = 2,75 мA,  $U_{K,9}=4$ ,15 В;  $I_{\rm B0}=25$  мкА и  $U_{\rm B,9}=0$ ,155 В. Для умень-

пення мощности питания каскада се следует брать при возможно меньшем токе коллектора.

Проводим через рабочую точку нагрузочную линию 3, соответствующую сопротивлению  $R_{\rm K}'$  из второго уравнения (4-2). По формуле (3-10) вычисляем выходное сопротивление транзистора в рабочей точке  $R_{22}=$  =  $(12-2)\cdot[(3,9-2,4)\cdot0,001]=6700$  Ом. Следовательно,  $R_{\rm K}'=2460\times6700$ , (2400+6700)=1765 Ом.

Строим проходную характеристику транзистора, соответствующую нагрузочной линии 3. Входное сопротивление транзистора для рабочей точки  $A_1$  определяем по наклону касательной I к входной характеристике (см. рис. 2-2, a) в точке с токм  $I_{\rm B}=25$  мкА. Оно равно  $R_{\rm BX}=(0,3-0,13).[(0,25-0)~0,001]=680$  Ом. По формуле (2-17) вычисляем сопротивление источника сигнала для рассчитываемого каскада  $R_{\rm C}=6.680=4080$  Ом. Пз табл. П-3-1 принимаем резистор сопротивлением 4,3 кОм. Для точки 6 на рис. 2-2, a определяем  $U_{\rm B>0}=-0,175$  В

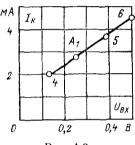


Рис. 4-3.

и из рис. 4-2  $I_{\rm K6}=4,5$  мА. Тогда по уравнению (3-1) находим  $U_{\rm BX}=0,175+75\cdot10^{-6}\cdot4300=0,5$  В. Аналогичные расчеты для точек  $5,\ A_1$  и 4 дают следующие результаты:  $I_{\rm K5}=3,62$  мА;  $U_{\rm BX}=0,38$  В;  $I_{\rm KA1}=2,75$  мА;  $U_{\rm BX}=0,38$  В;  $I_{\rm KA1}=2,75$  мА;  $U_{\rm BX}=0,38$  В;  $I_{\rm KA}=0,135$  В. По полученным данным на рис. 4-3 построена проходная характеристика,

Для создания необходимого выходного напряжения каскада амплитуда первой гармоники коллекторного тока должна быть  $I_{mK1}=0.29/1765=$ 

= 0,000165 А. При столь малых отклонениях тока от точки  $A_1$  рабочий интервал входиых напряжений также будет малым и трудно с достаточной точностью определить пять значений напряжений и токов для вычисления гармоник коллекторного тока. Поэтому возьмем на характеристике участок между точками 4 и 5, равноудаленными от точки  $A_1$  по оси входного напряжения. При этом за счет использования большего участка проходной характеристики влияние криволинейности даст большой коэффициент гармоник. Но это можно учесть с изисстным приближением. Для принятых условий пять токов для расчета гармоник коллекторного тока будут:  $I_1 = 2$  мА;  $I_2 = 2$ ,3 мА;  $I_3 = 2$ ,75 мА;  $I_4 = 3$ ,2 мА и  $I_5 = 3$ ,6 мА. Согласно формулам (3-5) получим  $I_{mK1} = 0$ ,33 (3,6 + 3,2 - 2,3 - 2) = 0,833 мА;  $I_{mK2} = 0$ ,25 (3,6 + 2) — 0,5 · 2,75 = 0,025 мА;  $I_{mK3} = 0$ ,167 · (3,6 - 2) — 0,33 (3,2 - 2,3) = —0,032 мА и  $I_{mK4} = 0$ ,083 (3,6 + 2) — 0,33 (3,2 + 2,3) + 0,5 × 2,75 = 0,005 мА.

Входное напряжение каскада при рассмотренных условиях согласно рис. 4-3 будет  $U_{m\,\mathrm{BX}}=0.5$  ( $U_{\mathrm{HX5}}-U_{\mathrm{BX4}})=0.5$  (0.38-0.135) = 0.12B. При этих же условиях из рис. 4-3 и 2-2, а находим  $U_{m\,\mathrm{BS}}=0.5$  (0.175-0.135) = 0.02 В. Амплитуда напряжения на выходе получится  $U_{m\,\mathrm{BMX}}=0.000833\cdot1765=1.47$  В, что в 1.47/0.29 = 5 раз больше требуемого. Для нормального режима работы каскада следует во стол ко же раз уменьшить входное напряжение, т. е. оно должно быть  $U_{m\,\mathrm{FX}}=0.000833\cdot1765=0.000833$ 

t=0.12/5=0.024 В. Аналогично  $t_{m\, 5.9}=0.02/5=0.004$  В. По послед ней формуле (2-19) находим  $t_{\rm r}=\sqrt{0.025^2+0.032^2+0.005^2}/0.833=0.05$ . Данные опыта показывают, что при коэффициентах гармоник менее 0.05 уменьшение амплитуды входного сигнала в t=0.05 уменьшеет коэффициент гармоник примерно во столько же раз [1]. Следовательно, можно считать для нормального входного сигнала каскада t=0.05/5=0.01 и в применении отрицательной обратной связи нет необходимости.

Рассчитаем элементы схемы каскада. Подставляя в равенство (3-16)  $R_{\rm K}+R_{\rm \Phi}$  вместо  $r_1$ , получаем  $U_1=0,00275$  (2400  $\div$  300) = 7,4 В. Из уравнения (3-17) получаем  $U_{R_3}=12-7,4-4,15=0,45$  В. По формуле (3-18) вычисляем  $R_3=0,45$  [(2,75  $\div$  0,025) 0,001] = 162 Ом. По табл. II-3-1 выбираем резистор сопротивлением 160 Ом. Из неравенства (3-19) получаем  $C_3 \geqslant (10 \div 20)$  (150-160) = (42 - 84)  $10^{-5}$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем электролитический кондецсатор емкость ю 1000 мкФ. Аналогично емкость кондецсатора фильтра  $C_{\Phi} \geqslant (10 \div 20)/(150 \cdot 300) = (2 \div 4) 10^{-4}$  Ф. Из табл. П-3-2 выбираем электролитический конденсатор емкостью сличический конденсатор емкостью 200 мкФ.

Пользуясь уравнением (3-20), вычисляем  $U_{R_s'} = 0.45 + 0.155 =$ 

= 0,605 В. При численном коэффициенте 8 из формулы (3-2) находим ток потенциометра питания базы  $I_n'=8\cdot25\cdot10^{-6}=0,0002$  А. По формулам (3-22) и (3-23) определяем  $R_6'=0,605/0,0002=3030$  Ом и  $R_6''=(12-0,605)/((200+25)\cdot10^{-6}=_{n}50\cdot000$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резисторы сопротивлением 3 и 51 кОм. Коэффициент нестабильности коллекторного тока вычисляем по уравнению (3-24)  $\sigma=1+160/3000+160/51000$ 

 $=\frac{1+100/3000+100/31000}{1+0.985+160/3000+160/51000}=14,8$ , что удовлетворительно.

Потребляемый каскалом ток  $I_0 = I_{\rm K0} + I_{\rm n} = 2,75 + 0,2 = 2,95$  мА.

Коэффициент усиления каскада будет  $K_0=0.29/0.024=12$ . По уравнению (4-5) вычисляем  $C_{3\mathrm{K}}=400+10+20\ 000+10=20\ 420\ пФ$ . Из равенства (4-4) находим  $G_{3\mathrm{K}}=1/1765+1/333=$ 

= 20 420 пФ. Из равенства (4-4) находим  $G_{\rm SK}=1/1765+1/333=0,0036$  См и  $R_{\rm DK}=1/0,0036=280$  Ом. По равенству (4-6) получаем коэффициент амплитудно-частотных искажений каскада  $M_{\rm B.K}=1,04$   $\sqrt{1+(6,28\cdot12\ 000\cdot2042\cdot10^{-11}\cdot280)^3}=1,14$ , что на 1 % меньше допустимого для каскада.

Емкость разделительного конденсатора вычисляем по неравенству

(4-7) 
$$C_6 \gg \frac{1}{6,28 \cdot 150 (1765 + 333) \sqrt{1,11^2 - 1}} = 105 \cdot 10^{-8} \Phi.$$

Из табл. П-3-2 выбираем кондепсатор емкостью 1,5 мкФ.

#### 4-3. Расчет резистивного каскада с общим коллектором

Резистивные каскады с ОК обладают малыми входными проводимостью и емкостью, а также низким выходным сопротивлением. Благодаря этому их используют как согласующий каскад, например, между диодным детектором и первым транзисторным каскадом низкочастотного тракта. Это позволяет увеличивать сопротивление нагрузочного резистора детектора, что повышает его коэффициент передачи и входние сопротивление. Схема каскада изображена на рис. 4-4. Сопротивление нагрузочного резистора в цепи эмиттера обычно выбирают по формуле (2-72). Коэффициент усиления каскада по напряжению всегда меньше единицы и определяется уравнением (2-73), его входные проводимость и емкость вычисляются по (2-74). В этих формулах индексом 1 обозначены параметры транзистора рассматриваемого каскада, а индексом 2 — следующего.

Сопротивление базового резистора определяют по уравнению

$$R_6 = (E_{K_0} - I_{K_0} R_9 - U_{E_9}) / I_E. \tag{4-9}$$

Пример 4-2. Определить характеристики и параметры схемы каскада с ОК на транзисторе МП41А, за которым должен следовать каскад,

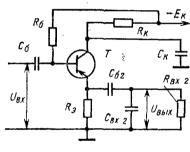


Рис. 4-4.

рассчитанный в примере 4-1. Необходимые исходные данные аналогичны примеру 4-1.

Режим работы транзистора по постоянному току принимаем таким же, как в примере 4-1 ( $I_{K0}=2.75$  мА,  $I_{B}=2.5$  мкА,  $U_{K9}=4.15$  В). Для этого полное резистивное сопротивление, включенное последовательно в коллекториую цепь транзистора, должно быть равно  $R_{K}^{*}=2700$  Ом. Для рабочей точки  $A_{1}$  (рис. 4-2) отношение приращений

 $\Delta I_{\rm K}/\Delta I_{\rm B}=(I_{\rm K5}-I_{\rm K4})/(0,00005)=[(3,62-2)]$  Ополителна приравления рис. 2-2, а для этой же рабочей точки по углу наклона касательной I находим  $\Delta I_{\rm B}/\Delta U_{\rm B9}=0,00025/(0,3-0,135)=0,0015$  См. Следовательно, проводимость прямой передачи транзистора в рабочей точке будег  $Y_{21}=\frac{\Delta I_{\rm K}}{\Delta U_{\rm B9}}=\frac{\Delta I_{\rm K}}{\Delta U_{\rm B9}}=\frac{\Delta I_{\rm K}}{\Delta U_{\rm B9}}=32\cdot0,0015=0,048$  См. По уравнению (2-71) получаем  $R_{\rm DK}=(10\div20)/0,048=210\div420$  Ом. Нз табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 300 Ом. При этом сопротивление

(2-71) получаем  $R_{\rm DK}=(10\div20)/0,048=210\div420$  Ом. Из табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 300 Ом. При этом сопротивление резистора в коллекторной цепи должно быть  $R_{\rm K}=R_{\rm K}''-R_{\rm 9K}=2700-300=2400$  Ом. По табл. П-3-1 принимаем резистор сопротивлением 2.4 кОм. Из равенства (2-73) находим коэффициент передачи каскада  $K_{\rm DK}=(0.048\pm0.0015)/(0.048\pm0.0015+0.0033\pm0.0018)=0.91.$  По формулам (2-74) вычисляем  $g_{\rm 11K}=0.0015(1-0.91)=0.000135$  См ( $R_{\rm BX,K}=7350$  Ом) и  $C_{\rm BX,K}=20$  000 (1-0.91)= 1800 пФ.

Заменяя в уравнении (3-19)  $C_0$  на  $C_{\rm K}$  и  $R_0$  на  $R_{\rm K}$ , получаем  $C_{\rm K} \ge (10 + 20)/(150 \cdot 2400) = (28 \div 50) 10^{-6}$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 33 мкФ. Пользуясь уравнением (4-9), находим  $R_6 = (12 - 0.00275 \cdot 300 - 0.155)/0.000025 = 440 000$  Ом. Из табл. П-3-1

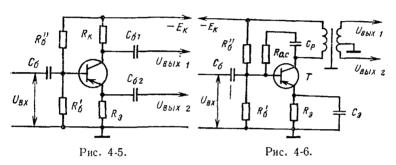
берем резистор сопрогивлением 430 кОм.

#### 4-4. Расчет фазоинверсных каскадов

Фазоинверсные каскады могут быть резистивиыми (рис. 4-5) и

трансформаторными (рис. 4-6).

1. В резистивном каскаде из-за сильной отрицательной обратной связи за счет эмиттерного резистора коэффициент усиления каскада по напряжению меньше единицы, что является большим недостатком и ограничивает его применение в приемниках. Чтобы выходные напряжения были равны по амплитуде, для сопротивлений резисторов должно выполняться равенство  $R_{\rm K}=R_{\rm 3}$ . Кроме того, сопротивление этих резисторов должно равняться сопротивлению источника сигнала  $R_{\rm c}$ , принятому в расчете выходного каскада для каждого транзистора. В первом приближении расчет параметров каскада выполняют по методике для каскада с ОК (см. § 4-3).



2. В трансформаторном каскаде коэффициент усиления может быть получен значительно больше единицы. Поэтому применение трансформаторного каскада позволяет уменьшить число каскадов в низкочастстном тракте по сравнению с применением резистивного фазоинверсного каскада. А это уменьшит потребляемый усилителем ток от источника питания и стоимость усилителя, хотя за счет трансформатора размеры и масса усилителя могут оказаться несколько большими.

Тип транзистора и режим его работы выбираются обычно при предварительном расчете низкочастотного тракта приемника по методикам § 2-3.

Полный коэффициент трансформации трансформатора, т. е. отношение числа витков вторичной обмотки  $w_2$  к числу витков первичной обмотки  $w_1$  в данном случае должно быть

$$n = w_2/w_1 = \sqrt{\frac{R_{\text{BX.K}}}{\eta_{\text{Tp}}R_{\text{K}}}}, \qquad (4-10)$$

где  $R_{\rm BX,K}$  — входное сопротивление выходного каскада, определяющееся формулой (3-27). Нагрузочное сопротивление  $R_{\rm K}$  должно равняться сопротивлению источника сигнала выходного каскада, которое находят из уравнения (3-29). Коэффициент усиления каскада на средней частоте полосы пропускания низкочастотного тракта записывается уравнением

$$K_{0} = \eta_{Tp} n \frac{R_{K} | Y_{21} |}{1 + R_{K} g_{22}}.$$
 (4-11)

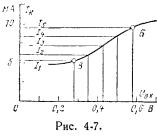
Электрические характеристики трансформатора находятся по методике, описанной в п. 2  $\S$  3-2, при этом вместо  $R_{\rm H}$  в формулы подставляется полное входное сопротивление выходного каскада, определяющееся равенством (3-27). Выбор характеристики элементов схемы каскада выбирается по методике п. 3  $\S$  3-2. Потребляемая каскадом мощность вычисляется по уравнению (3-26) с учетом формул (3-21) и (3-25).

Пример 4-3. Рассчитать трансформаторный фазоинверсный каскад по исходным данным примеров 3-3, 2-4 и 2-5, являющийся предвыход-

ным каскадом переносного приемника 1 класса,

Исходными данными из примера 3-3 являются:  $F_{\rm H}=150$  Гц,  $F_{\rm B}=12000$  Гц;  $R_{\rm C}=2592$  Ом;  $R_{\rm BX,K}=432$  Ом; амплитуда выходного напряження 5,15 В. В примере 2-5 для рассчитываемого каскада выбрал траизистор МП41A с исходной рабочей точкой  $U_{\rm K9}=-8$  В;  $I_{\rm K0}=-7,1$  мА и  $I_{\rm B0}=0,1$  мА (точка A на рис. 4-2). Коэффициент полезного действия трансформатора принят равным 0,65;  $R_{\rm BX}=410$  Ом;  $R_{\rm C}=2,4$  кОм и  $U_{m\,{\rm BX}}=0,25$  В.

Согласно формуле (1-2) для предвыходного каскада  $k_{\rm r}=0.3\cdot0.08=0.024$ . В примере 3-3 получено  $M_{\rm B,\,BMX}=1.29$ , что меньше значений,



определяющихся вторым уравнением (2-8). Поэтому формулу (2-9) для данного случая следует записать так:

 $M_{\rm B, \, K} = \sqrt[n]{V M_{\rm B}/M_{\rm B, \, BMX}} = \sqrt[4]{V \, \bar{5}/1,29} = 1,15$ . Из первого равенства (2-9) находим  $M_{\rm H, \, K} = \sqrt[16]{\bar{5}} = 1,11$ .

На рис. 4-2 изображены выходные карактеристики транзистора МП41А для малых коллекторных токов. Построим проходную характеристику транзистора для указанных данных. По пагрузочной линии 1 (см. рис. 4-2)

По этим данным на рис. 4-7 построена проходная характеристика. Для использовання метода пяти ординат на участке входных напряжений между точками B и B отмечаем через равные интервалы пять напряжений:  $U_1=0.28~\mathrm{B}$ ,  $U_2=0.355~\mathrm{B}$ ,  $U_3=0.43~\mathrm{B}$ ,  $U_4=0.505~\mathrm{B}$  и  $U_5=0.58~\mathrm{B}$ . Им соответствуют токи:  $I_1=5.2~\mathrm{MA}$ ,  $I_2=6~\mathrm{MA}$ ,  $I_3=7.2~\mathrm{MA}$ ,  $I_4=8.5~\mathrm{MA}$  и  $I_5=9.5~\mathrm{MA}$ . По первой формуле (3-5) находим  $I_{mK1}=0.33~(9.5+8.5-6-5.2)=2.28~\mathrm{MA}$ . Амплитуда сигнала в коллекторной цепи будет  $U_{mK1}=0.00228\cdot2592=5.9~\mathrm{B}$ , что превышает требуемое значение на 14~%. Поэтому уменьшим входной сигнал гранзистора на 10-15~%. В этом случае токи пяти точек на проходной характеристике следует взять:  $I_1=5.2~\mathrm{MA}$ ;  $I_2=6~\mathrm{MA}$ ;  $I_3=7.1~\mathrm{MA}$ ;  $I_4=8.2~\mathrm{MA}$  и  $I_5=9.1~\mathrm{MA}$ . Тогда  $I_{mK1}=0.33~(9.1+8.2-6-5.2)=$ 

= 2,01 мА и  $U_{m \mathrm{K}1} = 0,00201 \cdot 2592 = 5,2$  В, что лишь на 1 % превышает необходимое значение и может быть принято для дальнейшего

расчета.

По формулам (3-5) вычисляем высшне гармоннки коллекторного тока:  $I_{mK2}=0.25$  (9,1 + 5,2) - 0,5 $\cdot$ 7,1 = 0,03 мА;  $I_{mK3}=0.167$  (9,1 - 5,2) - 0,33 (8,2 - 6) = -0,074 мА и  $I_{mK4}=0.083 \cdot (9.1+5.2)$  - 0,33 (8,2 + 6) + 0,5 $\cdot$ 7,1 = 0,058 мА. Из последнего уравнения (2-19) находим  $k_{\rm F}=\sqrt{0.03^2+0.074^2+0.058^2/2},01=0.049$ .

Снижения нелинейных искажений до допустимого уровия добиваемся введением в каскад отрицательной обратной связи, для компенсации действия которой потребуется увелниить входной сигнал каскада в a=0.049/0.024=2.04 раза, что допустимо. Согласно формуле (3-25) при выбранной рабочей точке  $I_{\rm K\,0}=0.167$  (5,2+9,1)+0,33 (6+8,2) = 7,1 мA, а  $I_{\rm B\,0}=0.1$  мA,  $U_{\rm B\,0}=0.185$  В,  $R_{\rm nx}=(0.2-0.156)/[(0.15-0.04) 0.001]=400$  Ом. Входное сопротивление транзистора несколько отличается от данных примера 2-5. в котором оно определено равным 410 Ом. Но различие всего 2,5 %, поэтому пересчет проходной характеристики транзистора не требуется. По характеристике рис. 4-7 изменение коллекторного тока происходит в интервале 5,2—9,1 мА. Этвм токам по характеристикам рис. 4-2 соответствуют тока базы 40 и 140 мкА. По рис. 2-2, а находим, что данным базовым токам соответствуют напряжения  $U_{\rm E\,9\,B}=-0.155$  В и  $U_{\rm E\,9\,B}=-0.2$  В. Амплитуду входного сигнала транзистора вычисляем по формуле (2-15)  $U_{m\,\rm E\,9\,T}=0.5$  (0,2—0.155) = 0.0225 В.

Определим электрические параметры трансформатора. По равенствам (3-6) и (3-7) вычисляем допустимые сопротивления обмоток:  $r_1 = 2592(1-0.65)\cdot(2\cdot0.65) = 700 \text{ Ом}$  и  $r_2 = \frac{432}{2\cdot0.065}\cdot(1-0.65) = 116 \text{ Ом}$ .

Минимально допустимую индуктивность первичной обмотки трансформатора вычисляем по неравенству (3-8) $L_1 \geqslant \frac{2592 \cdot 0,65 \ (432+116)}{6,28 \cdot 150 \cdot 432 \ V \ 1,11^2-1} =$ 

=  $4,7 \Gamma_{H}$ .

По формуле (3-11) для трансформатора будет допустимо  $M_{\rm B,TP}==1,15,1,04=1,1$ . Для рабочей точки A на рис. 4-2 находим  $r_{22}=-(11-2)/(0,00775-0,0065)=7200$  Ом. При этом максимально допустимую индуктивность рассеяния трансформатора вычисляем по неравенству (3-9)  $L_s < \frac{7200+2592}{6,28+12000} \sqrt{1,1^2-1}=0,06$  Гн. Допустимый коэффициент рассеяния находим по равенству (3-12)  $k_s=0,06/4,7=0,013$ , что конструктивно осуществимо. Коэффициент трансформации трансформатора вычисляем по формуле (3-15)  $n=\sqrt{\frac{432}{0,65+2592}}=0,51$ .

По уравнению (3-16) находим  $U_1=0.0071\cdot 700=5$  В. Падение напряжения на эмиттерном резисторе вычисляем по фермуле (3-17)  $U_{R_3}=12-5-8=-1$  В. Следовательно, при заданном напряжении источника питания и выбранном напряжении на коллекторе транзистора нельзя допустить столь большого сопротивления первичной обмотки трансформатора. Данные опыта показывают, что трансформатор можно изголовить с примерно вдвое меньшим сопротивлением. Положим  $r_1=325$  Ом, тогда  $U_1=0.0071\cdot 325=2.3$  В в  $U_{R_3}=12-2.3-8=1.7$  В.

Сопротивление эмиттерного резистора вычисляем по уравнению (3-18)  $R_3 = 1.7/(0.0071 + 0.0001) = 236$  Ом. По табл. II-3-1 выбираем резистор сопротивлением 240 Ом. По неравенству (3-19) вычисляем емкость  $C_3 \ge \frac{10 \div 20}{6.28 \cdot 150 \cdot 240} = (44 \div 88) \ 10^{-6} \ \Phi. \text{ I I 3} \ \text{табл.} \ \Pi\text{-}3\text{-}2 \ \text{выбираем конден$ сатор емкостью 68 мкФ.

Согласно формуле (3-20) падение напряжения  $U_{R'} = 1.7 + 0.185 =$ 

= 1,885 В. Принимаем численное значение коэффициента равным 8 и по уравнению (3-21) находим  $I_0 = 8.0, 1 = 0,8$  мА. Вычисляем сопротивления плеч делителя напряжения по формулам (3-22) и (3-23)  $R_6' =$  $R_6'' = (12-1,885)/[(0,8+0,1) \ 0,001] =$  $= 1.885/0.0008 = 2360 \, \text{Om}$  и = 11 250 Ом. По табл. П-3-1 выбираем резисторы сопротивлением 2,4 и 11 кОм. Коэффициент нестабильности коллекторного тока вычис-1 + 240/2400 + 240/11000уравнения (3-24) σ⇒  $\frac{1-0.97+240/2400+240/11\ 000}{1-0.97+240/2400+240/11\ 000}$ = 7,4, что вполне достаточно при сильной отрицательной обратной

Ток, потребляемый каскадом от источника, будет  $I_0 = I_{0K} + I_{\Pi} =$ = 7.1 + 0.8 = 7.9 мA, а мощность согласно формуле (3-26)  $P_0 = 12$  (7.1+

 $+ 0.800,001 = 0.095 \,\mathrm{Br}$ 

Коэффициент усиления транзистора без отрицательной обратной связи вычисляем по равенству (2-22)  $K_{\rm T}=5,\!2/0,\!0225=231.$  Из формулы (2-24) находим  $\varepsilon=(2,\!04-1)/231=0,\!0045.$  Входную проводимость каскада вычисляем по уравнению (2-25)  $G_{\rm BX} = 1/400 + 1/2400 +$ + 1/1100 = 0,003 См. На рис. 4-6 цепь обратной связи включена непосредственно к коллектору. Поэтому, полагая n=1, сопротивление резистора цепи обратной связи находим из равенства (2-26)  $R_{0,c} =$  $= (1 - 0.0045)/(0.0045 \cdot 0.003) = 74\,000\,\text{OM}$ . Hepabehctbo (2-27) 74 000> > 10/0,003 = 3300 выполняется. Следовательно, сопротивление цепи обратной связи приемлемо. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 75 кОм. Емкость разделительного конденсатора вычисляем по неравенству (3-19), заменяя  $C_3$  на  $C_p$  и  $R_3$  на  $R_{0 \cdot c}$ :  $C_p \geqslant (10 \div 20)/(6,28 \times 10^{-6})$  $\times$  150·75 000) = (14÷28) 10<sup>-8</sup> Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 0,22 мк $\Phi$ .

Согласно рис. 4-7  $U_{\text{вх }B} = 0,56 \text{ B}$  и  $U_{\text{вх }B} = 0,28 \text{ B}$ . Заменяя в формуле (2-15)  $U_{\rm E3}$  на  $U_{\rm RX}$ , вычисляем амплитуду входного сигнала каскада без обратиой связи  $U_{m \text{ вх}} = 0.5 \cdot (0.56 - 0.28) = 0.14 \text{ B}$ . При действин отрицательной обратной связи амплитуда входного сигнала каскада, а следовательно, и выходного сигнала предыдущего каскада

должна быть  $U_{m \text{ вх. о. c}} = aU_{m \text{ вх}} = 2,04 \cdot 0,14 = 0,29 \text{ B}.$ 

Коэффициент усиления по напряжению каскада с учетом действия отрицательной обратной связи будет  $K_{\text{o o.c}} = U_{m \, \text{вых}}/U_{m \, \text{вх o.c}} =$ = 5,15/0,29 = 17,8. Сопротивление источника сигнала вычисляем по формуле (2-17)  $R_{\rm c}=6\cdot400=2400$  Ом, что соответствует данным табл. П-3-1.

#### РАСЧЕТ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ

#### 5-1. Исходные данные и задачи расчета

Из общих характеристик радиоприемного устройства исходными данными для расчета входной цепи являются диапазон рабочих частот  $f_{\min} - f_{\max}$ ; параметры приемной антенны  $L_A$ ,  $C_A$ ,  $r_A$ ,  $h_\pi$  (при работе в диапазоне частот даются их зависимости от частоты). При расчете структурной схемы приемника выбирается транзистор первого каскада и его рабочий режим. Поэтому считаются известными: схема и режим работы входной цепи; входные активная проводимость  $g_{
m BX}$  и емкость  $C_{\rm BX}$  первого каскада, составляющие нагрузку входной цепи; минимально допустимая полоса пропускания  $\Pi_{\rm min}$  или минимально осуществимое эквивалентное затухание колебательных контуров  $\delta_{ ext{9 min}}$ ; минимально необходимое ослабление сигналов зеркального канала  $d_3$  и промежуточной частоты  $d_{np}$ ; минимально допустимый коэффициент передачи. При наличии в приемнике усилителя радиосигнала  $\Pi_{\min}$  (или  $\delta_{\min}$ ),  $d_3$ и  $d_{
m np}$  при расчете структурной схемы приемника обычно согласовываются с аналогичными параметрами усилителя. Кроме того, в этом случае индуктивность и эквивалентная емкость колебательного контура обычно определяются при расчете усилителя радиосигнала.

При расчете входной цепи следует: определить (или уточнить) параметры колебательного контура; уточнить ее режим работы, выбрать связь антенны с первым колебательным контуром и входа первого каскада с последним контуром входной цепи; составить полную принци-

пиальную схему и рассчитать параметры всех ее элементов.

# 5-2. Расчет одноконтурной входной цепи с постоянной настройкой

В радиолюбительской практике приемники с постоянной настройкой применяются для приема телевизионных и радиовещательных частотно-модулированных сигналов и в линиях радиоуправления движением моделей. Как правило, эти приемники работают в диапазоне метровых или дециметровых воли. Антеннами для них служат полуволновые

электрические диполи, магнитные и штыревые антенны.

Для дипольных и штыревых антени наиболее удобно осуществлять трансформаторную связь с колебательным контуром входной цепи. Схема подобной входной цепи телевизионного приемника приведена на рис. 5-1. Благодаря постоянной настройке приемника и стандартным характеристикам приемных антени  $(r_A=75~{\rm CM})$  антенная цепь в данном случае настраивается на среднюю частоту спектра принимаемого сигнала. При этом вносимое антенной в колебательный контур входной цепи реактивное сопротивление получается малым и легко может быть скомпенсировано соответствующим выбором элементов колебательного контура  $LC_{\rm II}$  так, чтобы он был настроен на среднюю частоту спектра сигнала с учетом влияния как антенны, так и входа первого каскада приемника. В этих условиях входную цепь выполняют в режиме согла-

сования, для которого коэффициент передачи и эквивалентное затуха ние контура определяются уравнениями [1, 5]:

$$K_{08, \text{ U, C}} = \frac{0.5}{V r'_{A} (g/p_{2}^{2} + g_{ax})};$$
 (5-1)

$$\delta_{2,c} = 2\delta (1 + p_2^2 g_{BX}/g),$$
 (5-2)

где g — собственная активная проводимость входного контура;  $r_{\rm A}'$  — выходное сопротивление антенной цепи (для рис. 5-1 оно равно характеристическому сопротивлению кабеля, соединяющего антенну с приемником);  $\delta$  — собственное затухание колебательного контура;  $p_2 \approx L_1/L$  — коэффициент включения входа первого каскада к контуру.

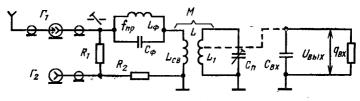


Рис. 5-1.

Из формулы (5-1) следует, что наибольший коэффициент передачи будет при  $\rho_2=1$ , т. е. при полном включении входа первого каскада к контуру. Но при этом согласно равенству (5-2) селективность входной цепи будет наихудшей. Увеличивается коэффициент передачи с уменьшением собственной активной проводимости контура.

Для обеспечения режима согласования коэффициент включения

Для обеспечения режима согласования коэффициент включения антенной цени к колебательному контуру применительно к рис. 5-1 должен выбираться по равенству

$$p_1 = \frac{M}{L} = k \sqrt{\frac{L_{cs}}{L}}, \qquad (5-3)$$

в котором

$$k = \frac{M}{VLL_{cs}} \tag{5-4}$$

- коэффициент связи между катушками.

Если требуется наилучшая возможная селективность входной цепи при минимально допустимом коэффициенте передачи  $K_{0\,n.\,q.\,q}$ , то коэффициенты включения антеиной цепи и входа первого каскада к контуру вычисляют по уравнениям:

$$p_{1\delta} = \sqrt{\frac{g}{2g'_{A}} \left(\frac{\delta_{9 \text{ min}}}{\delta} - 1\right)}; \tag{5-5}$$

$$p_{2\delta} = \sqrt{\frac{g}{2g_{BX}} \left( \frac{\delta_{9 \min}}{\delta} - 1 \right)}.$$
 (5-6)

Минимально осуществимое эквивалентное затухание контура выражается при этом равенством

$$\delta_{\text{9 min}} = \frac{\delta}{1 - 2K_{\text{0 B, U, I}} \sqrt{r_{\text{A}}' g_{\text{BY}}}}.$$
 (5-7)

Эквивалентная емкость контура определяется формулой

$$C_9 = p_1^2 (C_A' + C_{M1}) + C_K + C + C_R + p_2^2 (C_{BX} + C_{M2}),$$
 (5-8)

где  $C_{\rm M1}$  и  $C_{\rm M2}$  — монтажные емкости, относящиеся к выходу антенны и входу первого каскада;  $C_{\rm R}$  и  $C_{\rm II}$  — собственная емкость катушки и подстроечного конденсатора; C — конденсатор переменной емкости, с помощью которого контур перестраивается в пределах рабочих частот.

Если полагать заданным эквивалентное затухание контура входной цепи, то, выбрав коэффициенты включения по формулам (5-5), (5-6) и обозначив их  $p_{1K_{\rm B,\, II}}$  и  $p_{2K_{\rm B,\, II}}$ , можно получить максимально достижимый коэффициент передачи входной цепи

$$K_{0.8, \, \text{ц, max}} = \frac{0.5}{\sqrt{r'_A g_{\text{вx}}}} \left(1 - \frac{\delta}{\delta_9}\right).$$
(5-9)

Индуктивность, контурной ка

Индуктивность контурной катушки вычисляется по формуле (2-101).

Рис. 5-2.

**Пример 5-1.** Рассчитать входную цень для поддиапазона 12 пере-

носного приемника I класса по следующим исходным данным:  $r_{\rm A}'=300~{\rm OM}~(g_{\rm A}'=3,3~{\rm MCM});~\delta=0.02;~C_0=20~{\rm n\Phi}.$  Первый каскад приемника построен на транзисторе ГТ313Б по схемс с ОЭ. Коэффициент передачи и эквивалентное затухапие коптура входной цепи должны быть не хуже данных варианта 3 (см. табл. 2-9).

Возможный вариант схемы входной цепи для поддиапазона 12 показаи на рис. 5-2. Средняя частота поддиапазона 12 согласно § 2-5 равна 70,75 МГц, а параметры транзистора для нее  $g_{11}=0,006$  См и  $C_{11}=24$  пФ. Собственная проводимость контура по формуле (2-55)  $g=0,02\cdot6,28\cdot7075\cdot10^42\cdot10^{-11}=0,000178$  См.

Так как  $g'_{A} < g_{_{BX}}$ , то для режима согласования формулы (5-1) и (5-2) должны быть записаны так:

$$K_{0B, U, c} = \frac{\sqrt{g'_{A} + g/\rho_{1}^{3}}}{2\sqrt{g_{BX}}} \text{ in } \delta_{3, c} = 2\delta \left(1 + \rho_{1}^{3}g'_{A}/g\right). \tag{5-10}$$

Для варианта 3 табл. 2-9  $\delta_{0}=0.196$  и  $K_{0B,q}=0.3$ . Чтобы получить это эквивалентное затухание, из равенства (5-5) находим  $\rho_{1}=\sqrt{\frac{0.000178}{2\cdot0.0033}\left(\frac{0.196}{0.02}-1\right)}=0.49$ . По первой формуле (5-10) вычисля-

ем 
$$K_{\rm GP,\,II,\,C} = \frac{\sqrt{0,0033 + \frac{0,000178}{0,49^2}}}{2\,V\,\overline{0,006}} = 0,41$$
. Полученные данные лучше

характеристик варианта 3 табл. 2-9.

Рассмотрим построение входной цепи для получения минимального эквивалентного затухания, полагая  $K_{0P,\, L}=0,3,\,\, {
m T.}$  е. соответствующим варианту 3 табл. 2-9. По уравнению (5-7) находим  $\delta_{9\,{
m min}}=$ 

$$=\frac{0.02}{1-2\cdot0.3\,V\,\overline{300\cdot0.006}}=0,102$$
, что почти вдвое лучше режима согла-

сования. Поэтому целесообразно принять этот режим работы входной непи. По формулам (5-5) и (5-6) вычисляем необходимые коэффициенты включения:

$$\begin{split} \rho_{1\delta} &= \sqrt{\frac{0,000178}{2 \cdot 0,0033} \left(\frac{0,102}{0,02} - 1\right)} = 0,33 \text{ H } \rho_{2\delta} = \\ &= \sqrt{\frac{0,000178}{2 \cdot 0,006} \left(\frac{0,102}{0,02} - 1\right)} = 0,25. \end{split}$$

Проверим эквивалентную емкость контура. Для схемы на рис. 5-2  $C_{\rm M1}=0$  и  $C_{\rm A}=0$ . Положим  $C_{\rm M2}=3$  пФ,  $C_{\rm K}=1$  пФ. Тогда из уравнения (5-8) средняя емкость подстроечного конденсатора должна быть  $C_{\rm R}=20-1-0.25^2$  (24+3) = 17,2 пФ. Следовательно, заданная эквивалентная емкость контура осуществима. По табл. П-4-2 принимаем конденсатор типа КПК-1 с изменением емкости от 6 до 25 пФ. Индуктивность контурной катушки вычисляем по уравнению (2-101)  $L=1/[(6,\ 28\cdot7075)^210^32\cdot10^{-11}]=25\cdot10^{-8}$  Гн. В табл. 5-1 приведены минимальные индуктивности контурных катушек, при которых их можно выполнить с малым затуханием для указанных в таблице рабочих частот. Полученная индуктивность катушки удовлетворяет табл. 5-1 и приемлема для реализации.

Таблица 5-1

	1		l				1	i
f, MΓu	0.10,5	0,51	1-5	5-10	10-20	20-40	40-160	100-200
L <sub>min</sub> , мкГн	50050	300-30	30-12	12—6	6—3	3-0,3	0,30.1	0,1-0,05
$C_{\Sigma}$ , п $\Phi$	60-40	5540	50-30	40-25	35-20	30-15	15—10	13-8
$C_{\rm n}$ , n $\Phi$	3525	35-20	35-15	30-15	25-10	20-10	10-5	8-3
$c_{ ext{max}}$ , п $\Phi$	500350	500350	300-200	200-100	150-100	100-50	50-20	15-10
$C_{\min}$ , пФ	158	15-8	12-8	10—5	10-5	6-2	4-2	2-1
$C_{_{ m K}}$ , пФ	128	10—6	8-5	6-3	4-2	3-1,5	2—1	1-0.5
$C_{M1} = C_{M2}$ , $\Pi \Phi$	6	5	4	3	2,5	2	1,5	1

Будем считать выходную емкость кабеля, соединяющего выход антенны с катушкой связи, равной 8 пФ, собственную емкость катушки связи 1 пФ и монтажную емкость, включающуюся параллельно катушке связи, 1 пФ. При этих условиях для настройки антенной цепи на сред-

нюю частоту поддиапазона 12 согласно формуле (2-101) индуктивность катушки должна быть  $L_{\rm cB}=1/[(6,28\cdot7075)^210^3(8+1+1)10^{-12}]=52\times10^{-8}$  Ги, что вполне осуществимо.

Вычислим взаимоиндуктивность между катушками из выражения (5-3)  $M=0.33\cdot 25\cdot 10^{-8}=825\cdot 10^{-10}$  Ги. Согласно формуле (5-4)  $k=\frac{825\cdot 10^{-10}}{V25\cdot 10^{-8}\cdot 52\cdot 10^{-8}}=0,23,$  что осуществимо даже при однослойных катушках.

### 5-3. Расчет одноконтурной входной цепи с трансформаторной связью с антенной при переменной настройке

Одноконтурная входная цепь с трансформаторной связью наиболее часто применяется в приемниках декаметровых и более длинных волн, в которых используются несимметричные антенны (штыревые, проволочные). Принципиальная схема рассматриваемой входной цепи изображена на рис. 5-3.

Если в приемнике нет частотно-селективного усилителя радиосигнала, то параметры контура выбираются при расчете входной цепи.

Когда требуемый коэффициент диапазона более 1,3—1,5, подгонка диапазона осуществляется параллельным подстроечным конденсатором, емкость которого определяется уравнением

$$C_{\rm m} = \frac{C_{\rm max} - k_{\rm m}^2 C_{\rm min}}{k_{\rm m}^2 - 1} - C_{\rm K} - \frac{1}{-p_1^2 C_1 - p_2^2 C_2},$$
 (5-11)

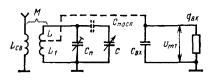


Рис. 5-3.

где  $C_{\rm max}$  и  $C_{\rm min}$  — максимальная и минимальная емкости конденсатора C, которым настраивается контур в днапазоне рабочих частот;  $p_1$  и  $p_2$  — коэффициенты включения к контуру выхода антениы и входа первого каскада;  $C_1$  и  $C_2$  — выходная емкость антенной цепи и входиая емкость первого каскада. При коэффициенте диапазона менее 1,3-1,5 целесообразнее подгонку коэффициента диапазона контура выполнять с помощью последовательного конденсатора  $C_{\rm noc,n}$ , так как это обеспечивает большее его характеристическое сопротивление и лучшие селективные свойства каскадов с таким контуром. Включение этого конденсатора показано штриховой линией на рис. 5-3. Подстроечный конденсатор  $C_{\rm n}$  в данном случае используется для выравнивания начальных емкостей всех контуров радиотракта с целью обеспечения их одноручечной настройки. Емкость последовательного конденсатора определяется формулой

$$C_{\text{noca}} = \mathcal{I} + \sqrt{\mathcal{I}^2 + \mathcal{B}}, \qquad (5-12)$$

где

$$\mathcal{I} = \frac{(k_{\pi}^{2} - 1) \left[ C_{\Sigma} (C_{\max} + C_{\min}) + C_{\max} C_{\min} \right]}{2 \left[ C_{\Sigma} + (C_{\max} - k_{\pi}^{2} (C_{\Sigma} + C_{\min})) \right]},$$

$$E = \frac{(k_{\pi}^2 - 1) C_{\Sigma} C_{\max} C_{\min}}{C_{\Sigma} + C_{\max} - k_{\pi}^2 (C_{\Sigma} + C_{\min})},$$
 (5-13)

здесь

$$C_{\Sigma} = C_{\Pi} + C_{K} + p_{1}^{2}C_{1} + p_{2}^{2}C_{2}$$
 (5-14)

— емкость контура  $\ell$ ез конденсатора переменной емкости и добавочного конденсатора  $C_{\text{пос. 3}}$ .

Эквивалентная емкость контура при подгонке коэффициента диапазона параллельным подстроечным конденсатором определяется уравнением

$$C_{\rm s} = C + C_{\Sigma},\tag{5-15}$$

а при подгонке последовательным конденсатором

$$C_{\mathfrak{g}} = \frac{CC_{\text{noch}}}{C + C_{\text{noch}}} + C_{\Sigma}. \tag{5-16}$$

Индуктивность контурной катушки определяется формулой (2-101). Наиболее часто собственную частоту антенной цени выбирают в соответствии с неравенством (2-88) для обеспечения постоянства коэффициента передачи в диапазоне частот. Коэффициент связи между катушками выбирается так, чтобы выполнялись три следующих условия. Он должен обеспечивать расстройку контура антенной не более допустимой (в пределах полосы пропускания контура)

$$k \leq k_{\Delta f} \approx \sqrt{\delta_{a} \left(1 - f_{A}^{2} / f_{max}^{2}\right)}.$$
 (5-17)

Коэффициент связи не должен превышать половины своего значения при согласовании

$$k_{\rm c} = \left(1 - \frac{f_{\rm A}^2}{f_{\rm max}^2}\right) \sqrt{\frac{\delta_{\rm s}}{\delta_{\rm A}^2}}.$$
 (5-18)

В приведенных формулах  $\delta_s$  и  $\delta_A'$  — эквивалентное затухание контура и затухание антенной цепи с учетом катушки связи соответственно. Наконец, он не должен превышать конструктивно осуществимого значения при выбранных типах намотки катушек. В случае однослойных катушек, намотанных рядом на цилиндрическом каркасе, коэффициент связи может достигать 0,25—0,3; для многослойной катушки связи и однослойной контурной катушки при тех же условиях 0,35—0,5 и при намотке витков катушки связи между витками контурной катушки 0,8—0,9. Применение общего матнитного сердечника увеличивает коэффициент связи между катушками в 2—3 раза.

Эквивалентное затухание контура входной цепн определяется уравнением

$$\delta_{\mathbf{a}} = \delta \left( 1 + p_1^2 g_{\mathbf{A}}^2 / g + p_2^2 g_{\mathbf{B}\mathbf{X}} / g \right). \tag{5-19}$$

Полоса пропускания входной цени вычисляется по равенству (2-85), а коэффициент петедачи — по формуле

$$K_{\text{OB, R}} = \frac{k\rho_2}{\delta_{\text{g}} \left(1 - I_{\text{A}}^2 / l^2\right)} \sqrt{\hat{L}_{\text{CB}}},$$
 (5.20)

С целью увеличения коэффициента передачи выголно повышать коэффициент связи между катушками. Для этого можно вволить компенсацию расстройки контура на средней частоте диапазона увеличением индуктивности контурной катушки на

$$\Delta L_{B,n} = 0.5k^2L \left( \frac{1}{(1-A)} + \frac{1}{(1-B)} \right), \tag{5-21}$$

где

$$A = f_{A \text{ min}}^2 / f_{\text{max}}^2$$
;  $B = f_{A \text{ max}}^2 / f_{\text{min}}^2$ . (5-22)

При такой компенсации расстройки коэффициент связи можно брать:

$$k'_{\Delta l} = \sqrt{\frac{2\delta_{\mathfrak{g}} (1 - A) (1 - B)}{B - A}}.$$
 (5-23)

Когда выполняется неравенство (2-88), выходная проводимость антенной цепи в первом приближении определяется равенством

$$g_{\rm A}' \approx \delta_{\rm cB}/(\omega L_{\rm cB}).$$
 (5-24)

При коэффициенте диапазона более 1,2-1,4 характеристики входной цепи вычисляют на крайних частотах поддиапазона, члобы иметь их зависимость от частоты, а при  $k_{\pi} > 1.4 \div 1.6$  еще и на среднеквидратичной частоте

$$f'_{\rm cp} = \sqrt{f_{\rm min}f_{\rm max}} . \tag{5-25}$$

Пример 5-2. Рассчитать параметры входной цепи с трансформаторной связью переносного приемника І класса для поддианазона 11. Первым каскадом приемника является резонансный усилитель радиосигнала на транзисторе ГТ308В ( $g_{11}=2.5$  мСм и  $C_{11}=39$  пФ). Характеристики входной цепи должны быть не ниже данных варианта 7 табл. 2-11. Антенна штыревая, ее характеристики приведены в табл, 2-10. Минимальная емкость конденсатора для перестройки контура 10 пФ. а максимальная — 365 пФ. Собственное загухание контура равно 0,01, максимально допустимое эквивалентное затухание контура 0.03. зату-

хание катушки связи 0,03.

Согласно табл. 2-2 крайние частоты поддиапазона 11 определены равными 25,1 и 26,6 МГц. Поскольку  $k_{\rm A}=1,06<1,3$ , то для подгонки граничных частот контура применяем последовательный конденсатор. Без определения коэффициентов включения нельзя найти суммарную начальную емкость контура (5-14). Поэтому целесообразно задаваться ее значением соответственно данным табл. 5-1. Для поддиапазона 11 ее следует взять равной  $C_{\Sigma} = 30$  пФ. При налаживании приемника подгонка этой емкости до нужного значения выполняется регулировкой емкости подстроечного конденсатора. Вычисляем коэффициенты по формулам (5-13)  $\mathcal{A} = \frac{(1,06^2-1)[30](365+10)+365\cdot10]}{2[30+365-1,06^2](30+10)]} = 2,55$  пФ и

$$B = \frac{(1,06^2 - 1)30 \cdot 365 \cdot 10}{30 + 365 - 1,06^2 \cdot (30 + 10)} = 37,5$$
 (пФ)<sup>2</sup>. По уравнению (5-12)

находим  $C_{\text{посл}} = 2,55 + \sqrt{2,55^2 + 37,5} = 9,2$  пФ. Эта емкость должна подбираться при налаживании приемника достаточно точно. Поэтому в качестве нее целесообразно взять по табл. П-4-2 конденсатор типа КПК-1 с изменением емкости от 2 до 15 пФ.

Максимальная эквивалентная емкость контура по равенству (5-16) будет  $C_{9,\max}=365\cdot 9,2/(365+9,2)+30=38,9$  пФ. Индуктивность контурной катушки вычисляем по формуле (2-101) на минимальной частоте  $L=1/[(6,28\cdot 251)^210^{10}389\cdot 10^{-13}]=105\cdot 10^{-8}$  Гн, что по табл. 5-1 приемлемо для реализации.

Антенна для приемника постояплая, поэтому можно считать  $f_{\rm A\,min}=f_{\rm A\,max}=f_{\rm A}$ . Согласно неравенству (2-88) принимаем  $f_{\rm A}=0.7\cdot25,1=17,6$  МГп. 113 табл. 2-10 для поддиапазона 11 выходная емкость антенны равна 6,3 пФ. Положим емкость катушки связи равной 1 пФ и емкость монтажа — 1,7 пФ. Тогда емкость антенного контура будет  $C_{\rm A}'=6,3+1+1,7=9$  пФ. Из равенства (2-101) индуктив-

ность катушки связи должна быть  $L_{\text{св}} = \frac{1}{(6,28 \cdot 176)^2 \cdot 10^{10} \cdot 9 \cdot 10^{-12}} = 91 \cdot 10^{-7}$  Гн. Согласно табл. 5-1 она может быть принята.

Применяем компенсацию расстройки контура аптенной на средней частоте поддиапазона. Вычисляем по формулам (5-22) коэффициенты:  $A=17,6^2/26,6^2=0,438$  и  $B=17,6^2/25,1^2=0,49$ . По равенству (5-23) вычисляем коэффициент связи при допустнмой расстройке  $k_{\Delta f}=$ 

$$=\sqrt{rac{2\cdot 0,03\,(1-0,438)\,(1-0,49)}{0,49-0,438}}=0,575$$
. По формуле (5-18) находим

коэффициент связи в режиме согласования  $k_{\rm c} = \left(1 - \frac{17,6^2}{26,6^2}\right)\sqrt{\frac{0.03}{0.03}} =$ 

= 0,562. Поскольку  $k_{\rm c} < k_{\Delta f}$ , то можно выбрать коэффициенты из условия получения максимального коэффициента передачи при заданном эквивалентном затухании контура. При заданном затухании минимальная полоса пропускания входной цепи согласно уравиению (2-85)  $H_{\rm B,\ u\ min}=0,03\cdot251\cdot10^5=753\,000$  Гц, что гораздо шире требуемой полосы пропускания приемника (см. § 2-4). Поэтому для повышения селективности входной цепи можно уменьшить эквивалентное затухание контура до 0,02. Изменение частоты в пределах поддиапазона 11 весьма малое (6  $\%_0$ ). В данном случае с допустимой погрешностью можно полагать все характеристики транзистора и входной цепи постояиными и равными своим значениям на средней частоте поддиапазона  $f_{\rm cp}=0,5\cdot(25,1+26,6)=25,85\,{\rm M}\Gamma_{\rm R}$ .

По формуле (2-55) вычисляем  $g=0.01/(6.28\cdot2585\cdot10^4\cdot105\times10^{-6})=586\cdot10^{-7}$  См. Из равенства (5-24) находим  $g_A'=0.03/(6.28\times2585\cdot10^4\cdot91\cdot10^{-7}=203\cdot10^{-7}$  См. По уравлению (5-5) получаем

$$p_{1K_{\mathrm{B, II}}} = \sqrt{\frac{586 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 203 \cdot 10^{-7}}} \left(\frac{0.02}{0.01} - 1\right) = 1,2$$
 и по (5-6)  $p_{2K_{\mathrm{B, II}}} = \sqrt{\frac{586 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 2.5 \cdot 10^{-3}} \left(\frac{0.02}{0.01} - 1\right)} = 0,108$ . Пользуясь формулой (5-3), вычис-

ляем необходимый коэффициент связи k=1,2  $\sqrt{\frac{105\cdot 10^{-8}}{91\cdot 10^{-7}}}=0,4$ . Это

меньше допустимого из условия расстройки и конструктивно осуществимо при однослойной контурной и многослойной катушках связи. Поэтому примем данный коэффициент связи за окончательное значение. По уравнению (5-21) находим  $\Delta L_{\rm B,\, H}=0,5\cdot0,4^2\cdot105\cdot10^{-8}$  (1/(1-0,438) + + 1/(1-0,49) =  $31\cdot10^{-9}$  Гн и для компенсации расстройки индуктивность контурной катушки должна быть  $L'=105\cdot10^{-8}+31\cdot10^{-9}=108\cdot10^{-8}$  Гн.

По формуле (5-20) вычисляем

$$K_{\text{B, IL}} = \frac{0.4 \cdot 0.108}{0.02 (1 - 176^2 \cdot 10^{10}/(2585^2 \cdot 10^8))} \sqrt{\frac{105 \cdot 10^8}{91 \cdot 10^7}} = 1.58$$

Таким образом, рассчитанияя входная цепь имеет в 1,5 раза меньшее эквивалентное затухание контура и в 2 раза больший коэффициент передачи по сравнению с вариантом 7 табл. 2-11.

### 5-4. Расчет одноконтурной входной цепи с внешнеемкостной связью с антенной при переменной настройке

Схема рассматриваемой входной цени приведена на рис. 5-4. Чтобы расстройка контура антенной не превышала допустимой, емкость конденсатора связи берут малой: в километровом диапазоне воли она не превышает 25-30 пФ, в гентаметровом — 10-15 пФ и в декаметровом — 2-5 пФ. При этом результирующая емкость антенной цепи

$$C'_{\rm A} = C_{\rm cs} C_{\rm A} / (C_{\rm cs} + C_{\rm A}) < C_{\rm cs}$$
(5-26)

получается малой и обычно выполияется условие

$$f'_{\rm A} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm A}C'_{\rm A}}} > (1.5 \div 2) f_{\rm max}.$$
(5-27)

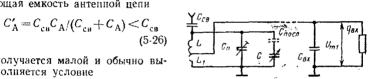


Рис. 5-4.

Расчет параметров колебательного контура выполняется для данной входной цепи по методике § 5-3.

Благодаря слабой связи антенной цени с контуром и малым потерям антенной цепи в данной входной цепи с малой погрешностью можно считать, что аптенная цепь не вносит активного сопротивления в контур входной цепи. Иначе говоря, в формуле (5-19) можно полагать  $g_{\bf A}'=0$ . Поэтому принимают полное включение антенны к контуру ( $p_1 = 1$ ), что и показано на рис. 5-4. На основании сказанного в данной схеме нельзя обеспечить выбор коэффициентов включения по формулам (5-5) и (5-6), чтобы получить минимальное затухание контура при заданном коэффициенте передачи или максимальный коэффициент передачи при заданном эквивалентном затухании.

Коэффициент передачи рассматриваемой входной цепи определяется уравнением

$$K_{0B, H} = \frac{C_{\rm A}C_{cB}}{C_{\rm A} + C_{cB}} \frac{p_2 L}{\delta_2} \omega_0^2.$$
 (5-28)

При постоянном δ<sub>э</sub> в широком диапазоне частот коэффициент передачи резко увеличивается с ростом частоты. Он также увеличивается с ростом коэффициента включения входа первого каскада к контуру. Но при этом увеличивается и эквивалентное затухание. Поэтому существует оптимальное значение

$$p_{\rm 2c} = \sqrt{g/g_{\rm BX}},\tag{5.29}$$

при котором обеспечивается режим согласования между проводимостями контура и входа первого каскада. В этом случае

$$K_{\text{OB, II, C}} = \frac{C_{\Lambda} C_{\text{CB}}}{C_{\Lambda} + C_{\text{CB}}} \frac{\omega}{2V gg_{\text{EX}}}$$
(5-30)

И

$$\delta_9 = 2\delta. \tag{5-31}$$

Когда требуется получить  $\delta_3 < 2\delta$ , режим согласования не приемлем и допустимый коэффициент включения входа первого каскада паходят из уравнения (5-19), полагая  $g_A'=0$ .

Из рис. 5-4 следует, что за счет антенны к контуру подключается емкость  $C_A'$  и расстраивает его. Поэтому при допустимой расстройке емкость конденсатора связи должна удовлетворять неравенству

$$C_{\rm cB} \leqslant \delta_{\rm g} C_{\rm g min}.$$
 (5-32)

Пример 5-3. Рассчитать параметры входной цепи с впецинеемкостной связью, полагая исходные данные соответствующими примеру 5-2.

Поскольку исходные данные соответствуют примеру 5-2, то пара-

метры контура сохраняются такими же.

Вычисляем по формуле (5-16)  $C_{9\,\mathrm{min}}=10\cdot 9,3/(10+9,2)+30=34,8$  пФ. Максимальная допустимая емкость конденсатора связи согласно неравенству (5-32)  $C_{\mathrm{CB}}\leqslant 0,02\cdot 34,8=0,7$  пФ. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 0,68 пФ.

Поскольку  $\delta_3/\delta=2$ , что соответствует уравнению (5-31), то осуществим режим согласования. По уравнению (5-29)  $p_{2\,c}=V_0/\sqrt{586\cdot 10^{-7}/0.0025}=0.15$ . По формуле (5-28) вычисляем  $K_{0\,B,\,LL}=\frac{6.3\cdot 0.68}{6.3+0.68}$  10<sup>-12</sup>  $\frac{0.15\cdot 10^{5}\cdot 10^{-7}\cdot 6.28^{2}\cdot 2585^{2}\cdot 10^{8}}{0.02}=1.28$ .

## 5-5. Расчет входной цепи с переменной настройкой при магнитной антенне

Магнитные антенны чаще всего применяют в декаметровом и болсе длинноволновых днапазонах волн. Их преимуществом являются малые размеры, благодаря чему легко использовать направленные свойства для ослабления действия мешающих радностанций, Однако эти антенны обладают очень малой действующей высотой. В формуле:

$$h_{\pi} = 164 d_{\rm c}^2 \mu_{\pi} \omega f \cdot 10^{-10},$$
 (5-33)

 $d_{\rm c}$  — диаметр стержия сердечника;  $\mu_{\rm A}$  — его действующая магнитная пронидаемость; w — число витков; f — частота сигнала. Действующая высота магнитной антенны обычно не превышает 0,5-1 см, что сильно увеличивает удельный вес собственных шумов приемника по сравнению с внешними помехами. Для повышения  $\mu_{\rm A}$  следует брать большее отношение  $l_{\rm c}/d_{\rm c}$ , где  $l_{\rm c}$  — длина сердечника.

При нескольких рабочку подднапазонах на одном сердечиные выполняют антепны для двух подднапазонов. В этом случае оптималь-

пое размещение обмоток на сердечнике соответствует рис. 5-5 и определяется равенствами:

$$a/l_c = 0.3 \text{ H } l_\kappa/l_c = 0.2,$$
 (5-34)

в которых  $I_{\kappa}$  — длина намотки контурной катушки. Диаметр контурной катушки  $d_{\kappa}$  должен быть по возможности ближе к лиаметру сердечника.

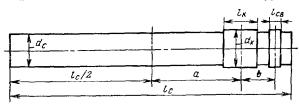
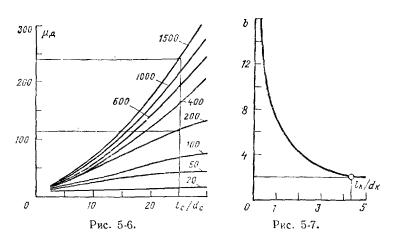


Рис. 5-5.



Поэтому катушки наматывают на тонкий каркас, туго насаживаемый на сердечник.

Параметры контура рассматриваемой входной цепи выбираются по методике § 5-3. При известной индуктивности контурной катушки число ее витков определяется уравнением

Лействующую магнитную проницаемость сердечника определяют по графикам рис. 5-6. Материал сердечника выбирают так, чтобы в рабочем днапазоне частот он обеспечивал малое эквивалентное затухание контура. На километровых волнах берут сердечники с магнитной проницаемостью 600—2000, на гектометровых — 400—1000, на декаметро-

вых 100-400 и метровых 10-75. Параметр b определяют по графику рис. 5-7. После вычисления числа витков выбирают диаметр провода без изоляции d для намотки катушки так, чтобы выполнялось неравенство

$$1,3d < l_{\kappa}/\omega < 3.$$
 (5-36)

Собственное затухание контуров в километровом и гектометровом диапазонах волн обычно составляет 0.008-0.01, а в декаметровом и метровом -0.01-0.02.

На рис. 5-8 приведены наиболее распространенные схемы входных цепей с ферриговыми антеннами. На рис. 5-8, а изображена схема с индуктивной связью со входом первого каскада. Она обеспечивает достаточно хорошее постоянство коэффициента передачи в днапазоне рабочих частот, по ее полоса пропускания значительно возрастает с увеличением частоты, что ухудшает селективность в конце поддиапазона. Схема с внутриемкостной связью (рис. 5-8, б) дает достаточно большое

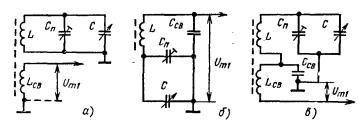


Рис. 5-8.

возрастание коэффициента передачи с частотой, но обеспечивает хорошее постоянство полосы пропускания. Ее применение целесообразно при высоких требованиях к селективности. Схема с индуктивно-емкостной связью со входом первого каскада (рис. 5-8, в) обеспечивает больший коэффициент передачи при лучшем постоянстве параметров в диапазоне частот, поэтому имеет применение в высококлассных приемниках.

1. При трансформаторной связи со входом первого каскада и заданном эквивалентном затухании входного контура индуктивность катушки связи вычисляют по формуле

$$L_{\rm cb \, \delta_{\rm g}} \approx 0.44 \, (\delta_{\rm g} - \delta) / (g_{\rm gx} f_{\rm min}).$$
 (5-37)

Здесь  $g_{\rm RX}$  должно соответствовать минимальной частоте поддивпазона. Если требуется обеспечить минимальный коэффициент шума первого каскада, то берут:

$$L_{\rm cs.m} \approx 0.448/(g_{\rm m}f_{\rm min}) \tag{5-38}$$

Проводимость  $g_{\rm in}$  соответствует условию обеспечения минимального коэффициента шума в первом каскаде. Для схемы с ОЭ она определяется равенством

$$g_{\text{m}} = \sqrt{\frac{g(1+r_6g) + G_{\text{m}}(1+r_6g)^2 + r_6b_{11}^2 + R_{\text{m}}(g+g_{11})^2}{r_6 + R_{\text{m}}}}.$$
 (5-39)

Эквивалентное затухание входного контура

$$\delta_{\mathbf{a}} = \delta \left( 1 + 2.26 \frac{L_{ca}}{\delta} g_{ax} f \right). \tag{5.40}$$

Коэффициент передачи входной цени

$$K_{\theta\theta\cdot\Pi} = \frac{0.6}{\delta_{\theta}} \sqrt{\frac{L_{cB}}{L}}.$$
 (5-41)

При внутриемкостной связи со входом первого каскада и заданном эквивалентном затуханни емкость конденсатора связи берут из уравнения

$$C_{c_{\mathsf{B}}\delta_{\mathsf{g}}} = \frac{1}{\omega_{0\,\min}^2 L} \left( \sqrt{\frac{g_{\mathsf{BX}}\omega_{\min}L}{\delta_{\mathsf{g}} - \delta}} - 1 \right). \tag{5-42}$$

Входная проводимость гранзистора должна соответствовать минимальной частоте поддиапазона. Для обеспечения минимального коэффициента шума первого каскада следует принимать:

$$C_{\text{c.B. m}} = \frac{V g_{\text{m}}/g - 1}{\omega_{0 \, \text{min}}^2 L}.$$
 (5-43)

При расчете по формулам (5-39) и (5-42) проводимость контура и параметры транзистора должны соответствовать минимальной частете подднапазона.

Конденсатор связи включается в контур последовательно с основными конденсаторами и уменьшает коэффициент диапазона. Поэтому даиную схему можно применять при относительно малых  $k_{\rm g} < 1,5$  и если

$$C_{\rm cg} \ge (20 \div 30) (C_{\rm max} + C_{\Sigma}) - C_{\rm gx}.$$
 (5-44)

Эквивалентное затухание контура вычисляется по формуле

$$\delta_{\vartheta} = \delta \left[ 1 + \frac{g_{\text{BX}}}{g \left( 1 + \omega^2 L C_{\text{CB}} \right)} \right]. \tag{5.45}$$

Коэффициент передачи определяется уравнением

$$K_{\text{OB, H}} = 1/(\delta_{\text{g}} C_{\text{cB}} L \omega_{\text{min}}^2). \tag{5-46}$$

Чтобы обеспечить требуемый коэффициент диапазона, суммарная емкость  $C_{\Sigma}$  делжна выбираться по уравнению

$$C_{\Sigma} = \sqrt{\frac{0.25 (C_{\text{max}} + C_{\text{min}} + C_{\text{cB}})^{2} + \frac{C_{\text{cB}}}{k_{\pi}^{2} - 1} (C_{\text{max}} - k_{\pi}^{2} C_{\text{min}}) - C_{\text{max}} C_{\text{min}}} - \frac{C_{\text{cB}}}{-0.25 (C_{\text{max}} + C_{\text{min}} + C_{\text{cB}})}.$$
 (5-47)

3. При трансформаторно-эмкостный связи для заданного эквивалентного затухания индуктивность катушки связи берут вдвое

меньше значения, определяющегося формулой (5-37), а емкость конденсатора связи вдвое больше значения, получающегося по уравнению (5-42). Коэффициент передачи в этом случае равен сумме значений, получающихся при расчете по формулам (5-41) и (5-46) на одина-

ковых рабочих частотах,

Пример 5-4. Рассчитать параметры входной цепи поддиапазона 2 переносного приемпика 1 класса при трансформаторной связи с первым каскадом. В п. 3 § 2-5 для подднапазона 2 определено минимально необходимое эквивалентное затухание контура  $\delta_9 = 0,039$  и собственное 0,01. В первом каскаде приемника используется транзистор ГТ308В с параметрами из табл. 6-2. Емкость конденсатора переменной емкости изменяется от 10 до 365 пФ.

Согласно табл. 2-2 граничные частоты поддиапазона 2 равны 515

Согласно табл. 2-2 граничные частоты поддиапазона 2 равны 515 и 1640 к $\Gamma$ ц при  $k_{\rm g}=3,18$ . Поскольку  $k_{\rm g}$  достаточно большой, подгонку коэффициента диапазона контура выполняем с помощью подстроечного конденсатора. Чтобы получить требуемый коэффициент диапазона,

следует иметь:

$$C_{\Sigma} = \frac{(C_{\text{max}} - k_{\text{A}}^{2} C_{\text{min}})}{(k_{\text{A}}^{2} - 1)}.$$
 (5.48)

В данном случае  $C_{\Sigma}=(365-3,18^2\cdot 10)$   $(3,18^2-1)=29$  пф, что соответствует табл. 5-1 и может быть принято. По уравнению (5-15) находим  $C_{9\,\mathrm{max}}=365+29=394$  пФ и по равекству (2-101)  $L=1/(6,28^2\cdot 515^2\cdot 10^6\cdot 394\cdot 10^{-12})=0,000242$  Гн. Выбираем сердечник длиной 20 см, диаметром 8 мм при магнитной проницаемости 1500. По рис. 5-6 для  $I_{\mathrm{c}}/d_{\mathrm{c}}=20/0,8=25$  находим  $\mu_{\mathrm{d}}=240$ . Принимаем  $d_{\mathrm{K}}=1,15\cdot 0,8=0,92$  см. По второму равенству (5-34) определяем  $I_{\mathrm{K}}=0,2\cdot 20=4$  см. Отношение  $I_{\mathrm{K}}/d_{\mathrm{K}}=4/0,92=4,35$ . По рис. 5-7 получаем коэффициент b=2. Подставляя полученные значения в уравнение (5-35), имеем  $w=2280\times$ 

$$\times \sqrt{\frac{0.00^{\circ}242 \left(1.15+V \overline{1.15}\right)}{240 \cdot 2 \cdot 0.0092 \left(0.09+0.95 \cdot 0.2\right) \left(1-0.765 \cdot 0.6^{2}-0.255 \cdot 0.2^{2}\right)}} = 42.$$

По равенству (5-25) находим  $f_{\rm cp}'=\sqrt{515\cdot 1640}=920$  кГц. Из формулы (5-33) вычисляем для начала подднапазона  $h_{\rm д515}=164\cdot 0,008^2\cdot 240\cdot 42\cdot 515\, 000\cdot 10^{-10}=0,0053$  м. Аналогично получаем  $h_{\rm д920}=0,0096$  м и  $h_{\rm д1640}=0,0171$  м. Пользуясь уравнением (5-37), находим  $L_{\rm CB}\approx 0,44\, (0,039=0,01)\,/\, (0,001\cdot 515\, 000)=0,000025$  Гн.

Проверим значение суммарной емкости  $C_\Sigma$ . Положим  $C_{\mathbf{k}}=4$  пФ, а  $C_{\mathbf{m}}=2$  пФ. Для схемы входной цепи с магнитной антенной в формуле (5-14) следует считать  $C_1=0$ , а коэффициент связи между катушками  $k\approx 0$ ,6. Тогда по аналогии с формулой (5-3) можно записать

 $p_2=0.6$   $\sqrt{\frac{0,000025}{0,000242}}=0.2$ . Средняя емкость подстроечного конденсатора согласно уравиению (5-14) должна быть  $C_{\rm II}=29-4-0.2^2$  (2 +40) = 23,3 пФ. Из табл. П-4-2 выбираем конденсатор типа КПК-1 емкостью 6-25 пФ.

По равенству (5-40) вычисляем эквивалентное затухание контура для середины и конца поддиапазона:  $\delta_{3920} = 0.073$  и  $\delta_{21640} = 0.133$ . Коэффициент передачи находим по формуле (5-41)  $K_{0.3,11.515} =$ 

 $=\frac{0,6}{0,039}\sqrt{\frac{0,000025}{0,000242}}=5;\;\;K_{\rm OB,\, 1920}=2.7\;\;$  и  $K_{\rm OB,\, 11640}=1.5.\;\;$  Полоса пропускания согласно равенству (2-85)  $\Pi_{51},=0,039\cdot515=20\;$  кГц,  $\Pi_{920}=67\;\;$  кГц и  $\Pi_{1640}=212\;\;$  кГц.

#### 5-6. Расчет входной цепи приемника «для охоты на лис»

Схема рассматриваемой входной цепи показана на рис. 5-9. Чтобы получить днаграмму направленности в виде кардноиды, необходимо обеспечить равные коэффициенты передачи по полю от штыревой антенны  $A_1$ 

$$K_{0 \text{ B. fl. m}} = \frac{\rho_2 h_{\text{fl. m}}}{\omega_{\text{min}} C_{2 \text{max}} \delta_{\text{s}} Z_{\text{A}}}$$
 (5-49)

и рамочной (или магнитной) антенны

$$K_{0 \text{ B. H. p}} = p_2 h_{\text{A. p}} / \delta_{\text{s.}}$$
 (5-50)

Индуктивностью входного контура является индуктивность  $L_{\rm A~p}$  рамочной антенны. Поэтому расчет начинают с определения необходимого изменения эквивалентной емкости входного контура для обеспечения требусмого коэффициента диапазона. Емкость конденсатора  $^{\rm g}$  связи  $C_{\rm cB}$  со входом первого каскада должия удовлетворять неравенству

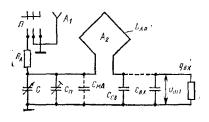


Рис. 5-9.

(5-44), в котором  $C_{\Sigma}$  определяется уравнением (5-14). Эквивалентное затухание входного контура находится из равенства

$$\delta_{9} = \delta \left[ 1 + \rho_{1}^{2} \frac{1}{R_{A} \left( 1 + \frac{1}{\omega_{\min}^{2} C_{A}^{2} R_{A}^{2}} \right) \delta \omega_{\min} C_{9 \max}} + \rho_{2}^{3} \frac{g_{BX}}{\delta \omega_{\min} C_{9 \max}} \right], \tag{5-51}$$

где

$$\rho_{1} = \frac{C_{\text{cn}} + C_{\text{RX}}}{C_{\text{max}} + C_{\text{n}} + C_{\text{MA}} + C_{\text{RX}} + C_{\text{cn}}}$$
(5-52)

$$p_2 = \frac{C_{\text{max}} + C_{\text{n}} + C_{\text{MA}}}{C_{\text{max}} + C_{\text{n}} + C_{\text{MA}} + C_{\text{BX}} + C_{\text{CB}}};$$
 (5-53)

$$C_{\text{s max}} = \frac{(C_{\text{max}} + C_{\text{n}} + C_{\text{MA}}) (C_{\text{ex}} + C_{\text{cB}})}{C_{\text{max}} + C_{\text{n}} + C_{\text{n}} + C_{\text{MA}} + C_{\text{ex}} + C_{\text{cB}}}$$
(5-54)

и С<sub>мА</sub> — емкость, вносимая в контур от монтажа и штыревой антенны. При выполнения веравенства (5-44) коэффициент включения входа первого каскада и. должен превышать 0,03—0,05, а коэффи-

циент включения штыревой антенны будет больше 0,97-0,95, что является одним из исходных данных расчета. Обозначим:

$$C_{\mathbf{n}} + C_{\mathbf{M}\mathbf{A}} = C_{\Sigma}. \tag{5-55}$$

Тогда для обеспечения диапазонных свойств контура необходимая емкость  $C_n$  находится из равенства (5-47) с учетом (5-55). Сопротивление антенного резистора определяется неравенством

$$R_{\rm A} \ge \frac{(3 \div 6) \left(C_{\rm max} + C_{\Sigma}\right)}{\omega_{\rm min} C_{\Sigma} C_{\rm MA}}.$$
 (5-56)

Чем больше это сопротивление, гем лучше фазировка сигналов от обенх антени при их сложении, выше селективность, но несколько меньше коэффициент передачи штыревой антенны, так как модуль полного согротивления этой антенны

$$Z_{\rm A} \approx \sqrt{R_{\rm A}^2 + 1/(\omega^2 C_{\rm MA}^2)}$$
. (5-57)

Действующая высота штыревой антенны длиной  $l_{\mathsf{A}}$ 

$$h_{A_{11}} \approx (0.5 \div 0.6) l_{A_{\bullet}}$$
 (5-58)

Индуктивность рамочной антенны вычисляется по формуле (2-101) для отп.

Пример 5-5. Рассчитать входную цепь приемника «для охоты на лис» по следующим исходным данным: диапазон рабочих частот 3,5-3,8 МГц, выходная емкость штыревой антенны 8 пФ, начальная емкость контура усилителя радиосигнала  $C_{\Sigma}=130\,$  пФ, собственное затухание входного контура 0,008, конденсатор переменной емкости 4-20 пФ. В первом каскаде приемника используется транзистор ГТ310Б.

По табл. П-1-2 и П-1-5 определяем для средней частоты диапазона 3,65 МГц:  $g_{11}=0$ ,63 мСм и  $C_{11}=63$  пФ. При среднем значении численного коэффициента из уравнения (5-44) находим  $C_{\rm cR} \geqslant 25~(20+130)-63=3687$  пФ. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 3900 пФ. Подставляя в уравнение (5-47) вместо  $C_{\rm cs}$  сумму емкостей  $C_{\rm cs}+C_{\rm H}=3900+63=3963$  пФ, получаем необходимую емкость

$$C_{\Sigma} = \sqrt{\frac{0,25 (20 + 4 + 3963)^2 + \frac{3963}{1,085^2 - 1} (20 - 1,085^2 \cdot 4) - 4 \cdot 23}{-0,5 (20 + 4 + 3963)} = 77 \text{ n}\Phi}.$$

Из равенства (5-55) находим  $C_n=77-8=69$  пФ. По табл. П-4-2 принимаем конденсатор типа КПК-2 емкостью от 25 до 100 пФ. Положив численный коэффициент равным 5, по неравенству (5-56)

находим:

$$R_{\rm A} \ge \frac{5 (20 + 77) \cdot 10^{-12}}{6.28 \cdot 35 \cdot 10^{\frac{5}{2} \cdot 77 \cdot 8 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-12}} = 36 \cdot 10^{3} \, \text{Om}.$$

По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 36 кОм. Пользуясь уравнением (5-54), вычисляем:

 $C_{9,max} = (20 + 69 + 8) (3900 + 63) / (20 + 69 + 8 + 3900 + 64)$  $+ 63) = 95 \text{ n}\Phi.$ 

По формуле (2-101) находим индуктивность магнитной антенны  $L=1/\left(6,28^2\cdot35^2\cdot10^{10}\cdot95\cdot10^{-12}\right)=219\cdot10^{-7}$  Гн.

Из равенства (5-52) и (5-53) определяем:  $p_1 = (3900 + 63) / (20 + 69 + 8 + 3900 + 63) = 0,975$  и  $p_2 = (20 + 69 + 8) / (20 + 69 + 8)$ +8+3900+63)=0,024.

Эквивалентное затухание входного контура в соответствии с (5-51)

будет:

$$\delta_{a} = 0,008 \left[ 1 + \frac{0,975^{2}}{36 \cdot 10^{3} \left( 1 + \frac{1}{6,28^{2} \cdot 35^{2} \cdot 10^{10} \cdot 8^{2} \cdot 10^{-24} \cdot 36^{2} \cdot 10^{6}} \right) \times \right. \\ \left. \times 0,008 \cdot 6,28 \cdot 35 \cdot 10^{5} \cdot 95 \cdot 10^{-12} \right] \\ \left. + \frac{0,024^{2} \cdot 63 \cdot 10^{-5}}{0,008 \cdot 6,28 \cdot 35 \cdot 10^{5} \cdot 95 \cdot 10^{-12}} \right] = 0,0212.$$

Выбираем для магнитной аптенны сердечник длиной 20 см. диаметром 8 мм и  $\mu = 200$ . По графикам рис. 5-6 находим  $\mu_n = 115$ . Остальные геометрические соотношения антенны примем соответствующими примеру (5-4). Тогда по формуле (5-35) число витков

$$w = 2280 \cdot \sqrt{\frac{\frac{219 \cdot 10^{-7} (1,15 + \sqrt{1,15})}{115 \cdot 2 \cdot 0,0092 (0,9 + 0,95 \cdot 0,2) \times}}{\times (1 - 0,765 \cdot 0,6^2 - 0,255 \cdot 0,2^2)}} = 12,3.$$

Из уравнения (5-33) получаем  $h_{\rm A,n}=164\cdot 0.008^2\cdot 115\cdot 12.3\cdot 35\cdot 10^5\cdot 10^{-10}=0.0052$  м. По формуле (5-50) получаем  $K_{\rm 0.B-H}=0.024\cdot 0.0052/0.0212=0.0059$  м. Из равенства (5-57) находим

$$Z_{A} = \sqrt{\frac{1}{36\ 000^{2} + \frac{1}{6.28^{2} \cdot 35^{2} \cdot 10^{10} \cdot 8^{2} \cdot 10^{-24}}}} = 36\ 000\ Om.$$

Подставляя полученное значение коэффициента передачи в уравнение (5-49), определяем необходимую действующую высоту штыревой антенны  $h_{\rm A,\, m}=0.0059\cdot 35\cdot 10^5\cdot 95\cdot 10^2\cdot 0.0212\cdot 36\,000/0.024=0.041$  м. Принимая среднее значение численного коэффициента, из формулы (5-58) находим длину штыря антенны  $l_A = 0.041/0.55 =$ = 0.075 M.

Глава шестая

#### РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЕЙ РАДИОСИГНАЛА

## 6-1. Исходные данные и задачи расчета

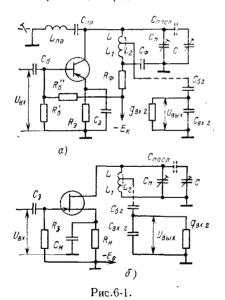
Общими характеристиками приемника определяются диапазон рабочих частот  $f_{cmin} - f_{cmax}$  или рабочие поддиапазоны, граничные частоты которых вычисляются при расчете структурной схемы при-емника. При расчете структурной схемы приемника выбираются:

число каскадов и их схемы: тип транзистора и его режим работы: напряжение источника питания; минимально необходимые коэффициент усиления  $K_0$ , эквивалентное затухание контура  $\delta_0$ , обеспечивающее минимально допустимые ослабления зеркального канала d, и сигналов с промежуточной частотой  $d_{\rm nn}$ ; входиме параметры преобразователя частоты  $g_{\rm BX, \, HY}$  и  $C_{\rm BX, \, HY}$ .

При расчете усилителя радиосигнала необходимо уточнить схему колебательных контуров, определить параметры всех его элементов, обеспечивающих работу в диапазоне рабочих частот; уточнить рабочий режим транзисторов, чтобы все исходные данные удовлетворялись с небольшим запасом: составить полную принципиальную схему усилителя и рассчитать параметры всех ее элементов, включая межкаскадные пепи.

#### 6-2. Расчет контуров с переменной настройкой конденсатором или варикапом

Типовая принципиальная схема транзисторного резонаненого усилителя с ОЭ и переменной настройкой изображена на рис. 6-1, а. На рис. 6-1, б представлена аналогичная схема с полевым однозатвор-



ным транзистором. Для двухзатворного полевого транзистора аналогичная схема дана на рис. 2-12. Сравнение каскадов показывает, что колебательные коитуры в них выполняются по одинаковой схеме. Такую же схему обычно имеет контур входной цепи (см. рис. 5-3). Выбор коэффициентов включения в контур транзистора каскада р; и входа следующего каскада р, осуществляется при расчете каскада, Однако без него согласно формуле (5-8) нельзя точно определить эквивалентную емкость контура. Поэтому предварительный расчет контура осуществляют, задавшись емкостью  $C_{\Sigma}$  по данным табл, 5-1. Затем выбирают конденсатор переменной емкости C, используя, например, табл. П-4-1 и данные табл, 5-1.

Когда коэффициент диапазона более 1,3-1,5, подгонку диапазона целесообразнее осуществлять подбором емкости подстроечного конденсатора

последовательно включенный конденсатор контура  $C_{\text{пос. л.}}$  Для этого по формуле (5-48) вычисляют емкость  $C_{\Sigma}$ . Если ее значение равно или превыщает минимальное, приведенное в табл. 5-1, то выбранный конденсатор переменной емкости обеспечит перестройку колебательного контура в заданном диапазоне частот. После этого по формуле (5-15) определяют максимальную эквивалентную емкость контура и по ее значению из уравнения (2-101) находят индуктивность контурной катушки. При наличии в приемнике нескольких поддиапазонов частот подобный расчет ведуг для поддиапазоно с наибольшим жоэффициентом диапазона. Если коэффициент диапазона менее 1,3—1,4, то подгонку диапазона выгоднее осуществлять включением в контур носледовательного конденсатора  $C_{\rm пос.n.}$  Для расчета его емкости используют уравнение (5-12). Конденсатор переменной емкости выбирают с учетом сказанного ранее. Вычислив максимальную емкость колебательного контура по равенству (5-16), из формулы (2-101) определяют индуктивность контурной катушки.

Если перестройка колебательного контура осуществляется с помощью варикапа, то его выбор производится так же, как и выбор конденсатора переменной емкости, т. е. по значениям минимальной и максимальной емкостей диода при возможном управляющем напряжении

$$U_{y} \leq (0.3 \div 0.5) E_{0},$$
 (6-1)

Таблица 6-1

Диод	Управляющее напряжение, В											Макси- мальная	
	0	0,5	I	2	3	4	5	6	7	10	15	рабочая частота, МГц	
ДГ-Ц27	80	37	30	20	15	12	10	9,5	9	8	7	150	
Д202	78	65	60	52	47	44	42	41	39	33	27	150	
Д231	980	800	760	740	715	707	700	692	685	670	650	150	
Д313	370	265	250	190	150	120	100	94	90			200	
Д316	620	<b>5</b> 00	<b>45</b> 0	400	385	363	<b>37</b> 0	362	355	343	320	200	
Д817	570	420	375	330	315	307	300	290	282	275	260	250	
Д902	17	15,1	14,5	12,5	11,2	10,2	9,5	8,7	8	6,5	4,5	500	

где  $E_{\rm o}$  — напряжение источника питапия приемпика. В табл. 6-1 приведены емкости некоторых полупроводниковых диодов в пикофарадах в зависимости от напряжения между их электродами. Анализ данных табл. 6-1 показывает, что при управляющем напряжении 6 В и емкостях  $C_{\Sigma}$ , приведенных в табл. 5-1, диоды с паибольшей максимальной емкостью (Д231, Д813, Д816, Д817) в радиовещательных поддиапазонах 1 и 2 обеспечивают коэффициент диапазона не более 1,2—1,7. Это значительно меньше требуемого (2,83—3,18).

Применим два диода Д813, которые при нулевом управляющем напряжении подключаются параллельно, что обеспечивает максимальную эквивалентную емкость контура  $C_{\mathfrak{I} max} = C_{\Sigma} + 2C_{\mathfrak{max}}$ . Для перестройки контура увеличивается управляющее напряжение на первом диоде до максимума, что уменьшает эквивалентную емкость контура. После этого первый диод отключается и на втором диоде увеличивается управляющее напряжение, чем достигается минимальная эквивалентная емкость контура  $C_{\mathfrak{I} min} = C_{\Sigma} + C_{\mathfrak{min}}$ . При этом согласно

формуле (2-1) коэффициент диапазона будет  $k_{\rm p} = \sqrt{\frac{50 + 2 \cdot 370}{50 + 94}} = 2,35$ .

Это также меньше требуемого. При включении указанным способом четырсх диодов можно получить  $k_{\pi}=3,28$ , что позволит получить

полное перекрытие рассматриваемых поддиапазонов.

Изменение емкости вариканов в зависимости от управляющего папряжения происходит по криволинейному закону. Поэтому достижение хорошей линейности шкалы настройки приемника для создания управляющего напряжения требует применения специальных потенциометров, обеспечивающих медленное (от угла поворота ручки) нарастание напряжения при малых его значениях и более быстрое при больших,

Благодаря палично активной проводимости варикап несколько увеличивает собственное загухание контура. Но варикапы позволяют уменьшать размеры и массу контура, что особенно желательно для портативных и переносных приемпиков. Из-за существенного разброса параметров при одноручечной настройке всех контуров раднотракта вариканами требуется применять специальные меры для обеспечения необходимого сопряжения настреск контуров [16].

В радиовещательных поддиапазопах с 3 по 12 один варикап (например, Д202 или Д902) обеспечит необходимую перестройку контура. **Пример 6-1.** Рассчитать параметры колебательного контура для поддиапазона 2 ( $f_{\min}=515$  кГц,  $f_{\max}=1640$  кГц,  $k_{\mu}=3.18$ ).

Из табл. П-4-1 выбираем конденсатор с изменением емкости от 10 до 365 пФ. Поскольку  $k_{\rm x} > 1.5$ , применяем нараглельный конденсатор для подгонки крайних частот контура и по формуле (5-48) вычисляем требующуюся емкость  $C_N = (365 - 3.18^2 \cdot 10) / (3.18^2 - 1) = 29 \text{ пФ},$ что практически допустимо, так как лишь на 3 % ниже данных табл. 5-1. Пользуясь формулой (5-15), вычисляем  $C_{9\,\mathrm{max}}=365\pm29=$ = 394 пФ. По уравнению (2-101) паходим индуктивность контурной катушки  $L=6.28^2\cdot 515^2\cdot 10^6\cdot 394\cdot 10^{-12}=0.00024$  Гн, что удовлетворяет данным табл. 5-1.

Пример 6-2. Рассчитать параметры колебательного контура для поддиапазона 12 при настройке варикапом ( $f_{\min} = 67 \text{ МГц}, f_{\max} =$ 

= 74.5 МГц,  $k_{\rm A}$  = 1.11,  $E_{\rm 0}$  = 12 В). Выбираем из табл. 6-1 диод Д902. При максимальном численном коэффицисите из равенства (6-1) находим  $U_y = 0.5 \cdot 12 = 6$  В. В этом случае изменение емкости диода согласно табл. 6-1 происходит от 8,7 до 17 пФ. При параллельном конденсаторе для подгонки коэффициента днапазона по формуле (5-48) получаем  $C_{\Sigma} = (17-1,11^2 \cdot 8,7) / (1,11^2-1)$ — 1) = 27,4 пФ, что удовлетворяет данным табл. 5-1. Из равенства (5-15) паходим  $C_{\rm s\,max}=17-27,4=44,4$  пФ и по уравнению (2-101) определяем  $L=1/(6.28^2\cdot 67^2\cdot 10^{12}\cdot 444\cdot 10^{-13})=127\cdot 10^{-9}$  Гн, что по данным табл, 5-1 приемлемо.

Если применить последовательный конденсатор для подгонки коэффициента диапазона, то, положив согласно табл. 5-1  $C_{\Sigma}=13$  п $\Phi$ ,

по формуле (5-13) вычисляем коэффициенты 
$$\mathcal{A}=\frac{(\overline{1,11^2-1})}{2}\times \frac{[13(17+8,7)+17\cdot8,7]}{[13+17-1,11^2(13+8,7)]}=16,8$$
 пФ и  $\mathcal{B}=\frac{(1,11^2-1)\cdot13\cdot17\cdot8,7}{13+17-1,11^2(13+8,7)}=16,8$  пФ и  $\mathcal{B}=\frac{(1,11^2-1)\cdot13\cdot17\cdot8,7}{13+17-1,11^2(13+8,7)}=133,8$  (пФ)2. Нз уравнения (5-12) получаем  $C_{\text{посл}}=16,8+16,8^2+133,8=37,2$  пФ. По формуле (5-16) вычисляем  $C_{\text{3-max}}=17\cdot37,2/(17+37,2)+13=24,7$  пФ и по равенству (2-101)  $L=1/(6,28^2\cdot67^2\cdot10^{12}\cdot247\cdot10^{-13})=228\cdot10^{-9}$  Гн. При последовательном

конденсаторе индуктивность контурной катушки получилась в 228/127 = 1,8 раза больше. Согласно уравнению (2-55) собственная проводимость колебательного контура будет в 1,8 раза меньше, чем при параллельном конденсаторе. Это улучшит селективные и усилительные свойства каскада (или входной цепи).

#### 6-3. Расчет каскада резонансного усилителя на максимальное усиление при постоянной настройке

Коэффициент усиления каскада не должен превышать своего устойчивого значения, которое определяется формулами (2-66) для схемы с ОЭ и (2-93) при схеме с ОБ. Поскольку тип транзистора и схема каскада выбираются при расчете структурной схемы приемника, то прежде всего определяется устойчивый коэффициент усиления  $K_{0 \text{ уст}}$  каскада.

1.  $\vec{B}$  случае заданной полосы пропускания максимальный коэффициент усиления каскада получается при выборе коэффициентов включения по формулам (5-5) и (5-6). В формуле (5-5) следует заменить проводимость  $g_A'$  на проводимость коллекторной цепи транзистора

$$g'_{22} = g_{22} + g_{\text{M-K}} = 1/r'_{22} = G_1.$$
 (6-2)

Здесь  $g_{\text{м. к}}$  — проводимость элементов цепи питания коллектора транзистора каскада, например резистора  $R_{\text{к}}$ , через который подводится напряжение на коллектор в схеме параллельного питания. В схеме последовательного питания  $g_{\text{м. k}}=0$ . Коэффициент усиления каскада  $K_{0\,\text{max}}$  в данном режиме вычисляют по равенству (2-86), заменяя  $g_{22}$  на  $g_{22}'$  согласно уравнению (6-2) и понимая под  $g_{11}$  — проводимость входа следующего каскада  $g_{\text{вх. пч}}$ . Если выполияется неравенство

$$K_{0\max} \leqslant K_{0\text{ yc}_1},\tag{6-3}$$

то режим максимального усиления при требуемой полосе пропускапия осуществим. Если же иеравенство (6-3) не выполняется, то расчет

каскада производят по методике § 6-5.

Расчет элементов схемы питания и стабилизации коллекторного тока проводится по формулам (3-16) — (3-24). При этом в формуле (3-16) сопротивление  $r_1$  следует заменить на  $R_{\Phi}$  согласно рис. 6-1, a. Падение напряжения на резисторе развязывающего фильтра  $U_1$  принимают равным 0.5-1.5 В, тогда

$$R_{\Phi} = U_1 / I_{K0}. \tag{6-4}$$

Емкость конденсатора фильтра вычисляют по формуле (3-19), заменяя в ней  $C_9$  па  $C_{\rm th}$ ,  $F_{\rm H}$  па  $f_{\rm C,min}$  и  $R_9$  на  $R_{\rm th}$ .

Для маломощных высокочастотных транзисторов следует принямать напряжение  $U_{5,9,0}{\approx}15\div0.3$  В.

Емкость разделительного конденсатора в схемах на рис. 6-1 должна удовлетворять неравенствам:

$$C_6 > (30 \div 100) C_{11 (2)}; \quad C_6 > (19 \div 20) g_{11 (2)} / f_{\min}.$$
 (6-5)

Пример 6-3. Рассчитать каскад резонансного усилителя по схеме с ОЭ при последовательном питании на получение максимального усиления для поддилиазона 12 связного приемника с фиксированной настройкой на средней частоте, используя транзистор ГТ313Б при  $I_{\rm K}=$ 

= 1 мА и  $U_{Ka} = -5$  В. Следующим каскадом является преобрагователь частоты на том же транзисторе по схеме с ОЭ при таком же режиме работы. Напряжение источника питания  $E_{\kappa 0}=12~{
m B}.$ 

Согласно табл. 1-3  $f_{\rm c\,min}=144$  МГц и  $f_{\rm c\,max}=146$  МГц. Следовательно,  $f_{\rm cp}=0.5$  (144+146) = 145 МГц. Полоса пропускания каскада  $H=f_{\rm c\,max}-f_{\rm c\,min}=146-144=2$  МГц. По формуле (2-85) находим  $\delta_9=2/145=0.0138$ . Собственное затухание контура будем

считать равным 0,008.

113 табл. П-1-1 находим:  $Y_{21}=0.032$  См;  $g_{11}=9.5$  мСм;  $g_{22}=970$  мкСм;  $C_{11}=12$  пФ;  $C_{12}=1$  пФ;  $C_{22}=4$  пФ;  $h_{21}^*=0.993$ . По равенствам (2-67) получим  $g_{11}$  (2) =  $0.75\cdot 9.5=7.1$  мСм и  $C_{11}$  (2) =  $0.8\cdot 12=9.6$  пФ. По уравнению (2-66) вычисляем  $K_{0}$  уст  $=\sqrt{\frac{\frac{2(1-0.9)0.032}{6.28 \cdot 1.45 \cdot 10^8 \cdot 10^{-12}}}{\frac{0.5 \cdot 0.032}{1.97 \cdot 10^{-5} \cdot 71 \cdot 10^{-4}}}} = 2,65.$  По равенству (2-86) получаем  $K_{0,\text{max}} = \frac{0.5 \cdot 0.032}{1.97 \cdot 10^{-5} \cdot 71 \cdot 10^{-4}} \left(1 - \frac{0.008}{0.0138}\right) = 2,55.$  Неравенство (6-3)

При отсутствии конденсатора для перестройки контура согласно уравнению (5-15) и данным табл. 5-1 принимаем  $C_9 = C_\Sigma = 10$  пФ.  $\Gamma$ о равенству (2-101) находим  $L=1/(6,28^2\cdot 1,45^2\times 10^{16}\cdot 10^{-11})=$ = 121·10<sup>-9</sup>. Гн, что по табл. 5-1 реализуемо. По выражению (2-55)

получаем 
$$g=0.008\cdot 6.28\cdot 145\cdot 10^6\cdot 10^{-11}=73\cdot 10^{-6}$$
 См. Вычисляем по (5-5)  $p_{1\delta_9}=\sqrt{\frac{73\cdot 10^{-6}}{2\cdot 97\cdot 10^{-5}}} \frac{\sqrt{0.0138}}{\sqrt{0.008}}-1 = 0.165$  и по (5-6)  $p_{2\delta_9}=\sqrt{\frac{73\cdot 10^{-6}}{2\cdot 71\cdot 10^{-4}}} \frac{\sqrt{0.0138}}{\sqrt{0.008}}-1 = 0.061$ . Положим  $C_{\text{м1}}=C_{\text{м2}}=1$  пФ и  $C_{\text{к}}=0.7$  пФ (см. табл. 5-1). Заменяя в формуле (5-8)  $C_{\text{A}}'$  па  $C_{22}$ . вычисляем среднюю емкость подстроечного конденсатора  $C_{\text{п}}=10-0.7-0.165^2$  (4 + 1) —  $0.061^2$  (12 + 1) = 9.1 пФ. По табл. П-4-2 принимаем конденсатор типа КПК-1 с изменением емкости от 4 до 15 пФ.

Схема каскада соответствует рис. 6-1, а при исключении из иле конденсаторов C и  $C_{\rm noc, n}$ . Принимаем напряжение  $U_1=1$  В и по фермуле (6-4) находим  $R_{\Phi}=1/10^{-3}=10^3$ . Ом. По табл. П-3-1 выбираем резистер сопротивлением 1 кОм. С учетом сказанного ранее вычисляем 1 кО перавенству (3-19)  $C_{\Phi} \geqslant (10 \div 20) / (144 \times 10^8 \cdot 10^3) = (7 \div 14) \times 10^{-11} \ \Phi$ . По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 120 пФ. По уравнению (3-17) находям  $U_{R_9} = 12 - 1 - 5 = 6 \ \mathrm{B}$ . Ток базы в рассочей точке в первом приближении определяется формулой

$$I_{\rm E0} = (1 - h_{216}) I_{\rm K0}.$$
 (6-6)

В данном случае  $I_{E0}=(1-0.993)\cdot 10^{-3}=7\cdot 10^{-6}$  А. По равенству (3-18) вычисляем  $R_0 = 6/(10^{-3} + 7 \cdot 10^{-6}) = 5950$  Ом. Из табл. П-3-1 принимаем резистор с сопротивлением 5,6 кОм. Падение напряжения на нем будег  $U_{R_9} = I_{K_0}R_9 = 10^{-3} \cdot 5,6 \cdot 10^3 = 5,6$  В. По формуле (3-19) получаем  $C_9 \ge (10 \div 20) / (144 \cdot 10^6 \cdot 5600) = (12 \div 24) \cdot 10^{-12}$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 22 пФ. Положим  $U_{\rm D\ni 0}=0.22$  В. Тогда по уравнению (3-20) получаем  $U_{R_6}'=5.6+$ + 0,22 = 5,82 В. Принимая численный коэффициент в уравнении

(3-21) равным 8, получаем  $I_{\rm R}=8\cdot7\cdot10^{-6}=56\cdot10^{-6}$  А. Вычисляем по формуле (3-22)  $R_5'=5.82/(56\cdot10^{-6})=104$  000 Ом и из равенства (3-23) находим  $R_6''=(12-5.82)/(56\cdot10^{-6}+7\cdot10^{-6})=98$  000 Ом. По табл. П-3-1 выбираем резисторы сопротивлением по 100 кОм. Коэффициент иестабильности коллекторного тока находим по уравиению (3-24)  $\sigma=\frac{1+5.6/100+5.6/100}{1-0.993+5.6/100+5.6/100}=9.3, \text{ что приемлемо. Согласно неравенствам } (6-5) C_6>(30\div100) 9.6=290\div960$  пФ и  $C_6>\frac{(10\div20)71\cdot10^{-4}}{(144\cdot10^6)}=(5\div10)\cdot10^{-10}$  пФ. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 1000 пФ.

2. В режиме согласования коэффициент усиления и эквивалентное затухание контура каскада определяются уравнениями (2-68) и (2-76) при замене проводимости  $g_{11\kappa}$  на выходную проводимость транзистора  $g_{22}=G_1$ . Коэффициенты включения к контуру вычисляются по формулам (2-54).

Пример 6-4. Рассчитать каскад резонансного усилителя в режиме согласования по основным исходным данным примера 6-3. По формуле (2-68) получаем  $K_{\text{ о. c max}} = \frac{0.5 \cdot 0.032}{\sqrt{(97 \cdot 10^{-5} + 73 \cdot 10^{-6}) \cdot 71 \cdot 10^{-4}}} = 5,9.$  Это больше коэффициента устойчивого усиления. Поэтому контур к транзистору необходимо включить с коэффициентом включения

$$\rho_{1} = \frac{K_{0 \text{ ycr}}}{K_{0. \text{ c max}}} \sqrt{\frac{g}{g_{22} \left[1 - \left(\frac{K_{0 \text{ ycr}}}{K_{0. \text{ c max}}}\right)^{2}\right] + g}}.$$
 (6-7)

В этом случае расчетные формулы приобретают вид:

$$K_{\text{o.c}} = \frac{0.5\rho_1 Y_{21}}{\sqrt{(\rho_1^2 g_{22} + g) g_{BX}}}; \tag{6-8}$$

$$\delta_9 = 2\delta (1 + p_1^2 g_{22}/g); \quad p_2 = \sqrt{\frac{p_1^2 g_{22} + g}{g_{BX}}}.$$
 (6-9)

В рассматриваемом случае

$$p_{1} = 2,65/5,9 \sqrt{\frac{73 \cdot 10^{-6}}{97 \cdot 10^{-\frac{1}{2}} \left[1 - \left(\frac{2,65}{5,9}\right)^{2}\right] + 73 \cdot 10^{-6}}} = 0,132;$$

$$K_{0 \cdot c} = \frac{0,5 \cdot 0,132 \cdot 0,032}{\sqrt{(0,132^{2} \cdot 97 \cdot 10^{-\frac{1}{2}} + 73 \cdot 10^{-6})71 \cdot 10^{-4}}} = 2,65;$$

$$\delta_{a} = 2 \cdot 0,008 \left(1 + 0,132^{2} \cdot \frac{0,00097}{0,000073}\right) = 0,02;$$

$$p_{3} = \sqrt{\frac{0,132^{2} \cdot 97 \cdot 10^{-\frac{1}{2}} + 73 \cdot 10^{-6}}{0,0074}} = 0,113.$$

Заменяя в формуле (5-8)  $C_{\rm A}'$  на  $C_{22}$ , вычисляем среднюю емкость подстроечного конденсатора  $C_{\rm H}=10-0.7-0.132^2~(4+1)-0.0113^2\times \times (12+1)=9.05~{\rm n}\Phi$ . Конденсатор может быть того же типа, как и в примере 6-3.

Сравним данные примеров 6-3 и 6-4. В режиме согласования коэффициент усиления на 4 % выше, а эквивалентное затухание контура на 45 % больше. Выбор режима расчета определяется тем, какой из параметров каскада (усиление или селективность) необходимо иметь лучшим.

### 6-4. Расчет каскада резонансного усилителя на минимальную полосу пропускания при постоянной настройке и заданном усилении

Данный режим расчета чаще всего применяется на декаметровых и более коротких волнах, когда неравенство (6-3) не выполняется и расчет следует вести на получение  $K_{0 \text{уст}}$ ; эквивалентное затухание при этом должно быть возможно меньшим. Реализуется данный режим при коэффициентах включения, соответствующих равенствам (5-5) и (5-6). В формуле (5-5)  $g'_{\Lambda}$  следует заменить на  $g_{22}$ . Минимально осуществимое эквивалентное затухание контура при этом будет:

$$\delta_{\text{9 min}} = \frac{\delta Y_{21}}{Y_{21} - 2K_0 V g_{22} g_{\text{BX}}(2)}.$$
 (6-10)

Пример 6-5. Рассчитать каскад усилителя радиосигнала по схеме с ОЭ на транзисторе ГТ313Б при  $I_{\rm K0}=1$  мА,  $U_{\rm ЭK0}=$  5 В,  $E_{\rm 0}=12$  В ( $Y_{\rm 21}=54$  мСм,  $C_{\rm 12}=1$  пФ,  $C_{\rm 22}=4$  пФ,  $C_{\rm 11}=24$  пФ,  $g_{\rm 11}=6,1$  мСм,  $g_{\rm 22}=550$  мкСм). Входные параметры следующего каскада:  $g_{\rm BX}$  ( $_{\rm 2}$ ) = 0,75  $g_{\rm 11}=4,6$  мСм и  $C_{\rm BX}$  ( $_{\rm 2}$ ) = 24 пФ. Частота сигнала 72,14 МГи, ширина спектра АМС 30 кГц (что соответствует сигналу стереофонических программ в Московской области). Собственное затухание контура 0,007.

Рассчитаем по формуле (2-42) необходимую полосу пропускания приемника, полагая  $b_c=10^{-6},\ b_r=2\cdot 10^{-4},\ f_{np}=8.4$  МГц при верхней настройке гетеродина:  $\Pi=3\cdot 10^4+2$  V  $10^{-12}\cdot 7214^2\cdot 10^8+10^8$ 

 $+4\cdot10^{-8}(72,14+8,4)^2\cdot10^{12}=62\ 200\ \Gamma$ ц. Согласно формуле (2-85), чтобы получить такую полосу пропускания, следует обеспечить эквивалентное затухание контура  $\delta_9=62\ 200/72\ 140\ 000=0,00086$ . Это в 8 раз меньше собственного затухания контура и неосуществимо. Поэтому рассчитаем усилитель на получение возможно меньшего эквивалентного затухания.

По уравнению (2-66) вычисляем  $K_{\text{uycr}} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)0.054}{6.28 \cdot 72\,140\,000 \cdot 10^{-12}}} = 4.88$ . По формуле (6-10) находим

$$\delta_{\text{smin}} = \frac{0.007 \cdot 0.054}{0.054 - 2 \cdot 4.88 \text{ V} \cdot 55 \cdot 10^{-5} \cdot 46 \cdot 10^{-4}} = 0.0098.$$

С учетом данных табл. 5-1 считаем  $C_9=C_\Sigma=15$  пФ. По уравиенню (2-101) получаем  $L=1/\left(6,28^2\cdot7214^2\cdot10^8\cdot15\cdot10^{-12}\right)=324\cdot10^{-9}$  Гп, что удовлетворяет табл. 5-1.

По равенству (2-55) находим 
$$g = 0.007 \cdot 6.28 \cdot 7214 \cdot 10^4 \cdot 15 \times 10^{-12} = 476 \cdot 10^{-7}$$
 См. Вычисляем по (5-5)  $p_1 = \sqrt{\frac{476 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 55 \cdot 10^{-5}}} \left( \frac{0.0098}{0.007} - 1 \right) = \sqrt{\frac{476 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 55 \cdot 10^{-5}}}$ 

= 0,13 и по (5-6) 
$$p_2 = \sqrt{\frac{476 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 46 \cdot 10^{-4}} \left(\frac{0,0098}{0,007} - 1\right)} = 0,045$$
. Заменяя

в формуле (5-8)  $C_{\rm A}'$  на  $C_{22}$  и полагая  $C_{\rm K}=C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=1$  пФ, вычисляем среднюю емкость подстроечного конденсатора  $C_{\rm R}=15-1-0.13^2\times (4+1)-0.045^2$  (24+1)=13,1 пФ. Режим работы транзистора соответствует примеру 6-3. Поэтому сопротивления схемы питания сохраняются теми же. Поскольку резонаисная частога усилителя в 144/72,14=2 раза меньше, емкость конденсатора фильтра следует взять в 2 раза больше. По табл. II-3-2 принимаем конденсаторы емкостью  $C_{\rm ch}=240$  пФ и  $C_{\rm 9}=47$  пФ.

В режиме согласования и обеспечения  $K_0 = K_{0,\text{уст}}$  эквивалентное затухание контура получилось бы 0,0153, что в 0,0153/0,0098 = 1,55 раза

ниже, чем в рассмотренном режиме.

# 6-5. Расчет резонансного усилителя на заданный коэффициент усиления и полосу пропускания при постоянной настройке

Общими формудами коэффициента усиления и эквивалентного затухания колебательного контура каскада резонансного усилителя являются:

$$K_0 = \frac{p_1 p_2 Y_{21}}{p_1^2 g_{22} + g + p_2^2 g_{\text{BX}(2)}}; \tag{6-11}$$

$$\delta_{\theta} = \delta \left( 1 + p_1^2 g_{22} / g + p_2^2 g_{BX/(2)} / g \right). \tag{6-12}$$

Для решения поставленной задачи надо так подобрать коэффициенты включения  $p_1$  и  $p_2$  қ контуру, чтобы они удовлетворяли уравнениям (6-11) и (6-12). Решениями этих уравнений могут быть значения коэффициентов, определяющихся формулами:

$$p_{1} = \sqrt{N/g_{32}} \stackrel{?}{\cdot} \sqrt{N^{2}/g_{32}^{2} - g_{BX(2)}M^{2}/g_{32}};$$

$$p_{2} = \sqrt{N/g_{BX(2)} - \sqrt{N^{2}/g_{BX(2)}^{2} - g_{22}M^{2}/g_{BX(2)}}},$$
(6-13)

где

$$N = 0.5g (\delta_9/\delta - 1)$$
 и  $M = \delta_9 g K_0/(\delta Y_{21})$ . (6-14)

Первая пара коэффициентов включения получается при знаках без скобок перед вторыми радикалами, а вторая — при знаках в скобках. Для схемы с двойным автотрансформаторным включением физически реализуемыми будут пары, в которых оба коэффициента включения получаются не более единицы. Когда в обеих парах хотя бы один коэффициент включения окажется больше единицы, то при заланных исходных данных невозможно получить требуемые  $K_0$  и  $\delta_9$ . Поскольку  $C_{\rm BX}$  (2)  $> C_{22}$ , то для уменьшения влияния междуэлектродиых емкостей транзисторов на эквивалентную емкость контура и для синжения последней целесообразно брать пару коэффициентов, в которой  $p_1 > p_2$ . Если в формулах (6-13) уменьшаемое и выпитаемое различаются мало (на 0,01 и меньше), то не следует вести расчет на лога-

рифмической линейке, так как это может привести к грубым опшбкам в определении  $p_1$  и  $p_2$ . В этих случаях следует вести расчет с помощью арифмометра или путем численных вычислений с точностью до 5—6-го знаков. Чтобы проверить правильность расчетов, следует произвести контрольное вычисление по формулам (6-11) и (6-12) и сравнить полученные результаты с исходными данными. Если они будут различаться более чем на 10-15~%. то необходимо уточнить расчеты  $p_1$  и  $p_2$ .

Когда в обенх парах коэффициентов хотя бы один голучается больше единицы, то принимают пару коэффициентов, получающуюся при знаках неред внутренным радикалом без скобок, и считают  $p_1 = 1$ . Параллельно выходу транзистора добавляют шунтирующую проводи-

мость

$$g_{10} = 2N - g_{BX/2}M^2 - g_{22}.$$
 (6-15)

Подставляя во вторую формулу вместо  $g_{22}$  прободимость  $g'_{22}=g_{22}+g_{\rm m}=2N-g_{\rm BX}$  (2) M, вычисляют второй коэффициент включения.

Пример 6-6. Рассчитать каскад усилителя радиосигнала для переого канала телевизионного приемника ( $f_0=52,5\,$  МГц) с полосой пропускания 8 МГц на транзисторе ГТЗІЗБ при  $I_{\rm K0}=1\,$  мА,  $U_{\rm K0}=-5\,$  в,  $E_{\rm K0}=12\,$  в ( $Y_{21}=64\,$  мСм,  $g_{11}=5,1\,$  мСм,  $g_{22}=410\,$  мкСм,  $C_{12}=1\,$  пФ,  $C_{22}=4\,$  пФ,  $C_{11}=31\,$  пФ). Параметры входа следующего каскада согласно (2-67):  $C_{\rm Bx}$  ( $g_{21}=64$  мСм,  $g_{22}=64$  пФ и  $g_{23}=64$  мСм,  $g_{23}=64$  мСм,  $g_{24}=64$  мСм,  $g_{25}=64$  мСм,

По формуле (2-66) вычисляем  $K_{\rm 0yct} = \sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.064}{6.28 \cdot 525 \cdot 10^5 \cdot 10^{-12}}} = 6.2$ . С учетом табл. 5-1 принимаем  $C_{\rm 3} \approx C_{\Sigma} = 15$  пФ. Но формуле (2-101) находим  $L = 1/6.28^2 \cdot 525^2 \cdot 10^{10} \cdot 15 \cdot 10^{-12} = 61 \cdot 10^{-8}$  Гн. что реализуемо. Полагая  $\delta = 0.01$ , по (2-55) вычисляем  $g = 0.01 \cdot 6.28 < 525 \cdot 10^5 \cdot 15 \cdot 10^{-12} = 495 \cdot 10^{-7}$  См. По равенству (2-85) находим  $\delta_{\rm 9} = 8.52.5 = 0.153$ . Рассчитываем по формулам (6-14)  $N = 0.5 \cdot 495 \cdot 10^{-7} \times (0.153/0.01 - 1) = 354 \cdot 10^{-6}$  См. и  $M = 0.153 \times 495 \cdot 10^{-7} \cdot 6.2/$  (0.01 ×  $\times 0.064$ ) = 0.0734.По формулам (6-13) вычисляем первую пару коэффи

шкентов: 
$$\rho_1 = \sqrt{\frac{354 \cdot 10^{-6}}{41 \cdot 10^{-5}} + \sqrt{\frac{354^2 \cdot 10^{-12}}{41^2 \cdot 10^{-10}}} - \frac{383 \cdot 10^{-5}}{41 \cdot 10^{-5}} \cdot 734^2 \cdot 10^{-8}} = 1,25$$
 и  $\rho_2 = \sqrt{\frac{354 \cdot 10^{-6}}{383 \cdot 10^{-5}} - \sqrt{\frac{354^2 \cdot 10^{-12}}{383^2 \cdot 10^{-10}}} - \frac{41 \cdot 10^{-5}}{383 \cdot 10^{-5}} \cdot 734^2 \cdot 10^{-8}} = -0,1$ . Она физически не реализуема. Вторая пара  $(\rho_1 = 0,157)$  и  $\rho_2 = 0$ 

== 0,415) реализуема.

Проверяем правильность расчетов коэффициентов включения. По формуле (6-11)  $K_0=0.157\cdot0.415\cdot0.064/(0.157^2\cdot41\cdot10^{-5}+495\times10^{-7}+0.415^2\cdot0.00383)=6.33$  и по равенству (6-12)  $\delta_9=0.01$  (! + -  $-0.157^2\cdot0.00031/0.0000495+0.415^2/0.00383/0.0000495=0.145. Эти данные отличаются от исходных на 2 и 5 %. Поэтому расчет достаточно точен.$ 

Заменяя в формуле (5-8)  $C_{\rm A}'$  на  $C_{22}$  и полагая  $C_{\rm K} = C_{\rm M1} = C_{\rm M2} = 1$  пФ, получаем  $C_{\rm H} = 15 - 1 - 0.157^2 \cdot (4+1) + 0.415^2 \cdot (25+1) = 9.4$  пФ.

Сопротивления резисторов схемы каскадов соответствуют данным примера 6-3, а емкости конденсагоров  $C_{\Phi}$  и  $C_{\mathfrak{g}}$  следует увеличить в 144/42,5 = 3,4 раза. По табл. П-3-2 принимаем  $C_{\Phi}=430$  вФ и  $C_{\mathfrak{g}}=75$  вФ.

#### 6-6. Расчет резистивного каскада

Резистивный каскад применяют в качестве усилителя радносигнала в тех случаях, когда входная цепь полностью обеспечивает нужную селективность по зеркальному каналу и промежуточной частоте, а требуемый коэффициент шума (2-59) не достигается при преобразователе частоты в качестве первого каскада приемника. Схема резистивного каскада применительно к низкочастотному тракту показана на рис. 4-1. При использовании резистивных каскадов в высокочастотном тракте в них не применяют цень отрицательной обратной связи  $R_{
m o.\,c},\ C_{
m p}$ . Нагрузкой транзистора служит параллельно соединенные активная проводимость  $G_{9K}$  и емкость  $C_{9K}$ , значения которых определяются уравнениями (4-4) и (4-5). Зависимость коэффициента усиления от частоты сигнала следует из равенства

$$K_{v} = \frac{Y_{21}|}{V G_{2K}^{2} + \omega^{2} C_{2K}}, \tag{6-16}$$

Если коэффициент усиления резистивного каскада не превышае, устойчивого коэффициента усиления (2-66), его устойчивость буде не ниже устойчивости резонансного усилителя с тем же транзистором. Чтобы усиление резистивного каскада равиялось  $K_{\rm nyc}$ , сопротивление коллекторного резистора  $R_{\kappa}$  должно определяться равенством

$$R_{K} = \frac{1}{\sqrt{\frac{|Y_{21}|^{2}}{K_{\text{OVCT}}^{2}} - \omega_{0}^{2}C_{\text{PK}}^{2} - g_{H} - g_{22}}},$$
 (6-17)

в котором проводимость  $g_n$  вычисляется по формуле (4-1). На относительно низких частотах, когда

$$\omega_0 C_{2K} < 0.1 (g_{11} + g_{22}),$$
 (6-18)

вместо формул (6-16) и (6-17) с небольшой погрешностью можно пользоваться уравнениями

$$K_0 \approx Y_{21} / G_{5K}$$
 is  $R_K = \frac{1}{|Y_{21}| / K_{6yet} - g_{11} - g_{22}}$ . (6-19)

Пример 6-7. Рассчитать трехкаскадный резистивный усилитель на транзисторе ГТ308В, обеспечивающий максимальное усиление на транзисторе 1 Т308В, обеспечивающий максимальное усиление для промежуточной частоты 8,4 МГп, Режим работы транзистора:  $I_{\rm K0}=1$  мА;  $I_{\rm E0}=7$  мкА;  $U_{\rm K90}=-5$  В;  $U_{\rm E90}=0.22$  В;  $E_{\rm K}=12$  В. Полагаем  $C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=3$  пФ. Выписываем из табл. П-1-1 — П-1-5 параметры транзистора для частоты 8,4 МГп;  $Y_{\rm 21}=0.035$  См;  $g_{\rm 11}=0.9$  мСм;  $g_{\rm 22}=110$  мкСм;  $C_{\rm 11}=40$  пФ;  $C_{\rm 12}=1$  пФ;  $C_{\rm 22}=4$  пФ. По формуле (2-66) вычисляем  $K_{\rm 0\,ycr}=\sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.035}{6.28\cdot84\cdot10^5\cdot10^{-12}}}=11.5$  По уравнению (4-5) получаем  $C_{\rm 9K}=4+3+40+3=50$  пФ. Вычисляем по равенству (6-17) сопротивление коллекторного резистора, полагая  $g_{\rm 12}=g_{\rm 13}$ 

зистора, полагая  $g_{ij} = g_{11}$ ,

$$R_{\rm K} = \frac{1}{V_{0,035^2/11,5^2 - 6,28^2 \cdot 84^2 \cdot 10^{10} \cdot 5^2 \cdot 10^{-22} - 0,0009 - 0,00011}} = \frac{1}{2080 \text{ OM}}$$

По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 2,2 кОм.

Вычислим параметры элементов схемы каскада. Положим  $R_{\Phi}=$ = 1 кОм. Тогда согласно выражению (3-16)  $U_1 = I_{K0}(R_{\phi} + R_{\kappa}) =$  $=10^{-3}$  (1 + 2,2)  $\cdot$   $10^{3}$  = 3,2 В. Из равенства (3-17) находим  $U_{R}$  == 12 - 3.2 - 5 = 3.8 В. По уравнению (3-18) вычисляем  $R_3 =$  $= 3.8/(10^{-3} + 7.10^{-6}) = 3770$  OM. Из табл. П-3-1 принимаем резистор сопротивлением 3,9 кОм. При этом  $U_{R_a} = 10^{-3} \cdot 3,9 \cdot 10^3 = 3,9$  В. Поскольку  $R_2$  взято на 130 Ом больше расчетного значения, сопротивление фильтра следует взять на столько же меньше, чтобы ток коллектора сохранился равным 1 мА. Согласно табл. П-3-1 берем его рав- $10 \div 20$ ным 820 Ом. По перавенству (3-19)  $C_3 > \frac{10-20}{84\cdot103\cdot3900} = (3\div6)\cdot10^{-10}$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 560 пФ. Согласно равенству (3-20)  $U_{R_8'}=3.9+0.22=4.12$  В. По уравнению (3-21) принимаем  $L_{\rm ff} = 10 \cdot 7 \cdot 10^{-6} = 7 \cdot 10^{-5}$  А. Вычисляем по формулам (2-22) н (3-23)  $R_6' = 4,12/7 \cdot 10^{-5} = 58\,800$  Ом н  $R_6'' = (12-4,12) / (7 \cdot 10^{-5})$  $+7\cdot10^{-6}$ ) = 102 000 Ом. По табл. П-3-1 выбираем резисторы сопротивлением 56 и 100 кОм. По равенству (3-24) получаем  $\sigma =$  $1 + 3900/56\ 000 + 3900/100\ 000$  $\overline{1-0.993+3900/56\ 000+3900/100\ 000}=9.6$ , что удовлетворительно. Подставив в формулу (3-19) согласно сказанному ранее соответствующие значения, получим  $C_{\rm th} \geqslant (10 \div 20) / (84 \cdot 10^5 \cdot 820) = (15 - 30) \times \times 10^{-10}$  Ф и по табл. П-3-2 примем конденсатор емкостью 2200 пФ. Общий коэффициент усиления усилителя будет  $K_{\text{nyc}} = 11.5^2 = 1320$ .

# 6-7. Расчет резонансного усилителя с переменной настройкой

Из формул (6-11) и (6-12) с учетом равенства (2-85) следует, что при постоянных  $p_1$  и  $p_2$  коэффициент усиления и полоса пропускания каскада резонансного усилителя имеют сложные зависимости от частоты. С ростом частоты  $Y_{21}$  и g уменьшаются, а  $g_{22}$  и  $g_{8X2}$  увелячиваются, причем для проводимостей транзистора нет достаточно простых зависимостей от частоты во всем его диапазоне рабочих частот. При настройке контура емкостью, как правило, полоса пропускания увеличивается с ростом частоты по закону более сильному, чем линейный, а коэффициент усиления — по закону слабее линейного. Для расчета каскада обычно задается минимальная полоса пропускания  $\Pi_{\min}$ , которая должна быть в начале поддиапазона

$$\Pi_{\mathrm{u}} = \Pi_{\mathrm{min}}.\tag{6-20}$$

Коэффициент усиления во всем поддианазоне должен удовлетворять неравенству (6-3). Согласно (2-66)  $K_{\rm 0yer}$  уменьшается с ростом частолы. Поэтому для получения возможно большего усиления в конце поддианазона стремятся обеспечить

$$K_{\text{or}} = K_{\text{over}}. (621)$$

Однако при отсутствии аналитических зависимостей  $K_0$  и  $\Pi$  от частоты уравнения (6-11) и (6-12) исльзя разрешить относительно коэффициентов включения так, чтобы выполнялись условия (6-20) и (6-21).

С погрешностью, допустимой для инженерных расчетов, можно воспользоваться приближенными зависимостями (2-105) и (2-106). В этоги случае из уравнения (2-105) с учетом равенства (6-21) находят  $K_{0:0}$  Подставляют это значение в формулу (6-11) и, решая уравнения (6-11) и (6-12) для начала поддиапазона, находят необходимые коэффициенты включения по методике § 6-5. После этого вычисляют  $K_0$  и H для крайних и среднеквадратичной частот поддиапазона.

Если контур настраивается варикапом, то за счет собственной активной проводимости днода  $g_{\mathtt{A}}$  затухание контура увеличивается и определяется уравнением

$$\delta' = \delta \left( 1 + g_{\pi}/g \right), \tag{6-22}$$

а его активная проводимость

$$g' = g\delta'/\delta. \tag{6-23}$$

Пример 6-8. Рассчитать параметры каскада усилителя радиосигнала для поддиапазона 2 радиовещательного приемника с транзистором ГТ308В при  $I_{\rm K0}=2.5$  мА,  $I_{\rm E0}=7$  мкА,  $U_{\rm ЭK0}=-5$  В,  $E_{\rm K0}=12$  В. Параметры колебательного контура соответствуют примеру 6-1. В радиотракте имеется еще один такой же колебательный контур (во входной цели). Минимальная полоса пропускания радиотракта 13 кГц; собственное затухание контуров 0,015. Следующим каскадом является преобразователь частоты на том же транзисторе при  $I_{\rm K0}=1$  мА.

Проводимости  $Y_{21}$ ,  $g_{11}$  и  $g_{22}$  прямо пропорциональны коллекторному току транзистора [5, 27]. Учитывая сказанное и используя данные табл. П-1, находим их значения для заданного режима и записы-

Таблица 6-2

f, кГц	У <sub>21</sub> , мСм	g <sub>11</sub> , мьСм	g <sub>25</sub> . мі.См	С <sub>12</sub> , пФ	С <sub>22</sub> , пФ	С <sub>11</sub> , пФ	g <sub>вх2</sub> , мкСм	С <sub>вад</sub> , пФ	K <sub>0</sub>	δ <sub>9</sub>	П, кГц
515	87	1000	25	1	4	40	300	32	44	0,0394	13
920	87	1200	30	1	4	40	360	32		0, <b>0</b> 67	39
1640	87	1330	42	1	4	40	460	32		0,134	1-0

ваем в табл. 6-2. По формуле (2-67) вычисляем входные проводимость и емкость транзистора следующего каскада и вносим их в табл. 6-2. По формуле (2-66) для конца поддиапазона находим  $K_{0,yet} =$ 

= 
$$\sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.087}{6.28\cdot 164\cdot 10^4\cdot 10^{-12}}}$$
 = 40. Вычисляем по (2-107)  $a=13\,000\times \times 1,56$ / (0,015 $\cdot$ 515 000) — 1 = 1,62 и по (2-108)  $b_{g11}=1330\,1000=1,33$ ,  $b_{g22}=42/25=1,7$ . Среднее арифметическое значение козффициента  $b=0,5\cdot (1,33+1,7)=1,5$ . С учетом условия (6-21) из формулы (2-105) находим  $K_{08}\approx 40\cdot (1+1,62\cdot 1,5\cdot 3,18)$ / [3,18 (1+1,62)] =

Вычисляем для начала поддиапазона по (2-100)  $\delta_3=13\,000\times \times 1,56/515\,000=0,0394$ , по (2-55)  $g=0,015\cdot 6,28\cdot 515\,000+394\cdot 10^{-12}=191\cdot 10^{-7}$  См. Находим коэффициенты по формулам (6-14)  $\lambda'=0.5\times$ 

$$\times$$
191·10<sup>-7</sup> (0,0394·0,015 — 1) = 155·10<sup>-7</sup> См и  $M$  = 0,0394·191·10<sup>-7</sup>  $\times$   $\times$ 42/ (0,015·0,087) = 0,0242. Вычислим по уравнениям (6-13) первую пару коэффициентов  $p_1 = \sqrt{\frac{155 \cdot 10^{-7}}{25 \cdot 10^{-6}} + \sqrt{\frac{155^2 \cdot 10^{-14}}{25^2 \cdot 10^{-12}}}}$   $= \frac{3 \cdot 10^{-4}}{25 \cdot 10^{-5}}$  0,0242<sup>2</sup> = 1,1 > 1. Такая пара не реализуема.

Вторая пара коэффициентов будет  $\rho_1=0{,}075$  и  $\rho_2=0{,}321$ . Принимаем ее для расчета.

Проверим осуществимость эквивалентной емкости контура. Согласно равенству (5-14) средняя емкость подстроечного конденсатора при  $C_{\rm K}=0$ ,  $C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=3$  пФ должна быть  $C_{\rm H}=29=0.075^2$  (3 + + 4) — 0,321² (3 + 40) = 25.4 пФ. Вычисляем для начала поддиапазона по уравнению (6-11)  $K_{0515}=0.075^{\circ}.0,321^{\circ}.0,087/$  (0,075² 0,000025 + 0,0000191 + 0,321² 0,0003) = 41.9 и по (6-12)  $\delta_{.515}=0.015$  (1 + 0,075² 0,000025/0,0000191 + 0,321² 0,0003/0,0000191) = 0,0394.

Полученные цифры практически соответствуют исходным данным и, следовательно, коэффициенты включения вычислены правильно. Результаты аналогичных расчетов для других частот радиотракта

приведены в табл. 6-2.

Пример 6-9. Рассчитать параметры каскада усилителя радиосигнала для поддиапазона 11 переносного радиовещательного приемника I класса с транзистором ГТ308В при  $I_{K0}=2.5$  мА,  $I_{E0}=7$  мкА,  $U_{K90}=5$  В,  $E_{\rm k}=12$  В. Параметры колебательного контура соответствуют примеру 5-2. В радиотракте имеется такой же колебательный контур входной цепи. Следующий каскад — преобразователь частоты на транзисторе того же типа при  $I_{K0}=1$  мА.

Схему каскада считаем соответствующей рис. 6-1, а. Согласно табл. 2-2 граничные частоты поддианазона 25,1 и 26,6 МГц. Поскольку  $k_{\rm g}=1,06$  сравнительно мал, то параметры транзистора и каскада в пределах поддианазона изменяются мало. Поэтому расчет проведем на средней частоте 25,85 МГц, для которой:  $Y_{\rm 21}=0.077$  См;  $g_{\rm 11}=7$  мСм;  $g_{\rm 22}=1$  мСм;  $C_{\rm 11}=36$  пФ;  $C_{\rm 12}=1$  пФ;  $C_{\rm 22}=4$  пФ. Согласно равенствам (2-67) принимаем  $g_{\rm 11}$  (2)  $\approx 0.75 \cdot 2.8=2.1$  мСм и  $C_{\rm 11}$  (2)  $\approx 0.8 \cdot 36=29$  пФ.

По формуле (2-66) вычисляем  $K_{0\,\mathrm{ycr}} = \sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.077}{6.28\cdot2585\cdot10^4\cdot10^{12}}} = 9,75$ . Пользуясь уравнением (2-86), получаем  $K_{0\,\mathrm{max}} = \frac{0.5\cdot0.077}{V\,1\cdot2.1\cdot10^{-6}}\,\left(1-\frac{0.01}{0.02}\right) = 13,3$ . Расчет ведем на устойчивый коэффициент усиления. Поскольку полоса пропускания контуров радиотракта в данном поддиапазоне много шире полосы пропускания приемпика (см. пример 5-2), то с целью повышения селективности рассчитаем каскад на получение минимальной полосы пропускания. По равенству (6-10) находим  $\delta_{3\,\mathrm{min}} = \frac{0.01\cdot0.077}{0.077-2\cdot9.75\,V\,1.2\cdot1\cdot10^{-6}} = 0.0131$ . Заменяя в уравнениях (5-5) и (5-6)  $g_A'$  на  $g_{22}$  и  $g_{\mathrm{BX}(3)}$ , по-

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{586 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 10^{-8}} \left(\frac{0.0131}{0.01} - 1\right)} = 0.099$$

мэвруц

$$p_2 = \sqrt{\frac{586 \cdot 10^{-7}}{2 \cdot 21 \cdot 10^{-4}} \left(\frac{0.0131}{0.01} - 1\right)} = 0.666.$$

Пример 6-10. Рассчитать параметры каскада усилителя радиосигнала для поддиапазона 12 перепосного радиовещательного приемника I класса на транзисторе I Т313Б по схеме с ОЭ. Параметры контура соответствуют примерам 5-1, 6-2 и варианту 3 табл. 2-9 ( $\delta_9 = 0,055$  и  $\delta = 0,02$ ). Режим работы транзистора такой же, как в примере 6-3. Граничые частоты поддиапазона  $f_{\min} = 67$  и  $f_{\max} = 74,5$  МГц. Следующий каскад — преобразователь частоты на транзисторе того же типа по схеме с общим эмиттером.

Средняя частота поддиапазона 70,75 МГц отличается от крайних лишь на 5%. Поэтому в первом приближении можно рассчитать усиление и полосу пропускания для средней частоты, на которой:  $Y_{21}=0,055$  См;  $g_{11}=6$  мСм;  $g_{22}=0,55$  мСм;  $C_{12}=1$  пФ;  $C_{22}=4$  пФ;  $C_{11}=24$  пФ. По формулам (2-67) получаем:  $g_{11}$  (2) = 0,75·6 = 4,9 мСм

 $n C_{11} = 0.8 \cdot 24 = 19 \ \pi \Phi$ . Согласно равенству (2-55)  $g = -0.02/(6.28 \cdot 7075 \cdot 10^5 \cdot 127 \cdot 10^{-9}) =$ =354 · 10<sup>-7</sup> См. Собственная проводимость варикана Д902 в рабочем диапазоне усилителя составляет примерно 10-5 См. По формулам (6-22) и (6-23) вычисляем  $\delta' = 0.02 [1 + 10^{-5}] (354 \times$  $\times 10^{-7}$ ) = 0,026 n g' = 354 · 10<sup>-7</sup> ×  $\times 0.026/0.02 = 454 \cdot 10^{-7} \text{ Cm}$ . Tak как при эквивалентном затухании 0,055 полоса пропускания контура  $\Pi_{K} = 0.055 \cdot 70.75 =$ =3.9 MFH B 3.9/0.18 = 22 pasa шире необходимой полосы приемника, то с целью получения паилучшей селективности расчет

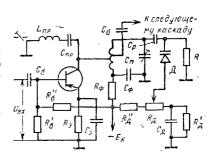


Рис. 6-2.

каскада выполним на обеспечение минимально возможного эквивалентного затухания при устоичивом усплении каскада.

По формуле (2-66)  $K_{0\,y\,c\,r} = \sqrt{\frac{2\,(1-0.9)\,0.055}{6.28\cdot745\cdot10^5\cdot10^{-12}}} = 4.9$ . Минимальное эквивалентное затухание определяем по уразнению (6-10), запечия  $\delta$  на  $\delta'$ ,  $\delta_{9\,min} = \frac{0.026\cdot0.055}{0.055-2\cdot4.9\,V\,0.55\cdot4.9\cdot10^{-6}} = 0.0365$ . Для обеспечения этого затухания коэффициенты включения вычисляем по формулам (5-5) и (5-6):  $\rho_1 = \sqrt{\frac{0.0000454}{2\cdot0.00055}} \left(\frac{0.0365}{0.026} - 1\right) = 0.32$ ;  $\rho_2 = \sqrt{\frac{0.0000454}{2\cdot0.0049}} \left(\frac{0.0365}{0.026} - 1\right) = 0.106$ .

Схема каскада показана на рис. 6-2. Задаваясь током делителя  $I'_{n}$ , состоящего из резисторов  $R'_{\pi}$ ,  $R_{\pi}$ ,  $R'_{\pi}$  и создающего управляющее напряжение, можно вычислить требуемые сопротивления резисторов

по уравнениям:

$$R'_{\text{A}} = 0.9 U_{\text{y min}} I_{\text{n}}; \quad R_{\text{A}} = 1.1 U_{\text{y max}} / I_{\text{n}} - R'_{\text{A}}; \quad R''_{\text{A}} = \frac{E_{\text{K}} - 1.1 U_{\text{y max}}}{I_{\text{n}}}.$$
 (6-24)

где  $U_{
m ymin}$  и  $U_{
m ymax}$  — минимальное и максимальное управляющее напряжения двода.

Емкость конденсатора  $C_{\rm p}$  выбпрается по неравенству (6-5), если заменить в нем  $C_{11/2}$ , и  $g_{11/2}$ , на  $C_{\rm mmin}$  п  $g_{\rm amax}$ . Емкость конденсатора  $C_{\rm g}$  вычисляется по неравенству (3-19) при замене  $R_{\rm g}$  на  $1/g_{\rm amax}$ . Резистор  $R_{\rm g}$  служит для подачи управляющего напряжения на катод двода. Его сопротивление определяется неравенством

$$R > 10/g_{\pi \, \text{min}}.$$
 (6-25)

В примере 6-2 минимальное и максимальное управляющие напряжения взяты равными 0 и 6 В. Примем  $I_{\Pi}=0.5$  мА и по формулам (6-24) нолучим  $R_{\Pi}'=0$ ,  $R_{\Pi}=1,1\cdot6/0,0005=13\,200$  Ом и  $R_{\Pi}''=(12-1,1\times \times 6)/0,0005=10\,800$  Ом. По табл. [1-3-1 принимаем резисторы сопротивлением 15 и 10 кОм. Из неравенств (6-5) получаем  $C_{\rm p}>(30\div 100)\,37=1110-3700\,$  пФ и  $C_{\rm p}>(10\div 20)\,0,00195/67\,000\,000=(29-58)\cdot10^{-11}\,$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор ембостью 1200 пФ. Согласно нерагенству (6-25)  $R>10/0,00001=1000\,$  ПО табл. П-3-1 берем резистор с сопротивлением 1 МОм. Сопротивления остальных резисторов схемы соответствуют примеру 6-3, а емкости конденсаторов должиы быть увеличены в  $144/67=2,2\,$  раза, т. с.  $C_5=2200\,$  пФ,  $C_{\Phi}=270\,$  пФ и  $C_9=51\,$  пФ.

 $oldsymbol{arGamma}$ лава седьмая

#### РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЕЙ СИГНАЛА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

#### 7-1. Исходные данные и задачи расчета

При расчеге радиовещательных приемпиков ГОСТ 5651—76 задается промежуточная частота:  $465\pm2$  кГц для приема АМС в первых 11 поддиапазонах;  $6.5\pm0.1$ ,  $10.7\pm0.1$  или  $8.4\pm0.1$  МГц для приема ЧМС. Эта частота должиа быть средней частотой полосы пропускания усилителя. Для других типов приемников промежуточная частота выбирается по методикам, описанным в § 2-6.

В расчете структурной схемы приемника (см. § 2-8) для тракта промежуточной частоты определяется: число каскадов, их схемы, типы транзисторов и их режимы работы; характеристики селективных систем каждого каскада; минимально необходимый коэффициент усиления каскада; необходимые регулировки и их характеристики; напряжение источника питания.

В расчете каскада уточняется режим работы транзистора и вычисляются параметры всех элементов схемы, включая межкаскадные связи, определяются параметры контуров и коэффициенты включения к ним электродов транзисторов, проверяется осуществимость необходимой глубниы регулирования усиления системой АРУ.

#### 7-2. Расчет каскадов резонансного усилителя

Связь между параметрами N-каскадного усилителя и составляющих его пдентичных каскадов выражается уравлениями;

$$K_{0y} = K_{0K}^{N}; \tag{7-1}$$

$$\Pi_{y} = \Pi_{K}/\psi_{1}(n);$$
 (7-2)

$$\delta_{\theta} = H_{y} \psi_{1}(n) / f_{\pi p}; \tag{7-3}$$

$$d_{\mathbf{y}} = d_{\mathbf{k}}^{N} = \left(\sqrt{1 + \xi_{d}^{2}}\right)^{N}. \tag{7-4}$$

Когда заданы параметры *N*-каскадного усилителя, по приведенным формулам определяются необходимые для расчета каскадов характеристики.

Чтобы при смене транзисторов коэффициент усиления и полоса пропускания усилителя отличались от требуемых менее чем на 10 %, эквивалентная смкость контуров должна удовлетворять неравенству

$$C_9 \geqslant \Delta C_m \frac{f_0}{H_V} \theta_1(n),$$
 (7-5)

где

$$\Delta C_m = p_2^2 \, \Delta C_{11} + p_1^2 \, \Delta C_{22}, \tag{7-6}$$

а  $\Delta C_{11}$  и  $\Delta C_{22}$  — возможные максимальные отклонения входной и выходной емкостей транзисторов усилителя от средних (паспортиых) значений. Если они не приводятся в паспорте, то их можно принимать равным 20-30~% среднего значения соответствующей емкости. Значения функции  $\theta_1$  (n) приведены в табл. 2-12.

После определения всех исходных данных расчет каскада выполняется по методикам § 6-3 — 6-5. Резонансный усилитель обладает наихудшей селективностью по сравнению с другими схемами при одинаковом числе каскадов, поэтому оп применяется сравнятельно редко в тракте промежуточной частоты радиовещательных, телевизионных и связных приемников.

## 7-3. Расчет усилителя с расстроенными каскадами

Чтобы иметь достаточно плоскую вершину кривой селективности и малый коэффициент прямоугольности, расстройку колебательных контуров каскадов принимают равной критической и вычисляют по уравнению

 $\Delta f_{\rm Kp} = 0.5 \delta_{\rm e} f_{\rm np}. \tag{7-7}$ 

Эквивалентное затухание контуров пары каскадов вычисляют по формуле (7-3), заменяя в ней функцию  $\psi_1$  (n) на  $\psi_2$  (n), значения которой даны в табл. 2-12. При подобной же замене для рассматриваемого усилителя справедлива формула (7-2). Коэффициент усиления и ослабление определяются равенствами:

$$K_{0v} = (0.5)^{0.5N} K_{0\kappa}^{N}; \tag{7-8}$$

$$d_{v} = \left[0.5 \sqrt{(2 - \xi^{2})^{2} + 4\xi^{2}}\right]^{0.5N}, \tag{7-9}$$

где  $\xi$  — обобщенная расстройка, определяющаяся формулой (2-64) или (2-65).

Недостатком усилителя с расстроенными каскадами является худшая линейность его фазовой характеристики, что увеличивает искажения сигнала в телевизионных и импульсных приеминках. Но для получения достаточно большого усиления при широкой полоке пропускания такие усилители приходится применять, так как форма их резопансной кривой близка к прямоугольной.

Пример 7.1. Рассчитать четырехкаскадный усилитель для телевизионного приемника с расстроенными парами кочтуров, обеспечивающий наибольшее усиление при полосе пропускания 8 МГц и промежуточной частоте 35 МГц. Тип и режим работы транзисторов соответствуют примеру 6-3. Собственное затухание контуров считать рав-

ным 0,01.

По табл. 2-12 находим  $\psi_e$  (4) = 0.88 и по (7-3) вычислуем  $\delta_e$  =  $= 8 \cdot 10^{6} \cdot 0.88/35 \cdot 10^{6} = 0.2$ . Расстройка контуров относительно промежуточной частоты согласно равенству (7-7) должна быть  $\Lambda_{reg}=0.5 imes$  $\times$  0,2·35·10<sup>6</sup> = 35·10<sup>5</sup> Гц, а частоты настройки контуров оудут  $f_1$  =  $f_{\rm np} - \Delta f_{\rm Kp} = 35\cdot10^6 - 35\cdot10^5 = 315\cdot10^5$  Гц и  $f_2 = f_{\rm np} + \Delta f_{\rm Kp} = 385\cdot10^5$  Гц. Параметры транзистора на этих частотах приведены в табл. 7-1. По уравнению (2-66) для первой частоты получим  $K_{0\,\mathrm{yet}}=\sqrt{rac{2\,(1-0.9)\,0.079}{6.28\cdot315\cdot10^5\cdot10^{-12}}}=8,9$ . Для второй частоты он равен 7,8. По формуле (2-86) вычисляем для первой частоты  $K_{0\,\mathrm{max}}=$  $=\frac{0.5\cdot0.079}{V(0.21\cdot3.1)\cdot10^{-6}}\left(1-\frac{0.01}{0.2}\right)=46$ . Расчет каждого каскада ведем на минимальный коэффициент устойчивого усиления 7,8.

Таблица 7-1

Частота, МГц	$Y_{21}$ , MCM	g11, мСм	g22, MKCM	Сп. пф	С22, пФ	С12, пФ	Коуст	Котах	g, mkCm	p <sub>1</sub>	p <sub>2</sub>	Г, мкГн	Ст. пФ	С2, пФ
31,5 38,6	79 76	3,1 3,8	210 270	46 36	4	1 1	8,9 7,8	46 45	71,3 87	0,418 0,51	0,34 0,36	0,705 0,474	151 145	247 221

Из табл. 2-12 получаем  $\theta_2$  (4) = 6,8. Полагаем  $\Delta C_{11} = 0.2 \cdot 46 =$ = 9,2 пФ и  $\Delta C_{22} = 0,2 \cdot 4 = 0,8$  пФ. Обычно коэффициенты включения пе превышают 0,3 — 0,4. Принимая их равными 0,35, из (7-6) ориентировочно находим  $\Delta C_{\rm max} = 0,35^2 \cdot 9,2 + 0,35^2 \cdot 0,8 = 1,2$  пФ. Нз перавенства (7-5) получаем  $C_9' \geqslant 12 \cdot 10^{-13} \frac{35 \cdot 10^6}{8 \cdot 10^6} \, 6,8 = 36 \cdot 10^{-12} \, \Phi$ .

Лля второй частоты индуктивность контурной катушки вычисляем из (2-101)  $L=1/\left(6.28^2\cdot385^2\cdot10^{10}\cdot36\cdot10^{-12}\right)=474\cdot10^{-9}$  Гн, что по табл. 5-1 вполне реализуемо. По формуле (2-55) находим g=0.01 imes $\times 6.28 \cdot 315 \cdot 10^{5} \cdot 36 \cdot 10^{-12} = 713 \cdot 10^{-7} \, \text{Cm}.$ 

Поскольку заданы  $K_0$  и  $\delta_{\mathfrak{d}}$ , то коэффициенты включения вычисляем по методике § 6-5. Находим для первой частоты по формуле (6-14) коэффициенты:  $N = 0.5 \cdot 713 \cdot 10^{-7} (0.2/0.01 - 1) = 678 \cdot 10^{-6}$  См и M = $=0.2\cdot713\cdot10^{-7}\cdot7,8/$  (0,01·0,079) =0,141. Так как  $N>g_{22}$ , то согласно (6-13) в первой паре коэффициентов будет  $p_1 > 1$  и ее нельзя реаливовать. Вычисляем вторую пару коэффициентов включения  $p_1=$ 

$$= \sqrt{\frac{678 \cdot 10^{-6}}{21 \cdot 10^{-5}}} - \sqrt{\frac{678^2 \cdot 10^{-12}}{21^2 \cdot 10^{-10}}} - \frac{31 \cdot 10^{-4}}{21 \cdot 10^{-5}} 0,141^2} = 0,215 \quad \text{H} \quad \rho_2 = \sqrt{\frac{678 \cdot 10^{-6}}{31 \cdot 10^{-4}} + \sqrt{\frac{678^2 \cdot 10^{-12}}{31^2 \cdot 10^{-8}}} - \frac{21 \cdot 10^{-5}}{31 \cdot 10^{-4}} 0,141^2} = 0,66.$$

При таких коэффициентах включения расчет по формулам (6-11) и (6-12) дает  $K_0=7.75$  и  $\delta_3=0.2004$ , что весьма близко к необходимым значениям, и подтверждает правильность проделанных вычислений. Но при данных значениях коэффициентов включения согласно (7-6) и (7-5) следовало бы эквивалентную емкость контура увеличить до 120 пФ. Это повысило бы g и N, а следовательно, и коэффициент включения  $\rho_2$ . Поскольку N и M не зависят от проводимости входа транзистора, то согласно (6-13) некоторого снижения  $\rho_3$  при соот-

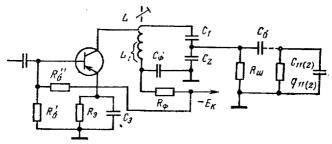


Рис. 7-1.

ветствующем увеличении  $\rho_1$  можно достигнуть увеличением указанной проводимости, включая на входе следующего каскада шунтирующую проводимость  $g_{uv}$ . при которой второй радикал в формулах (6-13) будет еще веществениым. Это будет при выполнении перавенства

$$N^2/(g_{22}M^2) - g_{11} > g_{11}$$
 (7-10)

В нашем случае для первой частоты  $N^2/$   $(g_{22}M^2)$  —  $g_{11}=678^2\times \times 10^{-12}/$   $(21\cdot 10^{-5}\cdot 0.141^2)$  —  $31\cdot 10^{-4}=0.1$  См и для второй 0.07 См.

Возьмем шунтирующее сопротивление 120 Ом, чему соответствует  $g_{\rm m}=0.00833$  См, что меньше обоих предельных значений. При этом по формулам (6-13) получим  $p_1=0.418$  и  $p_2=0.34$ . Расчет по уравнениям (6-11) и (6-12) дает  $K_0=7.85$  и  $\delta_9=0.2$ , что подтверждает правильность проделанных расчетов. По равенству (7-6) находим  $\Delta C_{\rm max}=0.34^2\cdot 9.2+0.418^2\cdot 0.8=1.2$  пФ, что соответствует принятой эквивалентной емкости контура.

По выражению (7-8) вычисляем коэффициент усиления  $K_{ay} = 0.5^{0.5} \cdot ^4 \cdot ^7.8^4 = 925$ . На рис. 7-1 приведена схема каскада с шунтирующим сопротивлением  $R_{\rm m}$  на входе следующего каскада. При делении емкостной ветви контура его емкости определяются уравнениями:

$$C_2 = (C_3 - C_0)/p_2^2 - C_{n_2} - C_{11/2};$$
 (7-11)

$$C_1 = (C_2 - C_0)/[p_2(1 - p_2)],$$
 (7-12)

в. которых

$$C_0 = C_K + p_1^2 (C_{11} + C_{M1}),$$
 (7-13)

а  $C_{\scriptscriptstyle\mathsf{M2}}$  и  $C_{\scriptscriptstyle\mathsf{M1}}$  — монтажные емкости входа следующего каскада и коллекторной непи данного каскада. Полагая  $C_{\rm K}=1$  пФ и  $C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=2$  вФ, из (7-13) получаем  $C_{\rm Q}=1+0.418^2$  (4 + 2) = 2.05 пФ. Из (7-12) и (7-11) находим  $C_2=(36-2,05)/0,34^2-2-46=247$  пФ и  $C_1=(36-2,05)/[0,34]=151$  пФ. Результаты расчетов для второй частоты приведены в табл. 7-1.

Режим работы транзистора совпадает с данными примера 6-3. Поэтому сопротивления резисторов схемы питания сохраняются теми же. Емкости конденсаторов  $C_9$  и  $C_{\bar{\mathrm{th}}}$  должны быть увеличены в 144/31,5=4,7 раза; по табл. П-3-2 принимаем их равными соответственно 100 и 620 пФ. Чтобы конденсатор  $C_{\oplus}$  не влиял существсино на эквивалентиую емкость контура, его емкость должна в 100 раз превышать эквивалентную емкость контура. Поэтому окончательно принимаем его емкость 3600 пФ.

Емкость разделительного конденсатора должна удевлетворять веравенствам (6-5). В нашем случае  $C_6\geqslant 1380\div 4600$  пФ и  $C_6\geqslant (10\div 20)\cdot 0.01143/315\cdot 10^5=(36\div 72)\cdot 10^{-10}$  Ф. Выбираем по табл.

П-3-2 конденсатор емкостью 3900 пФ.

### 7-4. Расчет усилителя с двумя связаниыми контурами

В радиовещательных и связных приемниках подобные усилители, как правило, применяются при связи между контурами, не превышающей критическую. В этом случае кривая селективности сохраняется

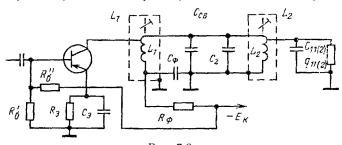


Рис. 7-2.

одногорбой, а коэффициент усиления и ослабление усилителя при одинаковом затухании колебательных контуров определяются уравнениями:

$$K_{0y} = \left[ \frac{\eta}{1+\eta^2} \frac{\rho_1 p_2 + Y_{21}}{g_9} \right]^N = K_{0x}^N;$$

$$d_y = \left[ \sqrt{(1+\eta^2 - \xi_d^2)^2 + 4\xi_d^2} / 1 + \eta^2 \right]^N = d_x^N,$$
(7-14)

$$d_{v} = \left[ \sqrt{(1+\eta^{2}-\xi_{d}^{2})^{2}+4\xi_{d}^{2}}/1+\eta^{2} \right]^{N} = d_{\kappa}^{N}, \tag{7-15}$$

где выражения, стоящие в квадратных скобках, определяют коэффициент усиления каскада Кок на средней частоте полосы пропускания и его ослабление  $d_{\kappa}$ ;

$$\eta = k/\delta \tag{7-16}$$

 параметр связи. Эквивалентные параметры первого и второго контуров выражаются равенствами (рис. 7-2)

$$\delta_{21} = \delta (1 + \rho_1^2 g_{22}/g); \quad \delta_{22} = \delta (1 + \rho_2^2 g_{11(2)}/g); \quad (7-17)$$

$$C_{91} = C_{01} + p_1^2 (C_{M1} + C_{22}); \quad C_{92} = C_{02} + p_2^2 (C_{M2} + C_{11(2)}); \quad (7-18)$$

$$C_{01} = C_{K1} + C_1; \quad C_{02} = C_{K2} + C_2.$$
 (7-19)

Эквивалентное затухание контуров N-каскадного усилителя определяется уравнением (7-3) при замене в нем функции  $\psi_1$  (n) на  $\psi_3$  (n) (см. табл. 2-12). Минимально допустимая эквивалентная емкость контуров вычисляется по неравенству (7-5) с подстановкой в него функции  $\theta_3$  (n) вместо  $\theta_1$  (n), а значение  $\Delta C_{\max}$  определяется максимальным значением из равенств

$$\Delta C_{1\max} = p_1^2 \Delta C_{22}; \quad \Delta C_{2\max} = p_2^2 \Delta C_{11}.$$
 (7-20)

Соответствующим подбором емкости  $C_{01}$  и  $C_{02}$  можно обеспечить полную идентичность эквивалентных параметров обоих колебательных контуров. Максимальное усиление каскада при заданном эквивалеитном затухании контуров определяется уравнением (2-86), а необходимые для этого коэффициенты включения — уравнетнями (5-5) и (5-6) при замене  $g_{\rm A}^{\rm I}$  и на  $g_{22}$ . Если задан коэффициент усиления, меньший максимально допустимого, то при этом выбором коэффициентов включения по (5-5) и (5-6) можно получить минимально осуществимое эквивалентное затухание контуров, соответствующее (6-10). Устойчивый коэффициент усиления данного каскада определяется уравкениями (2-66) и (2-93).

Пример 7-2. Рассчитать двухкаскадный усилитель с двумя связанными контурами при критической связи, полосе пропускания 13 кГц, промежуточной частоге 465 кГц и максимальном усилении на транвисторах ГТ308В. Нагрузкой усилителя служит вход детектора, рассчитанного в примере 2-24. Ослабление соседнего канала при расстройке = 10 кГи должно быть более 6 дБ. Рабочая точка транзисторов:  $U_{\rm 3K0} = -5$  В,  $I_{\rm K0} = 1$  мА,  $E_{\rm K0} = 12$  В. Их параметры:  $Y_{\rm 21} = 0.035$  См;  $g_{11} = 0.4 \text{ MCM}; g_{22} = 10 \text{ MKCM}; C_{22} = 4 \text{ H}\Phi; C_{12} = 1 \text{ H}\Phi; C_{11} = 40 \text{ H}\Phi;$  $h_{216} = 0.993.$ 

По табл. 2-12 находим  $\psi_3$  (2) = 0,88 и  $\theta_3$  (2) = 1,98. Вычисляем эквивалентное затухание контуров по формуле (7-3)  $\delta_9=13\,000\times 0.88/465\,000=0.0245$ . Полагая с некоторым запасом  $\rho_1=\rho_2=1$  и разброс параметров транзисторов равным 0,3, по (7-20) определяем  $\Delta C_{1\max}=1^2\cdot 0,3\cdot 4=1,2$  пФ,  $\Delta C_{2\max}=1^2\cdot 0.3\cdot 40=12$  пФ. По неравенству (7-5) минимально допустимая эквивалентная емкость должна быть  $C_3' \geqslant 12 \frac{465\ 000}{13\ 000} \ 1,98 = 850\ n\Phi$ . По (2-101) индуктивность кон-

турных катушек будет  $L = 1/(6.28^2 \cdot 465^2 \cdot 10^6 \cdot 85 \cdot 10^{-11}) = 138 \times$ ×10-6 Гн, что по табл. 5-1 реализуемо. Полагая собственное затухание Контуров равным 0,012, по (2-55) находим  $g = 0.012 \cdot 6.28 \cdot 465$  000  $\times$ 

 $\times 85 \cdot 10^{-11} = 298 \cdot 10^{-7}$  CM II  $g_9 = g\delta_9/\delta = 298 \cdot 10^{-7} \cdot 0.0245/0.012 = 208 \cdot 10^{-7} \cdot 0.0245/0.012$ 

Пользуясь формулой (2-86), вычисляем 
$$K_{0\,\text{max}} = \frac{0.5 \cdot 0.035}{\sqrt{10^{-2} \cdot 4 \cdot 10^{-4}}} \times$$
  $\times \left(1 - \frac{0.012}{0.0245}\right) = 141$  и по уравнению (2-66)  $K_{0\,\text{ycr}} = \sqrt{\frac{2\,(1 - 0.9)\,0.035}{6.23 \cdot 465\,000 \cdot 10^{-12}}} = 49$ . Расчет ведем на устойнявый коэффи-

цвент усиления. По первому уравнению (7-17) находим  $p_1=\sqrt{\frac{298\cdot 10^{-7}}{10^{-5}}\left(\frac{0,0245}{0,012}-1\right)}=1,76$ , что не реализуемо. Принимаем  $p_1=1$ . Из второго уравнения (7-17) находим  $p_2=\sqrt{\frac{298\cdot 10^{-7}}{0.004}}\times$ 

 $\times \left(\frac{0.0245}{0.012}-1\right)$  = 0,278. По выражению в квадратных скобках формулы (7-14) находим усиление каскада при полученных коэффициентах включения  $K_{0\mathrm{K}} = \frac{1}{1+1^2} \frac{1 \cdot 0.278 \cdot 0.035}{0.00061} = 80$ , что на 63 % превы шает устойчивый коэффициент усиления. Поэтому возьмем  $\rho_1 = K_{0,\mathrm{VCT}}/K_{0\mathrm{K}} = 49.80 = 0.613$ .

Чтобы обеспечить эквивалентное затухание первого контура, согласно первой формуле (7-17) следует иметь проводимость на выходе транзистора  $g_{22}' = \frac{g}{p_1^2} \left(\frac{\delta_2}{\delta} - 1\right) = \frac{298 \cdot 10^{-7}}{0.613^2} \left(\frac{0.0245}{0.012} - 1\right) = 826 \cdot 10^{-7}$  См.

Проводимость шунтирующего резистора для этого должна быть  $g_{18}=g_{22}'-g_{22}=(826-100)\cdot 10^{-7}$  См. Ей соответствует сопротивление 13 750 Ом. Согласно табд. П-3-1 принимаем резистор сопротивлением 13 кОм.

По уравнениям (7-19) с учетом (7-18) вычисляем емкость конденсаторов контуров, полагая  $C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=5$  пФ п  $C_{\rm K1}=C_{\rm K2}=10$  пФ,  $C_{\rm I}=C_{\rm S}-\rho_{\rm I}^2$  ( $C_{\rm M1}+C_{\rm 22}$ ) —  $C_{\rm K1}=850-0.613^2$  (5+4) — 10=836.6 пФ и  $C_{\rm I}=850-0.278^2$  (5+40) — 10=836.5 пФ. Эти емкости согласно табл. П-3-2 п П-4-2 можно составить прадледыми составном конденсаторов с постоянной емкостью 820 пФ и получеременного типа КПК-2 с изменением емкость от 6 до 60 пФ.

Принимаем падение напряжения на резисторе фильгра  $U_1=1$  В и по формуле (6-4) паходим  $R_{\Phi}=1/10^{-3}=10^3$  Ом, что соответствует данным табл. П-3-1. По неравенству (3-19) получаем  $C_{\Phi} \geqslant (10\div 20)/(465\cdot 10^3\cdot 10^3)=(21\div 42)\cdot 10^{-9}$  Ф; из табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостыю 0,033 мкФ. Пользуясь уравнением (3-17), вычисляем  $U_{R_3}=12-1-5=6$  В. По формуле (6-6) имеем  $I_{B0}=(1-0.993)\cdot 10^{-3}=7\cdot 10^{-6}$  А. Вычисляем из равенства (3-18)  $R_9=6/(10^{-3}+7\cdot 10^{-6})=5950$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 6,2 кОм. По неравенству (3-19) находям  $C_3\geqslant (10\div 20)/(465\cdot 10^3\cdot 6200)=(35\div 70)\cdot 10^{-10}$  Ф. Из табл. П-3-2 берем конденсатор емкостью 5600 пФ. Положим  $U_{B0}=0.22$  В. Тогда из (3-20) получим  $U_{R_6}=6+0.22=6.22$  В. Полагая в уравнении (3-21)

численный коэффициент равным 10, получаем  $I_{\rm H}=10\cdot7\cdot10^{-6}=7\cdot10^{-5}$  A. На (3-22) и (3-23) находим  $R_6'=6.22/(7\cdot10^{-5})=89\,000$  Ом и  $R_6''=(12-6.22)/(7\cdot10^{-5}+7\cdot10^{-6})=75\,000$  Ом. По табл. П-3-2 берем резисторы сопротивлением 90 и 75 кОм, Коэффициент нестабильности коллекторного тока вычисляем по формуле (3-24)  $\sigma=\frac{1+6200/90\,000+6200.75\,000}{1+6200.75\,000}=7.3$  ито достатенно

=  $\frac{1}{1-0.993+6200/90000+6200/75000}$ =7,3, что достать чно.

Согласно формуле (7-14) коэффициент усиления всего усилителя будет  $K_{\rm ny}=49^2=2400$ . Для стандартной расстройки 10 кГп из (2-65) получаем  $\xi=20~000/~(0.0245\cdot465~600)=1.75$ . По (7-15) находим  $d=[V~(1+1^2-1.75^2)^2+4\cdot1.75^2/1+1^2]^2=3.4$ , или 10.6 дБ, что сольше тробуемого.

Входное сопротивление детектора из примера 2-24 равно 4 кОм  $g_{\rm HX} = 0.0025$  См). Следовательно, для второго каскада должно быть  $ho_2=\sqrt{rac{298\cdot 10^{-7}}{0,00025}\Big(rac{0,0245}{0,012}\Big)}=0,352.$  Ток питания каскада  $I_0=I_{\rm K}+$  $+I_{\rm g}=10^{-3}+7\cdot10^{-5}=0.00107$  A.

Пример 7-3. Рассчитать трехкаскадный усилитель с двумя связанными контурами при критической связи на транзисторах ГТ308В по схеме с ОЭ при промежуточной частоте 8,4 МГц, обеспечивающий  $\Pi = 180$  к $\Gamma$ ц и наибольшее усиление. Режим работы транзисторов соответствует примеру 7-2. Селективность усилителя должна удовлетворять требованиям к приемникам I класса для приема ЧМС. Пара-

метры транзистора:  $Y_{21}=0.035$  См;  $g_{11}=0.9$  мСм;  $g_{22}=110$  мкСм;  $C_{12}=1$  и $\Phi$ ;  $C_{22}=4$  п $\Phi$ ;  $C_{11}=40$  п $\Phi$ ;  $h_{215}=0.993$ . По табл. 2-12 находим  $\psi_3$  (3) = 0.98 и  $\theta_3$  (3) = 1.89. Согласно уравнению (7-3) должно быть  $\delta_3=0.18\cdot0.98/8.4=0.021$ . Положим  $p_1=p_2=0,3$  и разброс параметров транзистора равным 0,19. По равенствам (7-20) вычисляем  $\Delta C_{1\,\mathrm{max}}{=}0,3^2\cdot 0,19\cdot 4{=}0,007$  пФ и  $\Delta C_{2\,\mathrm{max}}{=}$  $= 0.3^2 \cdot 0.19 \cdot 40 = 0.68$  пФ. Минимально допустимую эквивалентную емкость контуров находим из неравенства (7-5)  $C_2 >$  $\ge 0,68 \frac{8,4}{0.18} 1,89 = 60$  пФ. Ей согласно равенству (2-101) соответствует  $L = 1/(6.28^{2} \cdot 84^{2} \cdot 10^{10} \cdot 6 \cdot 10^{-11}) = 6 \cdot 10^{-6} \text{ Гн}, \text{ что по табл. 5-1 допу-}$ стимо.

Положим  $\delta = 0.01$  и по равенству (2-55) вычисляем  $g = 0.01 \times$  $\times 6.28 \cdot 82 \cdot 10^{5} \cdot 6 \cdot 10^{-11} = 316 \cdot 10^{-8} \text{CM} \text{ H } g_{9} = \frac{0.021^{1}}{0.01} 316 \cdot 10^{-8} = 663 \cdot 10^{-8} \text{CM}.$ 

По формуле (2-66) вычисляем  $K_{0\,\mathrm{yer}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}\,(1-0.9)\,0.035}{\frac{2}{6.28 \cdot 84 \cdot 10^5 \cdot 10^{-12}}}} = 11.5.$  Уравнение (2-86) дает  $K_{0\,\mathrm{max}} = \frac{0.5 \cdot 0.035}{\sqrt{0.00011 \cdot 0.0009}} \left(1 - \frac{0.01}{0.021}\right) = 29$  .

Расчет ведем на устойчивый коэффициент усиления. Для обеспечения эквивалентного затухания по первому уравнению (7-17) вычисляем

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{316 \cdot 10^{-8}}{0.00011} \left(\frac{0.021}{0.01} - 1\right)} = 0.178$$
 и по второму  $\rho_2 = \sqrt{\frac{316 \cdot 10^{-8}}{0.0009} \left(\frac{0.021}{0.01} - 1\right)} = 0.0622$ . По выражению в квадратных скобках формулы (7-14) вычисляем коэффициент усиления каскада при

данных коэффициентах включения  $K_0 = \frac{1}{1+1^2} \frac{0,178 \cdot 0,0622 \cdot 0,035}{0,0000663} =$ 

=29.4. Это больше устойчивого усиления в 29.4/11.5=2.55 раза. Во столько же раз снижаем коэффициент включения первого контура и берем его равным  $p_1 = 0.178/2.55 = 0.07$ . Из первого уравнения (7-17) вычисляем необходимую проводимость на выходе траизистора

 $\mathbf{g}_{22}' = \frac{316 \cdot 10^{-8}}{0.07^2} \left(\frac{0.021}{0.01} - 1\right) = 0.00071$  См. Для ее обеспечения на выкоде траизистора следует подключить шунтирующую проводимость  $\mathbf{g}_{11} = 0.00071 - 0.000011 = 0.0006$  См. или резистор сопротивлением 1670 Ом (по табл. П-3-1 берем резистор сопротивлением 1600 Ом).

Коэффициент усиления усилителя вычисляем по уравнению (7-1)  $K_{xy}=11,5^3=1520$ . Режим работы транзисторов соответствует примеру 7-2. Следовательно, сопротивления резисторов схемы каскада сохраняют свои значения, а емкости конденсаторов должны быть уменьшены в 8400/465 = 18 раз,

Для оценки селективности усилителя на штриховой кривой 3 (рнс. 2-14) отмечаем точки  $\mathcal{B}$  и  $\mathcal{B}$ , соответствующие ослабленням 2 и 20 (6 и 26 дБ). Для них  $\xi_{d_c}/\xi_{\rm H}$  равны соответственно 1,4 и 2,3. Следовательно, интервал частот, заключенный между абсциссами точек  $\mathcal{B}$  и  $\mathcal{B}$ , будет  $\Delta f_{\rm BB} = (2,3-1,4)-0,5/7 = (2,3-1,4)\cdot0,5\cdot180 = 81$  кГц, а средняя крутизна ската кривой селективности 20 дБ/ $\Delta f_{\rm BB} = 20/81 = 0,246$  дБ/кГц, что больше требуемого.

### 7-5. Расчет усилителя с ФСС

Фильтры сосредоточенной селекции из связанных колебалельных контуров дают лучшую селективность по сравнению с усилителем с двумя связанными контурами в каждом каскаде (при равном числе контуров), если эквивалентное затухание удовлетворяет уравнению (2-53). Для промежуточной частоты 465 кГц при эквивалентном зату-

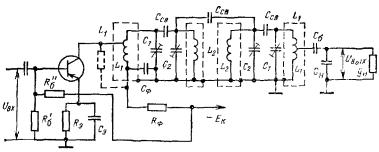


Рис. 7-3.

хании 0,01 минимально осуществимая полоса пропускания фильтра будет болсе 13 кГи, что ограничивает применение таких фильтров. Фильтры с пьезокерамическими и магнитострикционными колебательными системами лишены этого недостатка, так как облядают значительно меньшим эквивалентным затуханием своих резонаторов. Наиболее часто применяемая схема ФСС с внешнеемкостной связью между контурами приведена на рис. 7-3. Коэффициент усиления каскада с ФСС определяется равенством

$$K_0 = p_1 p_2 q Y_{21} / G_{\text{Bx}}, (7-21)$$

где  $p_1$  и  $p_2$  — коэффициенты включения первого и последнего контуров; q — коэффициент ослабления сигнала ФСС на средней частоте полосы пропускания (рис. 7-4);  $C_{\rm Hx}$  — входная или характеристическая проводимость ФСС (см. табл. 2-7). Абсинссы на рис. 7-4 определяются уравнением

$$x = 2\delta_{\text{a}} f_{\text{pp}} / \Pi_{\text{th}}. \tag{7-22}$$

Ослабление фильтра  $d_{\Phi}$  связано с ослаблением звена (рис. 7-5) и числом звеньев в фильтре m

$$d_{\Phi} = md_{3B}, \tag{7-23}$$

Коэффициенты включения вычисляются по формулам:

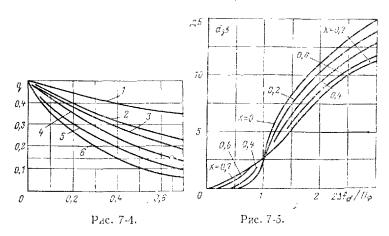
$$p_1 = \sqrt[4]{G_{\text{BX}}/g_{22}}; \quad p_2 = \sqrt[4]{G_{\text{BX}}/g_{\text{cl}}}.$$
 (7-24)

Если один или оба коэффициента окажутся больше единицы, то гринимают каждый из них равным 1 и из этих же уравнений вычисляют шунтирующую проводимость

$$g_{1022} = G_{BX} - g_{22}; \quad g_{1011} = G_{BX} - g_{11}.$$
 (7-25)

В ФСС обычно принимают  $G_{\rm Bulx} = G_{\rm ex}$ , а емкость связи между контурами находят из формулы

$$C_{\rm CB} = G_{\rm BA}/(2\pi t_{\rm BB}).$$
 (7-26)



Емкость этих конденсаторов должна соответствовать расчетному значению с погрешностью менее  $0.5\delta_{\alpha}$ . Каждая контурная катушка должна помещаться в экран, хорошо предотвращающий связь между контурами. Параметры внутренних контуров фильтра (второго и третьего на рис. 7-3) должны удовлетворять равенствам:

$$C_2 = \frac{G_{2X}}{\pi \Pi_{\Phi}} - 2G_{2B}; \quad L_2 = \frac{\Pi_{\Phi}}{4\pi G_{BX} f_{BP}^2},$$
 (7-27)

а первого и последнего — уравнениями:

$$C_1 = 0.5C_2; \quad L_1 = 2L_2.$$
 (7-28)

Пример 7-4. Рассчитать выходные параметры преобразователя частоты с четырехзвенным ФСС, обеспечивающим излосу пропускания 180 кГц при промежуточной частоте 8.4 МГц на транзисторе ГТЗ13Б в рабочей точке  $I_{\rm K0}=1$  мА,  $U_{\rm K30}=-5$  В,  $U_{\rm B30}=0.23$  В,  $E_{\rm K0}=12$  В. Его параметры:  $Y_{21}=0.09$  См;  $g_{11}=750$  мкСм;  $g_{22}=50$  мкСм;  $C_{12}=1$  пФ;  $C_{22}=4$  пФ;  $C_{11}=50$  пФ;  $h_{215}=0.993$ . В следующем каскале применен транзистор ГТЗ08В ( $g_{11}=9\cdot10^{-4}$  См,  $C_{11}=40$  пФ). Полагаем  $Y_{\rm 21np}=0.45$ ,  $Y_{21}$  н  $\delta=0.005$ .

Проверяем выполнение неравенства (2-53)  $\delta_9 \leqslant 0.18/(2.83 \cdot 8.4) = 0.0075$ . Принимаем  $\delta_9 = 0.007$  для выполнения перавенства. Коэффициент устойчивого усиления вычисляем по (2-66)  $K_{\rm Uycr} = \sqrt{-2(1-0.9)(0.09)}$ 

=  $\sqrt{\frac{2.31 - 0.09}{6.28 \cdot 8400000 \cdot 10^{-12}}}$ = 58. По формуле (7-22) находим параметр  $x = 2 \cdot 0.007 \cdot 8400000/180000 = 0.65$ . По рис. 7-4 определяем q = 0.14

Чтобы иметь возможно больший коэффициент усиления каскэда, примем  $G_{\rm BX}=g_{29}$ , что согласно (7-14) даст  $p_1=1$ . По (7-26) вычисляем  $C_{\rm CR}=(5\cdot 10^{-6})$  /  $(6.28\cdot 8\ 400\ 000)=95\cdot 10^{-14}\ \Phi$ . Пз (7-27) находим  $G_2=0.00005$ /  $(3.14\cdot 180\ 000)=19\cdot 10^{-13}=87\cdot 10^{-12}\ \Phi$  и  $L_2=180\ 000$ /  $(12.56\cdot 5\cdot 10^{-5}\cdot 84^2\cdot 10^{10})=41\cdot 10^{-7}$  Гн. По формулам (7-28) получаем  $G_1=0.5\cdot 87=43.5$  пФ и  $L_1=2\cdot 41\cdot 10^{-7}=82\cdot 10^{-7}$  Гн. По второй формулам (7-28) получаем  $G_1=0.5\cdot 87=43.5$  пФ и  $G_1=0.5\cdot 87=43.5$  пФ и  $G_2=0.5\cdot 87=43.5$  пФ и  $G_3=0.5\cdot 87=43.5$  и  $G_3=0.5\cdot 87=43.5$  пФ и  $G_3=0.5\cdot 87=43.5$  и  $G_3=0.$ 

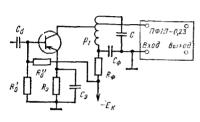


Рис.7-6.

муле (7-24)  $p_2 = \sqrt{\frac{5 \cdot 10^{-5}}{9 \cdot 10^{-4}}} = 0,236$ . Коэффициент усиления каскада вычисляем по формуле (7-21)  $K_0 = 1 \cdot 0,236 \cdot 0,14 \cdot 0,45 \times 0.09/5 \cdot 10^{-5} = 26,6$  что депустимо.

Положим собственную емкость катушек равной 2 пФ, тегда емкость конденсатора первого контура должна быть  $C_{\mathbf{K}\mathbf{i}} = C_1 - C_{\mathbf{K}} - p_1^2 C_{22} = 43.5 - 2 - 1 \cdot 4 = 37.5$  пФ, четвертого

контура  $C_{\rm K4}=43.5-2-0.236^2\cdot 50=38.7$  пФ. Емкости конденсаторов второго и третьего конгуров будут  $C_{\rm K2-3}=87-2=85$  пФ. По табл. 11-4-2 выбираем конденсаторы типа КПК-2 емкостью 6—60 пФ для первого и четвертого контуров и емкостью 10—100 пФ для второго и трегьего.

Схема каскада с пьезоэлектрическим фильтром приведена на рис. 7-6. Полоса пропускания согласующего колебательного колтура должна удовлетворять равенству

$$\Pi_{\rm K} = \delta_{\rm e} f_{\rm np} = (2.5 \div 3.5) \, \Pi_{\rm tb}.$$
 (7-29)

Коэффициенты включения определяются уравнениями:

$$p_1 = \sqrt{\frac{g}{g_{22}}} \quad \text{if} \quad p_2 = \sqrt{\frac{g}{G_{BX}} \left(\frac{\delta_9}{\delta} - 2\right)}, \tag{7.30}$$

где g — себственная проводимость контура.

Пример 7-5. Определить параметры преобразователя частоты на транзисторе ГТ308В, режим работы которого соответствует примеру 7-4. Селективней системой служит фильтр типа ПФ1П-0,23 ( $\Pi_{\Phi}=8\div11,5~{\rm к}\Gamma_{\rm H};~q=0,33;~G_{\rm Bx}=835~{\rm мкСм};~d_{\pm9~{\rm к}\Gamma_{\rm H}}\geqslant 40~{\rm дБ}).$ 

Согласно формуле (2-153) эквивалентная емкость согласующего контура должна быть  $C_9=3\cdot 10^{-4}/465\ 000=645\cdot 10^{-12}$  Ф. Индуктивность контурной катушки вычисляем по равенству (2-101)  $L==1/(6,28^2\cdot 465^2\cdot 10^6\cdot 645\cdot 10^{-12})=183\cdot 10^{-6}$  Гн. Положим  $\delta=0.01$ и по формуле (2-55) находим  $g=0.01\cdot 6.28\cdot 465000\cdot 645\cdot 10^{-12}=189\cdot 10^{-7}$  См.

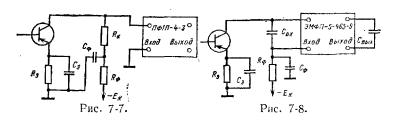
Из первой формулы (7-30) получаем  $p_1 = \sqrt{\frac{189 \cdot 10^{-7}}{10^{-5}}} = 1,35$  и берем  $p_2 = 1$ . Приняв численный коэффициент равным 3, а полосу пропускания

 $ho_1=1$ . Приняв численный кожфициент равным 3, а полосу пропускания фильтра максимальной, из равенства (7-29) вычисляем  $\delta_3=3\cdot 11\ 500/465\ 000=0,074$ . Находим по второму ураенению (7-30)  $\rho_2=1$ 

= 
$$\sqrt{\frac{189 \cdot 10^{-7} \left(0.074 - 2\right)}{835 \cdot 10^{-6} \left(0.01 - 2\right)}}$$
 = 0,38. Коэффициент преобразования каскада вычисляем по формуле (7-21), заменяя  $Y_{21}$  на  $Y_{21\text{пр}} = 0.45 \cdot Y_{21}$ ,  $K_{\text{np}} = 1 \cdot 0.38 \cdot 0.33 \cdot 0.45 \cdot 0.035 / 836 \cdot 10^{-6} = 2.3$ .

 $K_{0 \text{пр}} = 1 \cdot 0.38 \cdot 0.33 \cdot 0.45 \cdot 0.035/836 \cdot 10^{-6} = 2.3.$  При использовании пьезомеханического фильтра согласующий колебательный контур включать не обязательно. Но сопротивление коллекторного резистора (рис. 7-7) должно определяться равенством

$$R_{\kappa} = 1/G_{nx}.\tag{7-31}$$



**Пример 7-5.** Определить параметры преобразователя частоты по исходным данным примера 7-5, если селективной системой служит фильтр  $\Pi\Phi 1\Pi$ -4-3 ( $\Pi_{\Phi}=7\div 10$  кГц, q=0.25,  $G_{\rm PN}=0.5$  мСм).

фильтр ПФПП-4-3 ( $\Pi_{\Phi}=7 \div 10$  кГц, q=0.25,  $G_{\rm BN}=0.5$  мСм). По формуле (7-31) вычисляем  $R_{\kappa}=1/5\cdot 10^{-4}=2000$  Ом, что точно соответствует данным табл. П-3-1. Полагая в формуле (7-21)  $p_1=$ 

 $= p_2 = 1$ , находим  $K_0 = 1 \cdot 1 \cdot 0.25 \cdot 0.45 \cdot 0.035 \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 7.9$ .

Схема преобразователя частоты с электромеханическим фильтром показана на рис. 7-8. Параметры фильтра типа ЭМФП-5-465-9:  $\Pi_{\Phi}=8.4\div9.6$  кГи;  $C_{\rm вых}=2200$  пФ; q=0.45;  $C_{\rm ex}=300$  пФ;  $G_{\rm nx}=1$  мСм.

Пример 7-7. Определить параметры преобразователя частоты по исходным данным примера 7-5, если селективной системой служит фильтр типа ЭМФП-5-465-9.

Согласно рис. 7-8 в данном случае  $p_1=p_2=1$ , поэтому из формулы (7-21) получаем  $K_{010}=1\cdot 1\cdot 0.45\cdot 0.45\cdot 0.035/10^{-3}=7.1$ .

Глава восьмая

#### РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

### 8-1. Исходные данные и задачи расчета

Для радиовещательных приеминков ГОСТ 5651-76 задаются промежуточная частота и диапазон рабочих частот. При расчете структурной схемы определяются: полоса пропускания тракта промежуточной частоты —  $\Pi_{\rm np}$ ; тип, схема и основные характеристики селективной

системы преобразователя частоты; тип электронного прибора и его режим работы; минимально необходимый коэффициент преобразования; напряжение источника питания. Из расчета входной цепи и усилителя радносигнала получаются нараметры колебательных контуров радиотракта.

При расчете каскада: уточияется режим работы электронного прибора и вычисляются параметры элементов схемы, обеспечивающие его; выбирается тип электронного прибора для гетеродина, определяется его оптимальный режим работы и вычисляются параметры элементов схемы гетеродина; выбирается метод сопряжения настройки гетеродинного контура и рассчитываются его элементы; выбирается схема стабилизации режима работы электронных приборов, рассчитываются параметры всех се элементов.

# 8-2. Расчет преобразователя частоты с отдельным гетеродином

У траизисторных преобразователей частоты зависимость крутизны преобразования от амплитуды подводимого напряжения гетеродина сохраняется близкой к линейной лишь при амплитуле напряжения, подводимого от гетеродина, не более 0,08—0,12 В. Для уменьшения неличейных искажений подводимое от гетеродина напряжение обычно имеет амплитуду около 0,1 В. С целью повышения к. н. д. каскада рабочую точку целесообразно выбрать при токе коллектора не более 1—2 мА. При отмеченных услювиях крутизну преобразования можно вычаслять по приближенному равенству [5]

$$Y_{24 \text{ np}} \approx (0.3 \div 0.6) Y_{21},$$
 (8-1)

где  $Y_{21}$  — проводимость прямой передачи транзистора в рабочей точке. Коэффициент преобразования определяется уравнением

$$K_{\text{unp}} = \rho_1 p_2 q Y_{21 \text{ mp}} / G_{\text{ii}},$$
 (8-2)

где  $p_1$  и  $p_2$  — коэффициенты включения селективной системы преобразователя частоты в коллекторную цень транзистора и ко входу следующего каскада; q — коэффициент ослабления селективной системы на промежуточной частоте;  $G_{\rm H}$  — входная проводимость селективной системы. Для  $\Phi$ CC значения двух последиих параметров приводятся в табл. 2-7. Если нагрузкой служит одиночный контур, то q=1 и  $G_{\rm H}=g_{\rm 3}$ , а для двух связанных контуров при критической связи q=0.5 в  $G_{\rm H}=g_{\rm 3}$ .

Расчет параметров элементов схемы, обеспечивающих выбранный режим работы траизистора, выполняется по методике § 3-2. Для уменьшения влияния радкотракта на режим работы напряжение тегеродина обычно вводят в цепь эмиттера, а сигнальное — в цепь базы. Наиболее часто примениющайся схема со стабилизацией коллекторного тока транзисторов преобразователя частоты и гетеродина приведена на рис. 8-1. Благодаря большой емкости кондепсатора  $C_{\rm ct}$  нижние полюсы эмиттерных резисторов преобразовательного и гетеродинного транзисторов по переменным токам имеют потенциал пласси. Постоянные составляющие эмиттерных токов траизисторов  $T_{\rm n}$  и  $T_{\rm r}$ , а также делителей напряженяя, питающих базы транзисторов, протекают через траизистор  $T_{\rm ct}$ . Он совместно с дводом  $\mathcal I$  обеспечтвает стабилизацию коллекторных то

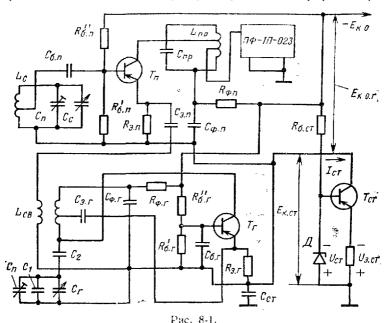
ков транзисторов  $T_{\mathrm{n}}$  и  $T_{\mathrm{r}}$  при изменениях напряжения источника пита-

ния и температуры [5].

При трансформаторной обратной связи в гетеродине коэффициент связи между коллекторной и контурной катушками должен на 10—20 % превышать критическое значение, определяющееся уравнением

$$k_{\rm kp} = \frac{g_{\rm r} + \rho_{\rm 0}^2 g_{\rm 11\,r}}{Y_{\rm 21\,r}} \sqrt{\frac{L_{\rm r}}{L_{\rm cB,r}}},$$
 (8-3)

где  $g_r$  — резонансная проводимость контура гетеродина, а  $p_\delta$  — коэффициент включения этого контура к участку база—эмиттер транзистора.



Для повышения стабильности работы гетеродина коэффициент связи берут не более 0,02—0,04, что обеспечивается подбором коэффициента включения. При настройке контура гетеродина емкостью его проводимость определяется из уравнения

$$g_{\rm r} = \delta_{\rm r}/(\omega L_{\rm r});$$
 (8-4)

проводимости  $g_{11\Gamma}$  и  $Y_{21\Gamma}$  также зависят от частоты. Поэтому при расчете гетеродина для работы в диапазоне частот при  $k_{\Pi\Gamma}\!\!>\!1,2\div 1,3$  следует определять значения  $k_{\kappa p}$  на крайних и средней частотах поддиапазона. Ва расчетное принимается большее из полученных значений.

В диапазонах километровых и гектометровых воли параметры транзисторов практически постоянны, а критический коэффициент связи

можно определять лишь на минимальной частоте.

В случае индуктивной трехточечной схемы гегеродина критическая индуктивность части контурной катушки, включаемой между базой и эмиттером транзистора, находится из уравнения

$$L_{69, \text{ Kp}} = \frac{g_{\text{c}}}{\rho_{\text{K}}^2 Y_{21}} L_{\text{K9}}, \tag{8-5}$$

где  $L_{\kappa_3}$  — индуктивность части контурной катушки гетеродииа, включенной между коллектором и эмиттером транзистора. Для обеспечения надежного режима самовозбуждения следует брать индуктивность  $L_{\kappa_3}$  на 15—20 % больше критического значения.

Приближенный расчет режима работы гетеродина, точность которого обычно достаточна для радиолюбительской практики, выполняют по следующей методике. Сначала выбирают метод сопряжения настройки. Если  $k_{\rm A} \lesssim 1.3 \div 1.4$ , то применяют сопряжение настройки с помощью одного, обычно параллельного ( $C_1$  на рис. 8-1) конденсатора. При расчете тракта радиосигнала определяют суммарную емкость его контуров  $C_{\Sigma}$ , которая согласно (5-8) и (5-14) включает в себя все емкости, кроме емкости конденсатора, с помощью которого контур перестранается в поддиапазоне частот. С целью уменьшения интерференционных искажений обычно применяют верхнюю настройку гегеродина, для которой

$$f_{\rm r} = f_{\rm c} + f_{\rm np}. \tag{8-6}$$

При точном сопряжении на крайних частотах поддиапазона емкость гетеродинного контура  $C_{\Sigma_\Gamma}$  вычисляется по формуле (5-48), если в нее при верхней настройке гетеродина вместо  $k_{\pi}$  подставить

$$k_{\rm m,r} = (f_{\rm c max} + f_{\rm np})/(f_{\rm c min} + f_{\rm np}).$$
 (8-7)

Емкость параллельного сопрягающего конденсатора определяется разностью

$$C_1 = C_{\Sigma_{\Gamma}} - C_{\Sigma}, \tag{8-8}$$

При нижией настройке гетеродина  $k_{\rm A,c}>k_{\rm A,c}$  и сопрягающие конденсаторы включают в контуры радиотракта. Допустимая максимальная относительная погрешность сопряжения  $b_{\rm c, дон}$  должна удовлетворять перавенству

$$b_{c, \text{ доп}} \leq 0.5\delta_{e, c}/\psi_1(n_c),$$
 (8-9)

где  $\delta_{\rm 3.c}$  и  $n_{\rm c}$  — эквивалентное затухание и число колебательных контуров в радиотракте. Значения функции, стоящей в знаменателе, приведены в табл. 2-12. Осуществимая относительная максимальная погрешность сопряжения при одном параллельном сопрягающем конденсаторе находится из помограммы на рис. 8-2, a по известному отношению  $f_{\rm np}/f_{\rm c}$  тах. Если она не удовлетворяет неравенству (8-9), то следует перейти к сопряжению настройки гетеродинного контура в трех точках, что достигается включением в гетеродинный контур двух сопрягающих конденсаторов: параллельного и последовательного ( $C_1$  и  $C_2$  на рис. 8-1). Обычно это бывает при  $k_{\rm d} > 1,5 \div 1,6$ . Расчет емкостей сопряжения в данном случае достаточно громоздок. Поэтому емкости сопрягающих конденсаторов обычно определяются по номограммам

[5, 13]. Из иомограммы на рис. 8-2,  $\delta$  находят  $b_f$ . Частоты точного сопряжения вычисляют по формулам:

$$f_{c1} = (1 + b_f) f_{c \, min}; \quad f_{c2} = \sqrt{f_{c \, min} f_{c \, max}}; \quad f_{c3} = \frac{f_{c \, max}}{1 + b_f}.$$
 (8-10)

Значение  $b_{\rm c}$  находят по номограмме на рис. 8-2,  $\epsilon$  и проверяют выполнение неравенства (8-9).

Емкость последовательного сопрягающего конденсатора определяют по номограмме на рис. 8-3. На шкале I отмечают точку A, соответствующую отношению  $f_{\rm np}/f_{\rm c}$  точку, а на шкале III точку B по известному  $k_{\rm gC}$ . Через течки A и B проводят прямую линию до пересечения с линией V и в месте их пересечения ставят точку B. Отмечают на шкале II точку  $\Gamma$ , которой соответствуют параметры конденсатора переменной

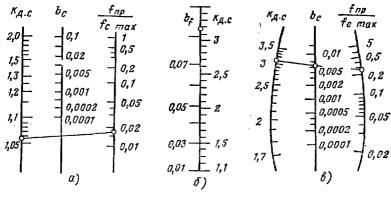


Рис. 8-2.

емкости  $C_{\max} = C_{\min}$ . Соединив точки B и  $\Gamma$  прямой линией, получают точку  $\mathcal L$  в нересечении со шкалой IV и определяют требуемую емкость конденсатора  $C_2$ .

Емкость парадледьного сопрягающего конденсатора находят, пользуясь номограммой на рис. 8-4. На шкалах I и IV находят точки A и B. Сосдиняют их прямой линией и в пересечении с линией II получают точку B. На шкале V определяют положение точки  $\Gamma$ . Соединяют прямой линией точки B и  $\Gamma$  и в пересечении со шкалой III получают точку  $\mathcal{A}$ . По (8-8) вычисляют емкость сопрягающего кондепсатора  $C_1$ . Пидуктивность контурной катушки гетеродина вычисляется по формуле

$$L_{\rm r} = \frac{(C_2 + C_1) L_{\rm c} \omega_{\rm c1}^2 + 1}{4\pi^2 (f_{\rm c1} + f_{\rm np})^2 C_2 (C_1 L_{\rm c} \omega_{\rm c1}^2 + 1)}.$$
 (8-11)

Рабочую точку транзистора применительно к схеме на рис. 8-1 можно выбрать по следующей методике. Коэфрициент включения к контуру участка база—эмиттер транзистора, обеспечивающий режим самовозбуждения, находят по формуле

$$p_{6, r} \approx 1.1 (0.5 - \sqrt{0.25 - g_1/Y_{21}}),$$
 (8-12)

Здесь  $Y_{24}$  — проводимость прямой передачи транзистора в рабочей точке. Транзисторы преобразователя частоты и гетеродина питаются стабилизированным напряжением. Оно обычно составляет около 50 % нормального напряжения источника питания. Так, при  $E_{\kappa 0}=9$  В

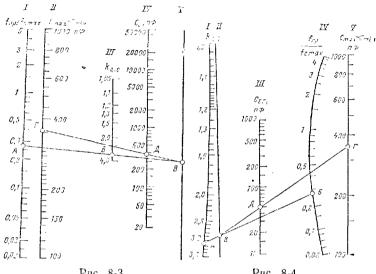


Рис. 8-3. Рис. 8-4.

стабилизпрованное напряжение составляет 4—4,5 В. Поэтому для расчета по формуле (8-12) следует брать пониженное значение проводимости прямой передачи, составляющее 0,75—0,85 значения, приводимого в справочниках. Напряжение в исходной рабочей точке между базой и эмиттером вычисляется по формуле

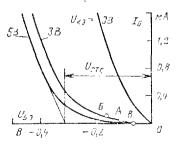


Рис. 8-5.

$$U_{\text{BO}} = U_{\text{ore}} + + 0.7p_{6,r}U_{\text{KO}}\cos(90^{\circ} - \phi_s)/(1 - p_{6,r}),$$
(8-13)

где  $U_{\text{оте}}$ — 'напряжение, при котором спрямленная входная характеристика пересскает ось абсцисс (рис. 8-5);  $U_{\text{K},9}$ — напряжение, прикладываемое к участку коллектор — эмиттер;  $\phi_s$  — фазовый угол проводимости прямой передачи, который определяют по формуле

$$\varphi_s := \varphi_0 f_{\Gamma}. \tag{8-14}$$

Значение параметра  $\phi_0$  для рабочих частот гетеродина, меньших 0,15  $f_{\rm rp}$ , определяют по табл. 8-1. Его размерность — градусы (угловые) на мегагерц, поэтому частоту гетеродина следует подставлять

в мегагерцах. После этого по формулам § 3-2 вычисляют параметры элементов ехемы питания транзистора, Индуктивность катушки связи с транзистором преобразователя частоты выбирают по равенству

$$L_{\rm CB} \approx (0.2 \div 0.3) L_{\rm r},$$
 (8-15)

Таблица 8-1

Тип тран- зистора	П402	П403	П416	П411	FT310B	FT308F	ГТ313Б	
φ₀, °/МГц	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,4	

а коэффициент связи между катушками вычисляют по формуле

$$k \approx (1 - p_{6, r}) U'_{mr} / (0.7 U_{K3}),$$
 (8-16)

где  $U'_{mr}$  — амплитуда напряжения гстеродина, которое необходимо подводить к транзистору преобразователя частоты. Чем оно меньше, тем меньше будут искажения, но и меньше проводимость преобразования, а значит, и коэффициент преоб-

разовання каскада согласно форму-

ле (8-2).

Стабилизатор папряжения нитания траизисторов гетеродина и преобразователя частоты, приведенный на рис. 8-1, работает так, что при значительном уменьшении напряжения источника питания  $E_{\kappa \alpha}$ их напряжение питания  $E_{\text{ког}}$  практически сохраняется постоянным, Происходит это потому, что при уменьшении напряжения источника питания изменяется режим работы транзистора стабилизатора так, что уменьшается его внутреннее сопротивление (сопротивление между коллектором и эмиттером по постоянному току). Стабилизирующий диод Д (например, типа 7ГЕ1А-С) имеет вольт-амперную

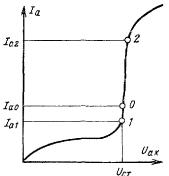


Рис. 8-6.

7ГЕ1А-С) имеет вольт-амперную характеристику, изображенную на рис. 8-6. При изменениях анодного тока диода от  $I_{\rm a1}$  до  $I_{\rm a2}$  падение напряжения на диоде практически сохраняется постоянным и равным  $U_{\rm cr}$ , которое называют напряжением стабилизации диода. Иля обеспечения этого в рабочей области диода между точками I и 2 внутреннее сопротивление диода должно уменьшаться обратно пропорционально протекающему через днод току. Согласно рис. 8-1 можно записать уравнение  $E_{\rm K0} = I_{\rm R}R_{\rm 6-cr} + U_{\rm cr}$ . Отсюда сопротивление базового резистора стабилизатора должно определяться по формуле

$$R_{6, cr} = \frac{E_{\kappa 0 \min} - U_{cr}}{I_{\pi 0}}.$$
 (8-17)

Здесь  $E_{\rm K0~mi,i}$ —минимально допустимое напряжение источника питания, а  $I_{20}$ — ток двода в его рабочей точке  $\theta$  (рис. 8-6), превышающий на 15—20  $^{9}_{00}$  ток  $I_{21}$ . Обычно  $E_{\rm K0~min}$ = (0,55  $\div$  0,6)  $E_{\rm K0}$ .

При уменьшении напряжения источника питания начинают уменьшаться коллекторные токи транзисторов  $T_{\rm R}$  и  $T_{\rm C}$ , а также токи через потенциометры питания базы, т. е. уменьшается коллекторный ток  $I_{\rm CT}$  транзистора  $T_{\rm CT}$ . Это вызывает соответствующее уменьшение эмиттерного тока транзистора  $T_{\rm CT}$  и снижение напряжения  $U_{\rm ЭСT}$ , что вызывает увеличение отрицательного напряжения на базе транзистора  $T_{\rm CT}$ , так как напряжение  $U_{\rm CL}$  на диоде сохраняется постояным. Внутреннее солротивление транзистора  $T_{\rm CT}$  при этом уменьшается, что снизит падение напряжения на нем и сохранит примерно прежним напряжение  $E_{\rm K,CT}$  питающее транзисторы  $T_{\rm R}$  и  $T_{\rm P}$ . Режим работы транзистора выбирают таким, чтобы уменьшение напряжения  $E_{\rm K,CT}$  примерно равнялось уменьшению напряжения источника питания. Это достигается соответствующим выбором сопротивления резистора  $R_{\rm 3,CT}$ 

$$R_{\rm a, cr} \approx (U_{\rm cr} - U_{\rm orc} - 0.15)/I_{\rm cr},$$
 (8-18)

где  $U_{\text{отс}}$  — напряжение отсечки базового тока стабилизирующего транзистора при

$$U_{\rm KBert} \approx E_{\rm K0min} - E_{\rm K0rt}$$
 (8-19)

В процессе налаживания стябилизатора уточияют сопротивление так, чтобы напряжение  $E_{\rm квr}$  сохранялось наиболее постоянным в заданном диапазопе изменения напряжения источника питания. В качестве стабилизирующих транзисторов используются транзисторы, для которых удовлетворяется неравенство

$$I_{\text{K max}} > (5 \div 10) I_{\text{ca}}$$
 (8-20)

Емкость конденсатора  $C_{\rm cr}$  должна удовлетворять неравенству

$$C_{\rm cr} \geqslant 0.1/f_{\rm c min}. \tag{8-21}$$

Пример 8-1. Рассчитать преобразователь частоты с отдельным гетеродином на транзисторах ГТЗ08В для подднапазона 2 перепосного радновещательного приемника 1 класса. Селективной системой каскада является пьезокерамический фильтр типа ПФ1П-0,23. Радиотракт приемника соответствует варианту 7 (см. табл. 2-11), а параметры усилителя радиосигнала — дапным примера 6-8. Схема каскада изображена на рис. 8-1. Настройка гетеродина верхняя. Параметры контура радиотракта определены в примере 5-4. Нормальное напряжение источника питапия 12 В, минимальное — 7,2 В.

При требуемом коэффициенте диапазона необходимо выполнять точное сопряжение настроек в трех точках. По номограмме на рис. 8-2,  $\delta$  находим параметр  $b_f=0.082$ , а по номограмме 8-2,  $\delta$  осуществимую погрешность сопряжения  $b_c=0.005$ . При двух одиночных контурак в радиотракте (по одному во входной цепи и усилителе радиосигнала) из табл. 2-12 находим  $\psi_1$  (2) = 1.56. По (8-9) вычисляем максимальную допустимую погрешность сопряжения настройки  $b_{c,qon}=0.5\times 0.039/1.56=0.0125$ , что больше реализуемого значения, определяющегося номограммой на рис. 8-2,  $\delta$ , и погрешность сопряжения **будет** меньше допустимой. Вычисляем по (8-10) частоты точного сопряжения:

 $f_{\rm c1}=(1\pm0.082)\cdot515\,000=556\,000$  Ги;  $f_{\rm c2}=1\,\overline{515\,000\cdot 1\,640\,000}=920\,000$  Ги;  $f_{\rm c3}=1\,640\,000/1+0.082=1\,515\,000$  Ги. По номограмме на рис. 8-3 находим  $C_2=380$  пФ, а по номограмме на рис. 8-4  $C_{\Sigma\Gamma}=48$  пФ. Согласно равенству (8-8) получим  $C_1=48-29=19$  пФ. В качестве  $C_1$  по табл. П-3-2 можно принять конденсатор емкостью 20 пФ. Индуктивность контурной катушки вычйсляем по формуле (8-11)

$$\begin{split} L_{\rm f} = & \frac{(38 \pm 2) \cdot 10^{-11} \cdot 242 \cdot 10^{-6} \cdot (6,28 \cdot 556)^2 \cdot 10^6 \div 1}{4 \cdot 3,14^2 \cdot (556 + 465)^2 \cdot 10^6 \cdot 38 \cdot 10^{-11} \cdot (2 \cdot 10^{-11} \cdot 242 \times -133 \cdot 10^{-6} \cdot 5,28^2 \cdot 556^2 \cdot 10^6 + 1} \\ & \times 10^{-6} \cdot 6,28^2 \cdot 556^2 \cdot 10^6 + 1 \end{split}$$

Проводимость гетеродинного контура с учетом равенства (8-6) находим по уравнению (2-55) для начала и конца поддиалазона  $g_{\Gamma,R}=0.01/[6,28\cdot(556-465)\cdot10^3\cdot133\cdot10^{-6}]=12\cdot10^{-6}$  См.  $g_{\Gamma,R}=57\times10^{-7}$  См. Поскольку  $f_{\rm c\ max}=1640$  кГц и  $f_{\rm r\ min}=1021$  кГц достаточно близки, то из табл. П-I-1 выписываем параметры транзнегоров при  $I_{\rm K}=1$  мА и  $U_{\rm K,9}=5$  В для частоты 1,5 МГц:  $Y_{21}=0.035$  См;  $g_{21}=0.052$  мСм;  $g_{22}=20$  мкСм;  $C_{11}=40$  пФ;  $C_{12}=1$  пФ;  $C_{22}=4$  нФ;  $I_{\rm K0}=3$  мкА;  $I_{\rm C}=3$  мкА;  $I_{\rm C}=3$ 

Рассчитаем режим работы гегеродина. Согласно сказанному ранее примем для обоих транзисторов каскада  $I_{\rm K,0}=1$  мА,  $U_{\rm K,0,0}=4$  В и будем полагать их прозодимость прямой передачи  $Y_{\rm 21}\approx 0.8\cdot 0.035=0.028$  См. По формуле (8-12) вычисляем для начала поддиапазона коэффициент включения базы транзастора к контуру

$$p_{6,r} \approx 1.1 \left[ 0.5 - \sqrt{0.25 - \frac{0.000012}{0.028}} \right] = 0.0005.$$

На рис. 8-5 приведены входиые характеристики траизистора ГТЗОВВ, из которых находим  $U_{\rm OTC}=-0.31$  В, а по табл. 8-1  $\phi_0=-0.7^\circ$ /МГи. Из (8-14) для средней частоты гетеродина 0.5 ( $f_{\rm C,min}+f_{\rm inp}+f_{\rm c,max}+f_{\rm inp})=0.5$  (515  $\pm$  465  $\pm$  1640  $\pm$  465)  $\pm$  103  $\pm$  1542  $\times$   $\times$  103 Ги находим  $\phi_s=0.7 \cdot 1.542=1.08^\circ$ . По (8-13) вычисляем  $U_{\rm B\to 0.7}=0.31-0.7 \cdot 0.0905 \cdot 4$  сов (90–1.08)  $\pm$  1  $\pm$  0.0905  $\pm$  0.31 В. Применительно к схеме на рис. 8-1 примем стабилизированное напряжение  $E_{\rm Kar}=-5$  В. По табл. П-3-1 выбираем  $R_{\rm dec}=470$  Ом. Подставляя это значение вместо  $r_1$  в (3-16), находим  $U_1=10^{-9} \cdot 470=0.47$  В. Емюсть конделсатора фильтра вычисляем по (3-19), заменяя  $R_9$  на  $R_{\rm dec}=2.000$  (10  $\pm$  20)/(980 000  $\cdot$  470)  $\pm$  (22  $\pm$  44)  $\pm$  1079  $\pm$  (принимаем конденсатор емкостью 0.033 мкФ). Согласно (3-17) получаем  $U_{R_9}=2.000$  (выбираем резистор сопротивлением  $U_{R_9}=2.000$  (выбираем резистор сопротивлением 1910 Ом). Из перавенства (3-19) вычисляем  $C_{3,p}>(10\pm20)$  980 000  $\pm$  510)  $\pm$  (2  $\pm$  4)  $\pm$  1078  $\pm$  (берем конденсатор емкостью 0.033 мкФ). Из (3-21) получаем  $U_{R_9}=2.000$  (берем конденсатор емкостью 0.033 мкФ). Из (3-21) получаем  $U_{R_9}=2.000$  (берем конденсатор емкостью 0.033 мкФ). Из (3-21) получаем  $U_{R_9}=2.000$  (500)  $U_{R_9}=2.000$  (600)  $U_{R_9}=2.000$  (600)  $U_{R_9}=2.000$  (700) находим  $U_{R_9}=2.000$  (700)  $U_{R_9}=2.000$  (700) находим  $U_{R_9}=2.000$  (700)  $U_{R_9}=2.000$  (700) находим  $U_{R_9}=2.000$  (700)  $U_{R_9}=2.000$  (700)  $U_{R_9}=2.000$  (700)  $U_{R_9}=2.000$  (700) находим  $U_{R_9}=2.000$  (700)  $U_{R_9}=2.0000$  (700)  $U_{R_9}=2.0000$  (700)  $U_{R_9}=2.0000$  (700)  $U_{R_9}=2.00000$  (700)  $U_{R_9$ 

Коэффициент нестабильности коллекторного тока соглас но (3-24) будет  $\sigma = \frac{1 + 510 \cdot 360 \cdot 000 + 510 \cdot 150 \cdot 000}{1 - 0.993 - 510 \cdot 36 \cdot 000 + 510 \cdot 150 \cdot 000} = 41$ , что плохо. Для его снижения надо увеличить ток потенииометра питания базы, Примем  $I_n = 0.5$  мЛ и, повторяя расчеты, получим  $R'_{6, r} = 1.8$  кОм,  $R'_{6, r} = 8.2$  кОм и  $\sigma = 5$ , что уже удевлетворительно. Подставляя в (3-19)  $R'_{6, r}$  вместо  $R_3$ , получаем  $C_{6\cdot r} > (10 \div 20)/(980 \cdot 000 \cdot 1800) = (6 \div 12) \times 10^{-9}$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 0,01 мкФ. Индуктивность катушки связи вычисляем по (8-15)  $L_{\rm cn} \approx 0.25 \cdot 133 \times 10^{-6} = 33 \cdot 10^{-6}$  Гн. Будем считать  $U'_{mr} = 0.1$  В, тогда по (8-16) находим  $h = (1 - 0.0005) \cdot 0.1/0.7 \cdot 4 = 0.035$ , что выполнимо при меогослойных катушках, которые применяются в рассматриваемом подднапазоне.

Примем режим работы транзистора преобразователя частоты таким же, как в гетеродине. Тогда сепротивления всех резисторов в его схеме будут одинаковыми с соответствующими резисторами схемы гетеродина. Но минимальная частота сигиала в данном случае будет в (515 + + 465),515 = 1,9 раза меньше. Во столько же раз больше должны быть емкости кондексаторов  $C_{\Phi,n}$ ,  $C_{g,n}$ ,  $U_{G,n}$ . Примем в качестве них кондексаторы емкостью 0,068, 0,068 и 0,022 мкФ соответственно.

Из (8-1) получаем  $Y_{\rm 21np}=0.57\cdot0.028=0.016$  См. Согласно табл. 2-7 средняя полоса пропускания фильтра ПФ1И-0.23 составляет 9,75 кГи, а входная проводимость  $G_{\rm ex}=835$  мСм и a=0.33. По (7-29) вычисляем необходимую полосу пропускания коллекторного согласующего фильтра  $\Pi_{\rm K}=3\cdot9.75=30$  кГи. На основании того же уръвнения его эквивалентное затухание должно быть  $\delta_3=30~000/465~000=0.0645$ . Эквивалентную емкость этого контура определяем по равенству (2-15)  $C_9\approx0.0003/465~000=64\cdot10^{-11}$  Ф. Индуктивность контурной катушки вычисляем по формуле (2-101)  $L=1/(6.28^2\cdot465~000^2\cdot64\times10^{-11})=0.000183$  Гн. При собственном затухании, равном 0,015, его активная проводимееть на основании ураннения (2-55) будет  $g=0.015\cdot6.28\cdot465~000\cdot64\cdot10^{-11}=28\cdot10^{-6}$  См. Из формул (7-30) находим  $\rho_1=\sqrt{0.000028\over0.0008028}\times$ 

 $\times \frac{(0.0645)}{(0.015)} = 0.278$ . Коэффициент пре бызования каскада опре-

деляем по формуле (8-2)  $K_{0,\mathrm{PP}}=1\cdot0.278\cdot0.33\cdot0.016,0.000835=1.76.$  Суммарный ток питания от источника преобразователя частоты и гетеродина, т. е. коллекторный ток транзистора  $T_{\mathrm{cr}}$  (см. рис. 8-1), будет  $I_{\mathrm{cr}}=2~(I_{\mathrm{K}0}+I_{\mathrm{n}})=2~(1+0.5)\cdot10^{-3}=3\cdot10^{-3}$  А. Максимальный коллекторный ток транзистора МП41A согласно табл. П-1-1 составляет 50 мА, неравенство (8-20) при этом выполняется, а транзистор может быть использован в схеме стабилизации напряжения питания.

Согласно (8-19)  $U_{\rm K3-cr}=7.2-5=2.2$  В. На рис. 2-2, а приведены входные характеристики транзистора МП41А. Из них следует, что для обенх характеристик ( $U_{\rm K3}=0$  и  $U_{\rm K3}=-5$  В) согласно постреению на рис. 8-5 напряжение отсечки примерно одинаково и равно 0,2 В. Таким же его можно считать и для  $U_{\rm K3}=2$  В. В качестве стабилизирующего можно выбрать днод Д101, для которого  $U_{\rm cr}=1.2$  В и  $I_{\rm a1}=0.2$  мА. По равенству (8-18) находим  $R_{\rm 3-cr}=(1.2-0.2-0.15)/0.003=280$  Ом (принимаем резистор сопротивлением 270 Ом). Согласно сказанному ранее выбираем рабочую точку диода  $I_{\rm A6}=$ 

= 1,2  $I_{\alpha 1}$  = 1,2·0,2 = 0,24 мA. Из (8·17) вычисляем  $R_{6,c\tau}$  = (7,2 — 1,2)/0,00024 = 25 000 Ом (принимаем резистор сопротивлением 24 кОм). По неравенству (8·21) получаем  $C_{c\tau} > 0,1/515$  000 =

 $= 2 \cdot 10^{-7} \Phi$  (берем конденсатор емкостью 0,22 мкФ).

Пример 8-2. Рассчитать параметры преобразователя частоты для поддиапазона 11 с отдельным гетеродином на транзисторах ГТЗ08В с режимом работы, соответствующим примеру 8-1. Схема каскада соответствует рис. 8-1. Параметры входного колебательного контура определяются примерами 6-9 и 5-2. Нагрузка транзистора такая же, как в примере 8-1.

Согласно табл. 2-2 граничные частоты поддиапазона 25,1 и 26,6 МГ и, а  $k_{\rm A}=1,06$ . Поэтому сопряжение настройки гетеродинного контура можно выполнить одним параллельным конденсатором. Из рис. 8-2, a находим, что относительная погрешность сопряжения принятой схемы менее 0,0001. По (8-9) вычисляем максимальную допустимую относительную погрешность сопряжения  $b_{\rm C \ max}=(0.5\cdot0,0159)/1,56=0.0051$ , что значительно больше осуществимой и сопряжение одним конденсатором приемлемо. Вычисляем  $k_{\rm A-\Gamma}=(26,6+0,465)/(25,1+0,465)=1,06$ . Поскольку практически  $k_{\rm A-\Gamma}=(26,6+0,465)/(25,1+0$ 

 $ho_{6.\ r} \approx 1.1 \, (0.5 - 10.5) \, - \, \frac{625 \cdot 10^{-7}}{0.025}) = 0.0022$ . Из (8-14) получаем  $\phi_s = 0.7 \cdot 25.6 = 18^{\circ}$  и по (8-13) находим  $U_{\rm B \oplus 0.r} = 0.31 + 0.7 \cdot 0.0022 \times 4 \cdot 0.309/1 - 0.0022 = 0.3123$  В. Это напряжение отличается от далных примера 8-1 лишь на 0.6 %. Поэтому режим исходной рабочей точки транзистора гетеродина совпадает с примером 8-1 и сопротивления всех резисторов схемы практически сохраняют те же значения. То же имеет место и для транзистора схемы преобразователя частоты. Поскольку минимальная частота в данном подднапазоне значительно больше, чем в диапазоне 2, то принятые в примере 8-1 емкости конденсаторов схемы удовлетворительны для подднапазона 11.

 $Y_{24}' = 0.8 \cdot 0.031 = 0.025$  См. По формуле (8-12) вычисляем необходимый коэффициент включения базы транзистора гетеродина к контуру

По (8-1) находим  $Y_{21\text{пр}}\approx 0.56\cdot 0.025=0.014$  См. Коэффициенты включения коллекторного контура вычисляем по формулам (7-30)  $p_1=\sqrt{\frac{0.000028}{0.0004}}=0.265;\ p_2=\sqrt{\frac{0.000028}{0.000835}}\left(\frac{0.0645}{0.015}-2\right)=0.278$  и по равенству (8-2) получаем  $K_{011}=0.265\cdot 0.278\cdot 0.33\cdot 0.014/0.000835=0.36$ .

# 8-3. Расчет преобразователя частоты с совмещенным гетеродином

Преобразователи частоты с совмещенным гетеродином применяют в тех случаях, когда коэффициент расширення полосы пропускания, определяющийся уравнением (2-52), не превышает 1,05. Поэтому можно пойти на некоторое ухудшение стабильности частоты гетеродина, что

6\*

имсет место в рассматриваемом преобразователе частоты. Такие преобразователи частоты используются в диапазонах километровых а гектометровых воли. Они применяются и в метровом диапазоне для приема сигналов местных станций с частотной модуляцией. В этом случае для сужения полосы пропускания приемника используется система автоматической подстройки частоты. Для этого параллельно гетеродинному контуру включается варикап, а управляющим напряжением к нему служит постоянная составляющая напряжения с пагрузочного резистора одного из диодов частотного детектора. Поэтому для системы автоматической подстройки частоты гетеродина требуется варикап и фильтр нижних частот, состоящий из резистора и конденсатора.

Расчет преобразователя частоты наиболее удобно выполнять в следующей последовательности: определить параметры гетеродин-

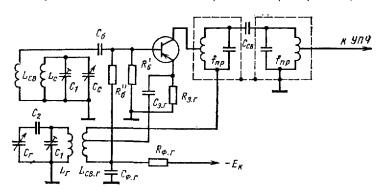


Рис. 8-7.

вого контура, включая элементы для сопряжения настройки с контурами радиотракта; выбрать тип и режим работы транзистора; вычислить параметры элементов схемы питания транзистора; определить связь контура с транзистором, обеспечивающую режим самовозбуждения и подведение к участку база — эмиттер транзистора гетеродинного напряжения в пределах 0,08 — 0,1 В; вычислить коэффициент преобразования. Первые три и последняя задачи решаются так же, как для преобразователя с отдельным гетеродином по методике § 8-2. Определение связи контура с транзистором решается применительно к особенностям выбранной схемы гетеродина и осуществляется также по приведенным в § 8-2 методакам.

Наиболее распространенной схемой преобразователя частоты с совмещеным гетеродином для диапазонов километровых и декаметровых голи является схема, приведенная га рис. 8-7 (приемники «Вста», «Чейва-М», «Квари-401» и др.). В схеме на рис. 8-7 для преобразовательного режима траизистор включен по схеме с ОЭ. Сопротивление нижней части катушки обратной связи гетеродина для токов частоты сигнала и промежуточной частоты очень мало и эмиттер через конденсаторы  $C_{3,r}$  и  $C_{0,r}$  сольшой емкости оказывается соединенным с шас. 4.

Для режима герерирования транзистор включен по схеме с ОБ, так как для токов частоты гетеродина сопротивление непочки  $C_6 \not\vdash_{cB}$  сравнительно мало. Средняя точка катушки  $L_{cB,r}$  соединена через

 $C_{9,\Gamma}$  с эмиттером. Верхний конец этой катушки через нижнюю часть катушки первого контура промежуточной частоты, имеющей малое сопротивление для токов частоты гетеродина, соединен с коллектором. Нижний конец  $L_{\text{CB-\Gamma}}$  через  $C_{\Phi,\Gamma}$ ,  $L_{\text{CH}}$  и  $C_{5}$  соединен с базой. Так образуется необходимая для режима самовозбуждения схема. Для работы в преобразовательном режиме используется напряжение гетеродина с нижней части катушки  $L_{\text{CB-\Gamma}}$ , включенной между базой и эмиттером. Оно определяется в первом приближении формулой

$$U_{m_{\Gamma}} \approx 0.6 \rho_6 U_{\text{K3}}. \tag{8.22}$$

Исходное напряжение между базой и эмиттером в рабочей точке должно быть

 $U_{\text{B3}} = U_{\text{orc}} + U_{mr}.$  (8-23)

Необходимый для режима самовозбуждения коэффициент включения катушки обратной связи в цепь база — эмиттер определяется неравенством

$$p_{6} = \frac{L_{69}}{L_{c8, r}} \ge \frac{1.2}{1 + k^{2}Y_{21}L_{c8, r}/L_{r}g_{r}}.$$
 (8-24)

Для ослаблення влияния сигнальных цепей на контур гетеродниа коэффициент связи между катушками  $L_{\rm r}$  и  $L_{\rm cв.r}$  берут небольшим, порядка 0.2-0.25. Индуктивность катушки обратной связи вычисляют по (8-15).

Пример 8-3. Рассчитать преобразователь частогы с совмещенным гетеродином на транзисторе ГТ308В по исходным данным примера 8-1. Параметры гетеродинного контура, индуктивность катушки связи, наприжение отсечки и ток коллектора транзистора сохраняются соответствующими примеру 8-1.

Полагая k=0,2, по (8-24) находим

$$p_6 \ge \frac{1.2}{1 + 0.2^2 \cdot 0.028 \cdot 0.000033/(0.000133 \cdot 0.000012)} = 0.051.$$

Принимаем с некоторым запасом  $p_6=0.06$ , а амилитуду напряжения гетеродина между базой и эмиттером равной 0.1 В. При этих условнях из (8-22) находим требующееся напряжение  $U_{\rm K,9}=0.1/(0.6\cdot0.06)=2.8$  В. По формуле (8-23) получаем  $U_{\rm B,9}=0.2+0.1=0.3$  В. Сохраняем сопротивление резистора и емкость конденсатора фильтра гетеродина соответствующими примеру 8-1, тогда  $U_1=0.47$  В. По равенству (3-17) получаем  $U_{R,9}=5-0.47-2.8=1.73$  В, а по (3-18)  $R_9=1.73/(10^{-3}+3\cdot10^{-6})=1720$  Ом. По табл. П-3-1 принимаем резистор сопротивлением 1,8 кОм. Из (3-19) находим  $C_{9..7}>(10\div20)/(515~000\cdot1800)=(11\div22)\cdot10^{-10}$  Ф. По табл. П-3-2 выбираем конденсатор емкостью 1500 пФ.

Для улучшения температурной стабилизации коллекторного тока принимаем, как и в примере 8-1,  $I_{\rm H}=0.5$  мА. По формуле (3-20) находим  $U_{R_{0,F}'}=1,73+0.3=2,03$  В. Вычисляем по равенствам (3-22) в (3-23)  $R_{0,F}'=2,03/0,0005=4050$  Ом и  $R_{0,F}'=(5-2,03)/(0,0005+0.00003)=4900$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резисторы сопротивлением 3.9 и 4.7 кОм. Согласно формуле (3-24) получаем  $\sigma=\frac{1+1800/3900+1800/4700}{1-0.993+1800/3900+1800/4700}=2,2,$  что удовлетворительно.

Поскольку крутизна преобразования и параметры нагрузки преобразователя частоты сохраняются такими же, как в примере 8-1, то

и коэффициент преобразования будет равен 1,76.

В транзисторных радиовещательных приемниках, предназначенных для приема ЧМС в поддиапазоне 12, используется стандартный блок, схема преобразователя частоты которого приведена на рис. 8-8, Она существенню отличается от схемы на рис. 8-7 в гетеродинной части. Схема гетеродина здесь является разновидностью так называемого днух-контурного гетеродина, в когором необходимая обратная связь между выходным и входным контурами осуществляется через проходную междувлектродинной, так и в преобразовательной частях используется по схеме с ОБ, то проходной емкостью является емкость коллектор—эмиттер Для используемого транзистора ГТЗ1ЗА она равна 4 пФ и

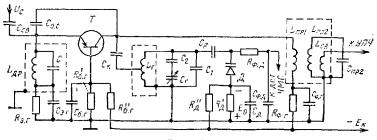


Рис.8-8

как будет гоказано дальше, педостагочит для образования требуемой положительной обратной связи. Поэтому между эмиттером и коллектором включен добавочный конденсатор  $C_{\rm 0-c}$ . Особенностью гетеродинного контура является подключение к нему варикапа Д902 для осуществления автоматической подстройки частоты гетеродина, что весьма пеобходимо, так как полоса пропускания в тракте ЧМС выбрана равной 180 кГц, т. е. меньше необходимого с учетом нестабильности частоты ситиала и гетеродина (см. пример 2-6 и табл. 2-6).

Выходной контур предыдущего каскада усилителя радносигнала относительно узконолосный и имеет на частоге гетеродина весьма малое сопротивление. Поэтому между эмиттером и базой включен контур  $L_{\rm ap}C$  с постоянной настройкой. Он позволяет создать между эмиттером и базой необходимое изиряжение обратной связи. Благодаря большой входной проводимости транзистора в схеме с ОБ (более  $|Y_{\rm M}|$ ) этот контур получается достаточно широкополосным и при сравнительно малом коэфрициенте диапазона (см. табл. 1-1) допускает постоянную настройку. Он также обеспечивает нужную фазу напряжения обратной связи гетеродина. Для решения этих задач резонансная частота контура должна быть

$$f_0 \approx (0.2 \div 0.3) f_{\rm r. cp}.$$
 (8-25)

Пеобходимая емкость конденсатора обратной связи определяется пераьенством

$$C_{\text{o, c}} > \frac{2}{\omega_{\text{c min}} \left(p_{\text{R}}^2/g_{\text{c}} - 1/Y_{21}\right)} - C_{22}.$$
 (8-26)

Для создания на входе транзистора папряжения гетеродина  $U_{mr}$  необходимо подводить к транзистору напряжение питания

$$U_{K9} = U_{mr} \frac{p_{K}^{2} Y_{21}}{0.6g_{r}}.$$
 (8-27)

Постоянное напряжение на входе детектора ЧМС, служащее управляющим напряжением для автоматической подстройки частоты гетеродина, при максимальной девиации частоты сигнала определяется равенством

$$U_{=} = (0.3 \div 0.4) U_{m},$$
 (8-28)

где  $U_m$  — амплитуда входного сигнала диодов при отсутствии модуляции сигнала, которая обычно составляет в радиовещательных приемниках 1-2 В. Поскольку расстройка частоты сигнала бывает и положительной и отрицательной, то полный диапазон изменения управляющего напряжения диода будет:

$$U_{\rm V} = 2U_{\perp}.$$
 (8-29)

Наихудшее воздействие варикапа на частоту гетеродина будет при максимальной эквивалентной емкости контура гетеродина. При изменении емкости варикапа под воздействием полного управляющего напряжения от  $C_{\rm A \, min}$  до  $C_{\rm A \, max}$  отклонение частоты гетеродина определяется уравнением

 $\Delta f_{\rm r} = \pm 0.5 \, \frac{\Delta C}{C_{\rm a}} f_{\rm r}, \tag{8-30}$ 

где

$$\Delta C = 0.5 \, (C_{\pi \, \text{max}} - C_{\pi \, \text{min}}). \tag{8-31}$$

Пример 8-4. Рассчитать параметры преобразователя частоты по рис. 8-8 на транзисторе ГТЗ13 $\Lambda$ . Параметры контура гетеродина:  $L_{\rm r}=0.11\,$  мкГн;  $C_2=47\,$  пФ;  $C_{\rm r}=2.2\div16\,$  пФ;  $C_1=18\,$  пФ;  $C_{\rm p}=13\,$  пФ;  $\delta=0.009$ ;  $L_{\rm пр1}=2.6\,$  мкГн ( $\delta=0.01$ );  $L_{\rm пр2}=6\,$  мкГн ( $\delta=0.01$ ). Напряжение источника питания  $5\,$  В. Селективной системой служат два связанных контура при  $\delta=0.012\,$  и критической связи. Промежуточная частота  $10.7\,$  МГц при верхней настройке гетеродина. Нагрузкой служит вход следующего каскада на гранзисторе ГТ322 $\Lambda$  по схеме с ОЭ ( $g_{11}=1.5\,$  мСм). В качестве варикапа используется диод Д902. Полоса втягивания системы подстройки частоты  $0.6\,$  МГц.

Параметры гетеродинного контура заданы, поэтому вначале рассчитаем работу системы подстройки частогы. На рис. 8-9 показана характеристика диода, Д902. Выберем рабочую точку O при начальном напряжении на аноде 3 В. Ей соответствует емкость днода  $C_{\pi_0}=11,2$  пФ. Предположим, что емкость монтажа и выходная емкость гранзистора вносят в контур емкость  $C_{m1}=1$  пФ, а емкость монтажа совместно с ценью управления диола составляст  $C_{m2}=6$  пФ. Тогда эквивалентная емкость контура гетеродина определится равенством  $C_{9-\Gamma}=C_{\text{M1}}++\mathcal{C}_2C_r/(C_2+C_r)+C_1+C_0$  ( $C_3-C_{\text{M2}}$ )/( $C_5+C_3+C_{\text{M2}}$ ). Для начала поддиапазона будет  $C_{9-\Gamma}$  тмах =  $1+47\cdot16/(47+16)+18+13$  (11,2 + 6)/(13 + 11,2 + 6) = 38,1 пФ. Из формулы (2-101) находим  $f_{\Gamma \min}=1/6,28$ 

промежуточной частоте это соогзетствует минимальной частоге сис-

нала  $f_{c\,\,\mathrm{min}}=(775-107)\cdot 10^5=668\cdot 10^5\,$  Гц, что согласно табл. 2-2 достаточно близко к начальной частоте поддиапазона 12 и подтверждает

правильность определения монтажных емкостей.

Наибольшее отклонение частоты гетеродина, при котором должна срабатывать система подстройки частоты, равно половине полосы втятивания, т. е. 0,3 МГц. При этом значении из равенства (8-30) находим  $\Delta C_{\rm max} = 2 \cdot 38,1 \cdot 0,3/77,5 = 0,3$  пФ. По формуле (8-31) вычисляем полный интервал изменения емкости диода  $C_{\rm A max} - C_{\rm A min} = 2 \cdot 0,3 = 0,6$  пФ. Для столь малых изменений емкости согласно рис. 8-9 можно с малой погрешностью считать ее зависимость от напряжения линейной. Построив касательную A - E в точке O, из треугольника ABE находим зависимость  $\Delta C = \frac{AB}{BE} \Delta U_y = 0,53 \ \Delta U_y$  пФ/В. Следовательно,

максимальное отклонение управляющего напряжения от нулевого значения должно быть  $\Delta U_{y\, max} = \Delta C_{max}/0.53 = 0.57$  В. Для этого согласно уравнению (8-28) потребуется амплитуда сигнала на входе дет

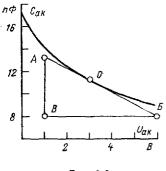


Рис. 8-9.

тектора U=0.57/0.35=1.6 В, что соответствует сказанному ранее. Следовательно, выбранная рабочая точка обеспечит требуемую полосу втягивания системы автоподстройки частоты гетеродина.

По формуле (2-55) вычисляем для начала диапазона  $g_{r,\, H}=0.009/(6,\, 28\cdot 775\cdot 10^5\cdot 11\cdot 10^{-8})=168\cdot 10^{-6}$  См. Примем напряжение  $U_{\rm K,9}=2.5$  В, а  $I_{\rm K}=1$  мА и  $U_{\rm OTC}=0.2$  В. Согласно табл. П-1-4  $Y_{21}=0.053$  См. Учитывая пониженное напряжение питания с учетом сказанного в § 8-2, примем  $Y'_{21}=0.8\cdot 0.053=0.042$  См. Зададимся амплитудой напряжения гетеродина на входе транзистора 0.1 В.

Для ее обеспечения из равенства (8-27) коэффициент включения контура должен быть  $\rho_{\rm K}=\sqrt{\frac{0.6\cdot2.5\cdot0.000168}{0.1\cdot0.042}}=0.244$ . Емкость конденсатора обратной связи определяем по (8-26)  $C_{\rm o.\,c}>$   $\frac{2}{6.28\cdot775\cdot10^3}\frac{(0.244^3/168\cdot10^{-6}-1/0.042)}{(0.244^3/168\cdot10^{-6}-1/0.042)}-4\cdot10^{-12}=85\cdot10^{-13}$  Ф. По табл. П-3-2 принимаем конденсатор емкостью 10 пФ. По (8-1) получим  $Y_{\rm 21np}=0.45\cdot0.042=0.019$  См.

Индуктивность коллекторного контура промежуточной частоты согласно рис, 8-8 образуют катушка  $L_{\rm пр1}$  и нижняя часть катушки  $L_{\rm r}$ . Но индуктивность второй гораздо меньше первой и можно считать, это частоту этого контура определяют  $L_{\rm BD1}$  и  $C_{\rm K}$ . По формуле (2-101) получаем  $C_{\rm K}=1/(6,28^2\cdot107^2\cdot10^{10}\cdot26\cdot10^{-7})=84\cdot10^{-12}$  Ф. Полятаєм сумму монтажной и междуэлектродной емкостей, подключающихся к контуру, а также собственную емкость контурной катушки равной 10 пФ. По табл. ГІ-3-2 выбираем конденсатор емкостью 75 пФ. Аналогично вычисляем  $C_{\rm np2} = 1/(6,28^2\cdot107^2\cdot10^{10}\cdot6\cdot10^{-6}=37\cdot10^{-12}$  Ф. По табл. П-3-2 выбираем конденсатор емкостью 76 пФ. По формуле (2-55) вычисляем проводимость контуров промежуточной частоты  $g_1 = 1/(6,28^2\cdot107^2\cdot10^{10}\cdot6\cdot10^{-6})$ 

=  $0.01 \cdot 6.28 \cdot 107 \cdot 10^5 \cdot 84 \cdot 10^{-12} = 565 \cdot 10^{-7}$  Cm  $g_2 = 0.01 \cdot 6.28 \cdot 107 \times 10^{-12}$  $\times$   $10^{6} \cdot 37 \cdot 10^{-12} = 25 \cdot 10^{-6}$  См. Вычисляем коэффициент включения нагрузки каскада ко второму контуру по равенству (7-25)  $p_2 =$  $=V\overline{g_2/g_H}=V\overline{25\cdot 10^{-6}/15\cdot 10^{-4}}=0,13$ . Коэффициент преобразования каскада вычисляем по равенству (8-2) с учетом сказанного в  $\S$  8-2  $K_{0\pi\rho}=$  $= 1 \cdot 0.13 \cdot 0.5 \cdot 0.019/565 \cdot 10^{-7} = 21.8.$ 

Положим ток потенциометра, обеспечивающего исходную рабочую точку диода, равным 0,5 мА. По закону Ома вычисляем  $R_{\pi}'=3/5 imes$  $\times$  10<sup>-4</sup> = 6667 Ом. Аналогично  $R_n'' = (5-3)/0,0005 = 4000$  Ом (выбираем резисторы сопротивлением 6,8 и 3,9 кОм). Подставляя в (3-19)  $R_{\rm m}'$  вместо  $R_{\rm s}$ , получаем  $C_{\rm m} = (10 \div 20)/(107 \cdot 10^5 \cdot 6800) = (14 \div 10^5 \cdot 6800)$ 

28)  $\cdot$   $10^{-11}$   $\,\Phi$  (выбираем конденсатор емкостью 220 п $\,\Phi$ ). Примем по табл. П-3-1  $R_{\Phi}=390$  Ом. Подставляя в (3-19)  $R_{\Phi}$  ,  $R_{\Phi}$ вместо  $R_{\rm B}$ , находим  $C_{\rm der} > (10 \div 20)/(107 \cdot 10^5 \cdot 390) = (24 \div 48) ×$  $\times$  10<sup>-10</sup>  $\Phi$  (выбираем конденсатор емкостью 3300 п $\Phi$ ). Заменяя в (3-16)  $r_1$  на  $R_{\Phi,r}$ , получаем  $U_1=10^{-3}\cdot 390=0.39$ . По уравнению (3-17) иаходим  $U_{R_9} = 5 - 0.39 - 2.5 = 2.11$  В. Из (3-18) находим  $R_{9.1} =$  $=2,11/(10^{-3}+3\cdot 10^{-6})=2100$  Ом (выбираем резистор сопротивлением **2** кОм). Вычисляем из (3-19)  $C_{\mathfrak{d},\mathfrak{p}} > (10 \div 20)/(107 \cdot 10^5 \cdot 2000) = (47 \div 10^5 \cdot 2000)$ 94)·10<sup>-11</sup>  $\Phi$  (берем конденсатор емкостью 680 п $\Phi$ ). По (3-20) вычисляем  $U_{R_6'}=2.11\pm0.2=2.31$  В. Принимаем ток потенциометра пи-

тания базы равным 0,5 мА для повышения термостабилизации тока коллектора. Из (3-22) и (3-23) находим  $R_6' = 2.31/0.0005 = 4620$  Ом и  $R_6'' = (5-2.31)/5 \cdot 10^{-4} + 3 \cdot 10^{-6} = 5350$  Ом (принимаем резисторы сопротивлением 4.7 и 5.1 кОм). Кожффициент пестабильности вычис-

1 + 2000/4700 + 2000/5100(3-24)  $\sigma = \frac{1}{1 - 0.993 + 2000/4700 + 2000/5100} = 2, 2,$ хорошо. По (3-19) вычисляем  $C_{6,r} > (10 \div 20)/(107 \cdot 10^5 \cdot 4700) =$  $= (2 \div 4) \cdot 10^{-10} \ \Phi$  (берем конденсатор емкостью 330 п $\Phi$ ). Ток витания каскада  $I_0 = I_{\rm K0} + I_{\rm nB} + I_{\rm n, a}$ . Здесь  $I_{\rm nB}$  и  $I_{\rm n, a}$ — токи потенциометров питания базы транзистора и управляющего диода. Следовательно,  $I_0 = 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-4} + 5 \cdot 10^{-4} = 2 \cdot 10^{-3}$  A.

Пример 8-5. Определить параметры преобразователя частоты по схеме на рис. 8-8 для использования его в приемнике I класса при  $f_{\rm an} = 8.4~{
m MFH}$  и селективной системе, состоящей из четырех контуров ФСС, рассчитанного в примере 7-4. В следующем каскаде используется транзистор ГТ308В ( $g_{11}=0.9$  мСм,  $C_{11}=40$  нФ). Режим работы транзистора соответствует примеру 8-4.

Параметры емкостной ветви гетеродинного контура сохраняют свои значения, а индуктивность катушки вычисляем по (2-101)  $L_{\rm r} =$ 

=  $\frac{1}{6,28^2 \cdot (67+8,4)^2 \cdot 10^{12} \cdot 381 \cdot 10^{-13}}$  = 117 · 10<sup>-9</sup> Ги. По формуле (2-55) для начала подпиапазона находим  $g_{\rm r,u}=0,009\cdot 6,28$  (67  $\pm$  8,4)  $\times$   $\times$   $10^6\cdot 381\cdot 10^{-13}=16\cdot 10^{-6}$  См. Нэ (8-27) вычисляем необходимый коэф $ho_{ ext{K}} = \sqrt{rac{0.6 \cdot 2.5 \cdot 0.00016}{0.1 \cdot 0.042}}$ -=0,24. Емкость кон-

денсатора обратиой связи находим по формуле (8-26)

$$C_{\text{o. c}} = \frac{2}{6,28 \cdot 754 \cdot 10^5 (0,24^2/0.00016 - 1/0.042)} - 4 \cdot 10^{-12} = 88 \cdot 10^{-13} \Phi.$$

Берем конденсатор емкостью 9,1 пФ.

Согласно табл. П-1-3 на промежуточной частоте проводимость  $g_{12}=5\cdot 10^{-5}$  См, что равно этой же проводимости транзистора ГТ308В, принятой в примере 7-4 для расчета ФСС. Поэтому коэффициенты включения первого и последнего контуров ФСС сохраняют свои величины, Подставляя в (7-21) согласно данным примера 8-4  $Y_{21$  пр вместо  $Y_{21}$ , получаем  $K_{01p}=1\cdot 0.236\cdot 0.14\cdot 0.019/5\cdot 10^{-5}=12.6$ . Режим работы транзистора соответствует примеру 8-4, поэтому сопротивления резисторов схемы каскада сохраняют свои значения. Так как  $f_{\rm Cmin}$  уменьшилась лишь на 3 %, то емкости конденсаторов схемы можно сохранить теми же.

# 8-4. Мостовой диодный преобразователь частоты

В диапазонах декаметровых и более длинных волн используются диодные преобразователи частоты, выполненные по мостовой схеме, которые также называют кольцевыми (рис. 8-10). Достоянствами мо-

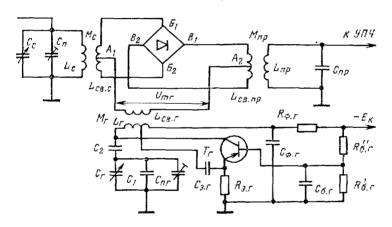


Рис. 8-10.

стовых преобразователей частоты являются: хорошая развязка гетеродина от цепей раднотракта и промежугочной частоты; меньший уровень комбинационных искажений; отсутствие потребления мощности от истечника питания приемника. Их недостатки заключаются в том, что коэффициент преобразования по напряжению и особенно по мощности существенно меньше единицы. Поэтому удельный вес шумов усилителя напряжения промежуточной частоты существению повышается, что требует, если необходима высокая чувствительность приемника, применения первого каскада в тракте промежуточной частоты с достаточно низким уровнем шумов или применения усилителя радносигнала.

Из рис. 8-10 следует, что все четыре днода по постоянному току включены последовательно друг за другом — по кольцу. Катушки связи с сигнальным и нагрузочным контурами имеют отвод от средней точки. Егогодаря этому они образуют внешний мост, плечами которого слу-

жат каждая из половии катушек связи. В одну диагональ этого места (между точками  $A_1$  и  $A_2$ ) включено напряжение от гегеродина, а во вторую (между точками  $B_1$  и  $B_2$ ) подводится напряжение сигнала. При балансе моста токи с частотой гетеродина в диагонали  $B_1 + B_2$  и токи с частотой сигнала в диагонали  $A_1 + A_2$  должим быть рарым нулю. Практически трудно добиться баланса моста на всех гарубниках частоты гетеродина и сигнала, поэтому имеется некоторое влаимное воздействие сигнальных и гетеродинных целей.

Диоды образуют второй (внутренний) мост. В одну его днагональ  $B_1 - B_2$  подводится напряжение сигнала, а со второй  $B_1 - B_2$  снимается напряжение промежуточной частоты. Это способствует улучшению развязки входных в выходных цепей преобразователя частоты. Коэффициент преобразования днодных преобразователей частоты уве-

личивается с ростом напряжения гетеродина, приложенного к каждому из дродов. Эта зависимость (µ<sub>пр</sub>) изображена на рис. 8-11, на котором по оси абсцие отложена приведенная амплитуда напряження гетеродина  $\gamma U_{mr}$ . Здесь  $\gamma$  — показатель экспоненты в случае аппрексимации вольт-амперной характеристики двода экспонентой. Для обычно непользуемых диолов (Д2Б, Д9Б, Д9А, Д9Ж, ДКСІ и им подобных)  $\gamma \approx (15 \div 25)1/B$ . Но с увеличением напряжения гетеродина возрастают нелинейные искажения и шумы преобразователя частоты. Согласно

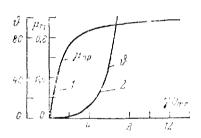


Рис. 8-11.

рис. 8-11 для  $\gamma=20$  и  $U_{mr}=0.15$  В параметр  $\mu_{np}$  равен 0,8. Дальнейшее увеличение напряжения гетеродина дает малый прирост коэффициента преобразования и не следует брать  $U_{mr}$  более 0,2—0,3 В. При таком выборе напряжения гетеродина виутренняя проводимость преобразования диода в сименсах определяется уравнением

$$g_{i \text{ np}} = (5 \div 10) \gamma \mu_{np} \vartheta \cdot 10^{-6},$$
 (8-32)

в котором коэффициент в определяется рис. 8-11.

Входная проводимость днолов между точками  $B_1$  и  $B_2$ , являющаяся нагрузкой источника сигнала, и выходная их проводимость между точками  $B_1$  и  $B_2$ , с которой должиа согласовываться нагрузочная проводимость преобразователя частоты, определяются уравнением

$$g_{\text{BX, c}} = g_{\text{HiX, np}} = g_{i \text{ np}} \sqrt{1 - \mu_{\text{np}}^2} = g.$$
 (8-33)

Проводимость между точками  $A_1$  и  $A_2$ , служащая нагрузкой гетеродина, соответствует равенству

$$g_{\rm BX, \, \Gamma} \approx (4 + 8) \, \vartheta \cdot 10^{-5} / U_{m\Gamma}.$$
 (8-34)

Для обеспечения хорошего баланса моста важна хорошая идентичность параметров днодов и перед постановкой в схему необходим их специальный отбор, Коэффициенты связи входного и выходного конту-

роз с их катушками связи определяются равенствами

$$k_c = \sqrt{\frac{g_c L_c}{g L_{cB, c}}} \text{ if } k_{np} = \sqrt{\frac{g_{np} L_{np}}{g L_{cB, np}}}.$$
 (8-35)

В них  $g_{\rm c}$  и  $g_{\rm np}$  — проводимости контуров сигнала и промежуточной частоты.

Параметры гегеродина и его коэффициенты связи с диодами рассчитываются по методике § 8-2. Коэффициент преобразования по напряжению, создаваемому из выходиом контуре  $L_{\rm np} - C_{\rm np}$  преобразователя частоты по схеме на рис. 8-10, определяется равенством

$$K_{0 \text{ np}} = 2\mu_{np}k_{np} \sqrt{\frac{L_{\text{cs. np}}}{L_{\text{np}}}}$$
 (8-36)

Если за этим контуром стоит ФСС, то в формулу (8-36) следует добавить мисскитель  $p_2q$ . Коэффициент шума рассматриваемого преобразователя частоты пра выполнении равенств (8-35) определяется уравнением

$$H = 1 + 2 \left(1 + 0.5bU_{\text{int}}^2\right) \left(1 + \mu_{\text{np}}^2 + \sqrt{1 + \mu_{\text{np}}^2}\right) / \mu_{\text{np}}^2, \tag{8-37}$$

Пример 8-6. Рассчитать нараметры мостозого преобразователя частоты по схеме на рис. 8-10. Параметры колтуроз сигнала и промежуточной частоты, а также гетеродина соответствуют примеру 8-1. Дводы ДЭВ ( $\gamma=20.1$  В,  $b=15.1/B^2$ ).

Согласно сказанному ранее принимаем подводимое к диодам напряжение гетеродина равным 0.25 В. По рис. 8-11 находим  $\mu_{\rm пp}=0.9$  и 0 = 25 1/В². Вычисляем внутреннюю проводимость диодов по равенству (8-32)  $g_{\rm l.n.p}=7.5\cdot 20\cdot 0.9\cdot 25\cdot 10^{-6}=338\cdot 10^{-6}$  См. Входная и выходная проводимость днодов согласно (8-33) будет  $g=338\times 10^{-6}$  Г 1 – 0.9² = 0.0015 См. По (8-15) вычисляем индуктивности  $L_{\rm CB-C}=0.25\cdot 242\cdot 10^{-6}=6\cdot 10^{-6}$  Гн и  $L_{\rm CB-D}=0.25\cdot 183\cdot 10^{-6}=46\times 10^{-6}$  Гн. Коэффициент связи иаходим по равенствам (8-35) для наименьшей проводимости сигнального контура. Она будет согласно равенству (2-55) на максимальной частоте сигнала  $g_{\rm c.m.in}=0.015$  (6.28×  $\times$  1 6 10 000  $\cdot$  0.000242) = 6  $\cdot$  10° См. Подставляя это значение, получаем

$$k_{c} = \sqrt{\frac{0.000066 \cdot 0.000242}{0.0015 \cdot 0.000065}} = 0.126 \text{ m } k_{np} =$$

$$= \sqrt{\frac{0.000028 \cdot 0.000183}{0.0015 \cdot 0.000045}} = 0.273.$$

Коэффициент связи между контурной катушкой гегеродина и катушкой  $L_{\rm cu,r}$  вычисляем по формуле (9-16)  $k_{\rm r}=(1-0.0005)~0.25/(0.7\cdot4)=0.089$ , что выполнимо при любом типе намотки катушек.

Коэффициент преобразования вычисляем по (8-36)  $k_{\rm пp}=2\cdot0.9 \times 0.273\cdot0.278\cdot0.33$   $\sqrt{\frac{0.00046}{0.000183}}=0.0226$ , что в 78 раз меньше, чем для транзисторного преобразователя из пример 4-8-1. Коэффициент шума получаем из (8-37)

$$UI = 1 + 2 (1 + 0.5 \cdot 15 \cdot 0.25^2) (1 - 0.9^2 + \sqrt{1 - 0.9^2})/0.9^2 = 3.27$$

#### РАСЧЕТ ДЕТЕКТОРОВ

#### 9-1. Расчет диодных детекторов АМС

Исходные данные и задачи расчета детекторов АМС подробно описаны в § 2-7. В современных приемниках применяются, как правило, диодные детекторы. В примере 2-24 произведен расчет основных нараметров и характеристик последовательного диодного детектора по схеме на рис. 2-16. В данном параграфе остановимся на выборе тех элементов схемы, которые не были рассчитаны в примере 2-24.

Чтобы коэффициент передачи детектора соответствовал графику на рис. 2-15, емкость конденсатора С, на рис. 2-16 должна удовлет-

ворять неравенствам

$$C_1 \geqslant 20C_{\pi}; \quad C_1 \geqslant \frac{5}{(R_1 + R_2) f_{\text{np}}}.$$
 (9-1)

Здесь  $C_{\pi} = C_{3\kappa}$  — емкость диода. Для того чтобы дегектор был безынерционен, должно выполняться неравенство

$$C_1 < \frac{5}{(R_1 + R_2)F_{11}}.$$
 (9-2)

Нелинейные искажения за счет инерционности нагрузки детектора будут отсутствовать, если

$$C_1 < \frac{\sqrt{1 - m_{\text{max}}^2}}{2\pi F_{\text{B}} (R_1 + R_2) m_{\text{max}}}.$$
 (9-3)

Допустимый уровень амплитудно-частотных искажений на верхней модулирующей частоте не превысит заданного значения при

$$C_1 \le \frac{1}{2\pi F_{\rm B}} \left( \frac{1}{R_{i_{\rm B}}} + \frac{1}{R_1 + R_2} \right) \sqrt{M_{\rm B}^2 - 1} \,.$$
 (9-4)

Здесь  $R_{i\pi}$  — внутреннее сопротивление детектора для токов модулирующей частоты, оно находится по кривой 3 (рис. 2-15). Емкссть кондепсатора  $C_2$  определяется неравенством

$$C_2 \ge 10/(f_{\rm HP}R_1).$$
 (9.5)

Допустимый уровень амплитудно-частотных искажений на нижней модулируютей частоте будет при выполнении перавенства

$$C_{\rm p} \ge \frac{1}{2\pi F_{\rm H} (R_{\rm ao6} + R_{\rm BX,H^4}) \sqrt{M_{\rm H}^2 - 1}}$$
 (9-6)

Коэффициент фильтрации детектора по схеме на рис. 2-16 определяется формулой

$$k_{\rm sp} \approx \left(0.01 + \frac{C_{\rm g}}{C_{\rm g} + C_{\rm 1}}\right) \frac{1}{2\pi f_{\rm np} C_{\rm 2} R_{\rm 1}}$$
 (9-7)

Пример 9-1. Рассчитать параметры элементов схемы детектора по исходным данным примера 2-24. Детектор предназначен для переносного приемника I класса. В низкочастотном тракте приемника имеются четыре каскада. Допустимый коэффициент фильтрации  $k_{\Phi}=10^{-3}$ .

Рассинтаем необходимую емкость конденсатора  $C_1$ . По  $(9\cdot 1)$   $C_1 > 20\cdot 1 = 20$  пФ и  $C_1 > 5/(1800 + 5600)$   $465000] = 145\cdot 10^{-11}$  Ф. Из  $(9\cdot 2)$  получаем  $C_1 < 5/[(1800 + 5600)$   $150] = 45\cdot 10^{-5}$  Ф. Согласно  $(2\cdot 9)$  определяем для каждого низкочастотного каскада, в том числе детектора  $M_{\rm B,K} = {}^{10}\sqrt{5} = 1,1$  и  $M_{\rm B,K} = {}^{10}\sqrt{5} = 1,1$ . По кривой 3 (рис.  $2\cdot 15$ ) определяем  $R_{I_X} = 600$  Ом, из  $(9\cdot 3)$  и  $(9\cdot 4)$  находим  $C_1 < \frac{V}{1-0.8^2} < \frac{1}{6.28\cdot 12\,000\,(1800 + 5600)\,0.8} = 135\cdot 10^{-11}$  Ф и  $C_1 < \frac{1}{6.28\cdot 12\,000} \times \frac{1}{1800 + 5600}$   $\sqrt{1,1^2-1} = 112\cdot 10^{-10}$  Ф. Определяем из  $(9\cdot 5)$  емкость конденсатора  $C_2 > 10/(465\,000\cdot 1800) = 12\cdot 10^{-9}$  Ф. Емкость разделительного конденсатора вычисляем по  $(9\cdot 6)$ 

$$C_{\rm p} > \frac{1}{6,28 \cdot 150 (11000 + 700) \sqrt{1,1^2 - 1}} = 19 \cdot 10^{-8} \, \Phi_{\bullet}$$

По табл. П-3-2 берем конденсаторы  $C_{\rm 1},\,C_{\rm 2},\,C_{\rm p}$  емкостью 1300 пФ, 0,012 н 0,22 мкФ соответственно.

Коэффициент фильтрации вычисляем по (9-7)  $k_{\Phi} \approx \left(0.01 + \frac{1}{1+1300}\right) \frac{1}{6.28 \cdot 465\ 000 \cdot 12 \cdot 10^{-9} \cdot 1800} = 0,00017$ . Это значительно меньше допустимого.

# 9-2. Исходные данные и задачи расчета детекторов ЧМС

Для радиовещательных приемников и телевизоров ГОСТ задает промежуточные частоты тракта ЧМС (10,7; 8,4 или 6,5 МГц), параметры модуляции сигнала  $F_{\rm B}$  и  $F_{\rm B}$ , а также  $\psi_{\rm max}=5$  и  $\Delta f_{\rm max}=75$  кГц и допустимый коэффициент амплитудно-частотных искажений.

При расчете структурной схемы приемника определяются: вхолное сопротивление первого каскада низкочастотного тракта; полоса пропускания высокочастотного тракта приемника  $\Pi_{\rm пр}$ ; схема детектора, типы днодов и сопротивления их нагрузочных резисторов (см. примеры 2-28 и 2-29).

При расчете каскада уточняется схема детектора, включая все элементы связи со смежными каскадами; определяются параметры детектора и всех элементов его схемы.

# 9-3. Расчет дифференциального детектора ЧМС

На рис. 9-1 приведена принципиальная схема дифференциального детектора ЧМС и показаны элементы связи со смежными каскадами. Так, транзистор  $T_1$  совместно с селективной системой детектора, состоящей из двух связанных контуров, образует ограничитель амплитуды. Сопротивление  $R_{\mathbf{BX},\mathbf{HY}}$  и конденсатор  $C_{\mathbf{BX},\mathbf{HY}}$  представляют собой полнов входное сопротивление первого каскада низкочастотного тракта.

В § 2-11 приведены формулы для определения сопротивления изгрузочных резистеров (2-144), эквивалентного затухания контуров (2-146), коэффициента включения диодов ко второму контуру (2-145) и коэффициента передачи детектора (2-143). Эквивалентную емкость контуров селективной системы  $C_{\text{э.п.р}}$  вычисляют по (2-153), а индуктивность контурных катушек по (2-101). Средние емкости подстроечных конденсаторсв контуров определяются равенствами:

$$C_{\text{n1}} \approx C_{\text{9, np}} - C_{\text{Kar}} - p_{\text{K}}^2 (C_{\text{w1}} + C_{22}) \text{ M}$$
 $C_{\text{n2}} \approx C_{\text{9, np}} - C_{\text{Kar}} - p_{\text{A}}^2 (0.5C_{\text{A}} + C_{\text{w2}}),$  (9-5)

где  $C_{\text{кат}}$  — собственная емкость катушек;  $C_{22}$  — выходная емкость транзистора ограничителя амплитуды;  $C_{\pi}$  — емкость днодов детектора;

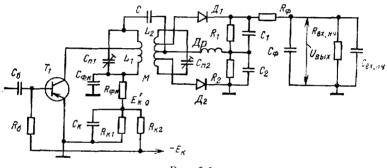


Рис. 9-1.

 $C_{\rm MI}$  и  $C_{\rm M2}$  — монтажные емкости, отнесенные к первому и второму контурам. Емкость конденсатора C находят по неравенству

$$C \geqslant 30g_2/f_{\rm np},\tag{9-9}$$

в котором  $g_2$  — проводимость второго контура селективной системы. Емкости конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  предполагаем равными и удовлетворяющими неравенствам (9-1)—(9-4), полагая в них  $R_2=0$  и  $m_{\rm max}=0.1$  (благодаря работе ограничителя амплитуды). Индуктивность дросселя определяется исравенством

$$L_{\rm ap} \ge 3 \, (f_{\rm np}^2 C_1).$$
 (9-10)

Емкость конденсатора переходного фильтра вычисляют по формуле

$$C_{\oplus} \approx 10^{-4}/R_{\oplus} - C_{\text{BX, BH}}.$$
 (9-11)

Коэффициент связи между контурными катушками определяется равенством

 $k = \eta \delta_{\mathfrak{g}}. \tag{9-12}$ 

**Пример 9-2.** Рассчитать параметры схемы дифференциального детектора по исходным данным примера 2-28 с учетом приведенных здесь данных. Детектор предназначается для переносного приеминка I класса, имеющего промежуточную частоту 8,4 МГц. Счатаем  $C_{\rm BX, nq} = 0.02$  мкФ и  $M_{\rm H} = M_{\rm B} = 1.1$ . В ограничителе амилитуды используется транзистор ГТЗ08В.

Полагая  $C_{\rm Kat}=0.5$  пФ,  $p_{\rm K}\approx p_{\rm A}\approx 0.5$  (максимально допустимое в схеме) в  $C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=4$  пФ, по формулам (9-8) вычисляем  $C_{\rm R1}=45-0.5-0.5^2$  (4 + 4) = 42.5 пФ, и  $C_{\rm R2}=45-0.5-0.5^2$  (0.5 × > 1 + 4) = 43.4 пФ. Следовательно, принятая в примере 2-28 экви-

валентная емкость контуров осуществима. Пидуктивность контурных катушек согласно (2-101) L= = 1  $(6.28^2 \cdot 84^2 \cdot 10^{10} \cdot 45 \cdot 10^{-12})=8 \cdot 10^{-6}$  Гн. что также осуществимо. Емкость конденсатора C из (9-9)  $C \geqslant (30 \cdot 24 \cdot 10^{-6})^2 (84 \cdot 10^{5}) = 9 \cdot 10^{-11} \ \Phi$ 

(выбираем конденсатор емкостью 100 пФ).

(выбираем конденсатор емкостью 100 пФ). По (9-1) находим 
$$C_1 > 20 \cdot 1 = 20$$
 пФ и  $C_1 > \frac{5}{2 \cdot 1600 \cdot 84 \cdot 10^5} = 19 \cdot 10^{-11}$  Ф. Пз (9-2) получаем  $C_1 < \frac{5}{2 \cdot 1600 \cdot 150} = 10^{-5}$  Ф. Согласно (9 3)  $C_1 < \frac{\sqrt{1-0.1^2}}{6.28 \cdot 12\,000 \cdot 1600 \cdot 0.1} = 82 \cdot 10^{-9}$  Ф. В нашем случае  $R_1/R_1 = 1600.100 = 16$ , чему по кривой  $3$  (см. рис. 2-15) соответствует  $R_{I_1} = 500$  Ом. Пз (9-4) находим  $C_1 < \frac{1}{6.28 \cdot 12\,000} \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{1600}\right) \times 1.12^{-1} = 160 \cdot 10^{-10}$  Ф. По табл. П-3-2 выбираем конденсатор ежкостью 0.05 мкФ. Падуктивность дросселя по неравенству (9-10)  $I_{\rm TP} > 3/(8.4^2 \cdot 10^{10} \cdot 15 \cdot 10^{-9}) = 28 \cdot 10^{-5}$  Гн. Емкость конденсатора переходного фильтъра определяем из (9-11)  $C_{\Phi} \approx 10^{-4}/750 - 2 \cdot 10^{-8} = 114 \cdot 10^{-9}$  Ф (берем конденсатор емкостью 0.15 мкФ). Коэффинент связи вычксляем по (9-12)  $k = 2 \cdot 0.035 = 0.07$ , что осуществимо при любом виде намоток катушек.

## 9-4. Расчет дробного детектора ЧМС

Принципиальная схема дробного детектора изображена на рис. 9-2. Транзистор T и селективная система детектора из двух связанных контуров используется в схеме последнего каскада усилителя промежуточной частоты. Коэффициент передачи детектора определяется по уравнению (2-143), сопротивления нагрузочных резисторов  $R_1$  и  $R_2$  по (2-144), эквивалентное затухание контуров должно удовлетворять неравенствам (2-146) и (2-147), необходимый коэффициент включения диодов ко второму контуру — (2-145), коэффициент связи между катушками контуров — (9-12). Кроме того, сопротивления пагрузочных резисторов должны удовлетворять неравенству

$$R_1 = R_2 \le 0.1/g_2. \tag{9-13}$$

Индуктивность третьей катушки и коэффициент связи между исю и первой катушкой вычисляют по уравнениям:

$$L_3 = (0.25 \div 0.5) L_1 \text{ H } k_{1-3} = (0.35 \div 0.45) \delta_9.$$
 (9-14)

Резисторы  $R_3$  и  $R_4$  служат для балансировки схемы летектора. 1!х сопротивление обычно равижется десяткам ом и подбирается в пронессе налаживания детектора. Резистор  $R_5$  увеличивает затухание катушки связи  $L_3$ , чтобы она не влияла на полосу пропускания селективной системы. Его сопротивление подбирается в процессе настройки делектора. Емкости конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  берутся разными и определяются по (9-1)—(9-4). Емкость конденсатора  $C_3$  вычисляют по неравенству

 $C_3 \ge 0.05 \div 0.1/R_1.$  (9-15)

Сопротивление резистора  $R_{\rm th}$  выбирают примерно равным  $R_{+{\bf x},+{\bf q},{\bf t}}$  а емкость конденсатора  $C_{\rm th}$  вычисляют по (9-11).

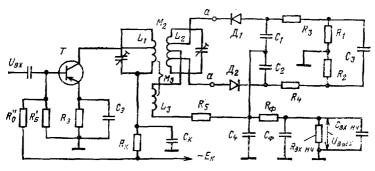
Пример 9-3. Определить параметры схемы дробного детектора по

исходным данным примеров 9-2 и 2-29.

Собственные параметры контуров, емкость и сопрогивление филь-

тра сохраняются соответствующими примеру 9-2.

Проверяем выполнение неравенства (9-13):  $0.1/(24\cdot 10^{-6})=4170>$  > 1600. Оно выполняется, следовательно, сопротивление нагрузочных резисторов и емкости шунтирующих их конденсаторов ( $C_1$  и  $C_2$ ) сохраняют значения, соответствующие примеру 9-2. Емкость конденсатора  $C_3$  вычисляем по (9-15)  $C_3 \ge 0.03 \div 0.1/1600 = (3 \div 0) \cdot 10^{-6}$  Ф. По



Pac. 9-2.

табл. П-3-2 берем конденсатор емкостью 50 мкФ. Коэффициент связи между катушками согласно (9-12)  $k=2\cdot0.06=0.12$ , что реализуемо. Пидуктивность катушки связи и ее коэффициент связи с катушкой первого контура вычисляем по (9-14)  $L_3=0.35\cdot8\cdot10^{-6}=28\cdot10^{-7}$  Гн и  $k_{1-3}=0.4\cdot0.06=0.024$ . Эти значения также реализуемы.

Глава десятая

## РАСЧЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ АМПЛИТУДЫ

### 10-1. Исходные данные и задачи расчета

Для радиовещательных и телевизионных приемников промежуточная частота для тракта ЧМС задается ГОСТ. При расчете структурной схемы приемника выбираются: схема и тип электронного прибора; напряжение  $U_{\rm пор}$  порога ограничения; амилитуда выходного напряжения  $U_{m\,{\rm вых}}$ ; коэффициент амплитудной модуляции  $m_{\rm n}$  входного сигнала помехой; требуемый коэффициент ограничения  $K_{\rm огр}$ .

Задачами расчета являются: выбор оптимального режима работы нелинейного элемента; расчет параметров элементов схемы; уточнение

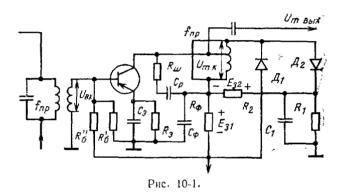
амплитуд входного и выходного сигналов.

#### 10-2. Расчет диодного ограничителя амплитуды

Варпант схемы днодного ограничителя амплитуды приведен на рис. 10-1. По токам частоты сигнала дноды включены параллельно коллекторному контуру каскада. К первому дводу подводится запирающее напряжение  $E_{31}$ , создающееся на резисторе коллекторного фильтра. Запирающее напряжение второго диода  $E_{32}$  создается на резисторе  $R_2$ , который образует совместно с резисторами  $R_{\Phi}$  и  $R_2$  делитель напряжения. При  $E_{31}=E_{32}=E_3$  сопротивления резисторов должны удовлетворять равенствам:

$$R_{\rm di} = E_3/(I_{\rm K} + I_{\rm D}); \quad R_1 = (E_{\rm K} - 2E_3)/I_{\rm D}; \quad R_2 = E_3/I_{\rm D}.$$
 (10-1)

Емкости конденсаторов  $C_{\Phi}$ ,  $C_{\delta}$  и  $C_{1}$  рассчитывают по (3-19), произволя соответствующие замены емкостей и сопротивлений.



В интервале входных напряжений до 0,3—0,4 В вольт-амперная характеристика диодов наиболее точно аппрокенмируется экспонентой [4, 10, 16]. В этом случае входная активная проводимость диодов, чаще применяемых в ограничителях амплитуды (Д2Б, Д9Б, Д9В, Д9А, Д9Ж, ДКС1), определяется уравнением

$$g_{\rm EX} \approx \frac{2 \vartheta \cdot 10^{-5}}{|U_{\rm m KOHT} - E_3|} = \frac{2 \vartheta \cdot 10^{-5}}{|U_{\rm mx}|},$$
 (10-2)

в котором параметр  $\vartheta$  определяется кривой 2 (см. рис. 8-11),  $U_{m \, {\rm конт}} -$  амплитуда сигнала на контуре. Если  $E_3 > U_{m \, {\rm конт}}$ , то дводы закрыты в входную проводимость следует считать равной нулю. Когда амплитуда входного сигнала превышает 0.4-0.6 В, вольт-амперная характеристика диодов становится более близкой к линейной и входная проводимость определяется равенством

$$g_{\rm EX} \approx S_{\rm BB},$$
 (10-3)

в котором  $S_{np}$  — проводимость прямой передачи диода. Если обозначить амплитуду сигнала, приложенного к дноду,

$$U_{m \text{ KOHT}} - E_3 = U_{m \text{A}}, \tag{1C-4}$$

то можно составить уравнение, определяющее зависимость амплитуды входного сигнала от  $U_{mn}$ :

$$U_{m_{\rm BX}} = \frac{E_3 + U_{m_{\rm A}}}{V K_{0 \times c_{\rm T}} K_0'} \left( \frac{g_{\rm BX}}{g_2} + 1 \right), \tag{10-5}$$

где  $g_{\bullet}$  — эквивалентная резонансная проводимость коллекторного контура без учета действия диодов;

$$K_0' = E_3/U_{m0BX} = U_{m0KOHT}/U_{m0BX} = Y_{21}/g_3$$
 (10-6)

приведенный коэффициент усиления каскада при закрытых диодах,
 при котором за выходной сигиал принимается напряжение на всем

контуре;  $U_{m\,0\,\mathrm{Bx}}$ — максимальная амплитуда входного сигнала, при которой диоды еще закрыты. Необходнмый коэффициент включения контура в коллекторную цень транзистора определяется равенством

$$p_{K} = K_{\text{OVCT}}/K_{0}'. \qquad (10.7)$$

С учетом сказанного можно составить методику расчета амплитудной характеристики каскада. Задаваясь определеным значением  $U_{m_{R}} < 0$ , определяют амплитуду выходного сигнала на контуре

$$U_{mK,RMx} = E_3 + U_{m\pi}.$$
 (10-8)

Затем по (10-5) вычисляют соответствующую ему амплитуду входного сигнала. Такие расчеты вы-

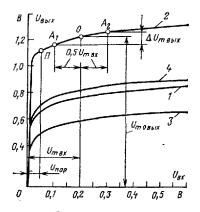


Рис. 10-2.

полняют для  $U_{m\pi}$  от 0 до 0,3—0,4В через 0,05 В. По полученным данным строят амплитудную характеристику и по ней определяют основные характеристики ограничителя амплитуды в соответствии с обозначениями, принятыми на рис. 10-2. Пороговое напряжение  $U_{\text{пор}}$  находят по точке  $\Pi$  характеристики, соответствующей примерно  $(0.85-0.9)U_{\text{вых max}}$ . Амплитуду исходного входного сигнала вычисляют по  $(2\cdot148)$ , полагая  $m_{\Pi}\approx 0.5$ . Коэффициент модуляции сигнала помехой вычисляют по формуле

$$m_{\text{II. BMX}} = \Delta U_{m_{\text{BMX}}} / (2m_{\text{OBMX}}),$$
 (10-9)

а коэффициент ограничения по равенству

$$K_{\rm orp} = m_{\rm H}/m_{\rm H, Bbix}.$$
 (10-10)

Наиболее приемлемые характеристики ограничителя амплитуды получаются, если брать  $E_3=0.3\div1.0$  В и обеспечивать иаибольшее приведенное усиление каскада. Последнее получается, если эквивалентная проводимость контура будет наименьшей для обеспечения нужной полосы пропускания детектора ЧМС. Чем меньше  $E_3$  в больке  $K_0'$ , тем меньше порог ограничения, но и меньше амплитуда выходного сигнала

Пример 10-1. Рассчитать параметры диодного ограничителя амплитуды на транзисторе ГТ308В при  $f_{\rm np}=8.4$  МГц и  $E_{\rm K}=9$  В. Селективной системой служат два связанных контура дифференциального детектора, рассчитанного в примере 9-2. Первый из них изображен

ва рис. 10-1, а второй для упрощения схемы не показан.

Выбираем диоды Д9Б ( $S_{\rm np}=0.01$  См,  $R_i=100$  Ом,  $\gamma=20$  1/B). Зададимся напряжением запирания  $E_3=0.5$  В, током потенциометра  $I_{\rm n}=0.5$  мА и рабочей точкой транэистора при  $I_{\rm K}=1$  мА и  $U_{\rm K9}=5$  В ( $Y_{21}=0.035$  См,  $C_{12}=1$  пФ). Согласно формулам (10-1) получеем  $R_{\rm \Phi}=0.5/[(1+0.5)\cdot 10^{-3}]=333$  Ом,  $R_1=(9-2\cdot 0.5)/(5\cdot 10^{-4})=16$  000 Ом и  $R_2=0.5/(5\cdot 10^{-4})=1000$  Ом (выбираем резисторы сопротивлением 330 Ом, 16 кОм и 1 кОм соответствено). Параметры остальных элементов схемы не вычисляем, поскольку методика их расчета многократно использовалась в предыдущих примерах.

По  $(2\cdot66)$  вычисляем устойчивый коэффициент усиления транзистора  $K_{0\text{yct}} = \sqrt{\frac{2(1-0.9)\,0.035}{6.28\cdot84\cdot10^5\cdot10^{-12}}} = 11.5$ . Эквивалентная проводимость контура  $g_3 = \frac{\delta_3}{\delta} g = \frac{0.035}{0.01} 24\cdot10^{-6} = 84\cdot10^{-6}$  См. По (10-6) получаем  $K_0' = 0.035/(84\cdot10^{-6}) = 416$ . Из равенства (10-7) находим коэффициент включения контура в коллекторную цень  $p_{\text{K}} = 11.5/416 = 0.028$ . Из первой формулы (7-17), пользуясь методикой, примененной в примере 7-2, находим проволимость шунтирующего сопротивления коллекторной цени  $G_{\text{II}} = \frac{0.00024}{0.028^2} \left(\frac{0.035}{0.01}-1\right) - 0.00012 = 0.07788$  См. ( $R_{\text{III}} = 13$  Ом). По (3-19) вычисляем  $C_{\text{P}} \ge (10 \div 20)/(8\,400\,000\cdot13) = (9 \div 18)\cdot10^{-8}\,\Phi$ . При  $U_{m_{\text{A}}} = 0$  из равенства (10-5) находим  $U_{m\,0\,\text{EX}} = \frac{0.5}{V\,11.5\cdot416} = 0.0072\,\text{B}$  и  $U_{m\,0\,\text{Bix}} = E_3 = 0.5\,\text{B}$ . Зададимся  $U_{m\,0} = 0.05\,\text{B}$ , гогда у $U_{m\,1} = 20\cdot0.05 = 1\,\text{H}$  по кривой 2 рис. 8-11 получаем 0 = 0.57. Из уравнения (10-2) вычисляем  $g_{\text{BX}} = 2\cdot0.57\cdot10^{-5}/0.05 = 228\cdot10^{-6}\,\text{См}$ . При  $U_{m\,2} \ge 0.5\,\text{B}$  согласно (10-3) получим  $g_{\text{BX}} > 10\,\text{ мCM}$ . Поскольку ограничивающих днодов два (см. рис. 10-1), то подставляем в формуле (10-5)  $2g_{\text{BX}}$  вместо  $g_{\text{BX}}$  и получаем  $U_{m\,2} = \frac{(0.5+0.05)}{V\,11.5\cdot416} \times \left(\frac{456\cdot10^{-6}}{84\cdot10^{-6}}+1\right) = 0.051\,\text{B}$ . Амвлитуду напряжения на всем контуре вычисляем по (10-8)  $U_{m\,2\,\text{Bix}} = 0.5 + 0.05 = 0.55\,\text{B}$ .

Даниые, полученные путем аналогичных расчетов для других значений  $U_{mg}$ , приведены в табл. 10-1 для варианта 1. По полученным значениям на рис. 10-2 построена амплитудиая характеристика ограничеств амплитуды (кривая 1). При  $E_3=1$  и  $E_3=0.3$  В входное и выходное папряжения соответствуют вариантам 2 и 3 табл. 10-1 и криевым 2 и 3 на рис. 10-2. Если при условнях варианта 1 применять телько один диод, то для этого будут справедливы характеристики варианта 4 и кривая 4 на рис. 10-2. Сравнение кривых 3 и 4 показывает, что при одном диоде характеристика ограничения ухудшается лишь на  $10-20\,\%$ . Поэтому ограничители амплитуды с одним диодом применяются часто.

Для варианта 2 находим  $U_{\text{пор}}=0.05$  В. По (2-148) получаем  $U_{\text{mobx}}\geqslant 0.05/(1-0.5)=0.1$  В. Если выбрать  $U_{\text{max}}=0.2$  В (точка O), то при  $m_{\text{H}}=0.5$  получим минимальное и максимальное значения сигнала при действии помехи равными  $U_{\text{max}}$  ( $1\pm0.5$ ). Их величины со-

ответствуют точкам  $A_1$  и  $A_2$  на кривой 2. Согласно рис. 10-2  $U_{m0BMX}$  = = 1,13 B, а  $\Delta U_{mBMX}$  = 0,09 B. Из (10-9) находим  $m_{\text{п.ных}}$  = 0,09/(2  $\times$   $\times$  1,13) = 0,044, по формуле (10-10) получаем  $K_{\text{orp}}$  = 0,5/0,044 = 11,4 или 21,1 дБ.

						1	аолиц	ца 10-1
					<i>U<sub>тд</sub>.</i> В			
	Вариант	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
1	$U_{\mathrm{BX}}$ , MB $U_{\mathrm{BMX}}$ , B	7,2 0,5	51 0,55	74 0,6	128 0,65	283 0,7	513 0,75	11 :0 0,8
2	$U_{\mathrm{BX}}$ , MB $U_{\mathrm{BMX}}$ , B	14 1	98 1,05	136 1,1	227 1,15	497 1,2	850 1,25	1910
3	$U_{ m BK}$ , мВ $U_{ m BMX}$ , В	<b>4,</b> 3 0,3	32 0,35	50 0,4	89 0,45	203 0,5	388 0,55	912 0,6
4	$U_{ m BX}$ , мВ $U_{ m BMX}$ , В	7,2 0,5	30 0,55	42 0,6	69 0,65	146 0,7	269 0,75	615 0,8

Таблица 10-1

# 10-3. Расчет транзисторного ограничителя амплитуды

Схема транзисторного ограничителя амилитуды приведена на рис. 9-1 (первый каскад). Для уменьшения порогового напряжения и увеличения коэффициента ограничения транзистор работает при пониженном коллекторном напряжении 2—3 В за счет использования делителя напряжения, состоящего из резисторов  $R_{\rm K1}$  и  $R_{\rm K2}$ . Для достаточно стабильной работы сопрогивления этих резисторов определяют из уравнений:

$$R_{\kappa 1} = E_{\kappa 0}/2I_{KA}$$
 и  $R_{\kappa 2} = (E_{\kappa} - E_{\kappa 0})/3I_{KA}$ , (10-11)

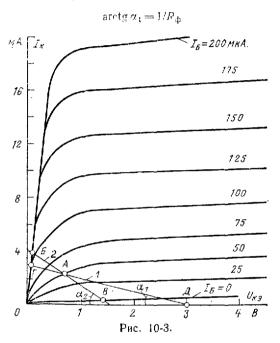
в которых  $I_{KA}$ — коллекторный ток транзистора в рабочей точке A (рис. 10-3). При этом ток, потребляемый каскадом от источника питания, будет  $3I_{KA}$ . Сопротивление резистора фильтра выбирают равным 0.5—1 кОм, а коэффициент включения контура в коллекторную цепь удовлетворяющим неравенству

$$p_{\rm K} \le (0.75 \div 0.85) \sqrt{R_{\Phi}g_{91}},$$
 (10-12)

где  $g_{24}$  — эквивалентная проводимость первого коллекторного коптура, Емкость кондевсатора фильтра вычисляют по (3-19). Сопротивление базового резистора определяют по формуле

$$R_6 = \frac{F_{\rm K} - U_{\rm BBA}}{I_{\rm K,max} - I_{\rm KA}} h_{\rm 21s}, \tag{1.-13}$$

Амплитудиая характеристика (рис. 10-4) определяется по следующей методикс. Выбирается напряжение питания коллекторной цени  $E_{\rm KG}$  и на поле выходиых характеристик (см. рис. 10-3) строится нагрузочная характеристика I по постоянному току. Она проходит через точку  $\mathcal{I}$ , которой соответствует напряжение  $E_{\rm KO}$  на оси абсцисс, под углом  $\alpha_{I}$ , определяющимся равенством



На этой характеристике выбирают рабочую точку A, соответствующую примерно середине отрезка  $\Gamma \mathcal{A}$  и находящуюся на характеристике, для которой

$$I_{\rm B} \approx 0.5 I_{\rm B \, max}. \tag{10-15}$$

(10-14)

Определяют для нее токи  $I_{KA}$  и  $I_{BA}$ . Через точку A проводят нагрузочную характеристику для переменного тока 2 с углом наклона  $\alpha_2$ , соответствующим уравнению

$$\arctan \alpha_2 = g_{a1}/p_K^2, \tag{10-16}$$

и определяют точки B и B, а по ним соответствующие им токи  $I_{K'\max}$  и  $I_{B\max}$ . Переносят точки A, B и B на входную характеристику транзистора с напряжением  $U_{K,\Theta}$  наиболее близким к выбранному режиму, и определяют напряжения  $U_{E,\Theta}$ ,  $U_{E,\Theta}$ , и  $U_{E,\Theta}$ . По (2-15) вычисляют максимальную амплитуду входного сигиала  $U_{max,J}$  в линейном режиме, до которой ограничитель практически работает как усилитель и его

амплитудную характеристику можно считать прямолицейной. При этих значениях входного сигнала амплитуда напряжения на первом коллекторном контуре определяется равенством

$$U_{m_{\text{BMX},3}} = p_{\text{g}} Y_{21A} U_{m_{\text{BX},3}} / g_{31}. \tag{10-17}$$

Проводимость прямой передачи в рабочей точке определяется приближенным равенством

$$Y_{21} \approx 0.6Y_{21}I_{KA}/I_{KT}$$
 (10-18)

• где  $Y_{217}$  и  $I_{\rm KT}$  — параметры транзистора, соответствующие данным табл. П-1-4. Когда амилитуда входного сигнала превышает  $U_{max,n}$ , транзистор работает с отсечкой обоих полупериодов коллектор-

обоих полупериодов коллекторного тока и выходной сигнал соответствует уравнению

$$U_{m_{\text{Bb(X, I)}}} = U_{m_{\text{BX, A}}} H\left(\frac{U_{m_{\text{BX, B}}}}{U_{m_{\text{BX, A}}}}\right).$$
(10-19)

Коэффициент *H* определяется графиком на рис. 10-5. Он представляет собой часть амплитудной характеристики ограничителя, работающего в нелинейном режиме. Из нее следует, что пороговое напряжение ограничителя

$$U_{\text{mop}} \approx 1.5 U_{\text{max.a.}}$$
 (10-20)

а выходное напряжение при  $U_{m \text{ EX}} pprox (2 \div 2.5) U_{\text{пор}}$ 

Рис. 10-4.

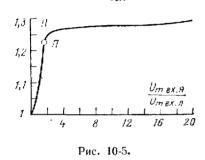
$$U_{m_{\rm BMX}} \approx (1.25 \div 1.26) U_{m_{\rm BMX}, x}$$
 (10.21)

Пример 10-2. Рассчитать параметры ограничителя амплитуды с транзистором ГТ308В по исходным данным примера 10-1, соответствующим требованиям к приемнику I класса.

Зададимся напряжением  $E_{\rm K0}=-3$  В и сопротивлением фильтра 1 кОм. Согласно равенству (10-14) агсtg  $\alpha_1=1/1000$ , чему соответствует линия I на рис. 10-3. Выбираем на ней исходную рабочую точку A, для которой  $I_{\rm KA}=2.3$  мА и  $I_{\rm BA}=50$  мкА. По неравенству (10-12) вычисляем коэффициент включения  $\rho_{\rm K}{\le}(0.75\div0.85)V$  1000 · 84 · 10<sup>-6</sup> =  $0.2\div0.25$ . Принимаем  $\rho_{\rm K}=0.18$ . По уравнению (10-16) получаем агсtg  $\alpha_2=84\cdot10^{-6}/0.18^2=0.0026$ . Линия 2 на рис. 10-3 соответствует этому углу. Для точки E получаем  $I_{\rm K, max}=3.8$  мА и  $I_{\rm D, max}=0.11$  мА. По формулам (10-11) находим  $R_{\rm K1}=3/(2\cdot0.0023)=650$  Ом и  $R_{\rm K2}=(9-3)/(3\cdot0.0023)=870$  Ом (выбираем резисторы сопротивлением 680 и 910 Ом). Емкость конденсатора фильтра определяем с учетом сказанного ранес по (3-19)  $C_{\rm th} \ge (10\div20)/(84\cdot10^6\times 1000)=(11\div20)\cdot10^{-10}$  Ф, аналогично  $C_{\rm K} \ge (10\div20)/(84\cdot00000\times 680)=(18\div36)\cdot10^{-10}$  Ф. По табл. П-3-2 выбпраем конденсаторы

емкостью 1500 и 2200 пФ. На входную характеристику транзистора (см. рис. 8-5), соответствующую коллекториому напряжению 3 В, переносим точки A, B и B. Им соответствуют  $U_{\rm B9}{}_A = 0,11$  В;  $U_{\rm B9}{}_B = 0,16$  В и  $U_{\rm B9}{}_B = 0,05$  В. Из табл. П-1-1 находим  $h_{216} = 0,993$ , следовательно,  $h_{219} = 0,993/(1-0,993) = 140$ . По равенству (10-13) вычисляем  $R_6 = 140 \frac{9-0,11}{(3,6-2,3)\cdot 10^{-13}} = 950$  000 Ом (принимаем резистор сопротивлением 910 кОм). По формуле (2-15) находим  $U_{mex.,s} = 0,5 \ (0,16-0,05) = 0,055$  В.

В табл. П-1-4 для  $I_{\rm KT}=1$  мА приведено  $Y_{\rm 21T}=0.035$  См. Согласно (10-18) получаем  $Y_{\rm 21A}\approx 0.6\cdot 0.035\cdot 2.3/1=0.049$  См. Выходное напря-



жение в конце линейного участка амплитудной характеристики вычисляем по равенству (10-17)  $U_{m \text{ вых.} , 1} = 0,18 \cdot 0,049 \times 0,055/(84 \cdot 10^{-6}) = 5,76 \text{ B. Для } U_{m \text{ вх.} , 6}/U_{m \text{ вх.} , 6} = 2$  по графику на рис. 10-5 получаем H = 1,24. По формуле (10-19) находим соответствующее данной амплитуде выходного сигиала  $U_{m \text{ вх.} , 6} = 2U_{m \text{ вх.} , 7} = 2 \cdot 0,055 = 0,11 \text{ B}$  и амплитуду выходного напряжения  $U_{m \text{ вых.} , 6} = 5,75 \cdot 1,24 = 7,1 \text{ B. Результаты аналогичных расчетов для других значе-$ 

ний входного сигнала приведены в табл. 10-2; рис. 10-4 построен по данным табл. 10-2. По равенству (10-20)

Таблица 10-2

$U_{m \text{ ex}}$ , B	0,055	0,075	0,11	0,2	0,4	0,6
$U_{m \text{ Bbx}}$ , B	5,75	6,39	7,1	7,25	7,3	7,34

получаем  $U_{\rm пор}\approx1.5\cdot0.055=0.082$  В, что соответствует точке  $\Pi$  на рис. 10-4. Согласно (2-148) амплитуда входного сигнала в рабочей точке должна быть  $U_{m0{\rm RV}}\geqslant0.082/(1-0.5)=0.164$  В. Возьмем его равным 0,2 В. При этом согласно рис. 10-4  $U_{m0{\rm\,Rb}\,\rm K}=7.25$  В и  $\Delta U_{m{\rm\,Rb}\,\rm K}=0.4$  В. По формуле (10-9) получаем  $m_{\rm Rd}\,\rm x=0.4/(2\cdot7.25)=0.0276$ , а по равенству (10-10) находим  $K_{\rm orp}=0.5/0.0276=18.1$  (25,1 дБ). Пстребляемый каскадом ток  $I_0=3I_{KA}=3\cdot2.3=6.9$  мА.

# 10-4. Ограничительные способности дробного детектора

В установившемся режиме при отсутствии амплитудной модуляции сигнала входное сопротивление детектора между точками a-a (см. рис. 9-2) выражается формулой

$$R_{\rm BX} = 2R_{\rm BX-AB} \tag{10-22}$$

в которой  $R_{\text{вх.},\Lambda}$  определяется кривой 1 (см. рис. 2-15). В этом случае эквивалентное затухание второго контура с учетом действия детектора будет:

$$g_{9} = \left(1 + 2\rho_{\mu}^{2} \frac{1}{R_{\text{nx.ng}}}\right). \tag{10-23}$$

При увеличении амплитуды сигнала под воздействием амплитудной модуляции ток диодов возрастает в  $1+m_{\rm H}$  раз, что как бы эквивалентно уменьшению нагрузочных сопротивлений диодов во столько же раз. Входное сопротивление диодов  $R_{\rm BX\,min}$  определится кривой I (см. рис. 2-15) для

$$R_{\min} \approx R/(1+m_n). \tag{10-24}$$

При уменьшении сигнала под воздействием амплитудной модуляции можно считать, что нагрузочные сопротивления возрастут до

$$R_{\text{max}} \approx R \left( 1 + m_{\text{p}} \right), \tag{10-25}$$

чему будет соответствовать  $R_{\rm nx\ max}$ . Подставляя сопротивления  $R_{\rm bx\ max}$  и  $R_{\rm nx\ min}$ в (10-23), можно получить значение проводимостей  $g_{\rm 9\ max}$  и  $g_{\rm 9\ min}$ . Кожффициент амплитудной модуляции выходного напряжения в первом приближении определяется соотношением

$$m_{\text{n.Bblx}} \approx \frac{2m_{\text{n}}g_{\text{g}}g_{\text{gmin}}}{g_{\text{g}}^2 + g_{\text{gmax}}g_{\text{gmin}}}.$$
 (10-26)

**Пример 10-3.** Определить коэффициент амплитудной модуляции выходного сиснала дробного детектора для исходных данных примеров 2-29 и 9-3 при  $m_{\pi}=0.5$ .

При отсутствии амплитудной модуляции сигнала для  $R/R_i=1600/100=16$  по кривой I (см. рис. 2-15) находим  $R_{\rm BX}=1200$  Ом, чему соответствует согласио (10-23)  $g_3=24\cdot 10^{-6}$  (1 + 2 · 0,268²/(1200 × × 24 · 10^-6) = 144 · 10^-6 См. По формулам (9-24) и (9-25) вычисляем  $R_{\rm min}=1600/(1-0,5)=1065$  Ом и  $R_{\rm max}=1600$  (1 + 0,5) = 2400 Ом. Этим сопротивлениям по кривой I (см. рис. 2-15) соответствуют  $R_{\rm BX}$  min = 800 Ом и  $R_{\rm ax}$  max = 1650 Ом. Для них по (10-23) определяем  $g_{9\,\rm max}$  = 24 · 10^-6 (1 + 2 · 0,268²/(1650 · 0,000024) = 0,000203 См и  $g_{9\,\rm min}$  =  $e^{i}$ 24 · 10^-6 (1 + 2 · 0,286²/(1650 · 0,000024) = 0,000111 См. По (10-26) находим  $m_{\rm B,BMX}=2\cdot 0,5\cdot 144\cdot 10^{-6}\cdot 111\cdot 10^{-6}/(144^2\cdot 10^{-12}+203\cdot 10^{-6}\cdot 111\times 10^{-6})$  находим  $m_{\rm B,BMX}=2\cdot 0,5\cdot 144\cdot 10^{-6}\cdot 111\cdot 10^{-6}/(144^2\cdot 10^{-12}+203\cdot 10^{-6}\cdot 114\times 10^{-6})$  начительно меньше, чем у диолного и транзисторного ограничителей амвлитуды.

#### РАСЧЕТ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ УСИЛЕНИЯ

## 11-1. Формулирование исходных данных и задачи расчета

Для радиовещательных приемников требованиями ГОСТ задается качество работы автоматического регулятора усиления.

При расчете структурной схемы приемника определяются: тип автоматической регулировки; каскады, усиление которых должно регулироваться; способ регулировки усиления в каждом каскаде.

Задачами расчета являются расчет выпрямителя и других элементов системы APУ и расчет и построение амплитудной характеристики приемника.

# 11-2. Расчет систем APУ при изменении режима работы транзистора

В простых и задержанных АРУ наибольшее распространение получила регулировка за счет изменения напряжения база-эмиттер, так как в этом случае требуется сравнительно малое регулирующее напряжение и мощность регулитора. Поэтому, как правило, необходимые характеристики регулировки получаются без дополнительных усилителей регулирующего напряжения. В системах усиленной АРУ иногда применяют регулировку усиления изменением напряжения коллектор—эмиттер, а чтобы получать достаточную глубину регулирования и относительно малое регулирующее напряжение, рабочую точку регулируемого каскада берут при пониженном напряжении  $U_{KS}$  (не более 2—3 В).

Общая глубина регулирования  $\Gamma$ , т. е. цанбольшее необходимое измецение усиления приемника системой АРУ, согласно обозначениям, принятым в табл. 11-1, определяется перавенством

Таблица 11-1

Клас	с прнемника	выс-	1	11	113	IV
Глубина авто- матической	$D = \frac{U_{\text{BX max}}}{U_{\text{BX mix}}}$	1000	100	20	20	20
регулиров- ка	$B = \frac{U_{\text{max max}}}{U_{\text{max min}}}$	2,5	4	3,16	4	4
Глубина ручн	ої регулировки	1000	316	316	100	100

$$\Gamma \geqslant K_{\text{max}}/K_{\text{min}} = U_{\text{Bax min}}/U_{\text{Bx min}}$$
:  
:  $U_{\text{BAX max}}/U_{\text{Bx max}} = R/B = \Gamma_{\text{EI}}\Gamma_{\text{E2}} \dots \Gamma_{\text{En}}$ , (11.1)

Глубина регулирования одного каскада

$$\Gamma_{\rm R} = K_{\rm 0 \kappa max} / K_{\rm 0 \kappa min} \tag{11-2}$$

определяется изменением коллекторного тока транзистора, от которого зависит проводимость прямой передачи под воздействием регулирующего напряжения:

$$q_{\min} = I_{\text{K-min}} / I_{\text{K-max}}, \tag{11-3}$$

Минимальный коллекторный ток должен в 85—100 раз превышать обратный коллекторный ток, а максимальный обычно берут не более 2—3 мА, так как при больших токах глубина регулирования мало увеличивается из-за чрезмерио больших значений проводимостей тран-зисторов, снижающих максимальное усиление каскада, а мощность питания регулируемых каскадов возрастает.

Сопротивление фильтра АРУ определяется неравенством

$$R_{\text{th, any}} \ge (5 \div 20)/g_{110},$$
 (11-4)

в котором  $g_{110}$  — входная проводимость транзистора при нулевом управляющем напряжении, т. е. при  $I_{\rm K,ma,x}$ 

Для обеспечения требуемой глубилы регулирования сопротивление эмиттерного резистора вычисляют по неравенству [5]

$$R_{\vartheta} \leqslant \frac{1}{N} - \frac{R_{\Phi \text{-apy}}}{h_{\text{abo}}},\tag{11-5}$$

где

$$h_{219} = h_{216}/(1 - h_{216})$$
 (11-6)

- коэффициент передачи тока транзистора;

$$N = \frac{I_{\text{K} \max}}{U_{\text{v}}} (1 - q) = \frac{I_{\text{K} \max}}{U_{2} K_{y}} (1 - q)$$
 (11-7)

— коэффициент управления коллекторного тока. Здесь  $U_2$  — максимальная амплитуда входного напряжения выпрямителя APУ;

$$K_{\mathbf{v}} = U_{\mathbf{v}}/U_{\mathbf{z}} \tag{11-8}$$

— коэффициент передачи цепи управления и  $U_{\rm y}$  — управляющее вапряжение, подводимое непосредственно к управляемым каскадам. Емкость фильтра  ${
m APY}$  вычисляется по неравенству

$$C_{\phi,\text{apy}} \geqslant 5 \div 10/(F_{\text{H}}R_{\phi,\text{apv}}).$$
 (11.9)

Глубина регулирования усиления каскадов определяется формулами, приведенными в табл. 11-2. Если усиление предыдущего каскада воздействию регулируемого каскада не подвергается, то он не влияет на глубину регулирования последующего каскада и

$$\Gamma_{\text{K-objed}} = 1, \tag{11-22}$$

		Условия работы смежных каскадов				
Регулируемый каскад	Усиление после,	дующего каскада	Усиление предыдущего каскада подвергается воздействию			
	яе регулируется	регулируется	регулируемого каскада			
Резонанс- ный усилитель	$\Gamma_{K} = 1 + \frac{(g + p)g_{11 \max}(1/q - 1)}{g_{9 \max}}$ (11-10)	$\Gamma_{\kappa}^{"} = 1 + \frac{g(1/q - 1)}{g_{\text{smax}}}$ (11-11)	$\Gamma_{\kappa, \text{npex}} = \frac{(g + p_2^s g_{22 \text{npex}}) (1 - q)}{g_{9 \text{max npex}}}$ $= 1 - \frac{(g + p_2^s g_{22 \text{npex}}) (1 - q)}{(11-12)}$			
Резист ивный усилитель	$\frac{F_{\kappa} = 1 + (1/R + g_{11 \text{ max}})(1/q - 1)}{G_{9\kappa}}$ (11-13)	$\Gamma_{\kappa}'' = 1 + \frac{1/g - 1}{RG_{9\kappa}}$ (11-14)	$\Gamma_{\text{K.npex}} = 1 - \frac{g_{11} (1 - q)}{G_{9K}}$ (II-15)			
у силитель с двумя съязинными контурами	$\Gamma_{\kappa}' = \frac{1}{q} \sqrt{\frac{1 - \rho_{1}^{2} g_{22 \max}}{g_{19 \max}} (1 - q)} $ (11-16)	$\Gamma_{h}^{} = 1 + \frac{g_{2}'}{g_{29  \text{max}}} \left( \frac{1}{q} - 1 \right) (11-17)$	$\Gamma_{\text{K.npex}} = \sqrt{\frac{g_{\text{3min}}}{g_{\text{2smax}}}}  (11-18)$			
3 силитель с ФСС	$\Gamma_{\mathbf{K}} = 1/q \tag{11-19}$	$\Gamma_{K}^{(i)} = 1/g$ (11-20)	$\Gamma_{\kappa, \text{npeg}} = 1$ (11-21)			

Когда усиление последующего и предыдущего каскадов регулируется, то глубина регулирования рассматриваемого каскада определяется равенством

 $\Gamma_{\rm g} = \Gamma_{\rm K}'' \Gamma_{\rm g, npeg}, \tag{11-23}$ 

а если усиление последующего каскада не регулируется, то

$$\Gamma_{\kappa} = \Gamma_{\kappa}' \Gamma_{\kappa, \, \text{npex}}. \tag{11-24}$$

Коэффициент усиления высокочастотного тракта приемника, с выжода которого подводится сигнал на вход выпрямителя АРУ, можно записать уравнениями:

$$K_{0 \text{ BQ}} \approx U_{\text{Bb(X,DD)}} / E_A = U_2 / E_A = K_{\text{HPF}} K_{1 \text{per}} K_{2 \text{per}} \dots K_{N \text{per}}.$$
 (11-25)

Задаваясь различными значениями  $U_2$ , удовлетворяющими параметру APV B из табл. 11-1 и уравнению (11-1), можно найти глубину регулирования каждого каскада. При этом для определения значения параметра q, соответствующего новому значению  $U_2$ , используется равенство

 $q = 1 - NU_2 K_v / I_{K \text{ max}}.$  (11-26)

По полученным значениям определяют коэффициенты усиления этих каскадов

$$K_{iper} = \frac{K_{iper \, max}}{\Gamma_{Ki}}.$$
 (11-27)

Подставляя эти значения в (11-25), находим  $K_{0 \text{ вч}}$ , а по его значению и напряжению  $U_2$  — соответствующий им входной сигнал приемника  $E_A$ . После этого строят амплитудную характеристику приемника как зависимость  $U_2$  от  $E_A$ . При этом наибольшее значение напряжения  $U_2$  не следует брать более 2—3 В. При больших амплитудах входной сигнал последнего каскада усилителя промежуточной частоты может оказаться более 0.1 В, что увеличит нелицейные искажения сигнала.

Простая АРУ. Рассмотрим особенности выбора элементов простой

системы АРУ на примере.

Пример 11-1. Рассчитать параметры простой APV, если в нереносном приемнике ( $F_{\rm H}=150~\Gamma$ ц) регулируется усиление двух каскадов УПЧ, соответствующих примеру 7-2. В предшествующем им каскадов селективной системой служит ФСС. Усиление нерегулируемых каскадов высокочастотного тракта равно 3. Диод выпрямителя APV типа Д9В. Принимаем  $I_{\rm K~min}=100\cdot 3=300~{\rm mkA},~I_{\rm K~max}=2,5~{\rm mA}~{\rm u}$  по

Принимаем  $I_{\rm K\,min}=100\cdot 3=300$  мкА,  $I_{\rm K\,max}=2.5$  мА и по формуле (11-3) получаем  $q_{\rm min}=0.3/2,5=0.12$ . Проводимости  $Y_{21}$ ,  $g_{11}$  и  $g_{22}$  в первом приближении прямо пропорциональны  $I_{\rm K}$ , а емкость  $C_{12}$  мало зависит от него. Поэтому согласно табл. П-1-1 для максимельного коллекторного тока принимаем:  $Y_{21}=2.5\cdot 0.035=0.087$  См;  $g_{11}=1$  мСм;  $g_{22}=25$  мкСм н  $C_{12}=1$  пФ.

Минимальная полоса пропускания каскадов будет при максимальном регулирующем напряжении, и для него следует выбирать коэффициенты включения. В этом случае по формуле (2-66) получаем  $K_{\text{nycr}} =$ 

$$=\sqrt{\frac{2(1-0.9)0.12\cdot0.087}{6.28\cdot465000\cdot10^{-12}}}=27$$
 (для пулевого управляющего напря-

жения  $K_{0 \text{ уст}}=78$ ). Пз первой формулы (7-17) вычисляем  $p_1=V_{0,0000298} = V_{0,000029} = V_{0,000029} = V_{0,000025} = V_{0,0000274} = V_{0,000025} = V_{0,0000274} = V_{0,00$ 

$$\delta_2' = \frac{(0.0000298 + 0.000018)}{0.0000298} \ 0.012 = 0.0192.$$

= 0,000018 См ( $R_{\rm HI} = 56$  кОм), чему соответствует

обеспечення необходимого эквивалентного затухания при максимальном регулирующем напряжении к контуру должна подключаться шунтирующая проводимость  $g_{\rm m2}=0.000061-0.31^2\cdot0.12\cdot0.001=$ 

При нулевом управляющем напряжении по аналогии с (6-23) получим  $g_{19~max}=0.0000298+0.0000278+0.000025=0.000082$  См. и  $g_{29~max}=0.0000298+0.000018+0.31^2\cdot0.001=0.000144$  См. При различных эквивалентных проводимостях контуров в (7-14) следует подставлять их среднеквадратичное значение [4], т. е.  $K_{0~max}=0.5\cdot1\times 0.31\cdot0.087/(0.000082\cdot0.000144)=124$ , что в 1.6 раза больше устойчивого. Поэтому снизим второй коэффициент включения до значения  $p_2=\frac{78}{124}=0.31-0.19$ . При этом потребуется  $p_2=\frac{78}{124}=0.31-0.19$ . При этом потребуется  $p_2=\frac{78}{124}=0.000084$  См, а усиление каскада при максимальном и пулевом управляющем напряжениях будет 16,3 и 98.Максимальному усилению согласно

= 0,0000576 См. По (11-6) получаем  $h_{219}=0.993/(1-0.993)=142$ . Выбираем по (11-4)  $R_{\Phi, \text{ ару}}=(5\div20)/0,001=5000\div20$  000 Ом. Принимаем резистор сопротивлением 12 кОм. Емкость конденсатора фильтра по (11-9)  $C_{\Phi, \text{ ару}}=(5\div10)/(150\cdot12$  ССО) =  $(3\div6)\cdot10^{-6}$  Ф. По табл. П-3-2 берем конденсатор емкостью 5 мкФ.

(2-66) ссответствует  $h_1=0.84$ . что допустимо. Поэтому окончательно принимаем  $p_1=1$ ,  $p_2=0.19$ ,  $R_{\rm int}=R_{\rm int}=36$  кОм и  $g_1'=g_2'=$ 

Полагаем  $U_{2\,\,\mathrm{max}}=2$  В. Коэффициент передачи цепи управления простой АРУ практически равен  $K_{\pi}$  выпрямителя АРУ. Примем его равным 0,8. Коэффициент управления вычисляем по (11-7)  $N=\frac{25\cdot 10^{-4}}{2\cdot 0.8}(1-0.12)=0.00133$  См.

Сопротивление эмиттерного резистора согласно неравенству (11-5)  $R_3 \geqslant 1/0.00138 - 12\,000/142 = 639$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем резистор сопротивлением 560 Ом. Остальные элементы схемы питания траняистора рассчитываются по методике § 3-2. Эти расчеты выполнялись во многих примерах и здесь опущены. Перед первым регулируемым каскадом стоит ФСС и изменение параметров первого регулируемого каскада не меняет усиления предыдущего каскада. Поэтому согласно (11-23) и (11-17) получаем для первого каскада  $\Gamma_{\rm KI} = \Gamma_{\rm KI}^{\prime\prime} = 1 + \frac{0,0000576}{0,000084} \left(\frac{1}{0,12} - 1\right) = 6,03$ . Для второго каскада с учетом (11-24),

(11-18) II (11-16) HINECM 
$$\Gamma_{\text{K2}} = \Gamma'_{\text{K2}} = \frac{1}{0.12} \sqrt{1 - \frac{1^2 \cdot 0.000025}{0.000082} (1 - 0.12)} = \frac{1}{0.000082}$$

= 7.13. По формуле (11-2) минимальнее усиление каскадов будет  $K_{01}$  = 98/6.03 = 16.3 и  $K_{02}$  — 98/7.13 = 13,7. Пля принятого  $U_2$  = 2 В из (11-25) получаем  $E_A$  = 2/(3·16,3·13,7) — 0,003 В. Результаты аналогичных расчетов для других значений напряжения  $U_2$  приведены в табл. 11-3. Кривая I на рис. 11-1 изображает амплитудную характеристику высокочастотного тракта приемника с простой АРУ. Сравнение данных табл. 11-1 и 11-3 показывает, что рассчитанная система престой АРУ удовлетворяет требованиям к приемникам 1—1V классов.

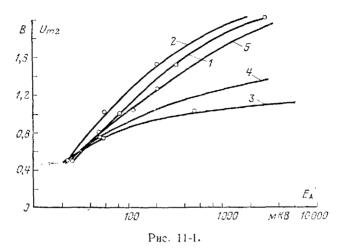
Таблица 11-3

Система АРУ	U2, B	2	1,75	1,5	1,1	1	0,75	0,5
Простая Задержанная Задержанная усиленная Задержанная днодом	$E_A$ , MKB $E_A$ , MKB $E_A$ , MKB	18€0 —		320 202 — 15 000	113 72 6380 320	89 58 497 79	50 33 58 43	26 17,3 17,3 20

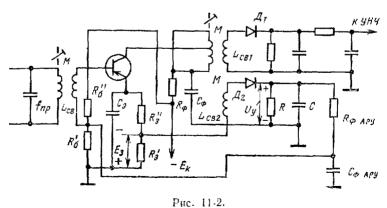
Задержанная АРУ, Вариантов построения схем задержанной АРУ достаточно много. В некоторых приемниках 11—IV классов в качестве выпрямителя АРУ используется диодный детектор приемника. Подведение к нему небольшого напряжения задержки (около 0,3-0,4 В) не приводит к существенному увеличению нелипейных искажений и позволяет исключить применение отдельной катушки связи и диода из схемы приемника. Однако в приемниках I и высшего классов для системы АРУ применяется отдельный выпрямитель. Один из вариантов такой схемы, обладающей рядом преимуществ, показан на рис. 11-2. Диод  $\mathcal{J}_1$  используется в схеме детектора приемника. К нему подводится ет катушки связи  $L_{\rm crit}$  выходное напряжение УПЧ. Диод  $\mathcal{A}_{\rm c}$  работает в качестве выпрямителя АРУ. К нему подводится напряжение промежуточной частоты  $U_2$ . При одинаковых параметрах  $L_{\rm cg1}$  и  $L_{\rm cg2}$  получается  $U_2 = U_{mnp}$ . Напряжение задержки создается на резисторе  $R'_{s}$ . Подбирая его значение, можно получить требуемое напряжение задержки

$$E_{\mathbf{a}} = I_{\mathrm{K}\,\mathrm{max}} R_{\mathbf{a}}' \tag{11-28}$$

Достоинством такого способа получения  $E_3$  является то, что при увеличении сигнала и управляющего напряжения уменьшается ток коллектора транзистора, а значит, и напряжение задержки, что повышает управляющее напряжение и глубину регулирования каскада.



При стабильном напряжении  $E_3$  с ростом управляющего напряжения уменьшается падение напряжения на эмиттерном резисторе, а это способствует увеличению усиления каскада и противодействует работе системы  ${\rm APY}_*$ .



Управляющее напряжение в данной схеме определяется уравнением

$$U_{y} = (U_{2} - E_{3}) K_{A^{2}} = (U_{2} - U_{R'_{3}}) K_{A^{2}},$$
 (11-29)

Если  $|E_3| \geqslant U_2$ , то в цепи диода  $\mathcal{I}_2$  ток не протеклег и управляющее напряжение будет равно нулю.

Требуемый в данной схеме коэффициент управления определяется

формулой

$$N = \frac{I_{\text{K max}} \left[ 1 - q_{\min} \left( 1 - K_{\text{A}} \right) \right]}{K_{\text{A}} \left( U_{\text{A max}} + q_{\min} I_{\text{K max}} \frac{R_{\phi, \text{apy}}}{h_{219}} \right)},$$
 (11-30)

При замене (11-8) на (11-29) формула для определения параметра q в зависимости от напряжения  $U_2$  записывается так:

$$q = \frac{I_{\text{K max}} + K_{\text{g2}} N U_2}{I_{\text{K max}} (1 - N R_2^* K_{\text{g2}})}.$$
 (11-31)

Из этого выражения следует, что при

$$U_{a} > \frac{I_{\text{K max}}}{NK_{ex}} = U_{a \text{ npeg}} \tag{11-32}$$

получается  $q\leqslant 0$ . Согласно (11-3) это может быть лишь при  $I_{\mathrm{K}\min} < 0$ . A это означает, что система APУ при таких значениях  $U_2$  должна закрыгь транзистор регулируемого каскада. В этом случае сигнал на вход выпрямителя АРУ не должен поступать и управляющего напряжения не должно быть. При таком условии ток транзистора должен быть максимальным. Данное несоответствие является результатом того, что вывод формулы (11-30) производился с определенными допущениями, которые почволяют вести расчеты лишь для  $U_2 < 0.9 U_2$  пред. Если напряжение задержки постоянно, то в (11-30) следует вместо  $U_2$  подставить  $U_2 = E_3$ .

Расчет амплитудной характеристики аналогичен расчету для про-

стой АРУ, по начинают ее с минимального значения сигнала

$$U_{2\min} = E_3, \tag{11-33}$$

увеличивая ступенями до значений, примерно равных  $(0.8-0.9)U_{2,\mathrm{пред}}$ . Пример 11-2. Рассчитать систему задержанной APV по исходным

данным примера 11-1 так, чтобы она удовлетворяла требованиям к

переносному приемнику І класса.

По (11-32) находим  $U_{2\,\mathrm{mpe}\,\mathrm{g}}=0.0025/(0.00138\cdot0.8)=2.26\,\mathrm{B}$ . Возьмем  $U_{2\,\mathrm{max}}=0.88U_{2\,\mathrm{mpe}\,\mathrm{g}}=0.88\cdot2.26=2\,\mathrm{B}$ . Согласно табл. 11-1 для приемников I класса  $U_{2\,\mathrm{min}}=U_{2\,\mathrm{max}}/4=2/4=0.5\,\mathrm{B}$ . На основании (11-33) находим  $E_3=0.5\,\mathrm{B}$ . По (11-28) должно быть  $R_5'=0.5/(25\,\mathrm{S})$  $(10^{-4}) = 200$  Ом. Следовательно,  $R_9'' = 360$  Ом.

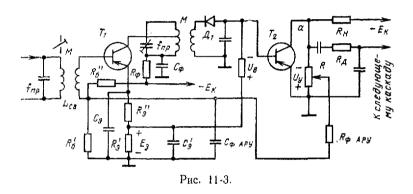
При  $U_{2}$  min система APV сще не работает, q=1,  $\Gamma_{\rm R1}=\Gamma_{\rm R2}=1$  и согласно (11-25)  $E_{\rm A}=0.5/(3\cdot98\cdot98)=173\cdot10^{-7}$  В. Возьмен  $U_{2}=1.00$ = 0,75 В. Для него согласно (11-31)  $q = \frac{0,0025 - 0,8 \cdot 0,00138 \cdot 0,75}{0,0025} = 0,86$ . Этому соответствует согласно (11-23) и (11-17)  $\Gamma_{\kappa 1} = \Gamma_{\kappa 1}^{\kappa} = 1 +$  $+\frac{0.0000576}{0.000084}\left(\frac{1}{0.86}-1\right)$ =1,11, а в соответствии с (11-16)  $I_{\rm K2}=I_{\rm K2}^{\prime}$ =  $=\frac{1}{0.86}\left[1-\frac{1^2\cdot0.000025}{0.000082}\left(1-0.86\right)=1.14. \text{ Hs (11-27) находим }K_1=\right]$  = 98/1,11 = 88 и  $K_2$  = 98/1,14 = 85. По (11-25) вычисляем  $E_A$  = 0.75/(3·88·85) = 0,000033 В. Результаты аналогичных расчетов для других значений напряжения  $U_2$  приведены в табл. 11-3, а кривая 2 на рис. 11-1 изображает амплитудную характеристику приемника с задержанной АРУ. Анализ этой кривой показывает, что действие АРУ удовлетворяет требованиям к приемникам I-IV классов.

Усиленная и задержанная APУ. В такой APУ регулирующее напряжение, получающееся на выходе выпрямителя APV, усиливается

в  $K_0$  раз усилителем постоянного тока, т. е.

$$U_{y} = U_{2}K_{\pi}K_{0}. \tag{11-34}$$

Требуемый коэффициент управления, параметр q и  $U_{2\ \rm npex}$  в данном случае рассчитываются по формулам (11-30) — (11-32) при добав-



лении к  $K_{\pi}$  множителя  $K_0$ . Для добавочного усилителя системы APУ обычно используется один из транзисторов трактов низкой или промежуточной частоты, что позволяет уменьшить число транзисторов в приемнике. Значение  $K_0$  обычно берут не более 3—5. При больших значениях управляющее напряжение становится весьма большим, что приводит к работе транзисторов регулируемых каскадов в режиме, близком к запиранию, и сопровождается большим уровнем нелинейных искажений. Расчет системы выполняется аналогично расчету задержанной APУ. На рис. 11-3 приведен один из вариантов схемы, в котором дополнительный усилитель построен на транзисторе первого каскада низкочастотного тракта  $T_2$ . При увеличении амплитуды сигнала возрастает постоянная составляющая напряжения детектора  $U_{\rm R}$ . Она увеличивает коллекторный ток транзистора  $T_2$  и отрицательный потенциал точки a уменьшается, что эквивалентно увеличению на базе регулируемого каскада закрывающего управляющего напряжения. Следовательно, усиление регулируемого каскада уменьшается.

В табл. 11-3 приведены основные характеристики системы, рассчитанные по исходным данным примера 11-2 при  $K_0=2$ . Анализ табл. 11-3 и рис. 11-1 показывает, что при 100-кратном повышении входного сигнала и  $U_2$   $\min=0.5$  В выходной сигнал изменяется для простой APV в 4 раза, для задержанной — в 3,9, а для задержанной и усилен-

ной лишь в 2,1 раза.

## 11-3. Расчет АРУ при регулируемых межкаскадных связях

На рис. 11-4 приведена наиболее часто применяемая схема APV с регулируемой межкаскадной связью. Выходное напряжение первого каскада с верхней половины катушки связи  $L_{\rm cs}$  подводится ко входу второго каскада через разделительный конденсатор  $C_6$  и диод  $\mathcal{A}_3$ . Емкость конденсатора выбирается в соответствии с неравенствами:

$$C_6 > \frac{10}{f_{\rm np}} \left( g_{\rm BX2} + \frac{1}{R_3} \right)$$
 in  $C_6 > 100 C_{\rm BX2}$ . (11-35)

При этом его проводимость на частоте сигнала оказывается много больше входной проводимости второго каскада ( $g_{8\lambda2} = 1/R_3$ ). Резистор

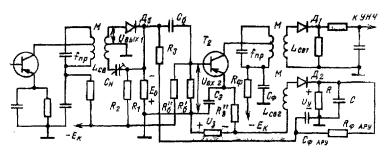


Рис. 11-4.

 $R_3$  предотвращает замыкание входа второго каскада для токов частоты сигнала конденсатором фильтра APУ. Его сопротивление выбирают по неравенству

 $R_3 < 0.25/g_{BX2}$  (11-36)

За счет деления между проводимостью диода  $\mathcal{A}_3$  и входной проводимостью второго каскада входное напряжение второго каскада определяется уравнением

$$U_{\text{BX2}} = \frac{g_{\text{XS}}}{g_{\text{XS}} + |Y_{\text{BX2}}|} U_{\text{Bbix1}}.$$
 (11-37)

Здесь

$$|Y_{\text{BX2}}| = \sqrt{(g_{\text{BX2}} + 1/R_3)^2 + \omega_{\text{BP}}^2 C_{\text{BX2}}^2}.$$
 (11-38)

Если проводимость диода  $\mathcal{U}_3$  уменьшать с ростом сигнала, то можно добиться достаточно постоянного значения  $\mathcal{U}_{\text{вх2}},$  что и требуется от системы APV. Система APV, приведенная на рис. 11-4, задержанная. Когда управляющее напряжение системы APV равно нулю, на аноде диода  $\mathcal{U}_3$  имеется положительное изпряжение  $E_0$  на резисторе  $R_1$ , составляющем вместе с резистором  $R_2$  делитель напряжения источника питания  $E_{\text{в}}$ :

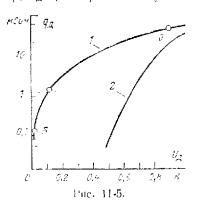
 $R_1 = E_0/I_p;$   $R_2 = E_K/I_n - R_1.$  (11-39)

где  $I_{\rm n}$  — ток делителя напряжения. Его обычно берут равным 0,3—0.8 мА. При  $E_0>0.3\div0.8$  В проводимость диода  $\mathcal{I}_3$  (см. табл. П-1-6)

бывает более 10 мСм, что обычно больше входной проводимости второго каскада. Согласно (11-37) при этом  $U_{\text{вуг}} \approx U_{\text{вых}}$ , что соответствует максимальному усилению первого каскада. Поэтому напряжение  $E_0$ 

обычно берут равным 0,8-1,2 В.

При работе выпрямителя APV управляющее напряжение подается на двод  $\mathcal{A}_3$  и уменьшает его проводимость. При  $\|U_Y\|>\|E_0\|$  активная составляющая проводимости двода  $\mathcal{A}_3$  становится малой. За счет этого согласно (11-37)  $U_{\text{BX2}} < U_{\text{BMX1}}$ , т. е. усиление первого каскада с учетом переходной ценочки будет малым, что и требуется от работы системы APV. Но двод  $\mathcal{A}_3$  кроме активной составляющей проводимости имеет еще и емкостную. При закрытом дводе она определяет передачу сигнала с няжнего конца катушки связи через нейтрализующую емкость  $C_{\text{п-}}$  на вход второго каскада подводится сигнал в противофазе с сигналом, проходящим через емкостную составляющую двода. Емкость двода



зависит от приложенного к нему постоянного напряжения  $\mid U_{\rm V} - E_0 \mid$ . Поэтому нельзя добиться полной нейгрализания сигиала через емкостную провод имость люда при всех значениях управляющего напряжения. Емкость конденсатора  $C_{\rm H}$  подбирают обычию экспериментально по минимуму прохождения сигиала при максимальном управляющем напряжении.

На рис, 11-5 приведены зависимости проводимости ино, ев Л9Ж (кривая I) и Д106 \ (кривая 2) от приложениого напряжения. Из-за емкостной составляющей проводимости диода погрешность расчета по (11-37)

возрастает. Она меньше (5-10%), если выполняется перавенство

$$q_{\text{a min}} \ge 5 \frac{6}{3} = 5 \omega_{\text{np}} C_{\text{g}}. \tag{11-40}$$

Поэтому максимальное управляющее напряжение определяется не графикам на рис. 11-5 при выполнении неравенства

$$U_{v,\max} \le E_0 + U_{x,\min}. \tag{11-41}$$

Обозначим проводимость днода при нулевом управляющем напрожении через  $g_{\rm gB}$  и через  $g_{\rm gmin}$  при максимальном управляющем изпражении. Глубина регулирования усиления первого каскада будет:

$$\Gamma_{\rm R} = \frac{g_{\rm g0}}{g_{\rm min}} \frac{g_{\rm gmin} + |Y_{\rm gx2}|}{g_{\rm g0} + |Y_{\rm gx2}|},$$
 (11-42)

Пример 11-3. Рассчитать элементы ехемы и характеристики задержанной APV с регулируемой межкаскадной связью, если каскады соответствуют примеру 7-1, а регулируемый двод Д9Ж ( $C_{\pi}=1$  пФ), Режим работы выпрямителя APV соответствует примеру 11-2.

Полагаем, что предыдущий каскад пастроен на частоту 38,5 МГц. Минимальную активную проводимость диода определяем по (11-40):  $g_{\rm g,min} \geqslant 5\cdot 6,28\cdot 385\cdot 10^3\cdot 10^{-12}=0,0012$  См. Этой проводимости по кривой I на рис. 11-5 (точка A) соответствует напряжение на диоде  $U_{\rm H,min} =$ = 0,115 В. Примем  $E_0=0.9$  В. По кривой 1 на рис. 11-5 (точка O) ему соответствует  $g_{00}=43$  мСм. Из (11-36)  $R_3<0.25/0.0038-66$  Ом  $+(6,28\cdot385\cdot10^3\cdot36\cdot10^{-12})^2$ =0.0217 См. Глубина регулирования усиления согласно (11-42)  $\Gamma_{\kappa}=\frac{0,043}{0,0012}\frac{0,0012-0,0217}{0,043}=12,6$ . Максимальпое управляющее напряжение вычисляем по равенству (11-41):  $U_{
m v,max}=$ = 0,9—0.115 = 0,785 В. Для этого максимальное входное напряжение выпрямителя АРУ согласно (11-29) должно быть  $U_{2\,\rm max}=0.785/0.8$  — -- 0.5 = 1.48 B.

Из неравенств (11-35) вычисляем  $C_6 \geqslant \frac{5}{385 \cdot 10^{\frac{5}{2}}} \left(0.0038 + \frac{1}{62}\right) =$  $=52 \cdot 10^{-10} \ \Phi$  и  $C_6 \ge 100 \cdot 36 = 3600$  пФ (берем конденсатор емкостью 5600 пФ). Примем ток потенциометра равным 0,5 мА. По (11-39) получим  $R_1 = 0.9/0.0005 = 1800 \text{ OM } \text{H} R_2 = 9/0.0005 = 1800 = 16200 \text{ OM} \text{ (BM-}$ бираем резисторы сопротивлением 1.8 и 16 кОм).

Амилитудную характеристику рассчитываем по следующей методике. Задаемся  $U_2 = 0.75 \text{ B} > E_1$  и из (11-29) вычисляем соответствующее ему управляющее напряжение  $U_y$  —  $(0.75-0.5)\cdot 0.8=0.2$  В. Заменяя в (11-41)  $U_{\pi\, \rm min}$  на  $U_x$  и  $U_{y\, \rm max}$  на  $U_y$ , находим напряжение на диоде  $U_z=0.9-0.2=0.7$  В. По кривой I (рис. 11-5) ему соответильной видерации. ствует  $g_{\pi}=27$  мСм. Подставляя это значение вместо  $g_{\pi \, \mathrm{min}}$  из (11-42),

паходим  $\Gamma_{\rm K} = \frac{0.043}{0.027} \frac{0.027 + 0.0217}{0.043 + 0.0217} = 1.2$ . По (11-27) вычисляем усиление каскада K' = 7.8/1.2 = 6.5. Предположим, что регулируется усиление двух одинаковых каскадов, а коэффициент усиления перегулируемых каскадов равен 415. Тогда по (11-25) получаем  $E_{\Lambda}=0.75/$  $(415 \cdot 6, 5 \cdot 6, 5) = 0,000043$  В. Результаты аналогичных расчетов для других значений напряжения сприала на входе выпрямителя АРУ приведены в табл. 11-3, а на рис. 11-1 им соответствует кривая 4.

Пример 11-4. Рассчитать резистивный каскад, который должен быть

первым в усилителе для примеров 11-1 и 11-2. По (2-66) получаем  $K_{0\,\mathrm{ye}\,\mathrm{I}}=$   $\begin{bmatrix} 0.2\,(1-0.9)\,0.087 \\ 6.28\cdot465\,000\cdot10^{-12} = 77. \end{bmatrix}$  Полагая  $C_{\mathrm{M}\,\mathrm{I}}=C_{\mathrm{M}\,\mathrm{2}}=3\,\mathrm{H}\Phi$ , вычисляем по (4-5)  $C_{\mathrm{B}\,\mathrm{K}}=4-3\div3=50\,\mathrm{H}\Phi$ . H3 (6-17) паходим

$$R_{\rm K} = \frac{1}{V (0.087,77)^2 - (6.28 + 465.000 \cdot 5 \cdot 10^{-11})^2 - 0.0009 \cdot -0.000025} = \frac{1}{-5050 \text{ Om.}}$$

При заданном  $I_{\rm K0}$  получится  $U_{R_{\rm K}} = 0.0025 \cdot 5050 = 12.6$  В. что больше

 $E_{\rm K}$  и не приемлемо. Положим  $R_{\Phi} = 100$  Ом. В примере 11-1 получено  $R_{\Phi} = 560$  Ом. 113 уравнения (3-17) и: ходим  $U_{R_{\rm K}} = E_{\rm K} = U_{\rm K} = U_{R_{\Phi}} = U_{R_{\Phi}} = 12 - 5$  –0,0025  $\cdot$  560 — 0,0025  $\times$  100 = 5,325 В. Следовательно,  $R_{\rm K} = 5,325/0,0025$  – 2130 Ом (берем

резистор сопротивлением 2,2 кОм). Из (3-20) получаем  $U'_{R_6}=1,4$  --+ 0,22 = 1,62 В. Сопротивление  $R_{\Phi}$ , ару в примере 11-1 получено равным 12 кОм. Чтобы цепь АРУ существенно не изменяла режим работы транзистора регулируемого каскада, должно выполняться неравенство  $R'_6 \approx (0,1\div 0,2)~R_{\Phi}$ , ару. Поэтому возьмем  $R'_6=2,2$  кОм. Сосласно (3-21) этому соответствует  $I_{\pi}=1,62/2200=0,000735$  А. По (3-23) вычисляем  $R'_6=\frac{12-1,62}{(735+7)\cdot 10^{-6}}=14$  100 Ом (берем резистор сопротивлением 15 кОм).

Из (4-4) получаем  $G_{\rm ek}=0.000025\pm0.000455\pm0.0009\pm0.000011\pm0.000013=0.0014$  См. Вычисляем по (6-16)

$$K_0 = \frac{0.087}{\sqrt{0.0014^2 + (6.28 \cdot 465\,000 \cdot 5 \cdot 10^{-11})^2}} = 61.$$

Пользуясь неравенством (3-19), находим  $C_{\Phi} \gtrsim (10 \div 20)/(465\ 000 \cdot 100) = 2(22 \div 44)\ 10^{-8}$  Ф и  $C_{\mathfrak{p}} \gtrsim (10 \div 20)/(465\ 000 \cdot 560) = (4 \div 8) \cdot 10^{-8}$  Ф (берем конденсаторы емкостью 0.33 и 0.068 мкФ). Полученные параметры элементов схемы каскада будут справедливы для каскадов, рассчитанных в примерах 6-8 и 6-9, поскольку их усиление регулируетсячистемой АРУ.

Глава двенадцатая

#### РАСЧЕТ РУЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ И НАСТРОЕК

## 12-1. Исходные данные и задачи расчета

В ГОСТ для радиовещательных приемников задается: глубина ручного регулирования усиления (см. табл. 11-1). При расчете структурной схемы приемника определяются: схема и место включения ручных регуляторов громкости и полосы пропускания (тембра) и минимальное значение верхней граничной частоты  $F_{\rm B \ min}$ ; длина шкалы настройки  $I_{\rm mi}$ ; число делений шкалы  $R_{\rm min}$  и замедление верньерного устройства  $\mathcal{B}_{\rm B}$ ; управляющее напряжение  $U_{\rm Y}$  для электрической перестройки контуров радиотракта и гетеродина.

Задачами расчета являются выбор и расчет параметров управляющего и других элементов схем ручных регуляторов и расчет характеристик регуляторов и проверка их соответствия заданным значениям.

## 12-2. Расчет ручного регулятора громкости

В сольнильные современных приемников ручной регулятор гром-кости (PPI) выполняют с помощью потенциометра  $R_{\rm p}$ , включаемого парадлельно нагрузочному резистору R (рис. 12-1) одного из каскадов низкочастотного тракта. Часто этим каскадом служит детектор.С целью уменьшения шунтирующего действия входной проводимости следующего каскада ( $g_{\rm BX2}$  и  $G_{\rm BA2}$ ) на нагрузочный резистор предыдущего каскада между каскадами включается добавочный резистор  $R_{\rm A}$ , роль которого и методика определения его сопротивления рассмотрены в § 2-7.

Обозначим через  $aR_p$  сопротивление потенциометра  $R_p$  между его подвижным контектом и полюсом, соединенным с шасси. При этом входное напряжение следующего каскада определится равенством

$$U_{\text{BX2}} = U_{\text{BbiX1}} \frac{aR_{\text{p}}}{[R_{\text{g}} + (1-a)R_{\text{p}}](g_{\text{BX2}}aR_{\text{p}} + 1) + aR_{\text{p}}}.$$
 (12-1)

Обычно выполняется неравенство

$$R_{\mathbf{p}} + R_{\mathbf{x}} \gg R. \tag{12-2}$$

Для малых уровней громкости, когда a < 0.01, справедливы не равенства:

$$g_{\rm BX2} R_{\rm p} a \ll 1$$
 и  $g_{\rm BX2} R_{\rm p} \gg 1$ . (12-3)

В случае выполнения неравенств (12-2) и (12-3) при заданной глубине регулирования усиления  $\Gamma$  сопротивление регулирующего потеициометра определяется равенством

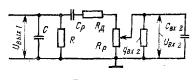


Рис. 12-1.

$$R_{\rm p} \approx \frac{R_{\rm g}}{R_{\rm g} g_{\rm BX2} a_{\rm min} \Gamma} \frac{(R_{\rm g} + R) g_{\rm BX2} + 1}{R_{\rm g} g_{\rm BX2}} - 1}.$$
 (12-4)

При использовании потенциометров с логарифмическим законом изменения сопротивления значение  $a_{\min}$  может быть принято равным 0,0002—0,001.

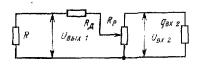


Рис. 12-2.

Пример 12-1. Определить полное сопротивление потенциометра РРГ ирименительно к приеминку / класса на рис. 12-1;  $\Gamma=317$ , используя данные примера 2-24, примем  $g_{\rm BX2}=0,0014$  См.

Положим  $a_{\min} = 0,0003$  и но (12-4) получим:

$$R_{\rm p} \approx \frac{15\,000}{15\,000 \cdot 0,0014 \cdot 0,0003 \cdot 317 \, \frac{(15+5,6)\,1000 \cdot 0,0014+1}{15\,000 \cdot 0,0014+1} - 1} = 5550 \,\,{\rm Om}.$$

Номпнальные сопротивления потенциометров соответствуют табл. П-3-1 при потрешности изготовления г=20 %. Поэтому принимаем потенциометр с максимальным сопротивлением 10 кОм.

В некоторых приемниках (ВЭФ, "Родина-68" и др.) потенциометр РРГ включается по схеме, изображениой на рис. 12-2. Для нее

$$U_{\text{BM2}} = U_{\text{BHN1}} \frac{aR_{\text{p}}R_{\text{BM2}}}{(R_{\text{p}} + R_{\text{BM2}}) R_{\text{g}} + aR_{\text{p}} [(1-a) R_{\text{p}} + R_{\text{BM2}}]}.$$
 (12-5)

При выполнении неравенств (12-3) для этой схемы можно записать:

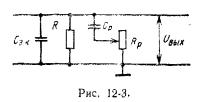
$$R_0 \approx \Gamma (R_{\pi}g_{BX2} + 1)/g_{BX2} - R_{\pi}/a$$
 (12-6)

Пример 12-2. Выбрать потенциометр РРГ для схемы на рис. 12-2 по исходным данным примера 12-1.

По (12-6) получаем  $R_{\rm p}\approx 317~(15~000\cdot0.0014\div1)/0,0014$  — 15  $000/0,0003=-45\cdot10^9~{\rm OM}.$  Обеспечение заданного  $\Gamma$  при  $R_{\rm p}<0$  показывает, что он реализуем при любом сопротивлении  $R_{\rm p}.$  Положив  $R_{\rm p}=100~{\rm кOM},$  из (12-6) получаем  $\Gamma=\frac{0,0014~(15~000+0,0003\cdot10^5)}{0,0003~(15~000\cdot0,0014+1)}=3180,$  что значительно больше требуемого. Следовательно, РРГ по схеме на рис. 12-2 обеспечивает большую глубину регулирования по сраввению со схемой на рис. 12-1.

# 12-3. Расчет регулятора полосы пропускания

1. Регулятор тембра выполняется в одном из каскадов низкочастогного тракта включением параплельно нагрузочной проводимости регулирующей цепочки  $C_{\rm p} \leftarrow R_{\rm p}$  (рис. 12-3). Ее параметры определяются формулами:



$$C_{p} = C_{sk} (F_{sk} F_{skmin} - 1);$$
 (12-7)

$$Q_{BblX}$$
  $R_{p} \ge \sqrt{\frac{C_{p} - 0.01C_{sK}}{0.4C_{sK}F_{s}^{2}C_{p}^{2}}},$  (12.8)

где  $C_{9\kappa}$  — эквивалентная см-кость, включенияя паралдельно нагрузочной проводимости кас-када, в котором включен регулятор.

Пример 12-3. Выбрать параметры цепочки регулятора полосы пропускания применительно к каскаду, рассчитанному в примере 4-1, чтобы получить  $F_{\rm B \ min}=2.5\ {\rm k}\Gamma{\rm u}$ .

По формуле (12-7) получаем  $C_{\rm p}=20\,420\,(12/2,5-1)=77\,600\,{\rm m}\Phi$  (выбираем конденсатор емкостью 0,082 мкФ). Пз (12-8) вычисляем  $R_{\rm p} \ge \sqrt{\frac{82\cdot 10^{-9}-0,01\cdot 2042\cdot 10^{-11}}{0,4\cdot 2042\cdot 10^{-11}\cdot 12^2\cdot 10^6\cdot 82^3\cdot 10^{-18}}}=3300\,{\rm OM}$  (выбираем потенциометр сопротивлением 3.3 кОм).

2. Регуляторы полосы пропускания высокочастотного тракта осуществляются в тракте промежуточной частоты, поскольку в нем настройка колебательных контуров постоянная. При использовании в качестве селективных систем пар связанных контуров регулировка осуществляется за счет изменения коэффициента связи между контурами. При трансформаторной связи это достигается механическим перемещением одной контурной катушки относительно другой, при внешнеемкостной связи — за счет применения подстроечного конденсатора для создания связи между контурами. В первом приближении минимальные коэффициенты связи и емкости конденсатора связи определяются перавенствами:

$$k_{\min} \approx kH_{\min}/H_{\max}; \quad C_{\text{comin}} \approx C_{\text{co}}H_{\min}, H_{\max}.$$
 (12.9)

Если селективными системами гракта промежуточной частоты служат одиночные контуры, регулировать полосу пропускания можно подключением к одному или нескольким контурам управляемых диодов. При  $\Pi_{\max}$  диоды должны иметь максимальную проводимость, т. е. быть открытыми. Для обеспечения  $\Pi_{\min}$  диоды закрываются управляющим напряжением. Поэтому контуры регулируемой полосы пропускания рассчитываются на получение минимальной полосы пропускания, т. е. для каждого из них начальное эквивалентное затухание должно быть

$$\delta_{\mathfrak{d}} = \frac{\Pi_{\min}}{f_{\min}} \psi_{1}(n). \tag{12-10}$$

Максимальная проводимость диода определяется равенством

$$g_{\pi \, \text{max}} = g_{\pi} (\Pi_{\text{max}} / \Pi_{\text{min}} - 1),$$
 (12-11)

где  $g_3$  — эквивалентная проводимость контура при минимальной полосе пропускания, т. е. при эквивалентном затухании, определяющемся формулой (12-10).

Усиление регулируемого каскада для обеспечения чувствительности приемника определяется для максимальной полосы. При минимальной полосе пропускания оно возрастет в  $\Pi_{\rm max}/\Pi_{\rm min}$  раз. За счет действия APV это изменение усиления в большей части будет скомпенсировано.

Пример 12-4. Выбрать диоды и определить режим их работы для расширения полосы пропускания до 30 к $\Gamma$ ц каскада, рассчитанного в примере 7-2. Такое расширение полосы пропускания может потребоваться для приема сигналов местных станций при  $F_{\rm R}=12~{\rm k}\,\Gamma$ ц.

Определяем полосу пропускання каскада из (7-2):  $\Pi_{\rm K}=13\,000\,\times$   $0.88=11\,450\,{\rm Fr}_{\rm L}$ . По формуле (12-11) получаем  $g_{\rm g,\,max}=61\,\times$   $10^{-6}\,(30/11,45-1)=99\cdot10^{-6}\,{\rm CM}$ . Выберем диод Д9Ж. По кривой I (см. рис. 11-5) находим, что этой проводимости соответствует напряжение на аноде диода  $0.015\,{\rm B}$  (точка E на кривой). Следова-

тельно, управляющее напряжение диода должно изменяться в интервале  $0-0.015~\mathrm{B}$ .

## 12-4. Расчет элементов шкалы и верньерного устройства

В настоящее время шкалы радновещательных приемников делают линейными. Перед шкалой 1 (рис, 12-4) движется визир 2, закрепленный на тросике 3, связанном со шкивом 4, который

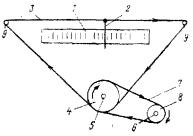


Рис. 12-4.

насажен на ось рогоров блока конденсаторов переменной емкости  $\mathcal{S}.$  Если длина шкалы  $t_{\rm m}$ , то диаметр шкива  $\mathcal{A}$  должен определяться равенством

$$D_1 = 2l_{\rm m}/\pi. \tag{12-12}$$

Ручкой настройки, насаженной на ось  $\theta$ , сравнительно легко пересгранвать приемник на частоту соседней станции при повороте на

10-15°. Вращение ручки настройки передается к оси роторов с помощью гросика 7. связывающего шкивы 4 и 8. При числе делений шкалы  $ec{q}_{
m m}$  диаметр шкива 8 определяется уравнением

$$D_8 = \frac{12 \div 18}{q_{\rm nt}} D_4. \tag{12-13}$$

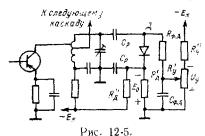
Диаметры роликов 9, обеспечивающих нагяжение тросика 3, не играют принципиальной роли и выбираются из конструктивных удобств (обычно 8—12 мм).

Пример 12-5. Вычислить параметры элементов шкалы и верньера,

ссли длина шкалы 150 мм, а число ее делений равно 100. По (12-12) и (12-13) находим  $D_4=2\cdot 0.15/3.14=0.0955$  м и  $D_8=$  $\frac{12 \div 18}{100}$  0,0955 = 0,012 ÷ 0,017 м. Чем меньше  $D_{\rm s}$ , тем легче осуществить настройку.

## 12-5. Расчет элементов схем питания управляемых диодов

На рис. 8-8 приведен один из вариантов подключения управляющего диода Д параллельно колебательному контуру для подстройки его частоты. На рис. 12-5 показано подключение дпода с целью управления полосой пропускания. Резисторы  $R'_{\bf Z}$  и  $R''_{\bf Z}$  обеспечивают исходное



напряжение  $E_0$  на аноде диода. Для этого их сопротивления должны быть:

$$R'_{\rm H} = E_0/I_{\rm H}$$
 If  $R''_{\rm H} = (E_{\rm K} - E_0)/I_{\rm H}$ . (12-14)

Емкости конденсаторов  $C_{\mathbf{p}}$  и  $C_{\Phi^+,\chi}$  определяются из (3-19) при соответствующих заменах  $R_{\mathfrak{p}}$  на  $1/g_{\mathfrak{q},\max}$  и  $R_{\Phi, A}$ . Сопротивление резис-

тора фильтра диода должно удовлетворять перавенству

$$R_{\Phi, \lambda} \ge \frac{15 + 30}{g_{\text{9 min}}}, \qquad (12-15)$$

в котором дельно — минимальная эквивалентная проводимость контура. Сопротивления резисторов, создающих управляющее напряжение, выбирают по равенствам:

$$R'_{y} = 1.4 \frac{U_{y \text{ max}}}{I_{II}}; \qquad R''_{y} = \frac{E_{x} - 1.4U_{y \text{ max}}}{I_{II}}.$$
 (12-16)

В (12-14) и (12-16)  $I_{\rm H}$  — ток делителей напряжения. Его обычно берут равным 0,4-0,8 мА. Запирающее напряжение днода определяют из неравенства

$$U_{\star} \ge -2U_{m,\max}, \qquad (12-17)$$

где  $U_{m \; {
m max}}$  — максимальная амилитуда сигнала на контуре. Макси мальное управляющее напряжение для диода должно быть:

$$U_{y \, \text{max}} = U_3 + E_0 \,. \tag{12-18}$$

Пример 12-6. Определить параметры элементов схемы управляемого диода для схемы на рис. 12-5 применительно к данным примера 12-4. Будем считать  $E_{\mathbf{x}}=9$  B,  $f_{\min}=465$  кГц,  $U_{\max}=10$  мВ.

В данном случае за исходное состояние принимаем режим получения максимальной полосы пропускания. Поэтому  $E_0=0.015$  В. Полагаем  $I_0=0.5$  мА и согласно (12-14) находим  $R_{\pi}'=0.015/0.0005=30$  Ом и  $R_{\pi}''=(9-0.015)/0.0005=18$  000 Ом (принимаем резисторы сопротивлением 30 Ом и 18 кОм).

При узкой полосе пропускания диод должен быть закрыт. 11з (12-17)  $U_3 \geqslant -|2\cdot 0.01| = -0.02$  В. Выбираем с некоторым запасом  $U_3 = -0.2$  В. Согласно (12-18) получим  $U_{y \text{ max}} = |0.2| + |0.015| = 0.215$  В. По формулам (12-16) вычисляем  $R_y' = 1.4 \cdot 0.215/0.0005 = 600$  Ом и  $R_y'' = (9-1.4 \cdot 0.215)/0.0005 = 17 400$  Ом. По табл. П-3-1 выбираем потенциометр и резистор сопротивлением 680 Ом и 18 кОм. 11з (12-15) получаем  $R_{\Phi, \pi} = (15 + 30)/0.000061 = (24 + 48) \cdot 10^4$  Ом (берем резистор сопротивлением 330 кОм). 11з (3-19) находим  $C_p \geqslant \frac{10 \div 20}{465000}$  99 · 10  $= (2 \div 4) \cdot 10^{-9}$  Ф и  $C_{\Phi, \pi} > (10 \div 20)/(465000 \times 33 \cdot 10^4) = (7 \div 14) \cdot 10^{-11}$  Ф. Принимаем конденсаторы емкостью 3300 и 100 пФ соответственно.

#### Глава тринадцатая

# РАСЧЕТ ТРАНЗИСТОРНОГО РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО ПРИЕМНИКА 1 КЛАССА

## 13-1. Исходные данные

Характеристики и требования к радновещательным приемникам определяются ГОСТ 5651-76. В табл. 43-1 приведены основные характеристики переносного приемника I класса с питанием от автономного источника, которые необходимы для расчета. Задачи расчета приемников сформулированы в § 1-1. В последующем расчет структурной схемы, каскадов и характеристик приемника выполняется для трех поддиапазонов: 1 (или 2), 11 и 12, существенно различающихся применяемыми антеннами, чувствительностью, селективностью и типами необходимых в высокочастотном тракте транзисторов. Расчет элементов схемы каскадов для остальных поддианазонов может быть выполнен аналогично.

# 13-2. Расчет структурной схемы

Расчет выполнен в соответствии с рекомендациями и методиками гл. 2 по приведенным в ней примерам.

1. Граничные частоты поддиапазонов определены в примере 2-2 и приведены в табл. 2-2.

	Основные хара	VTO DO OTH V II		Подда	аназоны	
_	Othornse Aupa	перистики	1	2	3-11	12
нон мощ	ность при <b>вых</b> од- ности 50 м <b>В</b> т (для	со входа висинией антен- ны не хуже, мкВ	150 (20)	150 (20)	100 (20)	10 (26)
	$_{ m B}$ с $P_{ m max}$ 150 мВт при отполении сиг- дБ	при впутренней магнит- ной антенне не хуже, мВ/м	1 (20)	0,7 (20)	0,3	0,015
	Ослабление сиги + 10 кГц не ме	ала при расстройке па пес, дБ	4(1	10	16	
Селектив- вость	Ослабление сигна; менее, дБ	юв зеркального капала не	-40	36	1;	22
		· •				0,2
Промежуточ	ная частота, МГц		0,465 + 0,002	0,465 + 0,003	0,165 + 0,002	[6,5] 1; 8,1 + 1; [0,7] 1]
Полоса прог	ускания, кГп				i	120 -180
Лействие	Пзменение входног	о сигнала более, дБ	10	1(1	30	1
АРУ	Изменение выходи	ого сигнала не более, дВ	[2	12	12	. —
	ность кривой верно изпазоне модулирую	сти по звуковому давлению ицих частот, кГц	0,15 - 1	0,15 -1	0,15—4	0,15—12
		е, %, при <i>т.</i> 0.8 ( <i>т.</i> 0.5) Св интервале частот 200	8 (7)	8 (7)	8 (7)	.5

<sup>11</sup>р и м е ч а и и я: 1. Напряжение автономного источника питлиня поминальное 9 или 12 В, минимальцое 5,6 или 7,2 В. 2. Среднее поминальное звуковое давление не менее 4-10° 11а. 3. Ослабление расстройки 1,9 кГц измеряется на частотах сменала 0,25, 1,12 и 69 МГц; 4. Ручная регулировка громкости не менее 50 дБ. 5. Эффективность работы ограничетеля амилитуды при приеме ЧМС не ниже 16 дБ. 6. Чувствительность со входа звукиевимателя при  $R_{\rm ux}$  = 0,5 МОм не ниже 0,25 В. 7. О чабление сигналов с промежугочной частотой не ниже 34 дБ. 8. Потребляемая энергия от автономного источника витация пра 30% выходной мощности не более 2 Вт.

2. Расчет структурной схемы инэкочастотного тракта приведен в примерах 2-4 и 2-5, а результаты записаны в табл. 13-2.

Таблица 13-2

	Транзи	Хардитеристика	каскада	По- треб-	Сопро- тивле- ние	Ам- плиту- да	
Каскад	стор	Схема	Режим	МЫЙ ТОК, М А	источ- ника сигна- ла, Ом	вход- ного сигна- ла, В	
Выходной Предвыходной Второй Первый	ГТ403Б МП41А МП41А МП41А	Двухтактная Однотактная Однотактная Однотактная	AB A A	95,6 7 2,5 2,5	648 2400 3900 3900	7,1 0,25 0,025 0,005	

3. Полоса пропускания приемника рассуштана в примере 2-6.

Основные результаты расчета приведены в табл. 2-6.

4. Выбор типа транзисторов и схем первых каскадоя приемника для поддиапазона 12 выполнен в п. 1 § 2-5. Рассмотрено десять варпантов построения радиотракта, состоящего из одноконтурной входной цепи и резонансного каскада усилителя радиосигнала (см. табл. 2-9). Приемник построен на транзисторе ГТ313Б по схеме с ОЭ.

Для поддианавонов 3-11 эта задача решена в п. 2 § 2-5. Рассмотрено 14 вариантов (см. табл. 2-11).

В подднапазонах 1 и 2 используется ферритовая антенна; решение задачи выполнено в и 3 §2-5. Рассмотрено пять вариантов (см. табл. 2-13). Для подднапазонов 1—11 в усилителе радноситиала признано целесообразным использовать транзистор ГТ308В по схеме с ОЭ.

5. Селективные системы тракто промежуточной частоты прием-

чика определены в примере 2-20.

6. Выбор схемы и расчет детектора АМС выполнены в примере 2-24.

 Возможные характеристики дифференциального детектора и транэисторного ограничителя определены в примерах 2-28 и 2-30,

а дробного детехтора — в примере 2-29,

- 8. Выбор типа транзисторов и числа каскадов тракта промежу-точной частоти для приема АМС выполнен в примере 2-25 (см. табл. 2-16). В примере 2-31 эта задача решена для приема ЧМС (см. табл. 2-20).
- 9. Проверка осуществимости регулировок усиления выполнена в примере 2-26 (для APУ) и в примере 12-2 (для PPГ). Системой APУ достаточно регулировать усиление двух каскадов: каскада УРС и первого каскада УПЧ при приеме AMC, первого и третьего каскадов при приеме ЧМС.
- 10. На основании принятых рашее решений структурная схема приемника должна соответствовать рис. 13-1. Здесь: I— входная цепь с одиночным контуром для поддвапазона 12; 2— резонансный УРС для поддвапазона 12 на транзисторе ГТ313Б по схеме с ОЭ эмиттером; 3— преобразователь частоты для поддвапазона 12 с четырехконтурным ФСС на транзисторе ГТ313Б с совмещенным гетеродином: 4— входная цель с одиночным контуром для поддвапазонов 1—11; 5— резонансный УРС для приема АМС на транзисторе ГТ308В по схеме с ОЭ

и первый каскад УПЧ по схеме с ОЭ с двумя связанными контурами при приеме ЧМС; 6 — блок ПЧ на транэисторе ГТ308В с отдельным гетеродином и ФСС типа ПФ1П-2 при приеме АМС, а также второй ревистивный каскад УПЧ при приеме ЧМС по схеме с ОЭ; 7 — гетеродии для преобразователя частоты при приеме АМС; 8 — электронный стабилнэатор напряжения для питания 2, 3, 6 и 7-го каскадов; 9 — первый каскад УПЧ (резистивный) при приеме АМС на транзисторе ГТ308В по схеме с ОЭ эмиттером и третий каскад (резистивный) УПЧ при приеме ЧМС на том же транзисторе и по той же схеме; 10 — второй каскад УПЧ при приеме АМС с двумя связанными контурами на транзисторе ГТ308В и ограничитель амплитуды при приеме ЧМС; 11 — лифференциальный детектор ЧМС на диодах Д2Е; 12 — последовательный детектор АМС нв диоде Д9Е; 13 — первый резистивный каскад

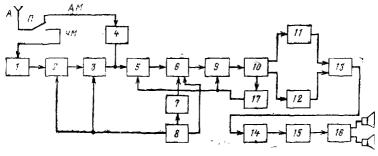


Рис. 13-1.

УНЧ на траизисторе МП41А; 14 — второй резистивный каскад УНЧ на траизисторе МП41А; 15 — предвыходной инверсный каскад УНЧ на траизисторе МП41А с траисформаторным выходом; 16 — выходной каскад по двухтактной схеме класса АВ с траисформаторным выходом на траизисторах ГТ403Б; 17 — выпрямитель задержанной АРУ на диоде Д9Е.

## 13-3. Расчет каскадов приемника

Пелесообразнее выполнять расчеты каскадов приемников в той же последовательности, что и в предыдущем параграфе, используя полученные характеристики как исходные данные для расчета на базе примеров, приведенных в гл. 1—12.

1. Окончательный расчет выходного каскада выполнен в примере

3-3. Схема каскада соответствует рис. 2-7.

2. Окончательный расчет предвыходного каскада проведен в примере 4-3 (см. рвс. 4-6).

3. Расчет второго каскада низкочастотного тракта проведен в при-

мере 4-1 (см. рис. 4-1).

4. Расчет первого каскада низкочастотного тракта выполним по методике, примененной в примере 4-1. В качестве первого каскада в  $\S$  2-3 выбран траизистор МП41А. Исходиыми данными для расчета на основании примера 4-1 являются:  $R_{\rm K}=3.9$  кОм,  $g_{\rm BX}=0.00156$  См,

 $C_{\text{BX}} = 0.02 \text{ MK}\Phi$ ,  $U_{m_{\text{BSIX}}} = 0.025 \text{ B}$ ,  $k_{\text{r}} = 0.01$ ,  $M_{\text{B}} = M_{\text{B}} = 1.11$ ,  $E_{\text{K}} = 12 \text{ B}$ .

Согласно (4-8) вычисляем  $R_{\Phi} \approx (0,1\pm0,2)$  3900 = 390 ± 780 Ох. (выбираем резистор сопротивлением 680 Ом). Если на поле выходных характеристик транзистора (см. рис. 4-2) провести из точки  $E_{\rm K}=12$  В нагрузочную характеристику 7 под углом, соответствующим сопротивлению в цепи коллектора 3900 ± 680 = 4580 Ом, то она пересечет характеристики в сугубо криволинейных участках, что приведет к работе каскада с больщими нелинейных участках, что приведет к работе каскада с больщими нелинейными искажениями. Поэтому целесообразно уменьшить сопротивление нагрузки постоянному току до 2,83 кОм ( $R_{\rm K}=2,4$  кОм и  $R_{\Phi}=430$  Ом). Этому сопротивлению соответствует прямая 2, принятая в расчете второго каскада. Выбираем рабочую точку в точке  $A_{\rm L}$  Следовательно, характеристики транзистора в исходной рабочей точке будут такими же, как в примере 4-1, а сопротивления и емкости элементов схемы (см. рис. 4-1) сохранят значения, соответствующие примеру 4-1.

По уравнению (4-4) вычисляем  $G_{\rm sk}=1/6700\div1/2400\div0,00156=0,00213$  См. Полагая  $C_{\rm M1}=C_{\rm M2}=10$  пФ, из (4-5) находим  $C_{\rm sk}=400\div10+20$  000  $\pm10=20$  440 пФ. Проходная характеристика транэистора данного каскада будет также соответствовать рис. 4-3. Амплитуда выходного напряжения каскада должна составлять 0,025 В. На основании рассуждений, аналогичных проведенным в примере 4-1, амплитуда входного сигнала каскада должна быть меньше 0,12 В в 1,47/0,02 = 59 раз, т. е.  $U_{m,\rm BX}=0,12/59=0,002$  В, а коэффициент гармоник  $k_{\rm T}=0,05/59=0,0008$ , что меньше допустимого, п отрицательную обратную связь применять не требуется. Входной сигнал рассчитываемого каскада в 0,005/0,002 = 2,5 раза меньше минимального входного сигнала низкочастотного тракта. Таким образом, в этом тракте имеется запас усиления в 2,5 раза и пересчета каскадов не требуется.

5. Расчет детектора АМС проведен в примерах 2-24 и 9-1 (см. рис. 2-16).

6. Расчет дифференциального детектора ЧМС выполнен в примерах (2-28) и 9-2 (см. рис. 9-1).

7. Ограничитель амплитуды рассчитан в примерах 2-30 и 10-2. Его выходное напряжение на коллекториом контуре 7,25 В, а коэффициент передачи частотного детектора 0,016. Следовательно, при максимальной девиации частоты согласно (2-143)  $U_{m\Omega \max} = 7,25 \cdot 0,016 = 0,116$  В, при девиации частоты 0,3 максимальной оно будет  $U_{m\Omega 0,3} = 0,3 \cdot 0,116 = 0,034$  В, что в 6,5 раза больше необходимого. Таким образом, детекторы и низкочастотный тракт приемника рассчитаны правильно.

8. Расчет входной цепи для поддиапазона 12 выполнен в примере 5-1 (см. рис. 5-2), а для поддиапазона 11 (см. рис. 5-3) в примере 5-2. Для поддиапазона 2 входная цепь совместно с ферритовой антенной рассчитана в примере 5-4 (см. рис. 5-8, а).

9. Расчет усилителя радиосиенала поддиапазона 2 выполнен в примере 6-8. Схема каскада соответствует рис. 6-1, а. Для поддиапазона і 1 расчет каскада дан в примере 6-9 (см. рис. 6-1, а), а для поддиапазона 12 — в примере 6-10 (см. рис. 6-2). В табл. 13-3 даны сводные данные для ВЦ и каскада УРС. Сравнение данных табл. 13-3 и табл. 13-1 показывает, что селективность по зеркальному каналу выше требуемой. Но селективность по промежуточной частоте в начале поддиапазона 2 (аналогично в конце поддиапазона 1) в 50/25,8 — 1,9 раза меньше требуемой. Поэтому в УРС поддиапазонов 1—11 следует включить фильт-

Под- да- апа-	Ча-	Характеристика ВЦ				Характеристика УРС					
апа- зол	стота, МГц	Ко, ни	ň,	$d_{\rm rep}$	<i>d</i> ,	ű,	Ra	గ్ర	a <sub>np</sub>		d .
2	0,515	3	0,039	5,1	60	1,40	11.9	0,689	5,1	fu	1.#1
	0,92	2,7	0,073	19,7	18	1.05	44	0,067	22,8	32.5	1 045
	1,64	1,5	0,133	24,4	7,1	1,05	39.4	0,134	24,2	7	1,04
11	25,85	1,58	0,02	2770	3,7	L.05	9.75	0,0131	4250	5,73	1,005
12	70,75	0,3	0,102	\$1.5	4,78	1,005	4,9	0,0284	292	16,7	1,065

Продолжение табл, 13-3

Под- ди-	Цa.		Xapa pa	актери ( Диотра	CTHRE KT8		Вну-			Вим, ра
ди- апа- зон	стота, МГц	Ko	И, кГц	a <sub>n:p</sub>	,	a <sub>e</sub>	тренияя антенна П <sub>а</sub> . мм	Fn. 7i	Внеш- няя антенна	Вну- тренняя янтенна
2 11 12	0,515 0,92 1,64 25,85 70,75	209 119 56 15,4 1,47	12 44 219 420 2120	25,8 450 590 10 000 23 800	3605 405 49,7 21,2 79,5	1,99 1,1 1,09 1,61 1,01	5,3 9,6 17,1 600	1.76 1.76 1.76 0.36 21.8	#6 #60 19 #800 9900 556	1370 1400 1180 — 323

рующую цепочку из последовательно включенных  $C_{\rm np}$  и  $L_{\rm np}$ , показанную на рис. 6-1, a. Она образует последовательный колебательный контур, настроенный на частоту 465 к $\Gamma$ ц элементом подстройки индуктивности катушки, Затухание этого контура должию быть возможно меньшим. Если  $f_{\rm np} < f_{\rm c}$ , то индуктивность катушки фильтрующего контура должиа удовлетворять неравенству  $L_{\rm np} \le L/(\delta_{\rm np} d_{\rm np})$ , в котором  $d_{\rm np}$  — необходимое добавочное ослабление сигнального контура. В нашем случае  $d_{\rm np} = 50/25, 8 = 2$  и при  $\delta_{\rm np} = 0,01$  получим  $L_{\rm np} < 0,00024/(0,01\cdot2) = 0,012$  Гн. С запасом возьмем  $L_{\rm np} = 0,001$  Гн, а по формуле (2-101) находим  $C_{\rm np} = 1/(6,28^2\cdot465\cdot000^2\cdot0,001) = 117 \times 10^{-12}$  Ф (выбираем конденсатор емкостью 120 пФ). Если  $f_{\rm np} > f_{\rm c}$ , следует пользоваться неравенством  $L_{\rm np} \le 1/(\delta_{\rm np} d_{\rm np} \omega_{\rm np}^2 C_{\rm b max})$ . В котором  $C_{\rm 3max} = 9$ квивалентная емкость сигнального контура.

10. Расчет преобразователя частоты подднапазона 2 выполнен в примере 8-1, а для подднапазона 11— в примере 8-2. Схема каскада приведена на рис. 8-1.

Для поддианазона 12 расчет преобразователя проведен в примерах 8-4 и 8-5 (см. рис. 8-8).

11. Расчет усилителя напряжения промежуточной частоты для приема АМС выполнен в примерах 7-2 и 11-4. Его коэффициент усиления  $61\cdot49=3000$ . Минимальное выходное напряжение преобразователя частоты АМС согласно табл. 13-3 равно 556 мкВ. Следовательно, входное напряжение детектора АМС будет  $U_{\rm BX, \ \mu}=0.000556\cdot3000=1.7$  В. Нормальное значение входного напряжения детектора в примерс 2-24 принято равным 0,6 В. Таким образом, в худшем случае запас усиления будет  $a_{\rm amc}=1.7/0.6\approx2.9$ .

Расчет усилителя напряжения промежуточной частоты для ЧМС осуществлен в примерах 2-31, 6-7 и 7-3. Усиление двух каскадов — первого и третьего регулируется системой АРУ. Для них согласно примеру 11-2  $I_{\rm KO}=2.5$  мА и наибольшее усиление, равное устойчивому, будет 18,1. Коэффициент усиления усилителя равен 18,1-11,5-18,1  $\approx 3760$ . Следовательно, согласно табл. 13-3 амплитуда сигнала на входе огравичителя амплитуды будет  $U_{\rm BX, O, a}=323\cdot 10^{-6}\cdot 3760=1,21$  В,

а запас усиления (см. пример 10-2)  $a_{\text{чмс}} = 1.21/0.2 = 6.$ 

Проверим требуемую селективность. По штрихпунктирной кривой I с двумя точками (см. рис. 2-14) находим  $\xi_{d_c}/\xi_{d_n}$  для уровней 2 и 20 — точки E и B на кривой. Абсциссы этих точек равны соответственно 1,15 и 2,4, что соответствует абсолютным расстройкам  $0.5II.1,15=0.5\cdot180\cdot1,15\approx104$  и  $0.5\cdot180\cdot2,4=216$  к $\Gamma_{\rm L}$ . Интервал частот между абсциссами точек E и E будет E одет E и E будет E одет E и E одет E одет E и E одет E одет

Для увеличения крутизны ската один из резисторных каскадов заменим каскадом с двумя связанными контурами. Их полоса пропускания должна быть на 5-10 % шире полосы пропускания ФСС, чтобы они не сужали существенно результирующую полосу пропускания тракта. Примем ее равной 190 кГц. Из табл. 2-12 находим  $\psi_3(1)=0.71$  и ло формуле (7-1) вычисляем  $\delta_9=190~000\cdot 0.71/8~400~000=0.0161$ . Абсолютным расстройкам 104 и 216 кГц будут соответствовать  $\xi_{d_c}/\xi_{d_{\Pi}}$ , т. е. 104/95=1.1 и 216/95=2.27. На штриховой кривой I (см. рис. 2-14) находим точки E'' и E'', соответствующие этим абсциссам. Для их ослабления равны 1.59 и 5.25, что дает добавочное ослабление в том же интервалс частот в 5.25/1.59=3.3 раза или на 10.4 дБ. Средняя крутизна ската кривой селективности тракта будет (20+10.4)/112=0.27 дБ/кГц, что больше требуемой.

Селективные системы каскадов — УРС при приеме АМС, транзистор которого используется в первом каскаде УПЧ тракта ЧМС, и преобразователь частоты при приеме АМС, транзистор которого применяется во втором каскаде УПЧ, — существенно различаются. Поэтому при переходе с приема ЧМС на прием АМС в этих каскадах с помощью переключателя диапазонов должны заменяться селективные системы. Для тракта промежуточной частоты ЧМС данные каскады целесообразно

строить по резисторной схеме.

В каскадах УПЧ тракта АМС селективными системами служат два связанных контура. Последний каскад тракта промежуточной частоты ЧМС является ограничителем амплитуды, за которым находится дифференциальный детектор. Следовательно, в ограничителе амплитуды селективной системой будут два связанных контура, т. е. такая же система, как и в последнем каскаде тракта АМС. В этом случае каскад согласно данным § 2-12 может быть построен без коммутации нагрузок. Но в рабочем режиме ограничителя коллекторное напряжение должно быть пониженным. Для этого при переходе на прием АМС сопротивле-

ние резистора  $R_{\rm K1}$  в схеме на рис. 9-1 должно быть увеличено так, чтобы  $E_{\rm K0}' = U_{\rm K3} + 1_{\rm K0} R_{\rm p} = 5 + 10^{-3} \cdot 10^{-3} = 6$  В. Его сопротивление должно определяться формулой

$$R'_{\kappa 1} = \frac{(E'_{\kappa \theta})^2 R_{\kappa 2}}{E'_{\kappa \theta} (E_{\kappa} - E'_{\kappa \theta}) - E'_{\kappa \theta} R_2 I_{\kappa \theta}}.$$

В нашем случае с учетом данных примера 10-2 получим  $R'_{\rm K1}=\frac{6^2\cdot 910}{6\,(12-6)-6\cdot 910\cdot 10^{-8}}=1075$  Ом Сопротивление резистора  $R_{\rm K1}=\frac{680}{6\,(12-6)-6\cdot 910\cdot 10^{-8}}=1075$  Ом Сопротивление резистора  $R_{\rm K1}=\frac{680}{6\,(12-6)-6\cdot 910\cdot 10^{-8}}=1075$  Ом (берем резистор сопротивлением  $R_{\rm K}$ , доб = 390 Ом). Коммутацию в схеме потенциометра питалия цепи коллектора можно представить рис. 13-2. При приеме АМС ключ  $\Pi$  должен размыкаться. В одном из каскадов тракта ЧМС пеобходимо иметь селективной системой два связанных контура при критической связи. Если это третий каскад, то его транзистор при приеме АМС будет использоваться в первом каскаде УПЧ тракта АМС. Следовательно, и этот каскад

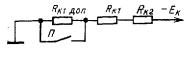


Рис. 13-2.

можно выполнить без коммутации селективных систем,

Таким образом, принимаем окончательное решение о построении тракта промежуточной частоты ЧМС: первые два каскада— резисторные, третий — с двумя связанными контурами при критической связи. Параметры та-

кого каскада можно взять из примера 7-3. Согласно сказанному ранее его полоса пропускания должна быть 190 кГц, а эквивалентное затухание 0,0161 и эквивалентная проводимость  $g_5 = \frac{0,0161}{0.01} \times 316 \cdot 10^{-8}$  См. Остальные параметры контура и схемы каскада можно взять, как для каскадов примера 7-3. Но кожфициенты включения кон

взять, как для каскадов примера 7-3. Но кожфонциенты включения контуров по формулам (7-17) должны быть 
$$p_1 = \sqrt{\frac{316 \cdot 10^{-8}}{0.00011}} \left\langle \frac{0.0161}{0.001} - 1 \right\rangle = \sqrt{\frac{316 \cdot 10^{-8} \cdot 0.0161}{0.0011}}$$

$$=0,132$$
 и  $p_2=\sqrt{rac{316\cdot 10^{-8}}{0,0009}}\Big(rac{0,0161}{0,01}-1\Big)=0,0462$  Согласно уравненик (7-14) коэффициент усиления каскада  $K_0=rac{1}{1+1^2}rac{0,132\cdot 0,0462\cdot 0,035}{509\cdot 10^{-8}}=$ 

= 21, что в 1,82 раза больше устойчивого. Для снижения усиления до устойчивого следует уменьшить коэффициент включения первого контура и взять его равным  $p_1' = 0.131/1.82 = 0.0725$ . Для обеспечения нужного эквивалентного затухания первого контура в коллекторной цени транзистора согласно (7-17) следует иметь проводимость  $g_{32}' = 0.0725$ 

$$=\frac{3[6\cdot 10^{-8}]}{0.0725^2}\left(\frac{0.0161}{0.01}-1\right)=368\cdot 10^{-8}$$
 См. Для этого в коллекторнук. цень следует добавить шунтирующую проводимость  $g_{\rm m}=g_{22}'-g_{22}=368\cdot 10^{-6}-11\cdot 10^{-5}=258\cdot 10^{-6}$  См. Ей соответствует резистор сопротивлением 3870 Ом. (принимаем резистор 3.9 кОм).

12. Расчет системы задержанной АРУ выполнен в примере 11-2 Схема выпрямителя АРУ и соединение его с одини из регулируемых каскадов приведены на рис. 11-2.

- 13. Росчет ручного регулятора громкости выполнен в примере 12 - 2
- 14. Расчет регулятора полосы пропускания низкочастотного трак*та* проведен в примере 12-3 (см. рис. 12-3).

## 13-4. Поверочный расчет основных характеристик приемника

1. Расчет характеристик селективности состоит в определении ординат характеристик селективности трактов радиосигнала, промежуточной частоты и всего высокочастотного тракта при одинаковых абсолютных расстройках. Решение этой задачи выполним на ряде

Пример 13-1. Определить самую широкую и наиболее узкую кривую селективности радиотракта приемника 1 класса, рассчитанного

в § 13-2 и 13-3.

Самая узкая кривая селективности радиотракта имеет место на минимальной рабочей частоте, а наиболее широкая — на максимальліон.

Для приема АМС наиболее узкая полоса пропускания радиотракта будет в начале первого, а наиболее широкая — в конце одиннадцатого поддиапазонов. В п. 3 § 2-5 для радиотракта поддиапызона 1 найдены эквивалентное затухание контуров  $\delta_{\text{3-c1}} = 0.135$  и  $f_{\min} = 147$  кГц. В примере 5-2 для поддналазона 11 определено  $\delta_{a, \text{ вил}} = 0.02$  и в примере 6-9  $\delta_{3,\text{ урс H}} = 0.0159$ . Для границы полосы пропускания приемника расстройка  $\Delta f = 0.5 \ H = 0.5 \cdot 12 \ 000$ 6000 Гц. 11о (2-64) вычисляем для начала подднапазона 1 обобщенную расстройку 5  $147\ 000 - 6000$ 147 000 =0,615. Из (2-63) находим

147 000 --- 6000 0.135 ослабление  $d=\sqrt{1-0.615^2}=1.17$ . Следующие расстройки берем равными 10 кГц (соседний канал),  $2\Pi$ ,  $3\Pi$ ,  $5\Pi$ ,  $f_{np}$  и  $f_3 = 2f_{np}$ . Ре-

зультаты аналогичных расчетов приведены в табл. 13-4.

147 000

Ослабление в тракте промежуточной частоты вычисляем следующим образом. При расстройке 6 кГц, соответствующей границе полосы пропускания фильтра типа  $\Pi\Phi 1\Pi$ -2, согласно табл. 2-7 получаем  $d_{\text{thec}}$  — 2. а при расстройке 10 кГц — 100. Обобщенная расстройка для двух связанных контуров тракта промежуточной частоты АМС согласно 1465 - 6 $\left| \frac{300}{465-6} \right| = 1$ . По равенству (7-15) вы-(2-64) будет  $\xi = \frac{1}{0.0245} \left| \frac{1}{465} \right|$ 

числяем соответствующее ей оснабление  $d=0.5~V\overline{(1+1^2-1^2)^2+4\cdot 1^2}-$ = 1,12. Общее ослабление в тракте промежуточной частоты будет  $d_{\rm np} = 2 \cdot 1.12 = 2.24$ . Перемножая  $d_{\rm n,c} \cdot d_{\rm up}$ , получаем ослабление всего приемпика для расстройки 6 кГц. Оно равно  $1.36 \cdot 2.24 = 3.1$ . Результаты аналогичных расчетов для других расстроек приведены в табл. 13-4.

Подобным же образом рассчитывается ослабление во всех элементах тракта ЧМС. При этом для определения ослабления ФСС используется штрихпунктирная кривая 1 с двумя точками (см. рис. 2-14) Результаты расчетов приведены в табл. 13-4.

Из последнего неравенства для  $L_{\rm np}$ , приведенного в п. 9 § 13-3. получим для поддианазона 1  $d_{\rm np} \geqslant 1/(0.01 \cdot 0.001 \cdot 6.28^2 \cdot 465\ 000^2 \cdot 394\ imes$  $\times$  10<sup>-12</sup>)  $\approx$  30. С учетом этого сравнение данных табл. 13-1, 13-3 и 13-4

						Расстр	ойка, кГ	ц		
Тра прием		Частота, МГц		6				10		
приса			вц	УРС	Тракт радио	Приемник	вЦ	УРС	Тракт радио	Приемпик
	УРС	0,147	1,17	1,17	1,36	3,1	1,44	1,44	2,06	390
		0,417				1				
AMC		26,6	1	1	I	2,24	1	1 1		190
11116	УПЧ	0,465	ФСС	Связанные контуры	Тракт ПЧ		ФСС	Связанные контуры	Тракт ПЧ	
			2	1,12	2,24		100	1,9	190	

Продолжение табл. 13-4

						Pac	стройка,	кГц				
Тра прием		Частота, МГц		2	4			t <sub>c</sub> - 465			930	
			вц	урС	Тракт радио			УЬС	Тракт радно	вц	УРС	Тракт радно
	УРС	0,147	2,83	2,83	8	>26000	10	10	100	38	38	1440
l		0,417					3,7	3,7	13,7	14,1	14,1	200
A MC		26,6	1	1	1	> 3200	2850	3380	96 - 105	3,6	4,5	16,6
AMC	УПЧ	0,465	ФСС	Связанные контуры	Тракт ПЧ							
			> 100	32	> 3200			ļ				

						Расстроі	іка, МГц			
Тра прием		Частота, МГц		0,09				0,1	8	
приси		ļ.	BIL	уРС	Тракт радно	Приемпик	вц	уРС	Тузк <b>т</b> радно	Присминк
	УРС	74,5	1	1	1	1,55	1	1	l	180
чмс	упч	8,4	ФСС	Связанные коптуры	Тракт НЧ		ФСС	Связанные контуры	Тракт ПЧ	
			1,4	1, I	1,55		60	3	180	

# Продолжение табл. 13-4

Тракт приеминка			Расстройка, МГц									
		Частота, МГц	0,54				$t_{\rm c} - 8.4$			16,8		
			BIL	УРС	Тракт радно	Приемник	вц	УРС	Тракт радио	вЦ	уРС	Тракт радио
ЧМС	УРС	74,5	1	1	38 000		81	292	23 800	5,6	19,4	109
	УПЧ	8,4	ФСС	Связанные контуры	Тракт ПЧ							
			> 1000	38	> 38 000							

показывает, что все характеристики селективности приемника значичельно выше требуемых.

2. Расчет характеристик чувствительности покажем на примере подднапазона 2.

На основанив данных п. 11 § 13-3 для средней частоты поддиапазона запас усиления составляет 2,9-1400,556 = 7,2. Следовательно, чувствительность приемника для этой частоты будет  $E_{A,920} = 0.7/7,2 = 0,097$  мВ, м. Для начала и конца поддиапазона с учетом данных табл. 13-3 будем иметь  $E_{A525} = \frac{1400}{1370}$  0,063 = 0,064 мВ,м и  $E_{A1640} = 0,76$  мВ/м. По полученным данным строят график зависимости чувствительности от частоты для каждого поддиапазона. Так в поддиапазонах 3—11 перекрытие по частоте очень малое, то для них чувствительность вычисляют лишь для средней частоты и графиков не строят. Так, для поддиапазона 11  $E_A = 110/2,9 = 34$  мкВ.

3. Амплитудная характеристика приемника находится по следующей методике. Покажем это на примере тракта АМС на средней частоте поддиапазона 11. Согласно п. 10 § 13-2 я рис. 13-1 коэффициент усиления перегулируемых каскадов высокочастотного тракта будет  $K_{\rm nep} = K_{0~\rm Bu}K_{0~\rm np2} = 1.58 \cdot 0.36 \cdot 49 = 27.8$ . При нулевом управляющем напряжении (см. п. 11 § 13-2) усиление регулируемых каскадов  $K_{\rm oper} = 9.75 \cdot 61 = 595$ . Полагая параметры выпрямителя APУ соответствующими примеру 11-2, получаем  $E_{\rm AO} = 0.5/(27.8 \cdot 595) = 0.000030~{\rm B}$ .

Схема первого регулируемого каскада резонансная, а второго — резисторная. Для первого каскада глубина регулирования определяется уравнением (11-10), а для второго — (11-13). Параметры первого каскада рассчитаны в примере 6-9 (g=0.0000586 См.  $p_2=0.066$ ,  $g_{11\, max}=7$  мСм.  $g_3=0.0000989$  См). Поэтому можно записать  $\Gamma_{K1}=\Gamma_{K1}^*=1$  —  $1 + 0.0000586 + 0.066^2 \cdot 0.007 \cdot 1 - 1 = 1 + 0.901 \left(\frac{1}{q}-1\right)$ . Под-

ставляя сюда значения q из табл. 11-3, окончательно получаем для  $U_2=0.75$  В  $\Gamma_{\rm K1}=1\pm0.901~(1/0.86\pm1)=1.145$ .

Результаты аналогичных расчетов для других входных напряжений выпрямителя АРУ приведены в табл. 13-5. Параметры второго

Таблица 13-5

	Напряжение <i>U</i> 2, В										
Параметр	0,5	0,75	1	1 1,25		1,75	2				
$\Gamma_{\kappa 1}$	1	1,145	1,351	1,654	2,145	3,14	5,95				
$K_1$	9,75	8,52	7,21	5,9	4,51	3,1	1,64				
$\Gamma_{\kappa_2}$	1	1.156	1,377	1,7	2,13	3,3	6,31				
$K_2$	61	52,\$	44,3	36,8	28,6	18,5	9,68				
$E_A$ , MKB	30	59	112	207	417	1100	4550				

каскада рассчитаны в примере 11-4 ( $G_{9K}=0.0014$  См,  $R_K=2.2$  кОм,  $g_{11/21}=0.0009$  См). 113 уравнения (11-13) получаем  $\Gamma_{K2}=\Gamma'_{K2}=1$   $\pm$  (0.000455 $\pm$  0.0009) 0.0014 ( $\Gamma_{K2}=\Gamma_{K2}=1$ ). Подстав-

ляя в это равенство значения q из табл. 11-3, паходим значения  $\Gamma_{\rm K2}$ . Они приведены в табл. 13-5. При увеличении выходного напряжения в 4 раза входной сигнал изменяется в 4550/30 == 150 раз, что больше требуемых 100.

Амплитудная характеристика приемника изображена кривой 5 на рис. 11-1. Сопротивление коллекторного резистора в резисторных каскадах трактов АМС и ЧМС одинаково (см. примеры 6-7 и 11-4), следовательно, коммутации нагрузок в коллекторной цепи не требуется.

Такие характеристики, как кривая верности, модуляционная и амплитудная характеристики нелинейных искажений, существенно зависят от свойств громкоговорителя. Поэтому их гасчет обычно не производят, а характеристики снимают при испытании приемвика.

Подсчитаем общий ток, потребляемый приемником от источника питания при приеме ЧМС. Согласно табл. 13-6 он равен 121,3 мА,

Таблица 13-

	ЪЬС	пч	प्रमप				УНЧ			
Параметр			1	2	3	OA	1	2	3	4
Потребляемый ток, мА	1,5	1,5	1,056	1,5	1,07	6,9	2,5	2,5	7	95,6

а потребляемая приемником мощность  $P_0=E_{80}I_{80}=12\cdot 0.1213=1.45$  Вт. что меньше допустимых по ГОСТ 2 Вт.

#### Глава четырнадцатая

## РАСЧЕТ ПРИЕМНИКА 2 КЛАССА НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРО-СХЕМАХ

# 14-1. Выбор типа интегральных микросхем и обоснование структурной схемы

В настоящее время выпускается несколько модификаций гибридных интегральных микросхем (ИМС) (К-224, К237, К112, К118 и др.). Они включают в себя транзисторы, резисторы с постоянным сопротивлением и конденсаторы малой постоянной емкости. Каждая модификация имеет несколько различных модулей, позволяющих выполнять группу каскадов приемника при добавлении внешие включаемых элементов: колебательных контуров, ФСС, катушек индуктивности, резисторов с переменным сопротивлением и конденсаторов большой емкости (обычно более 1000 пФ).

Наиболее удобной в настоящее время является модификация серии K237. Она позволяет выполнить радновещательный приемник для приема сигналов в поддиапазонах 1-11 всего на трех модулях. При добавлении еще двух модулей в приемник можно включить поддиапазон 12 [24]. Модуль K2ЖА371 служит для выполнения резистивного усилителя радносигнала  $(T_1)$ , баланеного преобразователя частоты  $(T_2-T_5)$ , отдельного гетеродина  $(T_4,T_6)$  и стабилизатора напряжения для

питания базовых цепей  $(T_3)$ . Его принципиальная схема приведена на рис. 14-1. Модуль K2MA372 (рис. 14-2) предназначен для выполнения усилителя напряжения промежуточной частоты (один каскад резо-

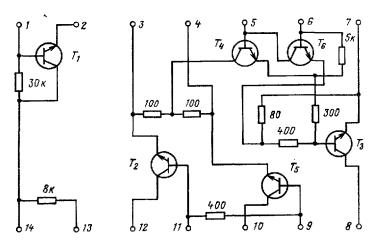


Рис. 14-1.

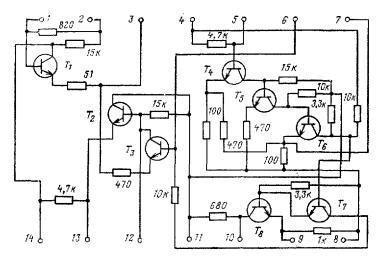
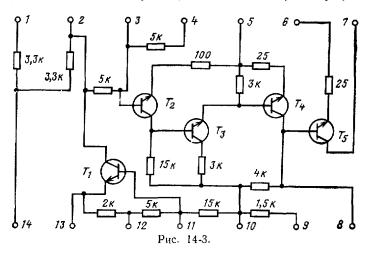


Рис. 14-2.

нансный на транзисторе  $T_1$  и три каскада резистивных на транзисторах  $T_4$ ,  $T_5$ ,  $T_6$ ), транзисторного детектора на двух транзисторах  $T_7$  и  $T_8$ , выпрямителя на транзисторе  $T_3$  и усилителя постоянного тока для задержанной и усиленной АРУ (на транзисторах  $T_3$  и  $T_2$ ).

Модуль типа K2VC371 (рис. 14-3) используется для создания предварительного пятикаскадного усилителя напряжения пизкочастотного гракта с однотактным выходом. При добавлении четырех транзисторов, образующих двухтактный бестрансформаторный выходной каскад, получается полная схема низкочастотного тракта приемника (рис. 14-3). С учетом сказанного эти три модуля позволяют построить супергете-



родинный приемник, имеющий структурную схему, показанную на рис. 14-4. Далее будет показано, что характеристики такого приемника соответствуют приемнику II класса, основные из них приведены в табл. 14-1. Кроме того, отметим следующие характеристики: промежуточная частота 465 кГи; система АРУ должна обеспечивать изменение выходного сигнала не более чем на 10 дВ в диапазоне входных сигна-

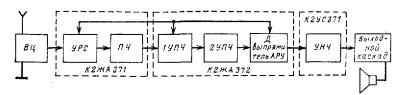


Рис. 14-4.

лов более 26 дБ; чувствительность со входа звукоснимателя не менее 0,25 В; ручная регулировка громкости не менее 50 дБ; среднее звуковое давление не менее 2,5  $\cdot$ 10<sup>6</sup> Па; грапичные частоты низкочастотного тракта — нижняя 200 Гц, верхняя 4 кГц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики менее 14 дБ; коэффициент гармоник при коэффициенте модуляции сигнала 0,8 не более 7 %; потребляемая от автономного источника питания при m=0,3 мощность не более

		Под	диапаз	юны
	Параметр	1	2	3-11
<sup>1</sup> [увствительность	со входа от внешней антен- ны не хуже, мкВ	150	150	200
cyberbarensanoem	при виутренней магнитной антение не хуже, м $\mathbf{B}_t$ м	2	I	
	сигнала при постройке <u>+</u> 10 кГц не менее, дБ	34	34	-
Селективность по ослаблению	зеркального капала не ме- пее, дБ	40	26	12
	сигналов с промежуточной частотой не менее, дБ	30	30	<b>3</b> 0

0,5 Вт; пормальное напряжение источинка питания 9 или 6 В (минимальное 5,6 или 3,8 В).

Расчет приемпика произведем, предполагая прием AMC на поддиапазонах 1—11.

### 14-2. Составление принципиальной схемы приемника

Для рассчитываемого приемника подходят громкоговорители типа 1ГД-37 или 1ГД-4А. Возьмем громкоговоритель 1ГД-37, обладающий следующими характеристиками:  $F_{\rm B}=150$  Гц,  $F_{\rm B}=10$  кГц, сопротивление постоянному току 6,5 Ом [11, 24]. Необходимую мощность сигнала для этого типа громкоговорителя обеспечивает модуль K2УС371 с дополительным выходным бестрансформаторным каскадом, изображенным арис. 14-5. В табл. 14-2 приведены основные характеристики выбранных модулей микросхем.

Согласно сказанному ранее микромодули № 1 и 2 позволяют подключить по промежуточной частоте лишь две селективные системы (на выходе микромодуля № 1 любую и в коллекторной цепи транзистора  $T_1$  микросхемы № 2 — резонансный контур). На основания данных § 2-4 полоса пропускания приемника не может быть уже 11-12 кГи. Вяяв полосу пропускания равной 11 кГц, с учетом ослабления соседнего канала (см. табл. 14-1) необходимый коэффициент прямоугольности кривой селективности вычисляем по формуле (2-111)  $K_{\pi,50} = 2 \cdot 10/11 = 1,82$  Из рис. 2-14 следует, что такой коэффициент прямоугольности может обеспечить лишь один четырехзвенный ФСС. Поэтому на выход микросхемы № 1 целессобразио подключать фильтр тип 14-12 (13 табл. 14-13) выписываем его основные параметры: 14-12 14-13 табл. 14-13 выписываем его основные параметры: 14-13 14-13 табл. 14-13 выписываем его основные параметры: 14-13 кСм. Следовательно, коэффициент включения входа фильтра ка выходу микро-

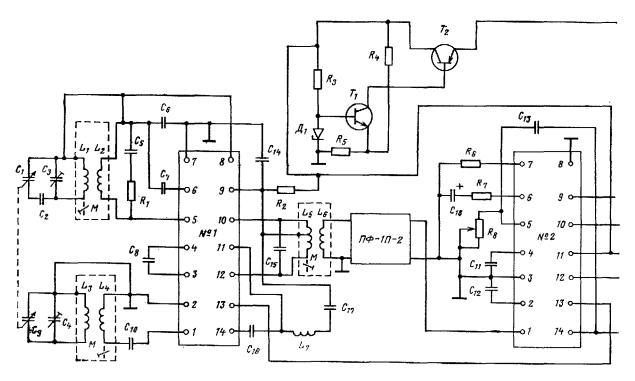
схемы К2ЖА371 должен быть p = 1  $\frac{\overline{g_{\text{пых}(I)}}}{g_{\text{вх. ф}}} = 1$   $\frac{0,0001}{0,000835} = 0,345$ . Таким образом, минимальное усиление сигнала в микросхеме № 1 с выбранной нагрузкой будет  $K_{\text{в1}} = 73 \ qp = 73 \cdot 0,25 \cdot 0,345 = 6,3$ .

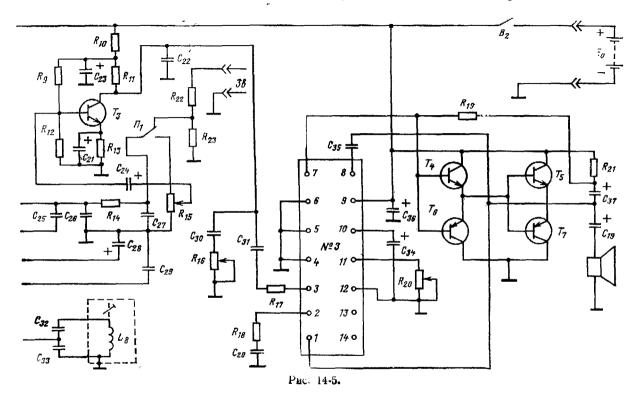
Таблина 14-2

	Параметр			K2ЖA371 (№ 1)	K2ЖA372 (№ 2)	K2УC371 (№ 3)
Амилитуда нор при $m = 0.3$ ,		дного с	сигнала		0,0120,035	J5 <del>-20</del>
Амплитуда нор при $m=0,3,$		одного (	сигнала		30	680
Коэффициент сигнала, кГц	усиленкя на ч	астоте	150	130150	-	_
			465	~	860 <b>25</b> 00	
			15 (0)	7384	_	
Нормальное сопротивле	входное на честоте	0,5 МГц		1,5	0,51	0,3
нис, кОм		15 /	МГц	0,5	-	_
	выходное	по сі	налу	10	880,0	0,0065
		жени	напря- пете- цина	4		
Погребляемый	ток (покоя) пе	более.	мА	3	4	5
Напряжение п	атапия, В			5	5	9

Согласно табл. 14-2 максимальный входной сигнал микросхемы № 3 30 мВ, что равно нормальному выходному сигналу микросхемы № 2. При этом максимальный входной сигнал микросхемы № 2 равен 35 мкВ, а минимальный входной сигнал микросхемы № 1 должен быть 35/6,3 == 5,6 мкВ.

В табл. 13-3 приведены подробные характеристики селективных систем радиотракта приемника I класса для поддиапазонов 2 и 11. Воспользуемся основными из них, определяющими диапазонные свойства и действующую высоту антенны, для дальнейшего расчета. В и. 3 §2-5 минимальная полоса пропускания радиотракта для приемника I класса выбрана равной 13 кГи. Это значение сохраним для рассчитываемого приемника. В его радиогракте имеется лишь одна селективная система — одивочный коптур входной цепи. Его эквивалентное затуха-





ние в начале поддиапазона 2 согласно формуле (2-100) и табл 2-12 должно быть  $\delta_s = \frac{13}{515} 1 = 0.0252$  По (2-64) вычисляем обобщенные расстройки, соответствующие промежуточной частоте на ближней частоте сигнала и зеркальному каналу по максимальной частоте поддиапазона,  $\xi_{\rm np} = \frac{1}{0.0252} \left| \frac{515 - (515 - 465)}{515} - \frac{515}{515 - (515 - 465)} \right| = 8.22$  и  $\xi_3 = \frac{1}{0.0252} \left| \frac{1640 + 2 \cdot 465}{1640} - \frac{1640}{1640 + 2 \cdot 465} \right| = 36.8$  Из (2-63) находим минимальные ослабления в раднотракте зеркального канала  $d_3 = \sqrt{1+36.8^2} = 36.8$ , что больше допустимого и по промежуточной частоте  $d_{\rm np} = \sqrt{1+8.22^2} = 8.28$ , что в 31,8/8,28 = 3,85 раза меньше необходимого. Поэтому в радногракте необходимо включить контур для увеличения ослабления сигналов с промежуточной частотой.

Входная проводимость микросхемы № 1 согласно рис. 14-1 определяется входной проводимостью транзистора КТ307Г. Его параметры на частоте 515 кГц:  $g_{11}=0.8$  мСм и  $C_{11}=60$  пФ. По формуле (5-37) вычисляем необходимую индуктивность катушки связи  $L_{\rm cs}=0.44$  (0,0252—0,01)/(0,0008-515-000) =  $162\cdot10^{-7}$  Гн. По (5-3) вычисляем коэффициент включения входа микросхемы № 1 к контуру входной цепн  $p_2\approx0.6$   $\sqrt{0.000162}_{0.000242}=0.156$ , что меньше, чем принято в примере 5-4. Поскольку входные емкости гранзисторов ГТ308В и КТ307Г близки, то при малом  $p_2$  необходимый коэффициент днапазона будет обеспечен. По (5-40) вычисляем эквивалентиюе затухание контура для средней и максимальной частот поддвапазона, полагая  $g_{11.920}=0.85$  мСм и  $g_{11.1640}=1$  мСм:  $\delta_{9420}=0.01\left(1+2.26\frac{0.0000162}{0.01},0.00085\cdot920,000\right)=0.0387$  и  $\delta_{91640}=0.076$  Нз (5-41) находим значения коэффициента передачи входной цепн  $K_{08.0515}=\frac{0.6}{0.0252}$   $\sqrt{0.0000162}_{0.000242}=6.2$ . Для частот 920 и 1640 кГц получаем соответственно 4 и 2.05.

Выходной сигиал входной цепи определяется соотношением  $U_{m_1} = Eh_3K_{0-BH}$ . Для начала поддианалона  $U_{m_3 1.5} = 10^{-3} \cdot 0,0053 \cdot 6,2 = 33 \cdot 10^{-6}$  В,  $U_{m_3 20} = 38 \cdot 10^{-6}$  В и  $U_{m_4 15 10} = 35 \cdot 10^{-6}$  В. Следовательно, сигнал на входе микросхемы  $N^2$  1 будет в  $33 \cdot 5,6 = 5,9$  раза больше требуемого. Для поддианазона 11 полоса пропускания входной цени во много раз шире полосы пропускания приемника. Поэтому эквивалентное затухание контура возьмем из условия необходимого ослабления зеркального канала. По (2-84) получаем  $\delta_{\mathfrak{p}_1}$  с  $= \frac{4 \cdot 465 \cdot 000}{266 \cdot 10^5} \sqrt{4^2 - 1} = 0,0181$ .

При этом из (2-64) находим 
$$\xi_{\rm np} = \frac{1}{0,0181} \left| \frac{25,1-(25,1-0,465)}{25,1} - \frac{25,1}{25,1-(25,1-0,465)} \right| - 3160$$
 и по (2-63) получаем  $d_{\rm np} =$ 

 $=V1+3160^2=3160$ , что больше необходимого. Следовательно, при выбранном эквивалентном затухании контура входной цепи требуемая селективность в поддиапазоне 11 обеспечивается.

Возьмем диапазонные характеристики входного контура и антенны такими же, как в примере 5-2. Согласно табл. П-1-2 входная проводимость транзистора КТ307Г на средней частоте рассматриваемого поддиапазона равна 2,3 мСм. Поскольку эквивалентное затухание контура задано, то рассчитываем входную цепь на получение максимального коэффициента передачи. Для этого согласно (5-5) и (5-6) коэффициенты

включения должны быть 
$$p_1 = \sqrt{\frac{0,0000586}{2 \cdot 0,0000203} \left(\frac{0,0181}{0,01} - 1\right)} = 1,08$$
 и  $p_2 = \sqrt{\frac{0,0000586}{2 \cdot 0,00023} \left(\frac{0,0181}{0,01} - 1\right)} = 0,1$ . Коэффициент передачи вычис-

ляем по равенству (5-9)  $K_{0\mathrm{B},\mathrm{H}} = \frac{0.5}{\sqrt{\frac{1}{0.0000203}}} \left(1 - \frac{0.01}{0.0181}\right) = 0.021,$ 

Амилитуда сигнала на выходе входной цепи в поддиапазоне 11 будет  $U_{m1}=2\cdot 10^{-4}\cdot 0.021=42\cdot 10^{-7}$  В, что составляет 4.2/5.6=0.75 минимального необходимого. В предыдущих расчетах принимальсь минимальные коэффициенты усиления, за счет чего в приемнике иместся запас усиления около 30-50~%. Благодаря этому скомпенсируется малый коэффициент передачи вхо лой цепи поддианазона 11. Кроме того, при детальном расчете можно также изыскать возможности для увеличения усиления приемника.

Согласно табл. 14-1 чувствительность низкочастотного тракта со входа звукоснимателя 0,25 В, что в 0,25/0,03 = 8 раз больше минимального входного сигнала микросхемы № 3. Для выходного сигнала звукоснимателя перед входом микросхемы № 3 следует включить делитель напряжения с коэффициентом деления 8. С учетом сказанного можно составить принципиальную схему приемника. На рис, 14-5 она приведена для поддвапазона 2. В дальнейшем проведем расчет ее элементов с учетом наличия в приемнике других поддвапазонов.

# 14-3. Расчет элементов схемы приемника, подключающихся к микросхемам

На корпусе каждой интегральной микросхемы (у выводов) указываются параметры тех внешие присоединяемых элементов, характеристики которых достаточно жестко лимитированы. Но для некоторых выводов таких указаний не дается и параметры подсоединяемых к инм внешних элементов могут быть рассчитаны и уточнены в процессе налаживания приеминка. Рабочие режимы транзисторов микросхем обеспечиваются, если напряжение пигания соответствует паспортным данным.

1. Входная цепь. Все ее параметры для поддиапазонов 2 и 11 подробно определены в § 14-2. В данном параграфе рассчитывают недостающие параметры элементов схемы. Емкость разделительного конденсатора  $C_{10}$  должна соответствовать неравенствам (6-5)  $C_{10} \geq (30 \div 100)$  (0 = 1800 ÷ 60 000 пф и  $C_{10} \geq (10 \div 20)$  0,0008/515 000 =  $(15 \div 30) \cdot 10^{-9}$  Ф (берем конденсатор емкостью 0,022 мкФ).

2. Основные параметры гетеродинного контура рассчитываются с учетом необходимого сопряжения настроек по методам § 8-2. Для поддиапазона 2 параметры контура рассчитаны в примере 8-1, их значения сохраняются. По (8-15) вычисляем индуктивность катушки связи  $L_{\rm cs}=L_2=0,25\cdot133\cdot10^{-6}=33\cdot10^{-6}$  Ги. Согласно табл. 14-2 проводимость от гетеродинного контура, пересчитанная к выводам катушки связи,  $g_{\rm cs}=25\cdot10^{-5}$  См. Следовательно, коэффициент включения

между контуром и катушкой связи определится в начале подднапазона равенством  $p_{\rm r}=\sqrt{\frac{g}{g_{\rm cB}}}=\sqrt{\frac{12\cdot 10^{-6}}{25\cdot 10^{-5}}}=0,22$ . Для его осуществления коэффициент связи между катушками согласно (5-3) должен быть k=0,22  $\sqrt{\frac{133\cdot 10^{-6}}{33\cdot 10^{-6}}}=0,44$ . Он осуществим при многослойных катушках, при общем стержисвом магнитном сердечнике катушек или при намотке витков катушек связи между витками гетеродинной катушки. В поддиапазоне 2 чаще всего применяются второй и третий методы.

3. Емкость выходного контура микросхемы № 1, настраиваемого на промежуточную частоту, вычисляем по (2-153)  $C_{15} = 0.0003/465~000 =$  $=645 \cdot 10^{-12} \, \Phi$ . С учетом монтажных емкостей по табл. П-3-2 берем кондеисатор емкостью 620 пФ. Индуктивность контурной катушки находим (2-101)  $L_5 = 1/(6.28^2 \cdot 465^2 \cdot 10^6 \cdot 645 \cdot 10^{-12}) = 182 \cdot 10^{-6} \, \text{Гн.}$  Индуктивность катушки связи со входом ФСС вычисляем по формуле (8-15)  $L_6=0.25\cdot 182\cdot 10^{-6}=46\cdot 10^{-3}$  Ги. Полагая  $\delta=0.01$ , собственную проводимость контура находим по (2-55)  $g_{\rm up}=0.01\cdot 6.28\cdot 465\ 000\cdot 645\times 10^{-12}=188\cdot 10^{-7}$  См. Чтобы этот контур не влиял на результирующую полосу пропускания приемника, выберем его полосу пропускания из условия  $H_{\rm inp}=1,25$   $H_{\rm dec}=1,25\cdot 11\,000=13\,700$  Гц. Для ее осуществления эквивалентное затухание контура определяем по равенству вления эквиваленное затухание контура определяем по равенству (2-85)  $\delta_{9, \text{ пр}} = 13700/465000 = 0,0294$ . Согласно табл. 14-2 эквивалентная проводимость контура должна быть  $10^{-4}$  См, а согласно табл. 2-7 входная проводимость ФСС  $g_{\text{вх}} = 835$  мкСм. Следовательно, коэффициент включения связи должен быть  $p_{\text{пр}} = \sqrt{\frac{g_{\text{пр}}}{g_{\text{вх}}} \times \frac{\delta_9}{\delta}}$ 

 $=V^{-188+10^{-7}} \frac{(0,0294)}{835+10^{-8}} = 0,21$ . Для его осуществления коэффециент связи между катушками вычисляем по (5-3) k=0,21 imes $imes \sqrt{rac{182 \cdot 10^{-6}}{46 \cdot 10^{-6}}} = 0,42$ . Он может быть обеспечен при многослойных

4. Последовательный контур  $L_7 - C_{16}$  является режекторным. Он служит для ослабления сигналов с промежуточной частотой и настраивается на нее. В резистивном каскаде его индуктивность должна удовлетворять неравенству  $L_{\Phi} < \frac{R_{\rm K}}{\delta_{\Phi} \omega_{\rm np} d_{\Phi}}$ . Положив  $d_{\Phi} = 20$ , получим  $L_{\Phi} < \frac{8000}{0.01 \cdot 6.28 \cdot 465\ 000 \cdot 20} = 0.0136$  Гп. С некоторым запасом возь-

мем  $L_7=0,001$  Гн и по (2-101) находим  $C_{10}=\frac{1}{6,28^2\cdot 465\,000^2\cdot 0,001}=$  $=117\cdot 10^{-12}$  Ф (берем конденсатор емкостью 120 пФ).

Резистор  $R_2$  и конденсатор  $C_{14}$  образуют развязывающий фильтр питания микросхемы № 1. Чтобы при потребляемом токе около 3 мЛ падение напряжения на резисторе не превышало 0,5 В, выбираем сопро->  $\frac{1.3 \div 20}{147\ 000 \cdot 150} = (45 \div 90) \cdot 10^{-8} \ \Phi$  (берем конденсатор емкостью  $0.68 \text{ MK}\Phi$ ).

Конденсатор  $C_{17}$  является разделительным, предотвращающим замыкание резистора сопротивлением 400 Ом (внутри микросхемы  $\Lambda \ge 1$ ) катушков  $L_7$ . Чтобы он не влиял на параметры контура  $L_7 - C_{15}$ . его емкость делжна быть  $C_{17} = (20 \div 40)$   $C_{16} = (20 \div 40) \cdot 120 = 2400 \div 4800$  пФ (берем конденсатор емкостью 3300 пФ).

Конденсатор  $C_{\theta}$  шунтирует эмиттерные резисторы транзисторов преобразователя частоты. Его емкость должна удовлетворять нера-

венству (3-19)  $C_8>\frac{10\div20}{147\,000\,(100+100)}=(68\div136)\cdot10^{-8}$  Ф (выбираем конденсатор емкостью 1 мкФ). Конденсатор  $C_7$  подсоединяет катушку связи с гетеродинным контуром к транзисторам гетеродина. Его емкостное сопротивление на минимальной частоте гетеродина должно быть в 20-30 раз меньше индуктивного сопротивления катушки, т.е.  $C_7>(20\div30)/[6,28^2\,(147+465)^2\cdot10^8\cdot33\cdot10^{-6}]=(4\div8)\cdot10^{-9}$  Ф (берем конденсатор емкостью 6800 пФ). Конденсатор  $C_6$  служит для соединения с шасси приемника верхнего на схеме конца катушки и должен иметь малое сопротивление по отношению к сопротивлению катушки

связи. Его емкость должна равняться емкости конденсатора  $C_7$ . 5. Входная проводимость микросхемы № 2 1—2,5 мСм достаточно близка к выходной проводимости ФСС — 417 мКСм. Поэтому соединение выхода ФСС со входом микросхемы № 2 может выполняться без добавсчных согласующих элементов. Конденсатор  $C_{12}$  вместе с резистором 15 кОм внутри микросхемы № 2 является своеобразным фильтром котлекторной цепи транзистора  $T_1$ . Его емкость должна удовлетворять перавенству (3-19) для частот всех поддиапазонов  $C_{12} > (10-20)$ 

 $> \frac{C_{14}}{147\,000\cdot 15\,000} = (45\div 90)\cdot 10^{-10}$  Ф (берем конденсатор емкостью 6800 пФ). Конденсатор  $C_{11}$  совместно с резисторами 4,7 и 10 кОм (внутри микросхемы) образует потенциометр питания базы транзистора  $T_{4}$ . Емкость конденсатора  $C_{11}$  должна удовлетворять неравенству (3-19) по оти жиению к резистору с сопротивлением 10 кОм, т. е.  $C_{11}>$ 

>  $\frac{(10\div20)}{147\,000\cdot10\,000}=(68\div136)\cdot10^{-10}$  Ф (принимаем конденсатор ем-

костью 0,01 мкФ).

6. Контур  $L_8C_{32}C_{33}$  является селективной системой первого каскада УПЧ на траизисторе  $T_1$ . Он настраивается на промежуточную частоту. Возьмем его индуктивность и эквивалентиую емкость такими же, как у контура  $L_5 - C_{15}$ , и будем полагать для него  $\delta = 0.01$ ,  $g = 188 \cdot 10^{-7}$  См,  $\Pi = 13.7$  кГи и  $\delta_3 = 0.0294$ . Нагрузкой первого каскада является входная проводимость траизистора  $T_4$  микросхемы № 2 ( $g_{8X4} \approx 0.0008$  См). Согласно рис.  $14 \cdot 2$  схема питания коллекторной цепи траизистора  $T_1$  параллельная. Коллекторное напряжение подводится через резистор сопротивлением 4,7 кОм. Оно в основном и определяет выходную проводимость траизистора. Для упрощения схемы контура коэффициенты включения к выходу траизистора  $T_1$  и ко входу траизистора  $T_4$  взяты одинаковыми. Поэтому для обеспечения необходимого эквивалентного затухания контура коэффициент включения

должен быть  $p=\sqrt{\frac{g}{g_{11(4)}+g_{22(1)}}}\left(\frac{8_9}{8}-1\right)=\sqrt{\frac{188\cdot 10^{-7}}{8\cdot 10^{-4}+1/4700}}\times \frac{(0.0294/0.01-1)}{(0.0294/0.01-1)}=0.19$ . Для приближенного расчета можно положить в (7-11) и (7-12)  $C_{\rm M2}=0$ ,  $C_{11(2)}=0$ ,  $C_0=0$ . Тогда емкости контура должны быть  $C_{33}=C_9/p^2=620/0.19^2=17\,100$  пФ и  $C_{32}=620/0.19\,(1-0.19)=4000$  пФ (берем конденсаторы емкостью 0.018 мкФ и 3900 иФ). Конденсатор  $C_{13}$  является разделительным между первым

и вторым каскадами УПЧ. Его емкость должна удовлетворять перавенствам (6-5). Для транявстора  $T_4$  (КТЗ19Г) на частоте 465 кГи  $C_{11}\approx 100$  пФ и  $g_{11}\approx 0.8$  мСм. Тогда  $C_{13}\geqslant (30\div 100)\cdot 100=3000\div 1000$  пФ и  $C_{13}\geqslant (10\div 20)$  0,0008/465 000 =  $(17\div 34)\cdot 10^{-9}$  Ф (берем конденсатор емкостью 0,022 мкФ). Резистор  $R_8$  вместе с резисторамы 4,7 и 10 кОм микросхемы образуют потенциометр литания базы траняистора  $T_4$ . Изменением его сопротивления регулируется рабочая точка транямстора  $T_4$  и коэффициент обратией снязи, а следовательно, и усиление этого каскада. Его сопротивление с некоторым запасом должно примерно вдвое пренышать сопротивление второго плеча потенциометра (берем резистор с переменным сопротивлением 33 кОм).

7. Резистор  $R_6$  включен наразлельно резистору в цепи эмиттера транзистора  $T_6$ . Согласно рис. 14-2 резисторы в цепях эмиттера транзисторов  $T_1$ ,  $T_5$  и  $T_6$  не шунтируются емкостями, благодаря чему в каскадах создается отрицательная обратная связь (для уменьшения искажений и повышения стабильности работы). Подбирая сопротивление резистора  $R_6$ , можно в некоторых пределах регулировать эту отрицательную обратную связь, а следовательно, и усиление микросхемы  $N_2$  Сопротивление этого резистора должно в 2-3 раза превышать сопротивление эмиттерного резистора (100 Ом) (выбираем его равным

270 Ом).

8. Цель  $R_7$ ,  $C_{18}$  совместно с резистором 10 кОм, включенным в цепь базы транзистора  $T_3$ , образует фильтр АРУ. Сопротивление резистора  $R_7$  берется малым (десятки — сотин Ом) и практически не влияет на постоянную времени фильтра. Емкость конденсатора определяется неравенством (11-9)  $C_{18} \geqslant (5\div 10)/(200\cdot 10\ 006) = (25\div 50)\cdot 10^{-7}\ \Phi$  (выбираем электролитический конденсатор емкостью 5 мк $\Phi$  и резистор

сопротивлением 100 Ом).

Конденсатор  $C_{29}$  служит для создания нулевого потенциала базы транзистора  $T_2$  микросхемы  $N\!\!\!\!/\, 2$  (выходной каскад APV). Его емкость должна удовлетворять (3-19) по отношению к минимальной модулирующей частоте и сопротивлению резистора 15 кОм, находящемуся внутри микросхемы (рис. 14-2),  $C_{29} \geqslant (10 \div 20) \cdot (200 \cdot 15\ 000) = (33 \div 66) \cdot 10^{-7}\ \Phi$  (выбираем конденсатор емкостью 5 мк $\Phi$ ). Конденсатор  $C_{28}$  служит для фильтрации напряжения питання микросхемы  $N\!\!\!\!/\, 2$ . Его емкость берут около 50—100 мк $\Phi$  (берем электролитический конденсатор емкостью 100 мк $\Phi$ ).

Конденсатор  $C_{25}$  совместно с резисторами 680 Ом внутри микросхемы  $\mathbb{N}_2$  образуют фильтр по токам промежуточной частоты коллекторной цели транзисторов  $T_7$  и  $T_8$  (детектора). По (3-19) находим его емкость  $C_{25} \geqslant (10 \div 20)/(465\ 000 \cdot 680) = (32 \div 64) \cdot 10^{-9}\ \Phi$  (выбираем кон-

депсатор емкостью 0,033 мкФ).

9. Выходном каскадом микросхемы № 2 (рис. 14-2) является каскад с транэнстором  $T_8$  по схеме с ОК. Ето выходное сопротивление определяется первой формулой (2-72). Оно обычно составляет 20—30 Ом. Входное сопротивление микросхемы № 3 определяется входным сопротивлением транзистора  $T_2$  (КТ319Д), использующегося в схеме с ОЭ. Оно составляет примерно 300—500 Ом. Поскольку  $R_{\rm RX3}\gg R_{\rm Bых2}$ , то можно подключать выход микросхемы № 2 ко входу микросхемы № 3 непосредственно (это подключение не скажется на режиме работы выходного каскада микросхемы № 2, но при этом фильтрация папряжения промежуточной частоты будет недостаточна). Поэтому между выходом микросхемы № 2 и входом микросхемы № 3 включают фильтр нижних частот  $C_{26}$ ,  $R_{14}$ ,  $C_{27}$ . Сопротивление резистора  $R_{14}$  берут на порядок больще  $R_{3X/3}$  (возымем резистор сопротивлением 6,8 кОм). Емкостное сопро-

тивление конденсатора  $C_{26}$  на высшей модулирующей частоге должно составлять (50—100)  $R_{-,1\times 2}$ , а  $C_{27}$ — (0,05—0,1)  $R_{14}$  на промежуточной частоге В соответствки с этим их емкости должны быть:  $C_{26}\approx 1/(70\times 8,28\cdot 4000\cdot 30)=2\cdot 10^{-8}$  Ф,  $C_{27}=1/(0,07\cdot 6,28\cdot 465,000\cdot 6800)\approx 7\times 10^{-10}$  Ф (выбираем конденсаторы емкостью 0,018 мкФ и 750 пФ).

Для передачи большей части выходного сигнала детектора (микросхемы № 2) к резистору ручного регулятора громкости  $R_{15}$  его сопротивление должно составлять  $(10 \div 20)$   $R_{14}$ , г. е.  $R_{15} = (10 \div 20) \cdot 6800 = (68 \div 136) \cdot 10^3$  Ом (принимаем резистор сопротивлением 100 кОм).

Чтобы малое входное сопротивление микросхемы № 3 существенно не уменьшало глубины регулирования РРГ, последовательно со входом микросхемы № 3 включают дополнительный резистор  $R_{17}$  с сопротивлением, в 5—10 раз превышающим  $R_{\rm RV,3}$ . Выбираем  $R_{17}\approx (5+10)$  (300÷ 500) = 1500÷5000 Ом (берем резистор сопротивлением 3,3 кОм). Конденсатор  $C_{31}$  разделительный. Его сопротивление на нижней модулирующей частоте должно быть менее 0.01-0.03 суммы сопротивлений резисторов  $R_{14}$  и  $R_{17}$ , т. е.  $C_{91}>(30+100)/[6.28+200(6800+3300)]=$  =  $(24+80)\cdot 10^{-7}$  (берем электролитический конденсатор емкостью 5 мкФ).

Коэффициент передачи сигнала с выхода микросхемы № 2 на вход микросхемы № 3 при наличии резисторов  $R_{14}$  и  $R_{17}$  определяется формулой  $K_{11} = R_{123}/(R_{14} + R_{17} + R_{1038})$  Он равен  $K_{11} = 400/(6800 + 3300 + 400) = 0,038$ . Согласно табл. 14-2 выходной сигнал микросхемы № 2 и входной сигнал микросхемы № 3 практически равны. Для компенсации потерь сигнала за счет включения резисторов  $R_{14}$  и  $R_{17}$  междумикросхемами № 2 и 3 следует включить добавочный усилитель с коэффициентом усиления  $K_{0} = 1/K_{0} = 26,3$ . Его может обеспечить резисторный усилитель по схеме с ОЭ на транзисторе  $T_{3}$  МПЗ5 (см. рис. 14-5).

10. Исходные дакные для расчета этого резисторного усилителя: коэффициент усиления  $K_0=35$  (с запасом для компенсации педостатка усиления раднотракта в поддиапазоне 11- см. § 14-2),  $F_{\rm H}=200$  Гц,  $F_{\rm H}=4000$  Гц,  $M_{\rm H}=M_{\rm B}=1.26,~E_{\rm K}=9$  В. Параметры транзистора при типовом режиме:  $U_{\rm K}\ni=5$  В;  $U_{\rm B}\ni=0.25$  В;  $I_{\rm K}0=2.5$  мА;  $I_{\rm B}0=1.5$  мА;  $I_{\rm B}0=1.5$  мКА;  $I_{\rm B}1=1.5$  мКА;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мКСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мКСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мКСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мКСм;  $I_{\rm B}1=1.5$  мСм;  $I_{\rm$ 

Данные примера 4-1 показывают, что при малых входных сигналах (менее 0,05 В) нелинейные искажения резисторного каскада не превышают 1 %. Поэтому проведем упрощенный расчет каскада без определе-

пия коэффициента гармоник.

С учетом резистора  $R_{17}$  входное сопротивление следующего каскада будет  $R_{\rm BX}=R_{17}+R_{\rm BX3}=3300+400=3700$  Ом. Из (4-3) находим необходимую эквивалентную проводимость нагрузки  $G_{\rm 9K}\approx Y_{21}/K_0=0,05/35=0,0014$  См. Положим  $R_6'=R_6''=\infty$  и из (4-4) вычислим необходимое сопротивление коллекторного резистора:  $1/R_{\rm K}=0,0014-0,0002-1/3700=0,0013$  См (берем резистор  $R_{11}$  сопротивлением 910 Ом). Возьмем сопротивление резистора фильтра  $R_{10}$  равным 560 Ом. По (3-19) вычисляем емкость конденсатора фильтра  $C_{23}>(10\div20)/(200\cdot560)=(9\div18)\cdot10^{-5}$  Ф (выбираем электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ).

Подставляя в (3-16)  $R_{11}+R_{10}$  вместо  $r_1$ , получаем  $U_1=25\cdot 10^{-4}$  (910+560) = 3,67 В. 113 (3-17) находим  $U_{R_2}=9$ —3,67—5 = 0,33 В.

Сопротивление эмиттерного резистора вычисляем по формуле (3-18)  $R_{13}=0.33/(0.0025+0.000015)=132$  Ом (берем резистор сопротивлением 130 Ом). Емкость эмиттерного конденсатора находим по (3-19)  $C_{21}>(10\div20)/(200\cdot130)=(4\div8)\cdot10^{-4}$  (берем электролитический

конденсатор емкостью 500 мкФ). Находям по (3-20)  $U_{R_6'} = 0.33 + 0.25 =$ 

= 0,58 В. Задаемся током потенциометра питания базы  $2\cdot 10^{-4}$  А и вычисляем по формулам (3-22) и (3-23)  $R_{12}=0,58/(2\cdot 10^{-4})=2900$  Ом и  $R_9=(9-0,0025\cdot 560-0,58)/(0,0002+0,000015)=32\ 600$  Ом (выбираем резисторы сопротивлением 3 и 33 кОм). Емкость переходного конденсатора  $C_{24}$  берем такой же, как у  $C_{31}$ .

11. Цепь  $C_{30}$ ,  $R_{10}$  является ручным регулятором верхней граничной частоты. Положим монтажные емкости коллекторной цепи каскада равными 20 пФ. За счет наличия резистора  $R_{17}$  к коллекторной цепи транзистора от входа микросхемы № 3 подключается емкость  $C_{11}' =$ 

 $=\frac{C_{\text{вх3}}}{R_{17}^2 4 \pi^2 F_{\text{B}}^2 C_{\text{вх3}} + 1} = \frac{3 \cdot 10^{-8}}{3.3^2 \cdot 10^6 \cdot 4 \cdot 3.14^2 \cdot 16 \cdot 10^6 \cdot 9 \cdot 10^{-16} + 1} = 42 \times \\ \times 10^{-10} \text{ Ф. По формуле (4-5) вычисляем для верхней частоты модулящий } C_{\text{вк}} = 600 - 20 + 4200 = 4820 \text{ пФ. По (2-20) получаем } M_{\text{в.т}} = \\ = \sqrt{1 + \left[\frac{4000}{10^6 (1 - 0.94)}\right]^2} = 1.0015. \text{ Из (4-6) шаходим необходимую}$ 

эквивалентную емкость каскада  $C_{9K}^{\prime} \sqrt{\left(\frac{M_{\rm B-K}}{M_{\rm B,T}}\right)^2 - 1} - \frac{G_{9K}}{2\pi F_{\rm B}} =$ 

 $=\sqrt{\frac{1,26}{1,0015}}^2-1-\frac{0,0014}{6,28\cdot4000}=43\cdot10^{-8}~\Phi.~$ Следовательно, параллельно резистору  $R_{11}$  следует добавить емкость  $C_{no6}=C_{22}=20$  емкостью 0,039~ мк $\Phi$ ). Будем считать минимальную верхнюю грашичную частоту каскада равной  $F_{n~min}=1,5~$  к $\Gamma$ и. По (12-7)~ вычисляем емкость конденсатора  $C_{30}=43~000\cdot(4000/1500-1)=71~000~$  п $\Phi$  (берем конденсатор емкостью 0,068~ мк $\Phi$ ). По (12-8)~ получаем  $R_{16}>\sqrt{\frac{68\cdot10^{-9}-0,01\cdot43\cdot10^{-9}}{0,4\cdot43\cdot10^{-9}\cdot16\cdot10^{6}\cdot68^{2}\cdot10^{-18}}}=72~500~$  Ом (берем резистор

сопротивлением 100 кОм).

12. Цепь  $R_{18}$ ,  $C_{20}$  служит для регулировки глубины обратной связи в каскадах микросхемы № 3. Ее параметры обычно равны  $R_{18}=68$  Ом и  $C_{20}=100$  мкФ и подбираются экспериментально. Изменением сопротивления резистора  $R_{19}$  можно регулировать усиление микросхемы. № 3. Резистор  $R_{20}$  определяет подбор режима транзисторов микросхемы. Его сопротивление должно быть 180 кОм. Конденсатор  $C_{35}$  замыжает цени обратной связи с выхода третьего  $(T_4)$  на вход первого  $(T_2)$  каскадов микросхемы № 3. Его емкость должна быть равна 3300 пФ. Резистор  $R_{19}$  является нагрузкой выходного каскада  $(T_5)$  микросхемы

Резистор  $R_{19}$  является нагрузкой выходного каскада  $(T_5)$  микросхемы № 3. Его сопротивление должно быть равно 2 кОм. Резистор  $R_{21}$  и конденсатор  $C_{37}$  образуют развязывающий фильтр коллекторной цепи выходного каскада микросхемы № 3. Сопротивление резистора берут равным 1,3 кОм. Емкость конденсатора согласно (3-19) должна быть  $C_{37} \ge (10 \div 20)/(200 \cdot 1300) = (4 \div 8) \cdot 10^{-6} \, \Phi$  (берем электролитический конденсатор емкостью 50 мк $\Phi$ ). Конденсатор  $C_{38}$  является фильтрующим для питающего напряжения всего приемника. Его емкость следует брать возможно большей. Возьмем электролитический конденсатор емкостью 500 мк $\Phi$ .

Конденсатор  $C_{19}$  является разделительным для включения нагрузки (громкоговорителя). Его сопротивление на низшей модулирующей частоте должно составлять менее 0,05 сопротивления громкоговорителя, т. е.  $C_{19} > 20/(6,5 \cdot 6,28 \cdot 200) = 0,0025$  Ф (выбираем электро-

литический коиденсатор емкостью 2000 мкФ). Конденсатор  $C_{34}$  вместе с резистором 1,5 кОм образует фильтр питания коллекторных цепей транзисторов  $T_2 = T_4$  микросхемы № 3. Его емкость согласно (3-19) должна быть  $C_{34} > (10 \div 20)/(200 \cdot 1500) = (33 \div 66) \cdot 10^{-6}$  Ф (берем элек-

тролитический конденсатор емкостью 50 мкФ).

13. Резисторы  $R_{22}-R_{23}$  образуют делитель напряжения для выходного сигнала звукоснимателя с коэффициентом деления  $\mathcal{A}=8$  (см. § 14-2). Чтобы резистор  $R_{23}$  не шунтировал существенно потенциометр РРГ  $R_{15}$ , примем его сопротивление равным 100 кОм. В этом случае для обеспечения требуемого деления следует взять  $R_{22}=(\mathcal{A}-1)R_{23}=(8-1)\cdot 10^5=7\cdot 10^5$  Ом (берсм резистор сопротивлением 680 кОм).

14. Параметры элементов схемы стабилизатора напряжения рассчитываются обычно приблизительно и уточняются в процессе налаживания приемника. Поэтому возьмем их соответствующими схеме приемника «Меридиан-202»:  $R_3=5.1$  кОм,  $R_4=2$  кОм и  $R_5=270$  Ом [24].

Таким образом, все параметры элементов схемы приемника для поддиапазона 2 определены. Аналогичным образом находятся параметры

элементов схемы для других поддиапазонов.

15. Определим ток питания приемника. Согласно табл. 14-2 максимальные токи микросхем соответственно равны 3, 4 и 5 мА. Ток питания добавочного каскада на транзисторе  $T_3$  равен 2.7 мА. При выходном сигнале 0,68 В на нагрузке выделяется мональном  $P_{\rm H} = 0.5 U_{\rm H}^2 / R_{\rm H} = (0.5 \cdot 0.68^2) / 6.5 = 0.0354 \, \text{Bt.}$ мощность ГОСТ 5651-76 потребляемая от автономного источника мощность определяется при выходной мощности, соответствующей 30 % номинальной,  $P_{\text{HOM}} = 9 \ \dot{P}_{\text{H}} = 9.0,0354 = 0.32 \ \text{Bt}, \text{ t. e. } \text{npn} \ P = 0.3 \cdot 0.32 = 0.1 \ \text{Bt}.$ Положим к. п. д. выходного каскада равным 0,6, что соответствует рабочему режиму каскада. При этом потребляемая от источника выходным каскадом мощность будет  $P_{0 \text{ вых}} = 0.1/0.6 = 0.18 \text{ Br}$ , чему соответствует потребляемый ток  $I_{\text{вых}} = 0.18/9 = 0.02 \text{ A}$ . Таким образом, полный ток питания приемника равен  $I_0 = 3+4+5+2,7+20 = 34,7$  мА, а потребляемая мощность  $P_0 = 9.0,0347 = 0.312$  Вт. что меньше допустимого.

Поскольку выбор элементов схемы выполнялся из условий обеспечения необходимых характеристик приемпика, то поверочного рас-

чета его характеристик можно не проводить.

### 1. ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ И ДИОДОВ

Таблица П-1-1

### Основные параметры транзисторов

Транзистор	Коэффициент передачи то- ка hži	Предельная частота f <sub>гр</sub> , МГц	Сопротивле- ние базы г <sub>6</sub> . Ом	С <sub>22</sub> , пФ	С12, пФ	IKEO MKA
Π402	0,94	50	100	14	6.0	15
П403	0,98	100	50	Liò	6,0 7,5	10
П416	0,99	120	50	9	7,0	5
П411	0,993	360	50	4,5	2,2	5 2 5 3 3
ГТ310Б	0,98	129	75	12	4	5
ГТ308В	0,993	400	50	4	1	3
ГТ313Б	0,993	600	50	4	L	3
ГТ403Б	0,985	1,0	100			
МП41А	0,97	1,4	150	4 <b>0</b> 0	40	20
КП302А		_	400	6	2,4	
КТ307Г	0,985	160	75	8	$  2 \rangle$	5 5
ҚТ319Г	0,99	50	120	10	3	5
КП350Б			400	3	0,05	

### Пр одолжение

	Po	жим при	измерен	и	Вт	_	
Транзистор	$U_{\mathrm{K}}(U_{\mathcal{C}})$	$I_{\rm K}^{(I_{\rm c})}$	$v_{\rm at}$ . B	$U_{32}$ . B	P K (P c), B	Ек тах, В	Ік шах, А
П402	5,0	1,0	_				
17403	5.0	1.0		_		_	
Π416	5,0 5,0	1,0					
Π411	5,0	1,0	_	-			
ГТ310Б	5,0 5,0	1,0					
ГТ308B	5,0	1,0					
ГТ313Б	5,0	1,0					
ГТ403Б	10	300			0,6/4	45	0,4/0.8
МП41А	10	10			0.15	20	0,05
ҚП302А	10	3	1		0,3	_	l –
КТ307Γ	.5	1	-			_	
ҚТЗ19Г	5	1					
КП350Б	10	5	り	0,5	-		_

 $\label{eq:Table} {\rm Tabrida} \ {\rm Tabrida} \ {\rm Theorem } 2.$  Проводимость  $g_{11}$  (мСм) при  $I_{\rm K}=1.0$  мД

frauguaron.	Частота, МГц								
Гранзистор	0,5	1	3	5	10	15	20		
П402	0,7	0,8	1,7	2,7	4,5	6,7	10		
П403	0,6	0,7	0,85	1.25	3,3	6,7	9		
П411	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,3	1,5		
П416	1,7	1,8	2	2,4	3,1	5	7,1		
ГТ310Б	0,5	0,5	0,6	0,7	2,3	3,9	5,6		
ГТ308В	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,5	2		
ГТ313Б	0,3	0,35	0,45	0,6	0,85	1,5	2		
ҚТ307Г	8,0	0,85	1, I	1,3	1,5	1,8	2		
ҚТ319Д	0,8	0,9	1,2	1,6	2,5	1,8	_		
ҚП302А					0,002	0,0025	0,003		
ҚП350Б	_				_	_	0,000		

### Продолжение

	Частота, МГд									
Транзистор	30	40	50	70	100	200	300			
		]					İ			
П 102				ļ		_	-			
П403	12,6				_	-	_			
17411	2,0	3,1	5	8	_	–				
П416	10,5	15	_		<u> </u>		_			
ГТ310Б	8,9	11	13	16		_				
ГТ308В	3	4	5	7,5	10	13	_			
ГТ313Б	3	4	5	6	8		<b>–</b>			
<b>КТ307Г</b>	2,8	4	5	_			_			
ҚТ319Д	_					_				
<b>ҚПЗ</b> 02 <i>A</i>	0,004	0,006	0,01	0,02	0,05	0,5	2,5			
<b>ҚП3</b> 50Б	100,0	0,002	0,005	0,01	0,1	0,3	1,25			
							•			

	Частога, МГ ц								
<b>Г</b> р игзи <b>стор</b>	0,5	ı	3	5	I	15	20		
Fue			00	90	.,,,,,	- 00	1500		
Π402	7	11	20	33	200	ā <b>0</b> 0	1500		
17403	9	10	13	16	49	80	150		
П411	9	9,5	10	16	20	50	125		
П416	10,5	11	12	15	50	75	140		
ГТ310Б	7	8	9	10	40	70	130		
ГТ308В	10	13	30	60	150	250	350		
ГТ313Б	8	10	15	30	60	100	150		
ҚП302А	2	3	5	10	17	22	30		
<b>КП3</b> 50Б	1	1,5	2	3	4	5	6		
ҚТ307Г	10	13	40	80	200	_	_		
ҚТ319Г	10	15	100	300	_	_	_		
КТ319Г	10	15	100	300	_		-		

Продолжение

	Частота, МГц								
Транзистор	30	40	50	70	100	200	300		
П402		_	_		_		-		
П403	220	_		_	_	_	_		
П411	170	250	330	500	800	_	_		
П416	210	<b>3</b> 50	500	-	-		_		
ГТ310Б	200	290	350	450	700	<b> </b>	_		
ГТ308В	430	550	650	750	900	1300	_		
ГТ313Б	200	280	400	550	750	1100			
ҚП302А	50	80	100	200	500	1600	8000		
КП350Б	7	8	10	50	200	700	1100		
<b>КТ</b> 307Г		_	-		_	_	_		
ҚТ319Г	_	_					_		

 ${\rm T} \ {\rm a} \ {\rm 6.7144} \ 4. \ {\rm \Pi} {\rm poводимость} \ \ Y_{21} \ \ ({\rm M} {\rm KCM}) \ {\rm пр} u \ I_{\rm K} = I \ {\rm MA}$ 

Гранзистор		Частота, МГц									
Гранзистор	0,5	1	3	5	10	15	20				
П402	30	30	30	30	29,5	29	24				
П403	31	31	31	31	30,5	29,5	26				
Π411	40	40	40	40	40	40	40				
П416	31	31	31	31	31	30	28				
ГТ310Б	26	26	26	26	25,5	25	24				
ГТ308В	35	35	<b>3</b> 5	<b>3</b> 5	<b>3</b> 5	34	33				
ГТ313Б	90	90	90	90	90	88	85				
МП41А	500	400	150		_						
<b>ҚП302</b> А	3	3	3	3	3	3	3				
ҚП <b>3</b> 50Б	6	6	6	6	6	6	6				
<b>КТ307Г</b>	22	22	22	21	18	16	14				
<b>КТ319Г</b>	20	20	18	14	10						

Продолжение

			Час	тота, МГ	`u		
Транзистор	30	40	50	70	100	200	300
Π402		_		_	_ ;		
П403	22	-	- 1	_		_	_
Г1411	37	34	30	28	_	1	
П416	25	23	- 1		_	!	
ГТ310Б	22	20	19	17	_	'	
ГТ308В	30	28	26	24	23	18 -	
ГТ313Б	80	75	65	55	42	25	17
мП41А	- 1	_			_	_	_
КП302А	3	3	3	3	2,9	2,7	
КП350Б	6	6	6	6	6	5,9	5,8
КТ <b>3</b> 07Г	11	_	- (	-	_	_	_
КТ319Г	_		_	_	_	_	

Таблица П-1-5

## 5. Емкость $C_{11}$ (пФ) при $I_{\rm K}\!=\!1$ мА

	Частота. МҐц								
Транзистор	0,5	I	3	5	10	15	20		
П402	160	150	135	130	110	85	80		
П403	150	140	125	120	115	90	84		
П411	33	32	31	30,5	30	30	30		
П416	130	125	120	101	92	84	78		
ГТ310Б	80	75	65	60	56	45	40		
ГТ308B	40	<b>i0</b>	40	40	40	40	40		
ГТ313Б	50	50	50	5 <b>0</b>	50	50	50		
МП41Λ	20 000			_					
КП302А	8	8	8	8	8	8	8		
КТ350Б	3	3	3	3	3	3	3		
КТ307Г	60	60	60	6 <b>0</b>	60	60	60		
КТ319Г	100	100	100	100					

### Продолжение

	Частота. МГц								
Транзистор	30	40	50	70	100	200	300		
П402					_				
IT403	78								
П411	28	26	22	21	20	~			
П416	70	66							
ГТ310Б	35	33	31	29					
ГТ308В	37	32	26	18	13	8	7		
ГТ313Б	47	38	32	24	18	10	8		
МП41А					'				
КП302А	8	8	8	8	8	8			
<b>ҚТ350Б</b>	3	3	3	3	3	3	3		
ŘΤ307Γ	60	60					- Jagerra		
<b>КТ319Г</b>									

Таблица П-1-6

### 6. Параметры точечных диодов

	Параметр								
Диод	$I_0 \leqslant MA$	S ≥, nCu	S <sub>oóp</sub> ≤, maGn	<i>U</i> обр' В	f <sub>max</sub> , ΜΓц	Сд≤, пФ			
ЛІА	16	2,5	0,025	20	150	ı			
Д1В	25	7.5	0,01	30 l	150	1			
Д1Е	12	10	0,0025	100	150	1			
Д2А	50	50	0,04	10	150	t			
Д2Е	16	10	0,0025	125	150	l			
.79A	25	10	0.025	10	80	1			
Д9Ж	15	10	-0.025	100 (	80	1			
ДК8А	15	10	0.025	10	80	1			

Таблица П-3-1 7. Шкала номинальных сопротивлений постоянных резисторов

	Д	(опустимы <b>е</b> отк.	лонения, 🥍	ó	
1.5	<u>+</u> 10	-t- 20	<u>1</u> 5	<u>-+</u> 10	<b>J.</b> 20
циницы,	десят	ки, сотни	ом и к	илоом, мет	аомы
1	I (	1	3,3	3,3	3,3
1,1		- 1	3,6	_	
1,2	1,2		3,9	3,9	
1,3			4,3		
1,5	1,5	1,5	4,7	4,7	4,7
1,6			5,1		
1,8	1,8		5,6	5,6	
2			6,2		
2,2	1,8 2,2 2,7	2,2	6,8	6,8	6,8
2,4			7,5		
1,8 2 2,2 2,4 2,7 3	2,7		4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1	8,2	-
3			9,1		
3	-	-	9,1	<u></u>	

Таблица П-3-2

### 8. Шкала номинальных емкостей конденсаторов

Допустимые отклонения, %								
<u>#</u> 5	± 10	<u>+</u> 20	± 5	<u>+</u> 10	± 20			
Едини	цы, десят	ки, сотн	интыс	чи пикоф	арад			
1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0	1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 2.7	1 - 1.5 - - 2,2 - -	3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.6 6.2 6.8 7.5 8,1	3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2	3,3 - - 4,7 - - 6,8 - -			
	i	Микроф:	арады					
0,010 0,012 0,015 0,018 0,022 0,027	0,010 0,012 0,015 0,018 0,022 0,027	0,010 0,015 0,022	0,33 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2	0,33 0,47 0,68 1,0 1.5 2,2	0,33 0,47 0,68 1,0 1,5 2,2			

	Д	опустимые от	клонения, %		
<u>t</u> 5	± 10	<u>±</u> 20	±5	± 10	± 20
0,033 0,039 0,047 0,056 0,068 0,082 0,1 0,15 0,22	0,033 0,039 0,047 0,056 0,068 0,082 0,1 0,15 0,22	0,033 0,047 0,068 0,1 0,15 0,22	3,3 4,7 6,8 10 15 22 33 47 68	3.3 4,7 6,8 10 15 22 33 47 68	3,3 4,7 6,8 10 15 22 33 47 68

II р и м е ч а и и е. Электролитические конденсаторы выпускаются с поминальными емкостями 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000 мкф.

 $\label{eq:Tadinu} T\ a\ d\ \pi\ u\ \mu\ a\ \Pi\mbox{-}4\mbox{-}1$  9. Блоки из двух конденсаторов переменной емкости

Марка	Диэлект- рик	С <sub>тіп</sub> ,	С <sub>тах</sub> , пФ	Емкость подстро- ечного конден- сатора, пФ	В каких прнемниках применяется
КПЕ КПЕ КПЕ КП4-3А КПЕ-3 КПТМ-1 КПТМ-4 КПЕ КПЕ-5	Воздух Воздух Воздух Твердый Твердый Твердый Твердый Твердый Твердый	12 10 9 6 6 6 6 5	495 365 270 200 250 260 260 120 240	2,5—7 2—8 2—12	Эфир-67, Родина-65 Спидола, ВЭФ-12 Альпинист Маяк, Микро, Эра Алмаз Рига-301 Орбита, Юпитер Сюрприз Сокол, Топаз-2

Таблица П-4-2 10. Емкости подстроечных керамических конденсаторов

Тип	Емкость, пФ						
КПК-1 ПКП-2	2-7 6-60	4—15 10—100	6—25 25—150	8-30 75-200	125—25 <b>0</b>		 275—375

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апериодические усилители на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет/Под редакцией Валитова Р. А. и Куликов. ского А. А. — М.: Советское радио, 1968. — 300 с. 2. Белов И. Ф., Дрызго Е. В. Справочник по транзисторным радио-

приемникам. — М.: Советское радио, 1970. — 519 с.

3. Радиоприемные устройства./Бобров Н. В., Максимов Г. В., Мичурин В. П. и др. — М.: Советское радио, 1971. — 496 с.

4. Расчет радиоприемников/Бобров Н. В., Максимов Г. В., Мичу-

рин В. И. и др. — М.: Воениздат, 1971. — 496 с.

- Бобров Н. В. Радиоприемные устройства. М.: Энергия, 1976. — 368 c.
- 6. Великан Я. Н., Гельмонт З. Я., Зеллах Э. В. Пьезокерамические фильтры. — М.: Связь, 1966. — 396 с.

Гозолинг В. Применение полевых транзисторов. — М.: Энергия,

1970. — 160 c.

8. Горшелев В. Д., Красноцветова З. Г., Федорцев Б. Ф. Основы проектирования радиоприемников. — М.: Энергия, 1977. — 384 с.

9. Гумеля Е. Б. Выбор схем транзисторных приемников. — М.:

Госэнергоиздат, 1963. — 75 с.

- 10. Гуткин Л. С., Лебедев В. А., Сифоров В. И. Радиоприемные устройства. — М.: Советское радио, ч. I, 1961. —703 с., ч. II, 1963. —
  - 11. Дольник А. Г. Громкоговорители. M.: Энергия, 1964. 32 с.
- 12. Екимов В. Д., Павлов К. М. Проектирование радиоприемных устройств. — М.: Связь, 1970. — 504 с.

13. Екимов В. Д. Расчет и конструирование транзисторных радио-

приемников. — М.: Связь, 1972. — 216 с. 14. Жеребцов И. П. Основы электроники. — М.: Энергия, 1974. —

- 15. Згут М. А. Условные обозначения и радиосхемы. М.: Энер-
- гия, 1964. 112 с. 16. Калихман С. Г., Левин Я. М. Основы теории и расчета радио-
- вещательных приемников на полупроводниковых приборах. М.: Связь, 1969. — 480 с.

17. Крупинин И. Т., Белкин А. И. Радиоприемники на транзисто-

рах. — М.: Энергия, 1974. — 128 с.

- 18. Куликовский А. А., Болошин И. А., Потрясай В. Ф. Основы учебного проектирования радиоприемников. — М.: Госэнергоиздат, 1956. — 250 c.
- 19. Левандовский Б. А. Шкалы и верньерные устройства. М.: Госэнергоиздат, 1952. — 64 с.

20. Левитин Е. А., Левитин Л. Е. Радновещательные приемники. -

М.: Энергия, 1967. — 367 с.

21 Ломанович В. Справочник по радиодеталям — М.: ДОСА АФ, 1966. — 63 с.

22. Маши Г., Фишер Г. Телевизновные приемники и приемные те-

левизионные антенны. — М.: Энергия, 1964. — 326 с.

23. Музыка З. Н., Пустоваров В. Е., Синицкий Б. Г. Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных устройств на траизисторах. -М.: Энергия, 1975. — 136 с.

24. Новоселов Л. Е. Транзисторные приемники «Спидола», «ВЭФ». «Океан». «Мериднан». — М.: Энергия, 1976. — 208 с.

25. Палшков В. В. Радиоприемные устройства. — М.: Связь, 1965. — 544 c.

26. Петров А. Н., Шматченко В. Ф. Полосовые электромеханиче-

ские фильтры радиочастот. — М.: Госэнергонздат, 1961. — 299 с.

27. Радиоприемные устройства на полупроводниковых приборах. Проектпрование и расчет/Под ред. Р. А. Валитова, А. А. Куликовского. — M.: Советское радио, 1968. — 384 с.

28. Рогинский И. Ю. Детали миниатюрной аппаратуры. — М.: Энер-

гия, 1971. — 120 с.

29. Синельников А. Х. Бестрансформаторные транзисторные усилители низкой частоты. — М.: Энергия, 1969. — 97 с.

30. Сифоров В. И. Радиоприемные устройства. — М.: Воениздат,

1954. — 804 c.

31. Справочник радиолюбителя/Под ред. А. А. Куликовского. — М.: Госэнергоиздат, 1961. — 500 с.

32. Транзисторы. Справочник/Под ред. И. Ф. Николаевского. -

М.: Связь, 1969. — 623 с.

33. Трохименко Я. К. Радноприемные устройства на гранзисторах. — К.: Техника, 1964. — 416 с.

34. Харченко К. П. УКВ аптенны. — М.: ДОСААФ, 1969. — 111 с.

35. Хомич В. И. Приемные ферритовые антенны. — М.: Госэнергоиздат, 1963. — 64 с.

36. Шуцкой К. А. Проектирование радиоприемников АМ и ЧМ

сигналов. — М.: Госэпергоиздат, 1958. — 128 с.

- 37. Фалькович С. Е., Музыка З. Н. Чувствительность радиоприемных устройств с транзисторными усилителями. — М.: Энергия, 1970. — 128 c.
- 38. Фрид Е. А., Азарх С. Х. Пьезокерамические фильтры. М.: Энергия, 1967. — 40 с.

39. Цыкин Г. С. Усилительные устройства. — М.: Связь, 1971. — 435 c.

40. Чистяков Н. И., Сидоров В. М. Радиоприемные устройства. -М.: Связь, 1974. — 408 с.

### оглавление

Гл	ава первая. Исходные данные для расчета радиопрнемника 1-1. Задачи расчета и принципы их решения	
	<ul> <li>1-2. Характеристики оконециого прибора и его выбор</li> <li>1-3. Характеристики принимаемых сигналов, помех присму и выбор приемной антенны.</li> </ul>	
Гл	1-4. Осиовные электрические характеристики приемника 1-5. Выбор и построение структурных схем приемников а в а в т о р а я. Расчет структурной схемы приемников АМС и ЧМС	1 1 1
	<ul> <li>2-1 Разбивка общего днапазона рабочих частот на подднапазоны</li> <li>2-2. Предварительный расчет выходного каскада</li> <li>2-3. Расчет структурной схемы инэкочастотного тракт.</li> </ul>	I 1 2
	<ul> <li>2-4. Расчет полосы пропускания приемпика</li> <li>2-5. Выбор типа транзисторов, селективных систем и схем каскадов тракта радиосигнала</li> </ul>	3
	2-6. Выбор промежуточной частоты и селективных систем приемника	6
	2-8. Выбор типа траизисторов и числа каскадов тракта промежу-	7 7
	<ul> <li>2-9. Проверка осуществимости регулировок</li> <li>2-10. Особенности расчета структурной схемы присмника с двойным преобразованием частогы</li> </ul>	7
	2-11. Особенности расчета сгруктурной схемы приемников ЧМС 2-12. Особенности расчета сгруктурной схемы комбинированных приемников АМС и ЧМС	8
Гл	и в а треть я. Расчег выходного каскада	9 9
	3-2. Расчет однотактного трансформаторного каскада 3-3. Расчет двухтактного трансформаторного каскада 3-4. Бестрансформаторные двухтактные каскады	9 9 10
ĺЛ	ва четвертая. Расчег усилителей напряжения низкочастот-	
	HOFO TPAKTA	10
	4-1. Псходные данные и задачи расчета	10
	4-3. Расчет резистивного каскада с общим коллектором	10
	1-4. Рясчет фазониверсных каскалов	10
ĺл	ва пятая. Расчет входных цепей	11
	5-1. Исходные данные и задачи расчета	11
	<ul> <li>5-2. Расчет одноконтурной входной цепи с постоянной настройкой</li> <li>5-3. Расчет одноконтурной входной цепи с трансформаторной связью с антенной при переменной настройке.</li> </ul>	11:
	5-4. Расчет одноконтурной входной цени с внешнеемкостной свя- зью с антенной при переменной настройке	11:
	5-5. Расчет входной цепи с переменной настройкой при магнитной антенне.  -6. Расчет входной цепи приемника «для охоты на лис»	120 125
Гл	ва шестая. Расчет усилителей радиосигнала	127
- *1	i-1. Исходиме данные и задачи расчета	127
	варикапом	128
	ление при постоянной настройке	131
	пропускания при постоянной настройке и заданном усиления Расчет резонаненого усилителя на заданный коэффиционт уси-	134
	ления и полосу пропускания при постоянной настройке	135

6-6. Расчет резистивного каскада	137
6-7. Расчет резонансного усилителя с переменной настройкой	138
Глава седьмая. Расчет усилителей сигнала промежуточной ча-	
стоты	142
7-1. Исходные данные и задачи расчета	142
7-2. Расчет каскадов резонансного усилителя	113
7-3. Расчет усилителя с расстроенными каскадами	113
7-4. Расчет усилителя с двумя связанными контурами	146
7-5. Расчет усилителя с ФСС	150
Глана восьмая. Расчет преобразователей частоты	153
8-1. Исходные данные и задачи расчета	153
8-2. Расчет преобразователя частоты с отдельным гетеродином	154
8-3. Расчет преобразователя частоты с совмещенным гетеродином	163
8-4. Мостовой диодими преобразователь частоты	170
Глава девятая. Расчет детекторов	173
9-1. Расчет диодных детекторов АМС	173
9-2. Исходиые данные и задачи расчета детекторов ЧМС	171
9-3. Расчет дифферсициального детектора ЧМС ,	174
у-4. Расчет дробного детектора ЧМС	170
Глава десятая. Расчет ограничителей амплитуды	177
10-1. Исходные данные и задачи расчета	1 7
10-2. Расчет диодного ограничитсяя амилитуды	178
10-3. Расчет транзисторного ограничителя амплитуды ,	181
13-4. Ограничительные способности дробного детектора	184
Глава одиннадцатая. Расчет автоматических регуляторов	
усиления	186
11-1. Формулирование исходных данных и задачи расчета	186
11-2. Расчет систем АРУ при изменении режима работы транзи-	
стора	186
11-3. Расчет АРУ при регулируемых межкаскадных связях	-195
Глава двенадцатая. Расчет ручных регуляторов и настроек	198
12-1. Исходные данные и задачи расчета	198
12-2. Расчет ручного регулятора громкости	198
12-3. Расчет регулятора полосы пропускания	200
12-4. Расчет элементов шкалы и верньерного устройства	201
12-5. Расчет элементов схем интания управляемых диодов	202
Глава тринадцатая. Расчет транзисторного радновещатель-	
ного приемника І класса	203
13-1. Исходные данные	203
13-2. Расчет структурной схемы	203
13-3. Расчет каскадов присмника	206
13-4. Поверочный расчет основных характеристик приемника	211
Глава четырнадцатая. Расчет приемника II класса на	
интегральных микросхемах	215
14-1. Выбор типа интегральных микросхем и обоснование струк-	
турной схемы	215
14-2. Составление принципиальной схемы приеминка	218
14-3. Расчет элементов схемы присмника, подключающихся к мик-	
росхемам	223
Приложение	230